1. **Kikuo Tominaga, Hidenori Fukumoto, Kumiko Kondo, Yukako Hayashi, Kei-ichiro Murai, Toshihiro Moriga *and* Ichiro Nakabayashi :** Al-impurity-doped Transparent Conductive Oxide Films of In2O3-ZnO System, *Vacuum,* **Vol.74,** *No.3-4,* 683-687, 2004.
2. **Kaoru Ohya, Yoshihiko Nakayama, Yoshitaka Hamada, Tetsuo Tanabe, Andreas Kirschner, Volker Philipps *and* Nobuaki Noda :** Modeling of Material Mixing Effects on Plasma Surface Interactions in Magnetic Fusion Devices, *Physica Scripta,* **Vol.T111,** 138-144, 2004.
3. **Kazuya Kusaka, Takao Hanabusa *and* Kikuo Tominaga :** Measurement of crystal orientation and residual stress in GaN film deposited by RF sputtering with powder target, *Vacuum,* **Vol.74,** *No.3-4,* 613-618, 2004.
4. **Tao Wang, J P Parbrook, N C Harrison, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Highly improved performance of a 350nm ultraviolet light-emitting diode containing AlxGa1-xN/AlyGa1-yN distributed Bragg reflectors, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.267,** *No.3-4,* 583-587, 2004.
5. **Retsuo Kawakami, Tomohisa Shimada, Yoshio Ueda *and* Masahiro Nishikawa :** Simulation Study of Dynamical Material Mixing on Tungsten Surfaces at Elevated Temperatures due to Hydrogen and Carbon Mixed Ion Beam Irradiation, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.329-333,** *No.0,* 737-741, 2004.
6. **Takenori Mitani, Retsuo Kawakami *and* Shuhei Kuriu :** Simulation Study of Sputtering Erosion and Impurity Deposition on Carbon and Tungsten Surfaces Irradiated with Deuterium Plasmas Including Carbon Impurity, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.329,** *No.329-333,* 830-835, 2004.
7. **Yoshio Ueda, Takahisa Funabiki, Tomohisa Shimada, Retsuo Kawakami *and* Masahiro Nishikawa :** Effects of Carbon Impurity in Fusion Plasmas on Erosion of RAF First Wall, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.329-333,** 771-774, 2004.
8. **Tomohisa Shimada, Takahisa Funabiki, Retsuo Kawakami, Yoshio Ueda *and* Masahiro Nishikawa :** Carbon Behavior on Tungsten Surface after Carbon and Hydrogen Mixed Beam Irradiation, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.329-333,** *No.0,* 747-751, 2004.
9. **Kazuhito Tajima, Shigeru Nakamura, Furukawa A. *and* Sasaki T. :** Hybrid-integrated Symmetric Mach-Zehnder all-optical switches and ultrafast signal processing, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.87,** *No.7,* 1119-1125, 2004.
10. **Yu-Huai Liu, Hong-Dong Li, Jin-Ping Ao, Young-Bae Lee, Tao Wang *and* Shiro Sakai :** Influence of undoped GaN layer thickness to the performance of AlGaN/GaN-based ultraviolet light-emitting diodes, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.268,** *No.1-2,* 30-34, 2004.
11. **Kazuya Kusaka, Takao Hanabusa, Kikuo Tominaga *and* Noriyoshi Yamauchi :** Effect of Substrate Temperature on Crystal Orientation and Residual Stress in Radio Frequency Sputtered Gallium-Nitride Films, *Journal of Vacuum Science & Technology A,* **Vol.22,** *No.4,* 1587-1590, 2004.
12. **Toshihiro Moriga, Yukako Hayashi, Kumiko Kondo, Yusuke Nishimura, Kei-ichiro Murai, Ichiro Nakabayashi, Hidenori Fukumoto *and* Kikuo Tominaga :** Transparent Conducting Amorphous Zn-Sn-O Films Deposited by Simultaneous DC Sputtering, *Journal of Vacuum Science & Technology A,* **Vol.22,** *No.4,* 1705-1710, 2004.
13. **Kaoru Ohya *and* Tohru Ishitani :** Monte Carlo simulation of topographic contrast in scanning ion microscope, *Journal of Electron Microscopy,* **Vol.53,** *No.3,* 229-235, 2004.
14. **Fawang Yan, Masashi Tsukihara, Akihiro Nakamura, Takayuki Yadani, Tetsuya Fukumoto, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Surface smoothing mechanism of AlN film by initially alternating supply of ammonia, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 2 (Letters),* **Vol.43,** *No.8B,* L1057-L1059, 2004.
15. **Yoshitaka Hamada, Shinji Ebisu *and* Kaoru Ohya :** Transition Behaviour between Erosion and Deposition on a Tungsten Surface Exposed to Deuterium Plasmas Containing Carbon Impurities, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.43,** *No.9A,* 6385-6391, 2004.
16. **Kaoru Ohya, Tetsuo Tanabe, Marek Rubel, Motoi Wada, Tadashi Ohgo, Takeshi Hirai, Volker Philipps, Andreas Kirschner, Albrecht Pospieszczyk, Alexander Huber, Genadij Sergienko, S. Brezinsek *and* Nobuaki Noda :** Modeling of erosion and deposition patterns on C-W and W-Ta twin limiters exposed to the TEXTOR edge plasmas, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.329-333,** *No.Part A,* 732-736, 2004.
17. **Kaoru Ohya *and* Tohru Ishitani :** Monte Carlo study of secondary electron emission from SiO2 induced by focused gallium ion beams, *Applied Surface Science,* **Vol.237,** *No.1-4,* 602-606, 2004.
18. **Kazuya Kusaka, Takao Hanabusa, Kikuo Tominaga *and* Noriyoshi Yamauchi :** Effect of substrate temperature on crystal orientation and residual stress in RF sputtered galium nitride films, *Materials Science Forum,* **Vol.490-491,** 613-618, 2005.
19. **Mitsuhiko Hataya, Takao Hanabusa, Kazuya Kusaka, Kikuo Tominaga *and* Tatsuya Matsue :** Residual stress measurement in sputtered copper thin films by synchrotron radiation and ordinary X-rays, *Materials Science Forum,* **Vol.490-491,** 661-668, 2005.
20. **Retsuo Kawakami :** Simulation Study on Influence of Chemically Eroded Carbon Impurity Transport on Net Sputtering Erosion of Carbon Materials Exposed to Edge Fusion Plasmas, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.44,** *No.2,* 1069-1075, 2005.
21. **森賀 俊広, 林 由佳子, 三河 通男, 村井 啓一郎, 富永 喜久雄 :** 第3世代透明導電性アモルファス薄膜の創製, *徳島大学工学部研究報告, No.50,* 7-12, 2005年.
22. **Kazuhiro Nishizono, Masaya Okada, Minoru Kamei, Daigo Kikuta, Kikuo Tominaga, Yasuo Ohno *and* Jin-Ping Ao :** Metal/Al-doped ZnO ohmic contact for AlGaN/GaN high electron mobility transistor, *Applied Physics Letters,* **Vol.84,** *No.20,* 3996-3998, 2004.
23. **Naotaka Kubota, Jin-Ping Ao, Daigo Kikuta *and* Yasuo Ohno :** Schottky Barrier Height Determination by Capacitance-Voltage Measurement on n-GaN with Exponential Doping Profile, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.43,** *No.7A,* 4159-4160, 2004.
24. **Tohru Ishitani *and* Kaoru Ohya :** Comparative study of scanning ion microscope and scanning electron microscope images using Monte Carlo simulations, *Microscopy and Microanalysis,* **Vol.10,** *No.Suppl 02,* 140-141, 2004.
25. **川上 烈生, 山上 喜廣, 富永 喜久雄, 服部 敦美, 來山 征士, 大野 泰夫 :** デジタル化・ネットワーク化時代の電気電子工学学生実験, *徳島大学高度情報化基盤センター「広報」,* **Vol.12,** 57-60, 2005年2月.
26. **Retsuo Kawakami *and* Mitani Takenori :** Simulation Study on Influence of Chemically Eroded Higher Hydrocarbons on SOL Impurity Transport and Effect of Dynamical Material Mixing on Erosion/Deposition of Tungsten Surfaces Exposed to Plasma Boundary, *16th International Conference on Plasma Surface interactions in Controlled Fusion Devices,* P1-29, Portland Maine, U.S.A., May 2004.
27. **Kazuya Kusaka, Takao Hanabusa, Kikuo Tominaga *and* Noriyoshi Yamauchi :** Effect of Substrate Temperature on Crystal Orientation and Residual Stress in RF Sputtered Gallium Nitride Films, *Proceedings of the 7th International Conference on Residual Stresses,* 613-618, Xi'an, Jun. 2004.
28. **Mitsuhiko Hataya, Takao Hanabusa, Kazuya Kusaka, Kikuo Tominaga, Tatsuya Matsue *and* Osami Sakata :** Residual Stress Measurement in Sputtered Copper Thin Films by Synchrotron Radiation and Ordinary X-rays, *Proceedings of the 7th International Conference on Residual Stresses,* 661-666, Xi'an, Jun. 2004.
29. **Daigo Kikuta, Ryohei Takaki, Junya Matsuda, Masaya Okada, Xin Wei, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Gate Leakage Reduction Mechanism of AlGaN/GaN MIS-HFETs, *2004 International Conference on Solid State Devices and Materials,* Tokyo, Sep. 2004.
30. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai *and* Ishitani Tohru :** Reconstruction of pseudo secondary electron images in scanning ion microscope, *15th International Workshop on Inelastic Ion Surface Collisions,* Mie, Japan, Oct. 2004.
31. **Michio Mikawa, Toshihiro Moriga, Yuji Sakakibara, Yukinori Misaki, Kei-ichiro Murai, Ichiro Nakabayashi *and* Kikuo Tominaga :** Preparation of ZnO-In2O3 transparent conducting films by pulsed laser depositon, *11th International Workshop on Oxide Electronics,* Hakone, Oct. 2004.
32. **Toshihiro Moriga, Michio Mikawa, Yuji Sakakibara, Yukinori Misaki, Kei-ichiro Murai, Ichiro Nakabayashi *and* Kikuo Tominaga :** Effects of introduction of argon on structural and transparent conducting properties of ZnO-In2O3 thin films prepared by pulsed laser deposition, *11th International Workshop on Oxide Electronics,* Hakone, Oct. 2004.
33. **Retsuo Kawakami :** Simulation Study on Effects of Chemically Eroded Methane and Ethylene Molecules on Carbon Impurity Transport and Net Erosion of Carbon Materials, *Joint Meeting of 14th Internaitional Toki Conference on Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion & 4th International Conference on Atomic and Molecular Data and Their Application,* 73, Toki, Oct. 2004.
34. **Yukako Hayashi, Kumiko Kondo, Yusuke Nishimura, Hiroshi Suketa, Kei-ichiro Murai, Toshihiro Moriga, Ichiro Nakabayashi *and* Kikuo Tominaga :** Characterizations of Transparent Conducting Amorphous ZnO-SnO2 Films Deposited by Opposed Target Sputtering System, *The 13th International Conference on Processing and Fabrication of Advanced Materials,* **Vol.1,** 209-218, Singapore, Dec. 2004.
35. **旗谷 充彦, 野田 和宏, 日下 一也, 富永 喜久雄, 英 崇夫, 松英 達也, 坂田 修身 :** ナノサイズCu薄膜の残留応力測定, *日本材料学会四国支部第5期総会·学術講演会講演論文集,* 5-6, 2004年4月.
36. **高木 亮平, 岡田 政也, 菊田 大悟, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETのサイドゲート効果における光の影響, *日本物理学会中四国支部，応用物理学会中四国支部，物理教育学会四国支部連絡協議会2004年度支部学術講演会,* 2004年7月.
37. **林 由佳子, 西村 勇介, 助田 祐志, 近藤 久美子, 森賀 俊広, 村井 啓一郎, 中林 一朗, 富永 喜久雄 :** ZnO-In2O3系アモルファス透明導電膜の評価, *第65回日本応用物理学会学術講演会,* 2004年9月.
38. **岡田 政也, 高木 亮平, 菊田 大悟, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET 電流電圧特性における光応答, *第65回応用物理学会学術講演会,* 2004年9月.
39. **川上 烈生 :** SOLプラズマ中の炭素不純物輸送への高次炭化水素CxDyの寄与, *平成16年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 39, 2004年9月.
40. **上田 良夫, 崎園 大, 沢村 功, 島田 朋尚, 川上 烈生, 西川 雅弘 :** タングステン第一壁上の炭素混合層の形成メカニズム, *プラズマ核融合学会 第20回年会 講演論文集,* 2004年11月.
41. **川上 烈生 :** プラズマ対向壁としての低放射化フェライト鋼F82Hの損耗特性, *平成17年電気学会全国大会講演論文集,* 222, 2005年3月.
42. **山上 喜廣, 川上 烈生, 富永 喜久雄, 岩崎 聡一郎, 松田 潤也 :** 電気回路の過渡現象に関する創成型学生実験への取り組みとその教育効果, *平成17年電気学会全国大会講演論文集,* 1, 2005年3月.
43. **富永 喜久雄, 林 由佳子, 森賀 俊広, 中林 一朗 :** ZnO-SnO2, ZnO-In2O3透明導電膜の作製と評価, *平成17年電気学会全国大会講演論文集,* **Vol.3,** 3-S19(1)-3-S19(2), 2005年3月.
44. **西村 勇介, 助田 祐志, 林 由佳子, 村井 啓一郎, 森賀 俊広, 中林 一朗, 富永 喜久雄 :** ZnO-SnO2系アモルファス透明導電膜へのAl，Gaドーピングの影響, *第52回応用物理学関連連合講演会,* 2005年3月.
45. **高木 亮平, 岡田 政也, 菊田 大悟, 敖 金平, 大野 泰夫 :** 熱酸化によるAlGaN/GaN MIS-HFETゲート電流の低減, *第52回応用物理学関係連合講演会,* 2005年3月.
46. **岡田 政也, 高木 亮平, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETしきい値電圧の温度及び光照射依存性, *第52回応用物理学関係連合講演会,* 2005年3月.
47. **川上 烈生 :** デタッチプラズマ照射下の炭素材から放出された炭素不純物の振舞いに関する研究, *平成16年度核融合科学研究所LHD数値解析システム利用共同研究報告書,* 日本, 2005年3月.
48. **富永 喜久雄 :** (共著)脱ITOに向けた透明導電膜の低抵抗・低温・大面積製膜技術, 株式会社 技術情報協会, 東京, 2005年7月.
49. **酒井 士郎, 高橋 清, 他 :** ワイドギャップ半導体光・電子デバイス, 森北出版 株式会社, 東京, 2006年2月.
50. **Kaoru Ohya, Tetsuo Tanabe, Andreas Kirschner, Takeshi Hirai, Volker Philipps, Motoi Wada, Tadashi Ohgo *and* Nobuaki Noda :** Dynamic transition between erosion and deposition on a tungsten surface exposed to edge plasmas containing carbon impurities, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.337-339,** 882-886, 2005.
51. **Retsuo Kawakami *and* Mitani Takenori :** Simulation Study on Influence of Chemically Eroded Higher Hydrocarbons on SOL Impurity Transport and Effect of Dynamical Material Mixing on Erosion/Deposition of Tungsten Surfaces Exposed to Plasma Boundary, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.337-339,** 45-49, 2005.
52. **Tao Wang, G Raviprakash, F Ranalli, N C Harrison, Jie Bai, R J P David, J P Parbrook, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Effect of Strain Relaxation and Exciton Localization on Performance of 350-nm AlInGaN Quantum Light-Emitting Diodes, *Journal of Applied Physics,* **Vol.97,** *No.8,* 083104-1-083104-4, 2005.
53. **Daigo Kikuta, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Evaluation of Surface States of AlGaN/GaN HFET Using Open-Gated Structure, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E88-C,** *No.4,* 683-689, 2005.
54. **Daigo Kikuta, Ryohei Takaki, Junya Matsuda, Masaya Okada, Xin Wei, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Gate Leakage Reduction Mechanism of AlGaN/GaN MIS-HFETs, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.44,** *No.4B,* 2479-2482, 2005.
55. **Kikuo Tominaga, Hidenori Fukumoto, Kumiko Kondo, Yukako Hayashi, Kei-ichiro Murai, Toshihiro Moriga *and* Ichiro Nakabayashi :** Amorphous Transparent Conductive Oxide Films of In2O3-ZnO with Additional Al2O3 Impurities, *Journal of Vacuum Science & Technology A,* **Vol.23,** *No.3,* 401-407, 2005.
56. **R.J. Choi, S. Kubo, M. Tsukihara, K. Inoue, Yoshiki Naoi, Katsushi Nishino *and* Shiro Sakai :** Effects of V/III flux ratio on AlInGaN/AlGaN quantum wells grown by atmospheric pressure MOCVD, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.2,** *No.7,* 2149-2152, 2005.
57. **Michio Mikawa, Toshihiro Moriga, Yuji Sakakibara, Yukinori Misaki, Kei-ichiro Murai, Ichiro Nakabayashi *and* Kikuo Tominaga :** Characterization of ZnO-In2O3 transparent conducting films by pulsed laser deposition, *Materials Research Bulletin,* **Vol.40,** *No.6,* 1052-1058, 2005.
58. **Fawang Yan, Yoshiki Naoi, Masashi Tsukihara, Takayuki Yadani *and* Shiro Sakai :** Interdiffusion induced In(Ga)NAs films growth on GaAs substrates by low-pressure metalorganic chemical vapor deposition, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.282,** *No.1-2,* 29-35, 2005.
59. **Toshihiro Moriga, Michio Mikawa, Yuji Sakakibara, Yukinori Misaki, Kei-ichiro Murai, Ichiro Nakabayashi *and* Kikuo Tominaga :** Effects of introduction of argon on structural and transparent conducting properties of ZnO-In2O3 thin films prepared by pulsed laser deposition, *Thin Solid Films,* **Vol.486,** *No.1,* 53-57, 2005.
60. **Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Dynamic Monte Carlo Simulation of Compositional and Topography Changes Induced by Ion Beam Irradiation, *e-Journal of Surface Science and Nanotechnology,* **Vol.4,** 32-38, 2006.
61. **Retsuo Kawakami, Tomohisa Shimada, Yoshio Ueda *and* Masahiro Nishikawa :** Influence of Carbon Impurity on Net Erosion of Reduced-Activation Ferritic/Martensitic Steel and Tungsten Materials Exposed to Hydrogen and Carbon Mixed Ion Beam Relevant to Fusion Plasma Boundary, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.45,** *No.1A,* 221-227, 2006.
62. **Takashi Okimoto, Masashi Tsukihara, Kazuhide Sumiyoshi, Ken Kataoka, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Effect of GaNP Buffer Layer on AlGaN Epilayers Deposited on (0001) Sapphire Substrates by Metalorganic Chemical Vapor Deposition, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 2 (Letters),* **Vol.45,** *No.8,* L236-L238, 2006.
63. **Kaoru Ohya, Tetsuo Tanabe *and* Jun Kawata :** Simulation of redeposition patterns of hydrocarbons released from carbon target in divertors, *Fusion Engineering and Design,* **Vol.81,** *No.1-7,* 205-210, 2006.
64. **Shinji Ebisu, Kaoru Ohya *and* Tetsuo Tanabe :** Dynamic erosion and deposition on carbon and tungsten sue to simultaneous bombardment with deuterium and beryllium ions in plasmas, *Fusion Engineering and Design,* **Vol.81,** *No.1-7,* 253-258, 2006.
65. **Retsuo Kawakami :** Simulation Study on Effects of Chemically Eroded Methane and Ethylene Molecules on Carbon Impurity Transport and Net Erosion of Carbon Materials, *Journal of Plasma and Fusion Research SERIES,* **Vol.7,** 94-97, 2006.
66. **Daigo Kikuta, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Gate leakage and electrical performance of AlGaN/GaN MIS-type HFET with evaporated silicon oxide layer, *Solid-State Electronics,* **Vol.50,** *No.3,* 316-321, 2006.
67. **Yoshiki Naoi, Hisao Sato, Hiroshi Yamamoto, Kodai Ono, Akihiro Nakamura, Masahiro Kimura, Suguru Nouda *and* Shiro Sakai :** Growth and fabrication of AlGaInN-based UV-LEDs using SiN nano-mask, *Proceedings of SPIE,* **Vol.5722,** 417-422, San Jose, Apr. 2005.
68. **Retsuo Kawakami :** Simulation study of carbon impurity dynamics on reduced-activation ferritic/martensitic steel material at elevated temperatures under hydrogen exposure, *7th International Symposium on Fusion Nuclear Technology,* 191, Tokyo, May 2005.
69. **Fawang Yan, Yoshiki Naoi, Masashi Tsukihara, Shuichi Kawamichi, Takayuki Yadani *and* Shiro Sakai :** Diffusion Effect Induced InAsN Films Growth on GaAs(100) Substrates by MOCVD, *The 23rd International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS-23),* TuP.79, Higashiura, Jul. 2005.
70. **Toshihiro Moriga, Yusuke Nishimura, Hiroshi Suketa, Kei-ichiro Murai, Kikuo Tominaga *and* Ichiro Nakabayashi :** Effects of Al, Ga -Doping on Transparent Conducting Properties of Amorphous ZnO -SnO2 Films, *Advanced Materials Development & Performance Conference 2005,* Auckland, Jul. 2005.
71. **Masaya Okada, Ryohei Takaki, Daigo Kikuta, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Temperature and Illumination Dependence of AlGaN/GaN HFET Threshold Voltage, *2005 Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Hyogo, Aug. 2005.
72. **Daigo Kikuta, Jin-Ping Ao, Junya Matsuda *and* Yasuo Ohno :** A Mechanism of Enhancement-mode Operation of AlGaN/GaN MIS-HFET, *2005 Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Hyogo, Aug. 2005.
73. **Yoshiki Naoi, Akihiro Nakamura, Kodai Ono, Hisao Sato, H Yamamoto, M Mikura, Suguru Nouda *and* Shiro Sakai :** Impurity induced disordering of p-type AlGaN-GaN Superlat-tice Structures, *6th International Conference on Nitride Semiconductors,* Th-P-023, Bremen, Aug. 2005.
74. **Kazuhide Sumiyoshi, Masashi Tsukihara, Fawang Yan *and* Shiro Sakai :** AlGaN Films grown on trenched sapphire substrates using a low-temperature GaNP buffer layer by MOCVD, *6th international conference on nitride semiconductors,* Tu-P-089, Bremen, Germany, Aug. 2005.
75. **Jin-Ping Ao, Ryota Kan, Toshio Hirao, Hideki Okada, Masaya Okada, Daigo Kikuta, Shinobu Onoda, Hisayoshi Itoh *and* Yasuo Ohno :** Gamma Radiation Effects on the Ohmic Contact of AlGaN/GaN HEMTs, *2005 International Conference on Solid State Devices and Materials,* 478-479, Kobe, Sep. 2005.
76. **Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Dynamic Monte Carlo simulation of Compositional and Topography Changes Induced by Ion Beam irradiation, *International Symposium on Surface Science and Nanotechnology,* Saitama, Japan, Nov. 2005.
77. **Kaoru Ohya *and* Kensuke Inai :** Simulation of redeposition patterns in the gaps between divertor tiles, *12th International Conference on Fusion Reactor Materials,* California, USA, Nov. 2005.
78. **Y Sumiyoshi, Masashi Tsukihara, Ken Kataoka, Kiyoshi Okimoto, Shuichi Kawamichi, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** High-quality AlGaN film grown on the patterned sapphire substrate using a low-temperature intermediate layer by MOCVD, *International COE Workshop on Nano Processes and Devices, and Their Applications,* 75-76, Nagoya University, Dec. 2005.
79. **榊原 友士, 高田 望美, 三河 通男, 村井 啓一郎, 森賀 俊広, 中林 一朗, 富永 喜久雄 :** PLD法によるサファイア基板上へのZnO-In2O3系透明導電膜の作製と評価, *第52回応用物理学関連連合講演会,* 2005年4月.
80. **菊田 大悟, 敖 金平, 松田 潤也, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN MIS-HFET のエンハンスメント動作, *第52回応用物理学関係連合講演会,* 2005年4月.
81. **助田 祐志, 西村 勇介, 高田 大輔, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** ポリカーボネート基板上に作製したZnO-In2O3系 アモルファス透明導電膜, *日本物理学会中国支部·四国支部 応用物理学会中国四国支部 2005年度支部学術講演会,* 2005年7月.
82. **川上 烈生 :** 炭素不純物を含む水素イオンで照射されたタングステン材表面の付着炭素不純物の振舞い, *第66回秋季応用物理学会学術講演会論文集, No.2,* 630, 2005年9月.
83. **月原 政志, 住吉 和英, 閻 発旺, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 高品質AlGaNへ向けての低温成長AlGaN層の検討, *第66回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* 274, 2005年9月.
84. **直井 美貴, 中村 晃啓, 小野 耕大, 酒井 士郎, 木村 真大, 納田 卓 :** p-AlGaN/GaN 超格子構造における不純物ドーピングによる混晶化, *第66回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* 279, 2005年9月.
85. **住吉 和英, 月原 政志, 河道 修一, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 低温GaNPバッファー層を用いた加工サファイア基板上のAlGaN MOCVD成長, *第66回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* 269, 2005年9月.
86. **閻 発旺, 住吉 和英, 月原 政志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** MOCVD法によるサファイア基板上へのSb添加AlNの成長, *第66回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* 269, 2005年9月.
87. **菅 良太, 平尾 敏雄, 小野田 忍, 伊藤 久義, 岡田 英輝, 岡田 政也, 菊田 大悟, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET電気特性へγ線照射の影響, *第66回応用物理学会学術講演会,* 2005年9月.
88. **松田 潤也, 菊田 大悟, 敖 金平, 大野 泰夫 :** 周波数可変カーブトレーサを用いたAlGaN/GaN MIS-HFETヒステリシスの解析, *第66回応用物理学会学術講演会,* 2005年9月.
89. **榊原 友士, 石田 勝也, 三河 通男, 村井 啓一郎, 森賀 俊広, 富永 喜久雄 :** PLD法によりc-サファイア基板上に作製したZnO-In2O3系透明導電膜の評価, *第66回応用物理学会学術講演会,* 2005年9月.
90. **三河 通男, 榊原 友士, 石田 勝也, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** PLD法により作製したZnO-In2O3系透明導電膜の構造·特性に及ぼす基板の影響, *第66回応用物理学会学術講演会,* 2005年9月.
91. **高田 大輔, 富永 喜久雄, 西村 勇介, 助田 祐志, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** Al2O3不純物添加 アモルファスZnO-In2O3系透明導電膜の特性, *第66回応用物理学会学術講演会,* 2005年9月.
92. **山本 真美子, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** フラックス法によるBP結晶成長, *電気関係学会四国支部連合大会,* 151, 2005年9月.
93. **河道 修一, 住吉 和英, 月原 政志, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 加工サファイア上に成長したAl0.07Ga0.93N薄膜の透過型電子顕微鏡による評価, *電気関係学会四国支部連合大会,* 150, 2005年9月.
94. **沖本 聖, 月原 政志, 住吉 和英, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** AlGaN-MOCVD成長における GaNPバッファ層の効果, *電気関係学会四国支部連合大会,* 149, 2005年9月.
95. **松田 義和, 菅 良太, 山岡 優哉, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET構造を用いたショットキーダイオード, *平成17年度電気関係学会四国支部連合大会,* 2005年9月.
96. **川上 烈生 :** 非平衡プラズマの自己組織化とドライエッチングとの関連性, *平成17年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 36, 2005年9月.
97. **住吉 和英, 酒井 士郎, 直井 美貴, 西野 克志 :** 窒化物半導体と紫外発光デバイス, *第7回IEEE広島支部学生シンポジウム(HISS),* 2005年11月.
98. **山本 真美子, 月原 政志, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** フラックス成長BP結晶上へのGaN成長, *第53回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* **Vol.22,** 346, 2006年3月.
99. **住吉 和英, 月原 政志, 沖本 聖, 河道 修一, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 低温中間層を用いた加工サファイア基板上のAl0.17Ga0.83N MOCVD成長, *第53回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* **Vol.25,** 378, 2006年3月.
100. **河道 修一, 西野 克志, 住吉 和英, 月原 政志, 酒井 士郎 :** 凹凸サファイア基板上に成長させたAlGaN薄膜の反転ドメイン, *第53回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* **Vol.25,** 379, 2006年3月.
101. **池田 賢司, Choi Rak-Jun, 福本 哲也, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎, Lee Min Soo, 小池 正好 :** AlInN-buffer層上のALEによるa面GaNの高品質化, *第53回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* **Vol.26,** 401, 2006年3月.
102. **石田 勝也, 榊原 友士, 三河 通男, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** PLD法により作製したZnO-In2O3系二層膜の特性評価, *第53回応用物理学関係連合講演会,* 2006年3月.
103. **助田 祐志, 西村 勇介, 瀧田 啓介, 高田 大輔, 下村 幸司, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** ZnO-In2O3系透明導電膜における特性のGa2O3ドーパントの添加量依存性, *第53回応用物理学関連連合講演会,* 2006年3月.
104. **松浦 一暁, 菊田 大悟, 敖 金平, 扇谷 浩通, 平本 道広, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** SiCl4ガスを用いたICP-RIEによるAlGaN/GaN HFETのゲートリセスエッチング, *第53回応用物理学関係連合講演会,* 2006年3月.
105. **敖 金平, 長岡 史郎, 岩崎 聡一郎, 岡田 政也, 大巻 雄治, 大野 泰夫 :** EB露光CuゲートAlGaN/GaN HFETの高周波特性, *第53回応用物理学関係連合講演会,* 2006年3月.
106. **川上 烈生 :** SOLプラズマ中の炭素不純物によるタングステン材表面の損耗変化に関する研究, *平成17年度核融合科学研究所LHD数値解析システム利用共同研究報告書,* 日本, 2006年3月.
107. **富永 喜久雄 :** ZnO系の最新技術と応用, 株式会社 シーエムシー出版, 東京, 2007年1月.
108. **Shiro Sakai, Kiyoshi Takahash *and* al. et :** Wide Bandgap Semiconductors, Nippon Gakujyutsu-shinnkoukai, Feb. 2007.
109. **Kikuo Tominaga, Ito Daisuke *and* Miyamoto Yoshinori :** Energetic negative ions in titanium oxide deposition by reactive sputtering in Ar/O2, *Vacuum,* **Vol.80,** 654-657, 2006.
110. **Retsuo Kawakami :** Simulation study of carbon impurity dynamics on reduced-activation ferritic/martensitic steel material at elevated temperatures under hydrogen exposure, *Fusion Engineering and Design,* **Vol.81,** *No.8-14,* 1683-1687, 2006.
111. **Masaya Okada, Ryohei Takaki, Daigo Kikuta, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Temperature and Illumination Dependence of AlGaN/GaN HFET Threshold Voltage, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E89-C,** *No.7,* 1042-1046, 2006.
112. **Daigo KIKUTA, Jin-Ping Ao, Junya MATSUDA *and* Yasuo Ohno :** A Mechanism of Enhancement-mode Operation of AlGaN/GaN MIS-HFET, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E89-C,** *No.7,* 1031-1036, 2006.
113. **Kaoru Ohya :** Dynamic simulation of erosion and redeposition on plasma-facing materials, *Physica Scripta,* **Vol.T124,** 70-75, 2006.
114. **F.W. Yan, Yoshiki Naoi, M. Tsukihara, S. Kawamichi, T. Yadani, K. Sumiyoshi *and* Shiro Sakai :** Diffusion effect-induced InNAs films growth on GaAs(100) substrates by MOCVD, *Physica B : Condensed Matter,* **Vol.376-377,** 595-597, 2006.
115. **Retsuo Kawakami :** Simulation Study of Carbon Impurity Dynamics on Tungsten Surfaces Exposed to Hydrogen Ions, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.348,** 256-262, 2006.
116. **Toshihiro Moriga, Yusuke Nishimura, Hiroshi Suketa, Kei-ichiro Murai, Kazuhiro Nogami, Kikuo Tominaga *and* Ichiro Nakabayashi :** Effects of Al, Ga-Doping on Transparent Conducting Properties of Amorphous ZnO-SnO2 Films, *International Journal of Modern Physics B,* **Vol.20,** *No.25-27,* 3902-3907, 2006.
117. **Shuichi Kawamichi, Katsushi Nishino, Kazuhide Sumiyoshi, Masashi Tsukihara, Fanwang Yan *and* Shiro Sakai :** Inversion domain in AlGaN films grown on patterned sapphire substrate, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.298,** 297-299, 2007.
118. **Katsushi Nishino, A. Sakamoto *and* Shiro Sakai :** Growth of thich a-plane GaN on r-plane sapphire by direct synthesis method, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.4,** *No.7,* 2532-2535, 2007.
119. **Kazuhide Sumiyoshi, Masashi Tsukihara, Ken Kataoka, Shuichi Kawamichi, Tadashi Okimoto, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Al0.17Ga0.83N film with Middle Temperature Intermediate Layer Grown on Trenched Sapphire Substrate by MOCVD, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.298,** *No.SI,* 300-304, 2007.
120. **K. Sumiyoshi, M. Tsukihara, K. Kataoka, S. Kawamichi, T. Okimoto, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Al0.17Ga0.83N Film Using Middle-Temperature Intermediate Layer Grown on (0001) Sapphire Substrate by Metal-Organic Chemical Vapor Deposition, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.46,** *No.2,* 491-495, 2007.
121. **M Tsukihara, K Sumiyoshi, T Okimoto, K Kataoka, S Kawamichi, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Effect of middletemperature intermediate layer on crystal quality of AlGaN grown on sapphire substrates by metal organic chemical vapor deposition, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.300,** *No.1,* 190-193, 2007.
122. **Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Monte Carlo Simulation of Hydrocarbon Redeposition on a Graphite Surface in Hydrogen Plasma, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.46,** *No.3A,* 1149-1156, 2007.
123. **Fawang Yan, Katsushi Nishino *and* Shiro Sakai :** Growth and Characteristics of GaN Film on Thin AlN/(0001) Sapphire Template Layer via Direct Reaction of Gallium and Ammonia, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 2 (Letters),* **Vol.45,** *No.27,* L697-L700, 2006.
124. **Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Hydrocarbon Redeposition in the plasma shadowed area and the gaps between diveroter tiles, *17th International Conference on Plasma Surface Interactions,* Hefei, China, May 2006.
125. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Tanabe T. *and* Takenaga H. :** Modeling of asymmetric redeposition distribution between inner and outer regions of the W-shaped divertor in JT-60U, *17th International Conference on Plasma Surface Interactions,* Hefei, China, May 2006.
126. **R.J. Choi, Shiro Sakai, Yoshiki Naoi, Katsushi Nishino, M. Koike *and* S.M. Lee :** Efficient non-polar a-plane light-emitting-diodes grown using AlInNbuffer and intermediate layer, *6th International Symposium on Blue Laser and Light Emitting Diodes,* Montpellier, May 2006.
127. **K. Sumiyoshi, M. Tsukihara, K. Kataoka, S. Kawamichi, T. Okimoto, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Al0.17Ga0.83N film with middle temperature intermediate layer grown on trenched sapphire substrate by MOCVD, *13th International Conference on Metal Organic Vapor Phase Epitaxy,* Miyazaki, May 2006.
128. **K. Ikeda, R.J. Choi, T. Fukumoto, K. Ono, Yoshiki Naoi, Katsushi Nishino *and* Shiro Sakai :** Visible light emitting diode using a-plane GaN on r-sapphire substrate with an InAlN buffer layer and a high temperature atomic layer epitaxy, *13th International Conference on Metal Organic Vapor Phase Epitaxy,* Miyazaki, May 2006.
129. **S. Kawamichi, Katsushi Nishino, K. Sumiyoshi, M. Tsukihara *and* Shiro Sakai :** Inversion domains in AlGaN films grown on patterned sapphire substrate, *13th International Conference on Metal Organic Vapor Phase Epitaxy,* Miyazaki, May 2006.
130. **M. Tsukihara, K. Sumiyoshi, T. Okimoto, K. Kataoka, S. Kawamichi, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Effect of middletemperature intermediate layer on crystal quality of AlGaN grown on sapphire substrates by metal organic chemical vapor deposition, *First International Symposium on Growth of III-Nitrides,* Linkoping, Jun. 2006.
131. **K. Matsuura, D. Kikuta, Jin-Ping Ao, H. Ogiya, M. Hiramoto, H. Kawai *and* Yasuo Ohno :** ICP Reactive Ion Etching with SiCl4 Gas for Recessed Gate AlGaN/GaN HFET, *The 2006 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2006),* Yokohama, Sep. 2006.
132. **Yoshiki Naoi, K. Ono, K. Ikeda, R.J. Choi, T. Fukumoto, Katsushi Nishino, Shiro Sakai, M. Koike *and* S.M. Lee :** Blue light emitting diode fabricated on a-plane GaN film over r-sapphire substrate and on a-plane bulk GaN substrate, *International Workshop on Nitride Semiconductors 2006,* Kyoto, Oct. 2006.
133. **Yoshiki Naoi, K. Ikeda, T. Hama, R.J. Choi, Katsushi Nishino, Shiro Sakai, M. Koike *and* S.M. Lee :** Investigation of InGaN films on a-plane GaN grown by metal organic chemical vapor deposition technique, *International Workshop on Nitride Semiconductors 2006,* Kyoto, Oct. 2006.
134. **Katsushi Nishino, A. Sakamoto *and* Shiro Sakai :** Growth of Thick a-plane GaN on r-plane Sapphire by Direct Synthesis Method, *International Workshop on Nitride Semiconductors 2006,* Kyoto, Oct. 2006.
135. **Jin-Ping Ao, Yoshikazu Matsuda, Yuya Yamaoka *and* Yasuo Ohno :** A Monolithic Cockcroft-Walton Voltage Multiplier Based on AlGaN/GaN HFET Structure, *International Workshop on Nitride Semiconductors 2006,* Kyoto, Oct. 2006.
136. **Masaya Okada, Kazuaki Matsuura, Jin-Ping Ao, Yasuo Ohno *and* Hiroji Kawai :** High-Sensitivity UV Phototransistor with GaN/AlGaN/GaN Gate Epi-Structure, *International Workshop on Nitride Semiconductors 2006,* Kyoto, Oct. 2006.
137. **Toshihiro Moriga, Hiroshi Suketa, Keisuke Takita, Daisuke Takada, Koji Shimomura, Kei-ichiro Murai *and* Kikuo Tominaga :** Transparent Conducting Amorphous ZnO-In2O3 Films Deposited on PC or PET Substrates, *American Vacuum Society 53rd International Symposium and Exhibition,* San Francisco, Nov. 2006.
138. **Kikuo Tominaga, Hiroshi Suketa, Keisuke Takita, Daisuke Takada, Koji Shimomura, Kei-ichiro Murai *and* Toshihiro Moriga :** Transparent Conductive Oxide Films of In2O3-ZnO with Additional Ga2O3 Impurities, *American Vacuum Society 53rd International Symposium and Exhibition,* San Francisco, Nov. 2006.
139. **Toshihiro Moriga, Katsuya Ishida, Akira Taki, Hirotaka Ohno, Yuji Sakakibara, Kei-ichiro Murai, Michio Mikawa *and* Kikuo Tominaga :** Characterization of ZnO-In2O3/ZnO Laminated Thin Films Prepared by Pulsed Laser Deposition, *American Vacuum Society 53rd International Symposium and Exhibition,* San Francisco, Nov. 2006.
140. **Retsuo Kawakami *and* Inaoka Takeshi :** Analysis of GaN Etching Damage by Capacitively Coupled RF Ar Plasma Exposure, *Proceedings of International Symposium of Dry Process,* 63-64, Nagoya, Nov. 2006.
141. **K. Ikeda, R. Matsuoka, T. Hama, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi, Shiro Sakai, M. Koike *and* S.M. Lee :** An a-GaN and an a-InGaN on r-Sapphire by Relatively High Temperature Metal organic Chemical Vapor Deposition, *The 3rd Asia-Pacific Workshop on Widegap Semiconductors,* Jeonju, Mar. 2007.
142. **谷口 太一, 井内 健介, 大宅 薫 :** 炭化水素分子の再付着分布への表面反射の影響, *第6回核融合エネルギー連合講演会,* 2006年6月.
143. **井内 健介, 大宅 薫 :** ダイバータタイル隙間の炭化水素再付着シミュレーション, *応用物理学会中国四国支部・日本物理学会中国支部四国支部・日本物理教育学会四国連絡会議2006年支部学術講演会,* 2006年7月.
144. **瀧田 啓介, 助田 祐志, 高田 大輔, 下村 幸司, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** 有機基板上に製膜したZnO-In2O3系透明導電性薄膜の特性, *応用物理学会中国四国支部 日本物理学会 中国支部・四国支部 日本物理教育学会 四国連絡会議 2006年度支部学術講演会,* 2006年7月.
145. **瀧 旭, 山口 喬史, 大野 裕孝, 三河 通男, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** PLD法によりガラス基板上に作製した積層型透明導電膜の特性評価, *応用物理学会中国四国支部 日本物理学会 中国支部・四国支部 日本物理教育学会 四国連絡会議 2006年度支部学術講演会,* 2006年7月.
146. **濱 敬重, 南部 紗織, 沖本 聖, 月原 政志, 片岡 研, 住吉 和英, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 高Al組成窒化物系UV-LED用Ni/Au系透明電極の解析, *応用物理学会中国四国支部，日本物理学会中国支部・四国支部，日本物理教育学会四国連絡会議2006年度支部学術講演会講演予稿集,* 137, 2006年7月.
147. **沖本 聖, 月原 政志, 住吉 和英, 片岡 研, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎, 酒井 士郎 :** 低温成長層の導入によるAlGaNの高品質化, *応用物理学会中国四国支部，日本物理学会中国支部・四国支部，日本物理教育学会四国連絡会議2006年度支部学術講演会講演予稿集,* 142, 2006年7月.
148. **住吉 和英, 月原 政志, 片岡 研, 沖本 聖, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 低温中間層による凸凹サファイア基板上Al0.17Ga0.83NのMOCVD, *応用物理学会中国四国支部，日本物理学会中国支部・四国支部，日本物理教育学会四国連絡会議2006年度支部学術講演会講演予稿集,* 143, 2006年7月.
149. **仁木 貴敏, 月原 政志, 沖本 聖, 住吉 和英, 片岡 研, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 中間温度成長AlGaN層と多重量子井戸(MQW)層によるMOCVD成長AlGaN中の転位低減, *応用物理学会中国四国支部，日本物理学会中国支部・四国支部，日本物理教育学会四国連絡会議2006年度支部学術講演会講演予稿集,* 144, 2006年7月.
150. **稲岡 武, 川上 烈生 :** 低温プラズマエッチングされたn-GaNのショットキー接合リーク電流特性, *日本物理学会中国四国支部 応用物理学会中国四国支部 平成18年度支部例会講演論文集,* 24, 2006年7月.
151. **川上 烈生, 稲岡 武 :** 容量結合型高周波プラズマによるGaNエッチングの解析, *日本物理学会中国四国支部 応用物理学会中国四国支部 平成18年度支部例会講演論文集,* 23, 2006年7月.
152. **川上 烈生, 稲岡 武 :** 容量性結合ArプラズマによるGaNエッチングダメージの解析, *第67回秋季応用物理学会学術講演会論文集, No.1,* 162, 2006年8月.
153. **助田 祐志, 瀧田 啓介, 高田 大輔, 下村 幸司, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** 有機基板上に作製したZnO-In2O3系アモルファス透明導電膜の特性, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
154. **西野 克志, 坂本 旭, 酒井 士郎 :** 直接合成法によるr面サファイア上へのバルクa-GaN成長, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
155. **西野 克志, 宮村 高史, 酒井 士郎 :** TMA添加直接合成法によるバルクAlGaNの結晶成長, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
156. **岡田 政也, 松浦 一暁, 敖 金平, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** GaNキャップ層ピエゾ電荷を用いたエンハンスメントモードAlGaN/GaN HFET, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
157. **石尾 隆幸, 岡田 政也, 敖 金平, 廣瀬 和之, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETしきい電圧の温度依存性の測定, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
158. **山岡 優哉, 岡田 政也, 敖 金平, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETしきい電圧のゲートストレスバイアス依存性, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
159. **池田 賢司, Rakjun Choi, 福本 哲也, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎, 小池 正好, S.M. Lee :** a面成長InGaN/GaN LEDにおけるInGaN活性層の解析, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
160. **谷口 太一, 井内 健介, 大宅 薫 :** 炭化水素分子の再付着分布への表面反射の影響(Ⅱ), *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* 2006年9月.
161. **片岡 研, 沖本 聖, 仁木 貴敏, 住吉 和英, 月原 政志, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** SiNを用いたAlInGaN系紫外LED高出力化の検討, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年9月.
162. **濱 敬重, 小野 耕大, 池田 賢司, Rakjun Choi, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎, S.M. Lee, 小池 正好 :** a面バルクGaNおよびr面サファイア上a面GaNに作製した青色発光ダイオード, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年9月.
163. **菅 良太, 佐藤 弘明, 敖 金平, 小中 信典, 入谷 忠光, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器を用いたチップ間ミリ波信号伝送, *2006年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2006年9月.
164. **川上 烈生, 稲岡 武 :** 非平衡RFプラズマの自己組織化構造とドライエッチングとの相関性, *平成18年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 16, 2006年9月.
165. **金子 悠祐, 小林 利成, 村井 寛幸, 宮本 佳典, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** RFスパッタリング法によるTiO2薄膜の作製とその評価, *化学工学会 徳島大会,* 2006年10月.
166. **井内 健介, 戎 真志, 大宅 薫 :** イオン反射とスパッタリングのMDシミュレーション, *プラズマ・核融合学会，第23回年会,* 2006年11月.
167. **岡田 政也, 国貞 雅也, 敖 金平, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** GaN/AlGaN/GaNフォトトランジスタを用いたUVセンサ回路, *2007年電子情報通信学会総合大会,* 2007年3月.
168. **奥山 祐加, 菅 良太, 佐藤 弘明, 小中 信典, 粟井 郁雄, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器無線接続における位置ずれの影響, *2007年電子情報通信学会総合大会,* 2007年3月.
169. **松岡 遼, 池田 賢司, 濱 敬重, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎, Rakjun Choi, S.M. Lee, 小池 正好 :** MOCVDにより直接高温成長した高品質a面GaN・InGaN結晶成長, *第54回応用物理学会学術講演会,* 2007年3月.
170. **金子 悠祐, 小林 利成, 村井 寛幸, 宮本 佳典, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** RFスパッタリング法により作製したTiO2:NbおよびTiO2:Ta薄膜の熱処理効果, *第54回応用物理学関連連合講演会,* 2007年3月.
171. **井上 研一, 富永 喜久雄, 続木 貴志, 三河 通男, 森賀 俊広 :** PLD法によるIn-Ga-Zn系酸化物透明導電性薄膜, *第54回応用物理学関係連合講演会講演予稿講集,* **Vol.2,** 704, 2007年3月.
172. **富永 喜久雄, 高田 大輔, 下村 孝司, 助田 裕志, 瀧田 啓介, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** In2O3-ZnO系透明導電膜へのGa2O3添加の影響, *第54回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,* **Vol.2,** 704, 2007年3月.
173. **瀧田 啓介, 助田 裕志, 高田 大輔, 下村 孝司, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** PCおよびPET基板に常温で成膜したZnO-In2O3系アモルファス透明導電膜の特性, *第54回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,* **Vol.Vol.2,** 704, 2007年3月.
174. **井内 健介, 大宅 薫 :** タイル隙間の 炭化水素堆積分布のシミュレーション, *第21回トライアム研究会&核融合フォーラムサブクラスター会合合同研究会,* 2006年8月.
175. **川上 烈生 :** プラズマの自己組織化と材料の損耗特性との関連性に関する研究, *平成18年度核融合科学研究所LHD数値解析システム利用共同研究報告書,* 日本, 2007年3月.
176. **川上 烈生 :** ITERのプラズマ対向壁材としてのタングステンの可能性に関する研究, *平成17-18年度科学研究費補助金, 若手研究(B),* 日本, 2007年3月.
177. **酒井 士郎, 他 :** 化合物半導体の最新技術 大全集, 株式会社 技術情報協会, 東京, 2007年4月.
178. **Kaoru Ohya *and* Tohru Ishitani :** Focused Ion Beam Systems; Basics and Applications, Cambridge University Press, Cambridge, Sep. 2007.
179. **Kazuaki Matsuura, Daigo Kikuta, Jin-Ping Ao, Hiromichi Ogiya, Michihiro hiramoto, Hiroji Kawai *and* Yasuo Ohno :** Inductively Coupled Plasma Reactive Ion Etching with SiCl4 Gas for Recessed Gate AlGaN/GaN Heterostructure Field Effect Transistor, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.46,** *No.4B,* 2320-2324, 2007.
180. **M Yamamoto, Y Hamazaki, M Tsukihara, Yoshiki Naoi, Katsushi Nishino *and* Shiro Sakai :** Growth of AlN and GaN by metalorganic chemical vapor deposition on BP synthesized by flux method, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 2 (Letters),* **Vol.46,** *No.14,* L323-L325, 2007.
181. **Masaya Okada, Kazuaki Matsuura, Jin-Ping Ao, Yasuo Ohno *and* Hiroji Kawai :** High-sensitivity UV phototransistor with GaN/AlGaN/GaN gate epi-structure, *Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science,* **Vol.204,** *No.6,* 2117-2120, 2007.
182. **Jin-Ping Ao, Yoshikazu Matsuda, Yuya Yamaoka *and* Yasuo Ohno :** A monolithic Cockcroft-Walton voltage multiplier based on AlGaN/GaN HFET structure, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.4,** *No.7,* 2654-2657, 2007.
183. **Yoshiki Naoi, K. Ikeda, T. Hama, K. Ono, R. Choi, T. Fukumoto, Katsushi Nishino, Shiro Sakai, S. M. Lee *and* M. Koike :** Blue light emitting diode fabricated on a-plane GaN film over r-sapphire substrate and on a-plane bulk GaN substrate, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.4,** *No.7,* 2810-2813, 2007.
184. **Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Simulation of hydrocarbon redeposition in the gaps between divertor tiles, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.363-365,** 915-919, 2007.
185. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Tetsuo Tanabe *and* Hidenobu Takenaga :** Modeling of asymmetric redeposition distribution between inner and outer regions of the W-shaped divertor in JT-60U, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.363-365,** 78-85, 2007.
186. **Kensuke Inai, Kaoru Ohya *and* Tohru Ishitani :** Simulation study on image contrast and spatial resolution in helium ion microscope, *Journal of Electron Microscopy,* **Vol.56,** *No.5,* 163-169, 2007.
187. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Nisawa Koji *and* Itoh Akio :** Emission statistics of X-ray induced photoelectrons and its comparison with electron- and ion-induced electron emissions, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms,* **Vol.266,** 541-548, 2007.
188. **Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Minamoto Shingo *and* Kikuhara Yasuyuki :** Analysis of GaN Etching Damage by Capacitively Coupled RF Ar Plasma Exposure, *Thin Solid Films,* **Vol.516,** *No.11,* 3478-3481, 2008.
189. **Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Simulation of Hydrocarbon Redeposition on Plasma Shadowed Areas, *Contributions to Plasma Physics,* **Vol.48,** *No.1-3,* 275-279, 2008.
190. **Cheng-Yu Hu, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Annealing with Ni for ohmic contact formation on ICP-etched p-GaN, *Electronics Letters,* **Vol.44,** *No.2,* 155-157, 2008.
191. **Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Simulation of Hydrocarbon Redeposition on Plasma Shadowed Areas, *11th International Workshop on Plasma Edge Theory in Fusion Devices,* Gifu, May 2007.
192. **Shimomura Kouji, Kikuo Tominaga, Takada Daisuke, Suketa Hiroshi, Takita Keiji, Kei-ichiro Murai *and* Toshihiro Moriga :** In2O3-ZnO transparent conductive oxide film deposition on polycarbonate substrate, *Proc. of the nineth International Symposium on Sputtering & Plasma Processes,* 445-448, Kanazawa, Jun. 2007.
193. **Kikuo Tominaga, Takada Daisuke, Shimomura Kouji, Suketa Hiroshi, Takita Keisuke, Kei-ichiro Murai *and* Toshihiro Moriga :** Influence of additional ga2O3 on transparent conductive oxide films of In2O3-ZnO, *Proc. of the nineth International Symposium on Sputtering & Plasma Processes,* 449-452, Kanazawa, Jun. 2007.
194. **Retsuo Kawakami *and* Inaoka Takeshi :** Effect of Argon Plasma Etching Damage on Electrical Characteristics, *Proceedings of 9th International Symposium of Sputtering & Plasma Processes,* 391-394, Kanazawa, Jun. 2007.
195. **Inoue Kenichi, Kikuo Tominaga, Tsuduki Takashi, Mikawa Michio *and* Toshihiro Moriga :** Film deposition of transparent conductive In-Ga-Zn oxides by PLD method, *Proc. of the nineth International Symposium on Sputtering & Plasma Processes,* 441-444, Kanazawa, Jun. 2007.
196. **Kikuo Tominaga, Miyamoto Yoshinori, Ohkura Shinya, Kazuya Kusaka *and* Takao Hanabusa :** Comparison of film depositions of anatase TiO2 by planar magnetron sputtering with opposed Ti targets and conventional Ti targets, *The 20th Symposium on Plasma Science for Materials,* 108, Nagoya, Jun. 2007.
197. **Mikawa Michio, Kikuo Tominaga, Inoue Kenichi, Tsuduki Takashi *and* Toshihiro Moriga :** Influence of additional impurities on the properties of In-Zn-O transparent conductive oxide films, *The 20th Symposium on Plasma Science for Materials,* 110, Nagoya, Jun. 2007.
198. **Jin-Ping Ao, Yuya Yamaoka, Masaya Okada, Cheng-Yu Hu *and* Yasuo Ohno :** Investigation on Current Collapse of AlGaN/GaN HFET by Gate Bias Stress, *2007 Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Chiba, Aug. 2007.
199. **Cheng-Yu Hu, K. Matsuura, Masaya Okada, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Ohmic Contact for Dry-Etched p-GaN Realized by High Temperature Annealing, *2007 Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Chiba, Aug. 2007.
200. **Ryosuke Sumitomo, Kaoru Ohya, Hitoshi Tanaka *and* Fuji Ren :** Designing of Campus Information Navigator based on Human-Machine Dialog, *IEEE NLP-KE2007 Poster Session,* 111-116, Beijing, Aug. 2007.
201. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Hideaki Kuwada, Teruyuki Hayashi *and* Misako Saitoh :** Dynamic simulation of secondary electron emission and charging up of an insulating material, *6th Asian-Europian International Conference on Plasma Surface Engineering,* Nagasaki, Sep. 2007.
202. **Kensuke Inai, Yasuyuki Kikuhara *and* Kaoru Ohya :** Comparison of carbon deposition on plasma-exposed tungsten between molecular dynamics and dynamic Monte Carlo simulation, *6th Asian-Europian International Conference on Plasma Surface Engineering,* Nagasaki, Sep. 2007.
203. **T Okimoto, M Tsukihara, K Kataoka, A Kato, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** GaN- and AlGaN-based UV-LEDs on Sapphire by Metalorganic Chemical Vapor Deposition, *The 34th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS 2007),* Kyoto, Oct. 2007.
204. **Cheng-Yu Hu, Jin-Ping Ao, M. Okada, M. Sugimoto, T. Uesugi, T. Kachi *and* Yasuo Ohno :** Low Resistance Ohmic Contact Formation to Dry-Etched p-GaN, *The 34th International Symposium on Compound Semiconductors,* Kyoto, Oct. 2007.
205. **M Tohno, T Okimoto, Yoshiki Naoi, Katsushi Nishino, Shiro Sakai, T Kusuura, A Mitra, S Nouda, M Kimura, S Kawano *and* Y Muramoto :** GaN-LED's on nano-etched sapphire substrate by metal organic chemical vapor deposition, *The first International conference on White Light-Emitting Diodes(LEDs) and Solid State Lighting (SSL),* Tokyo, Nov. 2007.
206. **Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi *and* Mukai Takashi :** Synergy effect of Particle and Ultraviolet Radiations from Capacitively Coupled RF Argon Plasmas on n-GaN Etching Damage, *Proceedings of International Symposium of Dry Process,* 181-182, Tokyo, Nov. 2007.
207. **Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** EDDY code and PIC sheath code, *Workshop on Theory and Simulation of Boundary Plasmas,* Gifu, Mar. 2008.
208. **續木 貴志, 富永 喜久雄, 井上 研一, 三河 通男, 森賀 俊広 :** PLD法によるIn-Ga-Zn-O酸化物透明導電性薄膜, *平成19年度電気関係学会四国支部連合大会講演予稿集,* 130, 2007年9月.
209. **井上 研一, 富永 喜久雄, 續木 貴志, 三河 通男, 森賀 俊広 :** 不純物添加によるIn-Zn-O系酸化物透明導電膜の特性への影響, *平成19年度電気関係学会四国支部連合大会講演予稿集,* 123, 2007年9月.
210. **坂本 晃彦, 富永 喜久雄, 下村 幸司, 瀧田 啓介, 森賀 俊広, 中林 一朗 :** 1In2O3-ZnO系酸化物透明導電膜へのGa2O3添加による影響, *平成19年度電気関係学会四国支部連合大会講演予稿集,* 131, 2007年9月.
211. **岡田 健司, 富永 喜久雄, 大倉 信也 :** 不平衡マグネトロンスパッタ法と対向型マグネトロンスパッタ法によるTiO2膜の作製, *平成19年度電気関係学会四国支部連合大会講演予稿集,* 129, 2007年9月.
212. **下村 幸司, 富永 喜久雄, 高田 大輔, 助田 祐志, 瀧田 啓介, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** PC基板上へのIn2O3-ZnO系酸化物透明導電膜の作製, *平成19年度電気関係学会四国支部連合大会講演予稿集,* 127, 2007年9月.
213. **大倉 信也, 富永 喜久雄, 岡田 健司, 納田 隆弘, 白石 健太郎 :** 対向型マグネトロンスパッタリング法によるTiO2薄膜作製と光触媒の評価, *平成19年度電気関係学会四国支部連合大会講演予稿集,* 124, 2007年9月.
214. **川上 烈生, 稲岡 武 :** 容量結合型アルゴンプラズマエッチングダメージによるn-GaNの電子的特性, *第68回秋季応用物理学会学術講演会論文集, No.1,* 178, 2007年9月.
215. **大野 泰夫, 山岡 優哉, 岡田 政也, 胡 成余, 敖 金平 :** ゲートストレスバイアスによるAlGaN/GaN MIS HFETの電流コラプス評価, *第68回応用物理学会学術講演会,* 2007年9月.
216. **野久 保宏幸, 岡田 政也, 胡 成余, 敖 金平, 大野 泰夫 :** GaN MISダイオードによる絶縁膜界面評価, *第68回応用物理学会学術講演会,* 2007年9月.
217. **澤田 剛一, 新海 聡子, 敖 金平, 岡田 政也, 胡 成余, 廣瀬 和之, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** n‐GaNへの高温処理ZrN電極ショットキー特性, *第68回応用物理学会学術講演会,* 2007年9月.
218. **胡 成余, 岡田 政也, 敖 金平, 大野 泰夫 :** Ni処理を用いたドライエッチp‐GaNへの低抵抗オーミック形成, *第68回応用物理学会学術講演会,* 2007年9月.
219. **敖 金平, 澤田 剛一, 新海 聡子, 岡田 政也, 胡 成余, 廣瀬 和之, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** TiNゲートAlGaN/GaN HFETの特性評価, *第68回応用物理学会学術講演会,* 2007年9月.
220. **富永 喜久雄, 宮本 佳典, 大倉 信也, 岡田 健司 :** 対向型マグネトロン(PM)スパッタ法と不平衡PMスパッタ法によるTiO2膜の作製, *第68回応用物理学会学術講演会講演予稿集,* **Vol.2,** 638, 2007年9月.
221. **富永 喜久雄, 三河 通男, 井上 研一, 続木 貴志 :** In-Zn-Oアモルファス透明導電膜への不純物添加の影響, *第68回応用物理学会学術講演会講演予稿集,* **Vol.2,** 666, 2007年9月.
222. **遠野 充明, 沖本 聖, 加藤 篤, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎, 楠浦 崇央, ミトラ アヌパム :** ナノ・エッチングしたサファイア上へのGaNのMOCVD成長, *第68回応用物理学会学術講演会,* 2007年9月.
223. **奥山 祐加, 柏原 俊彦, 敖 金平, 粟井 郁雄, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器を用いたチップ間マイクロ波信号伝送, *2007年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2007年9月.
224. **遠野 充明, 沖本 聖, 直井 美貴, 西野 克志, 楠浦 崇央, ミトラ アヌパム, 納田 卓, 木村 真大, 川野 俊輔, 村本 宣彦 :** ナノ・エッチングしたサファイア基板上へのGaN-LEDのMOCVD成長, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* **Vol.11-5,** 2007年9月.
225. **加藤 篤, 月原 政志, 片岡 研, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** UV-LED用高Al組成AlGaN結晶の高品質化に関する研究, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* **Vol.11-11,** 2007年9月.
226. **松岡 遼, 池田 賢司, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** オフ角r面サファイア基板上にMOCVD法によるa面GaNのX線回折による評価, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* **Vol.11-14,** 2007年9月.
227. **仁木 貴敏, 片岡 研, 月原 政志, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** MOCVD成長AlGaNのMgドーピングによる結晶性への影響, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* **Vol.11-22,** 2007年9月.
228. **南部 紗織, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** AlGaN系紫外LEDのエレクトロルミネッセンスの温度特性, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* **Vol.11-11,** 2007年9月.
229. **沖本 聖, 遠野 充明, 南部 紗織, 北村 政治, 月原 政志, 片岡 研, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** AlGaN系紫外発光ダイオードの光出力に及ぼす電極形状の影響に関する研究, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* **Vol.11-29,** 2007年9月.
230. **川上 烈生, 稲岡 武 :** 容量結合型高周波プラズマナノプロセスリアクタの開発と放電及び分光特性, *平成19年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 18, 2007年9月.
231. **菊原 康之, 井内 健介, 大宅 薫 :** タングステン表面への炭素再堆積のMDシミュレーション, *プラズマ・核融合学会24回年会,* 2007年11月.
232. **井内 健介, 大宅 薫 :** プラズマ照射のないタイル表面への炭化水素再付着のシミュレーション, *プラズマ・核融合学会，第24回年会,* 2007年11月.
233. **大宅 薫, 井内 健介, 二澤 宏司, 伊藤 秋男 :** 1-100keV単色X線照射による金属の二次電子放出シミュレーション, *プラズマ・核融合学会，第24回年会,* 2007年11月.
234. **瀧田 啓介, 渡邊 隆之, 下村 幸司, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** PC基板上に製膜した酸化亜鉛-酸化インジウム系アモルファス薄膜へのAlドーピングによる特性向上, *第46回セラミックス基礎科学討論会,* 2008年1月.
235. **大宅 薫 :** プラズマ対向壁の損耗・再堆積のシミュレーション, *核融合エネルギーフォーラム 周辺&ペデスタル物理クラスタ会合,* 2008年2月.
236. **伊藤 秀起, 高橋 健介, 原内 貴司, 岡田 政也, 胡 成余, 敖 金平, 河合 弘治, 篠原 真毅, 丹羽 直幹, 大野 泰夫, 井川 裕介 :** マイクロ波整流用GaNショットキーダイオードの特性評価, *2008年電子情報通信学会総合大会,* 2008年3月.
237. **岡田 健司, 富永 喜久雄, 大倉 信也 :** RF-DC結合形スパッタ法と対向型スパッタ法によるTiO2薄膜の作製, *第55回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,* **Vol.2,** 610, 2008年3月.
238. **坂本 晃彦, 富永 喜久雄, 下村 幸司, 植野 貴大, 瀧田 啓介, 渡邊 隆之, 森賀 俊広, 中林 一朗 :** In2O3-ZnO系酸化物透明導電膜へのGa2O3添加の影響, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
239. **續木 貴志, 富永 喜久雄, 井上 研一, 三河 通男, 森賀 俊広, 中林 一朗 :** PLD法によるIn-Ga-Zn系酸化物透明導電性薄膜, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
240. **坂本 晃彦, 富永 喜久雄, 下村 幸司, 植野 貴大, 瀧田 啓介, 渡辺 隆之, 森賀 俊広, 中林 一郎 :** In2O3-ZnO系酸化物透明導電膜へのGa2O3添加の影響, *第55回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,* **Vol.2,** 640, 2008年3月.
241. **松岡 遼, 沖本 聖, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 金属蒸着膜を使ったAlGaN on GaN/Sapphireの選択MOCVD成長, *2008年(平成20年)春季第55回応用物理学会連合講演会,* 29p-B-18, 2008年3月.
242. **胡 成余, 敖 金平, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** p-基板層付きAlGaN/GaN HFETのVt-Vsub特性, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
243. **高橋 健介, 伊藤 秀起, 原内 貴司, 岡田 政也, 胡 成余, 敖 金平, 河合 弘治, 篠原 真毅, 丹羽 直幹, 大野 泰夫, 井川 裕介 :** GaNを用いたマイクロ波整流用ショットキーバリアダイオード, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
244. **R Matsuoka, K Ikeda, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Chracterization of a-plane MOCVD-grown GaN on off-angle r-plane sapphire substrates, *26th Electronic Materials Symposium (EMS-26),* **Vol.E12,** Jul. 2007.
245. **K Kataoka, M Tsukihara, T Niki, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** The segragation and saturation phenomena of Mg concentration in AlGaN, *26th Electronic Materials Symposium (EMS-26),* **Vol.H7,** Jul. 2007.
246. **北村 政治, 沖本 聖, 遠野 充明, 南部 紗織, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 340nm帯ナイトライド系 UV-LEDの自己発熱と電流集中効果による発光特性への影響, *第1回フロンティア研究センターシンポジウム,* **Vol.P1,** 2007年12月.
247. **松岡 遼, 池田 賢司, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** オフ角r面サファイア上MOCVD成長a面GaNのX線回折評価, *第1回フロンティア研究センターシンポジウム,* **Vol.P2,** 2007年12月.
248. **遠野 充明, 沖本 聖, 直井 美貴, 西野 克志, 酒井 士郎, 楠浦 崇央, ミトラ アムパム, 納田 卓, 木村 真大, 川野 俊輔, 村本 宣彦 :** ナノ微細加工サファイア基板上へのGaN系発光ダイオードの作製, *第1回フロンティア研究センターシンポジウム,* **Vol.P3,** 2007年12月.
249. **川上 烈生 :** 高周波プラズマの自己組織化と材料損耗特性との相関性, *平成19年度核融合科学研究所LHD数値解析システム利用共同研究報告書,* 日本, 2008年3月.
250. **川上 烈生 :** 窒化物系半導体デバイスのためのプラズマ誘因ダメージレスナノプロセス装置の研究開発, *平成19年度教育研究等支援事業(学長裁量経費)報告書,* 日本, 2008年3月.
251. **Retsuo Kawakami *and* Inaoka Takeshi :** Effect of Argon Plasma Etching Damage on Electrical Characteristics of Gallium Nitride, *Vacuum,* **Vol.83,** *No.3,* 490-492, 2008.
252. **Masaya Okada, Hideki Ito, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Mechanism of AlGaN/GaN Heterostructure Field-Effect Transistor Threshold Voltage Shift by Illumination, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.47,** *No.4,* 2103-2107, 2008.
253. **T Okimoto, M Tsukihara, K Kataoka, A Kato, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** GaN- and AlGaN-based UV-LEDs on Sapphire by Metalorganic Chemical Vapor Deposition, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.5,** *No.9,* 3066-3068, 2008.
254. **Cheng-Yu Hu, Jin-Ping Ao, Masaya Okada *and* Yasuo Ohno :** A Study on Ohmic Contact to Dry-Etched p-GaN, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E91-C,** *No.7,* 1020-1024, 2008.
255. **Jin-Ping Ao, Yuya Yamaoka, Masaya Okada, Cheng-Yu Hu *and* Yasuo Ohno :** Investigation on Current Collapse of AlGaN/GaN HFET by Gate Bias Stress, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E91-C,** *No.7,* 1004-1008, 2008.
256. **Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Kuwahara Akinobu, Kikuo Tominaga *and* Mukai Takashi :** Synergy Effect of Particle Radiation and Ultraviolet Radiation from Capacitively Coupled Radio Frequency Argon Plasmas on n-GaN Etching Damage, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.47,** *No.8,* 6863-6866, 2008.
257. **Kensuke Inai, Yasuyuki Kikuhara *and* Kaoru Ohya :** Comparison of carbon deposition on tungsten between molecular dynamics and dynamic Monte Carlo simulation, *Surface & Coatings Technology,* **Vol.202,** *No.22-23,* 5374-5378, 2008.
258. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Hideaki Kuwada, Teruyuki Hayashi *and* Misako Saito :** Dynamic simulation of secondary electron emission and charging up of an insulating material, *Surface & Coatings Technology,* **Vol.202,** *No.22-23,* 5310-5313, 2008.
259. **Toshihiro Moriga, Koji Shimomura, Daisuke Takada, Hiroshi Suketa, Keisuke Takita, Kei-ichiro Murai *and* Kikuo Tominaga :** In2O3-ZnO transparent conductive oxide film deposition on polycarbonate substrates, *Vacuum,* **Vol.83,** *No.3,* 557-560, 2008.
260. **Kikuo Tominaga, Daisuke Takada, Koji Shimomura, Hiroshi Suketa, Keisuke Takita, Kei-ichiro Murai *and* Toshihiro Moriga :** Influence of Ga2O3 addition on transparent conductive oxide films of In2O3-ZnO, *Vacuum,* **Vol.83,** *No.3,* 561-563, 2008.
261. **Kenichi Inoue, Kikuo Tominaga, Takashi Tsuduki, Michio Mikawa *and* Toshihiro Moriga :** The properties of transparent conductive In-Ga-Zn oxide films produced by pulsed laser deposition, *Vacuum,* **Vol.83,** *No.3,* 552-556, 2008.
262. **Yasuo Ohno *and* Jin-Ping Ao :** Future Applications of GaN Electron Devices, *Semiconductor Technology,* **Vol.33,** *No.12,* 72-74, 2008.
263. **Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Refractory Metal Nitride Schottky Contact on GaN, *Semiconductor Technology,* **Vol.33,** *No.12,* 75-79, 2008.
264. **Kaoru Ohya, Takuya Yamanaka, Kensuke Inai *and* Tohru Ishitani :** Comparison of secondary electron emission in helium ion microscope with gallium ion and electron microscopes, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms,* **Vol.267,** *No.4,* 584-589, 2009.
265. **大宅 薫, 相良 明男 :** 今，核融合炉の壁が熱い! 第3回 III. 壁の表面で何が起きているか, *日本原子力学会誌,* **Vol.50,** *No.8,* 511-515, 2008年8月.
266. **酒井 士郎 :** 短波長LEDチップを用いた白色照明, *光学,* **Vol.38,** *No.3,* 127-131, 2009年3月.
267. **Yasuyuki Kikuhara, Kensuke Inai, Atsushi Ito, Hiroaki Nakamura *and* Kaoru Ohya :** Hydrocarbon Reflection and Redeposition on Plasma-Facing Surfaces, *2nd Japan-China Workshop on Blanket and Tritium Technology,* 38-41, Sendai, Japan, May 2008.
268. **Kaoru Ohya, Yasuyuki Kikuhara, Kensuke Inai, Andreas Kirschner, D. Borodin, Atsushi Ito, Hiroaki Nakamura *and* Tetsuo Tanabe :** Simulation of hydrocarbon reflection from carbon and tungsten surfaces and its impact on codeposition patterns on plasma facing components, *18th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* Toledo, Spain, May 2008.
269. **Kensuke Inai, Kaoru Ohya, Yukihiro Tomita, Andreas Kirschner, A. Litnovsky *and* Tetsuo Tanabe :** Simulation of redeposition of carbon/hydrocarbon on a material surface with castellated structures, *18th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* Toledo, Spain, May 2008.
270. **Daiji Kato, Takahiro Kenmotsu, Kaoru Ohya *and* Tetsuo Tanabe :** Excited state distribution of reflected hydrogen atoms at metal surfaces - Development of theoretical models -, *18th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* Toledo, Spain, May 2008.
271. **Kazuo Hoshio, Mitsunori Toma, M. Furuibayashi, Akiyoshi Hatayama, Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Numerical Analysis of Incident Angle of Heavy Metal Impurity to Plasma Facing Components by IMPGYRO, *18th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* Toledo, Spain, May 2008.
272. **Mitsunori Toma, Kazuo Hoshino, Kensuke Inai, M. Ishida, Akiyoshi Hatayama *and* Kaoru Ohya :** Coupled IMPGYRO-EDDY simulation of tungsten impurity transport in tokamak geometry, *18th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* Toledo, Spain, May 2008.
273. **Kikuo Tominaga, Tsuduki Takashi, Inoue Ken-ichi, Mikawa Michio *and* Toshihiro Moriga :** Film properties of amorphous transparent conductive In-Ga-Zn oxides deposited on fuzed quartz by the PLD method, *14th International Conference on Solid Films and Surfaces,* 329, Dublin, Jul. 2008.
274. **Okada Kenji, Kikuo Tominaga, Retsuo Kawakami, Ohkura Shinya, Kazuya Kusaka *and* Takao Hanabusa :** Deposition of photocatalytic tiO2 films by planar magnetron sputtering system with opposed Ti targets, *14th International Conference on Solid Films and Surfaces,* 331-332, Dublin, Jul. 2008.
275. **Ryo Matsuoka, Takashi Okimoto, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** AlGaN epitaxial lateral overgrowth on Ti-evaporated GaN/sapphire substrate, *Second International Symposium on Growth of III-Nitrides,* MO-44, Izu, Jul. 2008.
276. **Kensuke Inai, Kaoru Ohya, Gakushi Kawamura *and* Yukihiro Tomita :** An EDDY-PIC Simulation of Codeposition of Hydrocarbon Isotopes on Castellated Structure of Plasma Facing Tiles, *14th International Congress on Plasma Physics,* Fukuoka, Sep. 2008.
277. **Yasuyuki Kikuhara, Kensuke Inai, Kaoru Ohya, Atsushi Ito *and* Hiroaki Nakamura :** Molecular dynamics simulation of hydrocarbon reflection of carbon and tungsten in realistic surface condition, *14th International Congress on Plasma Physics,* Fukuoka, Sep. 2008.
278. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Yasuyuki Kikuhara, T. Nakano, Jun Kawada, Hayato Kawazome, Yoshio Ueda *and* Tetsuo Tanabe :** Transport of heavy hydrocarbon and its redeposition on plasma facing walls, *14th International Congress on Plasma Physics,* Fukuoka, Sep. 2008.
279. **Mitsunori Toma, Kazuo Hoshino, Kensuke Inai, M. Ishida, Akiyoshi Hatayama *and* Kaoru Ohya :** Analysis of the high-Z impurity transport in a tokamak by the IMPGYRO code, *14th International Congress on Plasma Physics,* Fukuoka, Sep. 2008.
280. **Kaoru Ohya :** Modeling of hydrocarbon transport and redeposition in gaps, *11th ITPA meeting on SOL/divertor physics,* Nagasaki, Sep. 2008.
281. **Kaoru Ohya, Takuya Yamanaka, Kensuke Inai *and* Tohru Ishitani :** Comparison of secondary electron emission in helium ion microscope with gallium ion and electron microscopes, *17th International Workshop on Inelastic Ion-Surface Collisions,* Porquerolles, France, Sep. 2008.
282. **K. Takahashi, Jin-Ping Ao, Y. Ikawa, C. -Y. Hu, H. Kawai, N. Shinohara, N. Niwa *and* Yasuo Ohno :** GaN Schottky Diodes for Microwave Power Rectification, *The 2008 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2008),* Tsukuba, Sep. 2008.
283. **Cheng-Yu Hu, Katsutoshi Nakatani, Daigo Kikuta, Masahiro Sugimoto, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** VT-VSUB Characterization of AlGaN/GaN HFET with Regrown Epi-layer on p-GaN, *The 2008 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2008),* Tsukuba, Sep. 2008.
284. **Yuka Okuyama, Jin-Ping Ao, Ikuo Awai *and* Yasuo Ohno :** Wireless Inter-Chip Signal Transmission by Electromagnetic Coupling of Open-Ring Resonators, *The 2008 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2008),* Tsukuba, Sep. 2008.
285. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Yasuyuki Kikuhara, Atsushi Ito, Hiroaki Nakamura, Yukihiro Tomita *and* Tetsuo Tanabe :** Modeling of Hydrocarbon Redeposition in the Gaps of Castellated Structures, *Proceedings of 22nd IAEA Fusion Energy Conference, TH/P4-8,* Geneva, Oct. 2008.
286. **Katsuhiro Shimizu, Tomonori Takizuka, Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Tomohide Nakano, A. Takayama *and* Hisato Kawashima :** Kinetic Modeling of Impurity Transport in Detached Plasma for Integrated Divertor Simulation with SONIC (SOLDOR/NEUT2D/IMPMC/EDDY), *Proceedings of 22nd IAEA Fusion Energy Conference, TH/3-3,* Geneva, Oct. 2008.
287. **Heng-Yu Xu, Jin-Ping Ao, Hui Yu, Cheng-Yu Hu *and* Yasuo Ohno :** Device Isolation for AlGaN/GaN HFET Utilizing Heavy Metal Diffusion, *IEEE Nanotechnology Materials and Device Conference 2008 (NMDC2008),* Kyoto, Oct. 2008.
288. **Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Kikuo Tominaga, Mukai Takashi, Hiraoka Kensaku, Kudo Yuki *and* Koide Kuniyuki :** Model Analysis of Preferential Etching of III-V Nitrides by Capacitively Coupled Radio Frequency Argon Plasmas, *4th Vacuum and Surface Sciences Conference of Asia and Australia,* 187, Matsue, Oct. 2008.
289. **Okada Kenji, Kikuo Tominaga, Ohokura Sinya, Nouda Takahiro *and* Retsuo Kawakami :** Deposition of TiO2 films by a RF-DC Coupled Magnetron Sputtering, *4th Vacuum and Surface Sciences Conference of Asia and Australia,* 217, Matsue, Oct. 2008.
290. **Ikuo Awai, Kunihito Hori, Yuka Okuyama *and* Yasuo Ohno :** Non-contact Signal Transmission Based on Open Ring Resonator BPF, *Proceedings of the 38th European Microwave Conference,* Amsterdam, Oct. 2008.
291. **Daiji Kato, Takahiro Kenmotsu, Kaoru Ohya *and* Tetsuo Tanabe :** Polarization of excited states of atomic hydrogen reflected at Mo surface, *6th International Conference on Atomic and Molecular Data and Their Applications,* Beijing, Oct. 2008.
292. **Kensuke Inai, Kaoru Ohya, Hideaki Kuwada, Ryosuke Kawasaki, Misako Saito, Kaoru Fujiwara, Teruyuki Hayashi, Jack Jau *and* Kenichi Kanai :** Electron beam charging of a SiO2 layer on Si: a comparison between Monte Carlo-simulated and experimental results, *Proceedings of SPIE,* **Vol.7140,** 71400X, Taipei, Nov. 2008.
293. **Kaoru Ohya, Takuya Yamanaka, Kensuke Inai *and* Tohru Ishitani :** Modeling of secondary electron image contrasts in helium ion microscope, *SPIE Lithography Asia Taiwan 2008,* Taipei, Nov. 2008.
294. **Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Kikuo Tominaga *and* Mukai Takashi :** Effects of Capacitively Coupled Radio Frequency Krypton and Argon Plasmas on Gallium Nitride Etching Damage, *Proceedings of International Symposium of Dry Process 2008,* 187-188, Tokyo, Nov. 2008.
295. **Naoki Shinohara, Yushi Miyata, Tomohiko Mitani, Naoki Niwa, Kenji Takagi, Kenichi Hamamoto, Satoshi Ujigawa, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** New Application of Microwave Power Transmission for Wireless Power Distribution System in Buildings, *Asia Pacific Microwave Conference 2008,* Hong Kong, Dec. 2008.
296. **Takuya Yamanaka, Kensuke Inai, Kaoru Ohya *and* Tohru Ishitani :** Simulation of secondary-electron emission in helium ion microscope for overcut and undercut line-edge patterns, *Proceedings of SPIE,* **Vol.7272,** 72722L, SanJose, CA, USA, Feb. 2009.
297. **Kensuke Inai, Kaoru Ohya, Ryosuke Kawasaki, Hideaki Kuwada, Misako Saito, Teruyuki Hayashi, J. Jau *and* K. Kanai :** Simulation of SEM images and charging of an insulator/metal bilayer in trench/hole patterns, *SPIE Advanced Lithography 2009,* San Nose, California, USA, Feb. 2009.
298. **Daiji Kato, H. Iwakiri, K. Morishita, Kaoru Ohya *and* Tetsuo Tanabe :** Hydrogen trapping and erosion of W crystal, *IAEA 2nd CRM "Data for surface composition dynamics relevant to erosion processes",* Vienna, Austria, Mar. 2009.
299. **山中 卓也, 井内 健介, 大宅 薫, 石谷 亨 :** ヘリウムイオン顕微鏡における二次電子信号の評価シミュレーション, *日本顕微鏡学会，第64回学術講演会,* 2008年5月.
300. **藤間 光徳, 星野 一生, 井内 健介, 石田 真彦, 畑山 明聖, 大宅 薫 :** トカマク不純物コードIMPGYROと損耗・再堆積コードEDDYとの結合, *第7回核融合エネルギー連合講演会,* 2008年6月.
301. **大宅 薫, 井内 健介, 菊原 康之, 冨田 幸博, 中村 浩章, 伊藤 篤史, 田辺 哲朗 :** プラズマ対向壁における炭化水素の反射と再堆積, *第7回核融合エネルギー連合講演会,* 2008年6月.
302. **敖 金平, 許 恒宇, 于 僡, 胡 成余, 大野 泰夫 :** Ni拡散によるAlGaN/GaN HFET素子分離, *第69回応用物理学会学術講演会,* 2008年9月.
303. **胡 成余, 中谷 克俊, 敖 金平, 菊田 大悟, 杉本 雅裕, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET VT-VSUB特性を用いたp-GaN上バッファ層の評価, *第69回応用物理学会学術講演会,* 2008年9月.
304. **井川 裕介, 湯浅 頼英, 胡 成余, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETのゲートエッジ表面負帯電におけるDC特性の解析, *第69回応用物理学会学術講演会,* 2008年9月.
305. **星野 一生, 藤間 光徳, 井内 健介, 石田 真彦, 畑山 明聖, 大宅 薫 :** IMPGYROコードによるトカマク周辺プラズマにおける重金属不純物輸送のシミュレーション, *第2回シミュレーション科学シンポジウム,* 2008年9月.
306. **井内 健介, 菊原 康之, 大宅 薫, 伊藤 篤史, 中村 浩章, 河村 学思, 冨田 幸博 :** プラズマ対向壁における損耗・堆積のシミュレーション, *第2回シミュレーション科学シンポジウム,* 2008年9月.
307. **大宅 薫, 井内 健介, 菊原 康之, 冨田 幸博, 中村 浩章, 伊藤 篤史, 田辺 哲朗 :** プラズマ対向壁における炭化水素再付着のシミュレーション, *日本原子力学会，2008年秋の大会,* 2008年9月.
308. **松岡 遼, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** ストライプ状金属蒸着膜を使ったAlGaN on GaN/Sapphireの選択MOCVD成長, *2008年(平成20年)秋季第69回応用物理学会学術講演会,* 2a-CA-8, 2008年9月.
309. **川上 烈生, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** GaNエッチングダメージへのアルゴンプラズマ粒子と紫外放射光のシナジー効果, *第69回秋季応用物理学会学術講演会論文集, No.1,* 175, 2008年9月.
310. **續木 隆志, 富永 喜久雄, 丸山 貴之, 三河 通男, 森賀 俊広 :** PLD法により石英基板上へ作製したIn-Ga-Zn系酸化物透明導電性薄膜の特性, *第69回応用物理学会学術講演会講演予稿集,* 526, 2008年9月.
311. **川上 烈生, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 平岡 謙作, 工藤 裕貴, 小出 訓之, 向井 孝志 :** n-GaNのアルゴンプラズマエッチングダメージ, *平成20年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 13, 2008年9月.
312. **森 一郎, 森本 敏文, 川上 烈生 :** 揺らぎを介する二個のビーム電子とイオンの相互作用と集団`CLUMP'の形成, *平成20年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 12, 2008年9月.
313. **加藤 篤, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** SiO2 を斜め蒸着した凹凸GaN テンプレート上へのGaN成長, *平成20年度電気関係学会四国支部連合大会,* 11-1, 2008年9月.
314. **結城 勇介, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 直接合成法を用いたa 面GaN 結晶成長のためのNH3 流量の検討, *平成20年度電気関係学会四国支部連合大会,* 11-2, 2008年9月.
315. **遠野 充明, 直井 美貴, 酒井 士郎, 和地 順蔵 :** ナノインプリント技術によるサファイア基板上へのナノ構造の形成, *平成20年度電気関係学会四国支部連合大会,* 11-3, 2008年9月.
316. **南部 紗織, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 表面プラズモンポラリトンによる半導体LED の出力改善に関する検討, *平成20年度電気関係学会四国支部連合大会,* 11-4, 2008年9月.
317. **川崎 亮介, 桑田 英明, 井内 健介, 大宅 薫, 斉藤 美佐子, 林 輝幸, Jau Jack, 金井 健一 :** 電子ビーム照射による絶縁物薄膜の帯電と二次電子放出のシミュレーション, *LSIテスティングシンポジウム会議録,* 51-56, 2008年11月.
318. **清水 勝宏, 滝塚 知典, 大宅 薫, 井内 健介, 仲野 友英, 高山 有道, 川島 寿人 :** 非接触プラズマにおける不純物輸送のダイバータ統合モデリング, *プラズマ・核融合学会25回年会,* 2008年12月.
319. **井上 満夫, 井内 健介, 大宅 薫, 冨田 幸博, 河村 学思, 田辺 哲朗 :** 炭化水素のタイル再付着分布に及ぼすギャップ近傍のプラズマの影響, *プラズマ・核融合学会25回年会,* 2008年12月.
320. **茂原 直秀, 井内 健介, 大宅 薫, 菊原 康之, 伊藤 篤史, 中村 浩章, 田辺 哲朗 :** プラズマ対向壁に斜め入射する炭化水素の表面反射のMDシミュレーション, *プラズマ・核融合学会25回年会,* 2008年12月.
321. **大宅 薫 :** プラズマ対向壁の損耗・再堆積のシミュレーションの現状と展望, *未来エネルギー協会講演会,* 2008年12月.
322. **大宅 薫 :** プラズマ材料相互作用のシミュレーション研究, *PWI合同研究会,* 2008年12月.
323. **渡邊 隆之, 丸尾 洋一, 坂本 晃彦, 植野 貴大, 河村 亮輔, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** 対向ターゲット式DCマグネトロンスパッタリング法によりPET基板上に作製した酸化亜鉛-酸化インジウム系透明導電膜, *第47回セラミックス基礎科学討論会,* 2009年1月.
324. **宮田 侑是, 篠原 真毅, 三谷 友彦, 丹羽 直幹, 高木 賢二, 浜本 研一, 宇治 川智, 高橋 健介, 敖 金平, 大野 泰夫 :** GaNショットキーダイオードを用いた大電力レクテナの研究開発, *2009年電子情報通信学会総合大会,* 2009年3月.
325. **阿部 まみ, 奥山 祐加, 倉本 健次, 黒田 健太郎, 佐藤 弘明, 粟井 郁雄, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器無線接続における損失の検討, *2009年電子情報通信学会総合大会,* 2009年3月.
326. **成行 祐児, 松本 将和, 遠野 充明, 直井 美貴, 酒井 士郎, 深野 敦之, 田中 覚 :** ナノ加工を用いたGaNのC-V特性, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 30p-ZJ-3, 2009年3月.
327. **北村 政治, 川崎 晃一, 吉田 博紀, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** MOCVD法によるSi基板上へのSi1-x-yGexCy薄膜の成長, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 30p-E-6, 2009年3月.
328. **澤田 剛一, 敖 金平, 許 恒宇, 高橋 健介, 胡 成余, 河合 弘治, 篠原 真毅, 丹羽 直幹, 大野 泰夫 :** p型表面層を持つマイクロ波整流用GaNショットキーバリアダイオード, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
329. **井川 裕介, 湯浅 頼英, 胡 成余, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETにおける仮想ゲート型電流コラプスのSPICE回路モデル, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
330. **胡 成余, 中谷 克俊, 敖 金平, 菊田 大悟, 杉本 雅裕, 大野 泰夫 :** p層上デュアルゲートAlGaN/GaN HFETにおけるアバランシェホール電流の測定, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
331. **井内 健介, 大宅 薫 :** castellation geometry タイル表面における炭化水素の再付着シミュレーション, *周辺プラズマモデリング研究会,* 2008年7月.
332. **胡 成余, 中谷 克俊, 敖 金平, 大野 泰夫, 菊田 大悟, 杉本 雅裕 :** VT-VSUB特性を用いたp-GaN上のAlGaN/GaN HFETバッファ層評価, *電気学会電子材料研究会,* 2008年11月.
333. **井川 裕介, 湯浅 頼英, 胡 成余, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETのゲートエッジ負帯電による電流コラプスの2次元数値解析, *電気学会電子材料研究会,* 2008年11月.
334. **遠野 充明, 張 晶, 直井 美貴, 酒井 士郎, 和地 順蔵 :** ナノインプリント技術により周期的微細構造を施したGaN系デバイスからの電流注入発光特性, *電子情報通信学会電子デバイス研究会,* **Vol.ED2008-158,** 2008年11月.
335. **Yasuo Ohno *and* Jin-Ping Ao :** Future Applications of GaN Electron Devices, *15th National conference on Compound Semiconductor Materials, Microwave Devices and Optoelectronic Devices (China),* Nov. 2008.
336. **Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Refractory Metal Nitride Schottky Contact on GaN, *15th National conference on Compound Semiconductor Materials, Microwave Devices and Optoelectronic Devices (China),* Nov. 2008.
337. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai *and* 菊原 康之 :** Simulation of Erosion and Redeposition on Plasma Facing Walls, *第7回統合コード研究会,* Dec. 2008.
338. **川上 烈生, 下村 直行, 富永 喜久雄, 井上 廉 :** 電気電子工学科における新入生の学業実態 ∼アンケート分析∼, *徳島大学工学部FD工学教育シンポジウム2009,* 27-33, 2009年3月.
339. **大野 泰夫 :** 共振器結合を用いたワイアレス電力伝送, *日本機械学会マイクロナノ工学専門会議マイクロエネルギー研究会第三回会合,* 2009年3月.
340. **川上 烈生 :** 紫外線LEDを利用した柑橘類の品質維持の可能性に関する研究, *財団法人 阿波銀行学術・文化振興財団,平成19年度(第12回)学術部門助成報告書,* 日本, 2008年4月.
341. **川上 烈生 :** ワイドギャップ半導体用の高性能・低コスト・ドライ洗浄装置の開発, *JSTイノベーションサテライト徳島,平成19年度研究成果実用化検討(FS)研究報告書,* 日本, 2008年4月.
342. **川上 烈生 :** 窒化物系半導体デバイスのためのプラズマ誘因ダメージレスナノプロセス装置の研究開発, *平成20年度教育研究等支援事業(学長裁量経費)報告書,* 日本, 2009年1月.
343. **川上 烈生 :** 高周波アルゴンプラズマによる衝撃粒子エネルギー分布と粒子束の解析, *平成20年度核融合科学研究所LHD数値解析システム利用共同研究報告書,* 日本, 2009年3月.
344. **川上 烈生 :** UV-LEDと光触媒のシナジー効果による果実の鮮度維持技術の開発研究, *徳島大学研究連携推進機構(知的財産本部),産学連携研究者育成支援事業,* 日本, 2009年3月.
345. **川上 烈生 :** UV-LEDによる光触媒酸化作用を用いた果実の汎用型鮮度維持装置の開発研究, *JSTイノベーションサテライト徳島,平成20年度シーズ発掘試験(A),* 日本, 2009年3月.
346. **Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** GaN-based Schottky Diodes, Handbook of Light Emitting and Schottky Diode Research, Nova Science Publishers, Hauppauge, May 2009.
347. **Kikuo Tominaga, Takashi Tsuzuki, Takayuki Maruyama, Michio Mikawa *and* Toshihiro Moriga :** Properties of Amorphous Transparent Conductive In-Ga-Zn Oxide Films Deposited on Fused Quartz by PLD Method, *e-Journal of Surface Science and Nanotechnology,* **Vol.7,** 273-276, 2009.
348. **Kensuke Takahashi, Jin-Ping Ao, Yusuke Ikawa, Cheng-Yu Hu, Hiroji Kawai, Naoki Shinohara, Naoki Niwa *and* Yasuo Ohno :** GaN Schottky Diodes for Microwave Power Rectification, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.48,** *No.4,* 04C095, 2009.
349. **Yuka Okuyama, Jin-Ping Ao, Ikuo Awai *and* Yasuo Ohno :** Wireless Inter-Chip Signal Transmission by Electromagnetic Coupling of Open-Ring Resonators, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.48,** *No.4,* 04C025, 2009.
350. **K. Shimizu, T. Takizuka, Kaoru Ohya, Kensuke Inai, T. Nakano, A. Takayama, H. Kawashima *and* K. Hoshino :** Kinetic modelling og impurity transport in detached plasma for integrated divertor simulation with SONIC (SOLDOR/NEUT2D/IMPMC/EDDY), *Nuclear Fusion,* **Vol.49,** *No.6,* 065028, 2009.
351. **Kikuo Tominaga, Kenji Okada, Yoshinori Miyamoto, Shinya Ohkura, Kazuya Kusaka, Kentaro Shiraishi, Takahiro Ueno *and* Takao Hanabusa :** Deposition of photocatalytic TiO2 films by planar magnetron sputtering system with opposed Ti targets, *e-Journal of Surface Science and Nanotechnology,* **Vol.7,** 290-293, 2009.
352. **Ryo Matsuoka, Takashi Okimoto, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** AlGaN epitaxial lateral overgrowth on Ti-evaporated GaN/sapphire substrate, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.311,** *No.10,* 2847-2849, 2009.
353. **Y. Ueda, M. Fukumoto, A. Yamawaki, Y. Soga, Y. Ohtsuka, S. Brezinsek, T. Hirai, A. Kirschner, A. Kreter, A. Litnovsky, V. Philipps, A. Pospieszczyk, B. Schweer, G. Sergienko, T. Tanabe, K. Sugiyama, Kaoru Ohya, N. Ohno *and* TEXTOR team :** Effects of tungsten surface conditions on carbon deposition, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.390-391,** 44-48, 2009.
354. **Daiji Kato, Takahiro Kenmotsu, Kaoru Ohya *and* Tetsuo Tanabe :** Excited state distribution of reflected hydrogen atoms at metal surfaces - Development of theoretical models, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.390-391,** 498-501, 2009.
355. **Kaoru Ohya, Y. Kikuhara, Kensuke Inai, A. Kirschner, D. Borodin, A. Ito, H. Nakamura *and* T. Tanabe :** Simulation of hydrocarbon reflection from carbon and tungsten surfaces and its impact on codeposition patterns on plasma facing components, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.390-391,** 72-75, 2009.
356. **Kensuke Inai, Kaoru Ohya, Y. Tomita, A. Kirschner, A. Litnovsky *and* T. Tanabe :** Simulation of redeposition of carbon/hydrocarbon on a material surface with castellated structures, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.390-391,** 119-122, 2009.
357. **K. Hoshino, M. Toma, M. Furubayashi, A. Hatayama, Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Numerical analysis of incident angle of heavy metal impurity to plasma facing components by IMPGYRO, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.390-391,** 168-171, 2009.
358. **M. Toma, K. Hoshino, Kensuke Inai, M. Furubayashi, A. Hatayama *and* Kaoru Ohya :** Coupled IMPGYRO-EDDY simulation of tungsten impurity transport in tokamak geometry, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.390-391,** 207-210, 2009.
359. **A. Yamawaki, M. Fukumoto, Y. Soga, Y. Ueda *and* Kaoru Ohya :** Temperature dependence of carbon deposition on tungsten, *Fusion Science and Technology,* **Vol.56,** *No.2,* 1038-1042, 2009.
360. **Retsuo Kawakami, Takeshi Inaoka, Kikuo Tominaga *and* Mukai Takashi :** Effects of Capacitively Coupled Radio Frequency Krypton and Argon Plasmas on Gallium Nitride Etching Damage, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.48,** *No.8,* 08HF01-1-08HF01-4, 2009.
361. **Kensuke Inai, Kaoru Ohya, G. Kawamura *and* Y. Tomita :** An EDDY-PIC Simulation of Co-deposition of Hydrogen Isotopes on a Castellated Structure of Plasma Facing Tiles, *Journal of Plasma and Fusion Research Series,* **Vol.8,** 433-437, 2009.
362. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Y. Kikuhara, T. Nakano, J. Kawata, H. Kawazome, Y. Ueda *and* T. Tanabe :** Transport of Heavy Hydrocarbon and its Redeposition on Plasma Facing Walls, *Journal of Plasma and Fusion Research Series,* **Vol.8,** 419-424, 2009.
363. **M. Toma, K. Hoshino, Kensuke Inai, M. Ishida, A. Hatayama *and* Kaoru Ohya :** Analysis of the high-Z impurity transport in a Tokamak by the IMPGYRO code, *Journal of Plasma and Fusion Research Series,* **Vol.8,** 1116-1119, 2009.
364. **Jing Zhang, Yoshiki Naoi, Shiro Sakai, Atsuyuki Fukano *and* Satoru Tanaka :** Fabrication and Photovoltaic Measurements of Surface Nanostructure of AlGaInN-Based Photodetector, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.48,** *No.11,* 111001-1-111001-5, 2009.
365. **Kaoru Ohya *and* Andreas Kirschner :** Modeling of erosion and deposition by the Monte Carlo codes EDDY and ERO, *Physica Scripta,* **Vol.T138,** 014010-(7pp), 2009.
366. **Andreas Kirschner, Kaoru Ohya, D. Borodin, R. Ding, D. Matveev, V. Philipps *and* U. Samm :** Prediction of long-term tritium retention in the divertor of ITER: influence of modelling assumptions on retention rates, *Physica Scripta,* **Vol.T138,** 014011-(6pp), 2009.
367. **M. Sakamoto, T. Miyazaki, Y. Higashizono, K. Ogawa, K. Ozaki, N. Ashikawa, M. Tokitani, T. Shoji, S. Masuzaki, K. Tokunaga, Kaoru Ohya, A. Sagara, N. Yoshida *and* K.N. Sato :** Surface modification of tungsten mirrors due to low-energy helium plasma irradiation in the compact PWI simulator APSEDAS, *Physica Scripta,* **Vol.T138,** 014043-(5pp), 2009.
368. **Tohru Ishitani, Takuya Yamanaka, Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Secondary electron emission in scanning Ga ion, He ion and electron microscope, *Vacuum,* **Vol.84,** *No.8,* 1018-1024, 2010.
369. **Daiji Kato, Takahiro Kenmotsu, Kaoru Ohya *and* Tetsuo Tanabe :** Linear polarization of photon emission from reflected neutrals of atomic hydrogen at metal PFCs, *Research Report of National Institute for Fusion Science, No.NIFS-PROC-81,* 150-161, 2010.
370. **Yuta Higashizono, Mizuki Sakamoto, Toshimasa Miyazaki, Kazuma Ogawa, Kazuki Ozaki, Yousuke Nakashima, Tatsuo Shoji, Naoko Ashikawa, Masayuki Tokitani, Kazutoshi Tokunaga, Suguru Masuzaki, Kaoru Ohya, Akio Sagara *and* Kohnosyke Sato :** Axial Profile of Balmer-Alpha Emission near a Tungsten Target in the Compact PWI Simulator APSEDAS, *Plasma and Fusion Research,* **Vol.4,** *No.0,* 043-1-043-3, 2009.
371. **大宅 薫, 井内 健介, 清水 勝宏, 滝塚 知典, 川島 寿人, 星野 一生, 畑山 明聖, 藤間 光徳, 冨田 幸博, 河村 学思, 芦川 直子, 田中 康規, 小野 忠良, 村本 哲也, 剣持 貴弘, 中村 浩章, 伊藤 篤史, 加藤 太治 :** 核融合炉のトリチウム蓄積・排出評価のための理論およびシミュレーションコードの開発, *プラズマ・核融合学会誌,* **Vol.85,** *No.10,* 695-703, 2009年10月.
372. **Kikuo Tominaga, Akihiko Sakamoto, Takayuki Watanabe *and* Toshihiro Moriga :** Effects of low-temperature and short-time annealing on amorphous transparent conductive oxide IZO (In2O3-ZnO) films, *6th International Symposium on Transparent Oxide Thin Films for Electronics and Optics (TOEO-6),* 75, Tokyo, Apr. 2009.
373. **M Sakamoto, T Miyazaki, Y Higashizono, K Ogawa, K Ozaki, N Ashikawa, M Tokitani, T Shoji, S Masuzaki, K Tokunaga, Kaoru Ohya, A Sagara, N Yoshida *and* KN Sato :** Surface modification of tungsten due to plasma irradiation in the compact PWI simulator APSEDAS, *12th International Workshop on Plasma Facing Materials and Components for Fusion Applications,* Juelich, Germany, May 2009.
374. **Kaoru Ohya *and* Andreas Kirschner :** Modeling of erosion and deposition by the Monte Carlo codes EDDY and ERO, *12th International Workshop on Plasma Facing Materials and Components for Fusion Apprications,* Juelich, Germany, May 2009.
375. **Andreas Kirschner, Kaoru Ohya, D Borodin, R Ding, D Matveev, V Philipps *and* U Samm :** Prediction of long-term tritium retention in the divertor of ITER: influence of modelling assumptions on retention rates, *12th International Workshop on Plasma Facing Materials and Components for Fusion Applications,* Juelich, Germany, May 2009.
376. **Atsushi Ito, Takahiro Kenmotsu, Yasuyuki Kikuhara, Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Y. Wang, S. Irle, K. Morokuma *and* Hiroaki Nakamura :** Hydrogen atom injection into carbon surfaces by comparison between Monte-Carlo, molecular dynamics and ab-initio calculations, *4th IAEA Technical Meeting (IAEA-TM) on the Theory of Plasma Instabilities,* Kyoto, May 2009.
377. **Jing Zang, S. Okuno, Yoshiki Naoi, Shiro Sakai, Atsuyuki Fukano *and* Satoru Tanaka :** The surface nanostructure photo-voltaic property of GaN-based photodetector, *Asia-Pacific Workshop on wide gap Semiconductors (APWS 2009),* MO3-7, Zhangjiajie, May 2009.
378. **Kaoru Ohya :** Integrated numerical simulations and modelling of erosion and deposition on plasma facing wall, *THIRD ITER SUMMER SCHOOL: Plasma Surface Interaction in Controlled Fusion Devices,* Aix en Provence, France, Jun. 2009.
379. **Retsuo Kawakami, Kikuo Tominaga, Okada Kenji, Nouda Takahiro, Takeshi Inaoka, Takeichi Atsushi, Fukudome Toshiaki *and* Murao Kenichi :** Etch Damage Characteristics of TiO2 Thin Films by Capacitively Coupled RF Ar Plasmas, *Proceedings of 10th International Symposium of Sputtering & Plasma Processes,* 500-503, Kanazawa, Jul. 2009.
380. **Jin-Ping Ao, Asato Suzuki, Kouichi Sawada, Satoko Shinkai *and* Yasuo Ohno :** Schottky Contacts of Reactive Sputtering Refractory Metal Nitrides on Gallium Nitride, *The 10th International Symposium on Sputtering & Plasma Processes,* 433-436, Kanazawa, Jul. 2009.
381. **Nouda Takahiro, Tominaga Kikuo, Okada Kenji, Murao Ken-ichi, Retsuo Kawakami, Kusaka Kazuya *and* Hanabusa Takao :** Deposition and characterization of TiO2 thin films by rf-dc coupled reactive magnetron sputtering, *Proceedings of 10th International Symposium of Sputtering & Plasma Processes,* 479-482, Kanazawa, Jul. 2009.
382. **Atsushi Ito, Takahiro Kanmotsu, Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Y. Wang, S. Irle, K. Morokuma *and* Hiroaki Nakamura :** Hydrogen atom and graphite surfaces interaction by molecular dynamics, Monte-Carlo and ab-initio calculations, *CREST International Symposium on Theory and Simulations of Complex Molecular System & International Symposium on Theory of Molecular Structure,* Kyoto, Jul. 2009.
383. **Kaoru Ohya :** Coupled EDDY/MD/PIC modeling of erosion and deposition on plasma facing walls, *2009 Japan-U.S. Workshop on Heat Removal and Plasma Material Interactions for Fusion, Fusion High Power Density Components and Systems, and IEA Workshop on Solid Surface Plasma Facing Components,* Berkeley, California, USA, Jul. 2009.
384. **Cheng-Yu Hu, Katsutoshi Nakatani, Hiroji Kawai, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Buffer layer doping concentration measurement using VT-VSUB Characterization of GaN HEMT with p-GaN substrate layer, *8th Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Nagano, Aug. 2009.
385. **Yusuke Ikawa, Yorihide Yuasa, Cheng-Yu Hu, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** 2D Device Simulation of AlGaN/GaN HFET Current Collapse Caused by Surface Negative Charge Injection, *8th Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Nagano, Aug. 2009.
386. **Kensuke Inai, Kaoru Ohya, Gakushi Kawamura *and* Yukihiro Tomita :** Electron velocity distribution at a sheath edge in the presence of secondary electron emission from a metal surface, *12th International Workshop on Plasma Edge Theoty in Fusion Devices,* Rostov Veliky, Russia, Sep. 2009.
387. **Daiji Kato, Takahiro Kenmotsu, Kaoru Ohya *and* Tetsuo Tanabe :** Linear polarization of photons emitted from excited hydrogen atoms formed above metal surfaces, *12th International Workshop on Plasma Edge Theory in Fusion Devices,* Rostov Veliky, Russia, Sep. 2009.
388. **Atsushi Ito, Kaoru Ohya, Kensuke Inai *and* Hiroaki Nakamura :** Dependency of tritium retention in graphite on temperature control of molecular dynamics, *12th International Workshop on Plasma Edge Theory in Fusion Devices,* Rostov Veliky, Russia, Sep. 2009.
389. **Kensuke Inai, Kaoru Ohya, Mitsuo Inoue, Yukihiro Tomita, Gakushi Kawamura *and* Tetsuo Tanabe :** Asymmetric Carbon Deposition in Toroidal and Poloidal Gaps of Plasma Facing Tiles, *14th International Conference on Fusion Reactor Materials,* Sapporo, Sep. 2009.
390. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Yasuyuki Kikuhara, Naohide Mohara, Atsushi Ito, Hiroaki Nakamura *and* Tetsuo Tanabe :** Molecular Dynamics Study on Hydrocarbon Interactions with Plasma Facing Walls, *14th International Conference on Fusion Reactor Materials,* Sapporo, Sep. 2009.
391. **Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Tominaga Kikuo, Niibe Masahito, Mukai Takashi, Takeichi Atsushi *and* Fukudome Toshiaki :** Synergy Effect of Xenon Plasma Ions and Ultraviolet Lights on GaN Etch Surface Damage and Modification, *16th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams,* 190, Tokyo, Sep. 2009.
392. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Ryosuke Kawasaki, Daiki Takami, Misako Saito, Teruyuki Hayashi, J. Jau *and* K. Kanai :** Modeling and Observations of Electron Beam Charging of an Insulator/Metal Bilayer and Its Impact on Secondary Electron Images in Defect Inspection Equipment, *Thw Twelfth Frontiers of Electron Microscopy in Materials Science,* Huis Ten Bosch, Sasebo, Japan, Sep. 2009.
393. **Cheng-Yu Hu, Hiroyuki Nokubo, Masaya Okada, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** MIS Diode Characterization on n-GaN by C-V Measurement at 150 C, *The 2009 International Conference on Solid State Devices and Materials,* Sendai, Oct. 2009.
394. **Katsutoshi Nakatani, Jin-Ping Ao, Keisuke Ohmuro, Masahiro Sugimoto, Cheng-Yu Hu, Yuji Sogawa *and* Yasuo Ohno :** Evaluation of GaN MOSFET with TEOS SiO2 Gate Insulator, *The 2009 International Conference on Solid State Devices and Materials,* Sendai, Oct. 2009.
395. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Naohide Mohara, Yohei Miyake, Atsushi Ito, Hiroaki Nakamura, D. Borodin *and* Andreas Kirschner :** Molecular Dynamics and Dynamic Monte Carlo Study of Mixed Material and Its Impact on Plasma Wall Interactions, *9th International Symposium on Fusion Nuclear Technology,* Dalian, China, Oct. 2009.
396. **Kensuke Inai, Yukihiro Tomita, Mitsuo Inoue, Gakushi Kawamura *and* Kaoru Ohya :** A Coupled PIC/ELECTRAN Simulation of Sheath Formation with Secondary Electron Emission from Plasma Facing Walls, *9th International Symposium on Fusion Nuclear Technology,* Dalian, China, Oct. 2009.
397. **Cheng-Yu Hu, Daigo Kikuta, Katsutoshi Nakatani, Jin-Ping Ao, Masahiro Sugimoto *and* Yasuo Ohno :** Low Resistance Ohmic Contact to Deeply Dry-etched p-GaN, *The 8th International Conference on Nitride Semiconductors,* Cheju, Oct. 2009.
398. **Cheng-Yu Hu, Daigo Kikuta, Katsutoshi Nakatani, Jin-Ping Ao, Masahiro Sugimoto *and* Yasuo Ohno :** Monitoring and control of substrate voltage for AlGaN/GaN HEMTs with p-GaN epi-layer, *The 8th International Conference on Nitride Semiconductors,* Cheju, Oct. 2009.
399. **Kohei Hara, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** GaN Re-growth Using Ta Mask by Metalorganic Chemical Vapor Deposition, *The 8th International Conference on Nitride Semiconductors,* MP9, Cheju, Oct. 2009.
400. **Takesi Noda, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Crack Reduction of AlGaN on GaN/sapphire by Metalorganic Chemical Vapor Deposition, *The 8th International Conference on Nitride Semiconductors,* MP14, Cheju, Oct. 2009.
401. **Yuji Nariyuki, Masakazu Matsmoto, Yoshiki Naoi, Shiro Sakai, Atsuyuki Fukano *and* Satoru Tanaka :** Evaluation and Re-growth of GaN on Nano-patterned GaN on a Sapphire Substrate, *The 8th International Conference on Nitride Semiconductors,* TP113, Cheju, Oct. 2009.
402. **Jing Zhang, Yoshiki Naoi, Shiro Sakai, Atsuyuki Fukano *and* Satoru Tanaka :** GaN Surface Nanostructure Photodetector Based on Back Side Incidence, *The 8th International Conference on Nitride Semiconductors,* TP145, Cheju, Oct. 2009.
403. **Yoshiki Naoi, Mitsuaki Tohno, Tianya Tan, Masakazu Matsmoto, Shiro Sakai, Atsuyuki Fukano *and* Satoru Tanaka :** GaN-bsed Light Emitting Diodes with Periodic Nano-structues on the Surface Fabricated by Nanoimprint Lithography Technique, *The 8th International Conference on Nitride Semiconductors,* ThP106, Cheju, Oct. 2009.
404. **M. Sakamoto, Y. Higashizono, T. Miyazaki, K. Ozaki, K. Ogawa, N. Ashikawa, M. Tokitani, T. Shoji, S. Masuzaki, K. Tokunaga, Kaoru Ohya, A. Sagara, N. Yoshida *and* K.N. Sato :** Surface modification of tungsten irradiated by low energy plasma in the compact PWI simulator APSEDAS, *7th General Scientific Assembly of the Asia Plasma and Fusion Association in 2009 and Asia-Pacific Plasma Theory Conference in 2009,* Aomori, Oct. 2009.
405. **Kaoru Ohya, Naohide Mohara, Yohei Miyake, Kensuke Inai, Atsushi Ito, Hiroaki Nakamura, Yoshio Ueda *and* Tetsuo Tanabe :** Molecular dynamics study of plasma surface interactions for mixed materials, *7th General Scientific Assembly of the Asia Plasma and Fusion Association in 2009 and Asia-Pacific Plasma Theory Conference in 2009,* Aomori, Oct. 2009.
406. **Hayato Kawazome, Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Jun Kawata, Kenji Nishimura *and* Tetsuo Tanabe :** Calculation of D/XB values of hydrocarbon molecules in tokamak edge plasmas, *19 th International Toki Conference (ITC-19) on Advanced Physics in Plasma and Fusion Research,* Toki, Japan, Dec. 2009.
407. **M. Sakamoto, Y. Higashizono, H. Zushi, K. Nakamura, K. Hanada, H. Idei, K. Tokunaga, M. Hasegawa, S. Kawasaki, H. Nakashima, T. Fujiwara, A. Higashijima, T. Miyazaki, K. Ozaki, K. Ogawa, M. Tokitani, M. Miyamoto, N. Ashikawa, T. Shoji, S. Masuzaki, Kaoru Ohya, A. Sagara, N. Yoshida *and* K.N. Sato :** Plasma-Wall Interaction Study towards the Steady State Operation, *19th International Toki Conference (ITC-19) on Advanced Physics in Plasma and Fusion Research,* Toki, Japan, Dec. 2009.
408. **Koji Kawasaki, Seiji Kitamura, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Growth of SiGeC Thin Film on Si Substrate by Metal Organic Chemical Vaoir Deposition, *Fifth International Workshop on NEW GROUP IV SEMICONDUCTOR NANOELECTRONICS,* P-09, Sendai, Jan. 2010.
409. **Kohei Hara, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Ta-etching of GaN by the Metalorganic Chemical Vapor Deposition-re-growth of GaN, *2nd International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials,* PB055B, Nagoya, Mar. 2010.
410. **Jing Zhang, Takumi Taoka, Yoshiki Naoi, Shiro Sakai, Atsuyuki Fukano *and* Satoru Tanaka :** Front and Back Side Illumination of a Nano-Structured AlGaInN Photodetector, *2nd International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials,* PB064C, Nagoya, Mar. 2010.
411. **野田 丈嗣, 松岡 遼, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** MOCVD-GaN on Sapphire上AlGaNのクラックの低減に関する研究, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 1a-ZJ-14, 2009年4月.
412. **張 晶, 遠野 充明, 奥野 誠亮, 直井 美貴, 酒井 士郎, 深野 敦之, 田中 覚 :** GaNナノ加工pnダイオード光検出器, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 1a-ZJ-30, 2009年4月.
413. **直井 美貴, 酒井 士郎, 深野 敦之, 田中 覚, 納田 卓, 木村 真大, 川野 俊輔, 村本 宜彦 :** サファイア上周期的ナノ構造を形成するためのナノインプリント技術開発とGaN系LED, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 1p-ZJ-10, 2009年4月.
414. **遠野 充明, 直井 美貴, 酒井 士郎, 深野 敦之, 田中 覚 :** ナノインプリント技術により周期的ナノ構造を形成したGaN系光デバイスからのEL特性, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 1p-ZJ-11, 2009年4月.
415. **黒田 健太郎, 井川 裕介, 胡 成余, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET電流コラプスのステップストレス測定, *第70回応用物理学会学術講演会,* 2009年9月.
416. **下村 輝, 粟井 郁雄, 大野 泰夫 :** ミリはインターコネクトにおける設置面の影響, *2009年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2009年9月.
417. **高橋 健介, 敖 金平, 胡 成余, 篠原 真毅, 丹羽 直幹, 大野 泰夫 :** マイクロ波電力整流用GaNショットキーダイオードのSパラメータ解析, *2009年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2009年9月.
418. **倉本 健次, 阿部 まみ, 奥山 祐加, 敖 金平, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器を用いた非接触広帯域入出力インターフェイス, *2009年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2009年9月.
419. **阿部 まみ, 倉本 健次, 敖 金平, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器無線接続における基板抵抗の影響, *2009年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2009年9月.
420. **成行 祐児, 松本 将和, 直井 美貴, 酒井 士郎, 深野 敦之, 田中 覚 :** ナノ加工を施したGaN上への再成長及びその評価, *第70回応用物理学会学術講演会,* 8p-F-2, 2009年9月.
421. **新部 正人, 前田 佳恵, 川上 烈生, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** ArおよびKrでRFプラズマエッチングしたGaN結晶の表面組成分析, *第70回秋季応用物理学会学術講演会論文集, No.1,* 189, 2009年9月.
422. **川上 烈生, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 新部 正人, 向井 孝志 :** 容量結合型KrプラズマによるGaNエッチングダメージ解析, *第70回秋季応用物理学会学術講演会論文集, No.1,* 188, 2009年9月.
423. **張 晶, 直井 美貴, 酒井 士郎, 深野 敦之, 田中 覚 :** 裏面入射GaN系表面ナノ構造光検出器, *第70回応用物理学会学術講演会,* 10a-E-9, 2009年9月.
424. **原 航平, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** Taマスクを用いた下地層エッチングによるGaN再成長, *第70回応用物理学会学術講演会,* 11a-E-9, 2009年9月.
425. **野田 丈嗣, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** MOCVD-GaN on Sapphire上AlGaNのクラックの低減に関する研究(2), *第70回応用物理学会学術講演会,* 11a-E-10, 2009年9月.
426. **直井 美貴, 松本 将和, 譚 天亜, 酒井 士郎, 深野 敦之, 田中 覚 :** 表面ナノ周期構造を有するInGaN-LEDからの輻射光空間分布特性, *第70回応用物理学会学術講演会,* 11a-X-8, 2009年9月.
427. **丸尾 洋一, 大森 悠丘, 渡邊 隆之, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** 有機高分子基板上に製膜したZnO-In2O3系, *日本材料学会四国支部 第6回夏季材料セミナー,* 2009年9月.
428. **稲岡 武, 川上 烈生, 富永 喜久雄, 新部 正人, 向井 孝志 :** 非対称放電系容量結合型RFクリプトンプラズマの放電及び発光特性, *平成21年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 30, 2009年9月.
429. **川上 烈生, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 新部 正人, 向井 孝志 :** クリプトンとアルゴンプラズマによる窒化ガリウムエッチングダメージ, *平成21年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 29, 2009年9月.
430. **大宅 薫, 茂原 直秀, 井内 健介, 伊藤 篤史, 中村 浩章, 上田 良夫, 田辺 哲朗 :** プラズマ対向壁に形成される混合層スパッタリングのシミュレーション, *プラズマ・核融合学会第26回年会,* 2009年12月.
431. **新部 正人, 前田 佳恵, 川上 烈生, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** プラズマエッチングしたGaN結晶のN-K吸収測定によるダメージ解析, *第23回日本放射光学会年会,* 2010年1月.
432. **大野 泰夫 :** 無線送電とワイドギャップ半導体, *2010年電子情報通信学会総合大会,* 2010年3月.
433. **阿部 まみ, 倉本 健次, 天羽 孝文, 敖 金平, 大野 泰夫 :** 誘電率の異なる基板間でのオープンリング共振器無線接続, *2010年電子情報通信学会総合大会,* 2010年3月.
434. **大宅 薫 :** 炭素再堆積層におけるプラズマ・壁相互作用のシミュレーション, *「マルチスケールでのプラズマ・壁相互作用の理解」研究会,* 2010年3月.
435. **西野 克志, 澤井 佑介, 成行 祐児, 野田 丈嗣, 直井 美貴, 酒井 士郎, 深野 敦之, 田中 覚 :** ナノ加工GaN基板上再成長層のTEM観察, *第57回応用物理学関係連合講演会,* 19a-TB2, 2010年3月.
436. **中谷 克俊, 祖川 雄司, 金 栄現, 敖 金平, 大野 泰夫, 宮下 準弘, 本山 慎一 :** プラズマCVD酸化膜を用いたGaN MOSFET, *第57回応用物理学関係連合講演会,* 2010年3月.
437. **黒田 健太郎, 井川 裕介, 光山 健太, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET電流コラプスにおける光照射の影響, *第57回応用物理学関係連合講演会,* 2010年3月.
438. **直井 美貴 :** LEDの光出力改善技術, *技術情報協会:LED照明の高輝度・長寿命化技術セミナー,* 2009年5月.
439. **大野 泰夫 :** 化合物半導体電子デバイス開発の軌跡, *電子情報通信学会シリコン材料・デバイス研究会資料,* 2009年6月.
440. **野崎 兼史, 高橋 義也, 敖 金平, 大野 泰夫 :** オープンゲートAlGaN/GaN HFETの電解質溶液を介した電流制御, *電子情報通信学会センサーデバイス・MEMS・一般研究会,* 2009年7月.
441. **下村 直行, 川上 烈生, 寺西 研二, 富永 喜久雄 :** 導入教育・初年度教育に関する考察, --- 徳島大学電気電子工学科のアンケート結果から ---, *電気学会研究会資料,* **Vol.FIE-09,** *No.3,* 41-46, 2009年8月.
442. **直井 美貴 :** 紫外線LEDの開発動向と今後の応用について, *徳島ビジネスチャレンジメッセ2009 LEDコンソーシアム基調講演,* 2009年10月.
443. **新部 正人, 前田 佳恵, 川上 烈生, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** プラズマエッチングしたGaN結晶のN-K吸収計測によるダメージ解析, *第45回X線分析討論会,* 2009年11月.
444. **川上 烈生 :** UV-LEDによる光触媒酸化作用を用いた果実の汎用型鮮度維持装置の開発研究, *第三回技術シーズ発表会 in 四国 ∼四国発!地域元気の取組みについて∼,* 2009年11月.
445. **黒田 健太郎, 井川 裕介, 光山 健太, 敖 金平, 大野 泰夫 :** ステップストレス測定によるAlGaN/GaN HFET電流コラプス解析, *電子情報通信学会電子デバイス，電子部品・材料，レーザ・量子エレクトロニクス研究会,* 2009年11月.
446. **高橋 健介, 敖 金平, 篠原 真毅, 丹羽 直幹, 藤原 暉雄, 大野 泰夫 :** マイク ロ波無線ユビキタス電源用GaNショットキーダイオードの開発, *電子情報通信学会電子デバイス，電子部品・材料，レーザ・量子エレクトロニクス研究会,* 2009年11月.
447. **原 航平, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** Taマスクを用いた下地層エッチングによるGaN再成長, *電子情報通信学会電子デバイス研究会,* **Vol.109,** *No.288,* 1-4, 2009年11月.
448. **張 晶, 直井 美貴, 酒井 士郎, 深野 敦之, 田中 覚 :** GaN系表面ナノ構造光検出器, *電子情報通信学会電子デバイス研究会,* **Vol.109,** *No.288,* 83-87, 2009年11月.
449. **Y.J. Choi, Yoshiki Naoi, Kohei Hara, Masakzu Matsumoto, Shiro Sakai *and* S.N. Yi :** GaN nanorod fabrication by reactive ion etching and nanoimprint lithography technique, *Proceedings of the fourth symposium on "The Fourth International Symposium:Development of the Global Doble Degree Program(GDPP)",* 54, Dec. 2009.
450. **川上 烈生 :** 果実の汎用型鮮度維持装置, *STイノベーションサテライト徳島 育成研究報告会 平成18年度採択育成研究課題報告,* 2009年12月.
451. **新部 正人, 前田 佳恵, 川上 烈生, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** プラズマエッチングしたGaN結晶のNEXAFS測定によるダメージ解析, *2010先端技術セミナー，高度産業科学技術研究所主催,* 2010年3月.
452. **西野 克志, 直井 美貴 :** 電気電子工学科基礎科目における再履修生を対象とした授業の試み, *工学教育シンポジウム2010(SEE2010),* 2010年3月.
453. **川上 烈生 :** 高周波クリプトンプラズマによる自己無撞着な衝撃粒子エネルギー分布及び粒子束の解析, *平成21年度核融合科学研究所LHD数値解析システム利用共同研究報告書,* 日本, 2010年3月.
454. **川上 烈生 :** UV-LEDによる薄膜系TiO2の光触媒反応活性化のための大気圧空気プラズマナノ表面処理技術の開発研究, *徳島大学研究連携推進機構(知的財産本部),産学連携研究者育成支援事業,* 日本, 2010年3月.
455. **川上 烈生 :** 分光計測(反射・透過・膜厚)システム一式, *徳島大学外部資金に係わる間接経費(学長裁量経費),* 日本, 2010年3月.
456. **Kaoru Ohya :** Plasma Interaction in Controlled Fusion Devices: 3rd ITER International Summer School, American Institute of Physics, Jun. 2010.
457. **永瀬 雅夫, 他 :** マクロ観察と新型顕微技法Q&A, --- 材料解析研究者・顕微鏡研究者のための ---, アグネ承風社, 東京, 2010年10月.
458. **Hiroyuki Kageshima, Hiroki Hibino *and* Masao Nagase :** Epitaxial Graphene Growth Studied by Low-energy Electron Microscopy and First-principles, *Materials Science Forum,* **Vol.645-648,** 597-602, 2010.
459. **Cheng-Yu Hu, Hiroyuki Nokubo, Masanari Okada, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Metal Insulator Semiconductor Diode Characterization on n-GaN by Capacitance Voltage Measurement at 150 °C, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.49,** *No.4,* 04DF11, 2010.
460. **Jin-Ping Ao, Katsutoshi Nakatani, Keisuke Ohmuro, Masahiro Sugimoto, Cheng-Yu Hu, Yuji Sogawa *and* Yasuo Ohno :** GaN Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor with Tetraethylorthosilicate SiO2 Gate Insulator on AlGaN/GaN Heterostructure, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.49,** *No.4,* 04DF09-1-04DF09-4, 2010.
461. **Jing Zhang, Yoshiki Naoi, Shiro Sakai, Atsuyuki Fukano *and* Satoru Tanaka :** GaN surface nanostructure photodetector based on back side incidence, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.7,** *No.7-8,* 1804-1806, 2010.
462. **Daiji Kato, Takahiro Kenmotsu, Kaoru Ohya *and* Tetsuo Tanabe :** Linear Polarization of Photons Emitted from Excited Hydrogen Atoms Formed above Metal Surfaces, *Contributions to Plasma Physics,* **Vol.50,** *No.3-5,* 445-450, 2010.
463. **Kensuke Inai, Kaoru Ohya, Gakushi Kawamura *and* Yukihiro Tomita :** Electron Velocity Distributions at a Sheath Edge in the Presence og Secondary Electron Emission from a Metal Surface, *Contributions to Plasma Physics,* **Vol.50,** *No.3-5,* 458-463, 2010.
464. **Atsushi Ito, Kaoru Ohya, Kensuke Inai *and* Hiroaki Nakamura :** Dependency of Tritium Retention in Graphite on Temperature Control of Molecular Dynamics, *Contributions to Plasma Physics,* **Vol.50,** *No.3-5,* 464-469, 2010.
465. **Yuji Nariyuki, Masakazu Matsumot, Takeshi Noda, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi, Shiro Sakai, Atsuyuki Fukano *and* Satoru Tanaka :** Evaluation and re-growth of p-GaN on nano-patterned GaN on sapphire substrate, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.7,** *No.7-8,* 2121-2123, 2010.
466. **Yoshiki Naoi, Masakazu Matsumot, Tianya Tan, Mitsuaki Tohno, Shiro Sakai, Atsuyuki Fukano *and* Satoru Tanaka :** GaN-based light emitting diodes with periodic nano-structures on the surface fabricated by nanoimprint lithography technique, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.7,** *No.7-8,* 2154-2156, 2010.
467. **Retsuo Kawakami, Tominaga Kikuo, Okada Kenji, Nouda Takahiro, Inaoka Takeshi, Takeichi Atsushi, Fukudome Toshiaki *and* Murao Kenichi :** Etch Damage Characteristics of TiO2 Thin Films by Capacitively Coupled RF Ar Plasmas, *Vacuum,* **Vol.84,** *No.12,* 1393-1397, 2010.
468. **Jin-Ping Ao, Asato Suzuki, Kouichi Sawada, Satoko Shinkai, Yoshiki Naoi *and* Yasuo Ohno :** Schottky contacts of refractory metal nitrides on gallium nitride using reactive sputtering, *Vacuum,* **Vol.84,** *No.12,* 1439-1443, 2010.
469. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Ryosuke Kawasaki, Misako Saito, Teruyuki Hayashi, Jack Jau *and* Kenichi Kanai :** Modelling and observations of electron beam charging of an insulator/metal bilayer and its impact on secondary electron images in defect inspection equipment, *Journal of Electron Microscopy,* **Vol.59,** S189-S193, 2010.
470. **Kaoru Ohya, Naohide Mohara, Kensuke Inai, Atsushi Ito, Hiroaki Nakamura, Yoshio Ueda *and* Tetsuo Tanabe :** Molecular Dynamics Study of Plasma Surface Interactions for Mixed Materials, *Journal of Plasma and Fusion Research SERIES,* **Vol.9,** 497-502, 2010.
471. **Hiroki Hibino, Hiroyuki Kageshima *and* Masao Nagase :** Graphene Growth on Silicon Carbide, *NTT Technical Review,* **Vol.8,** sf4-(6pp), 2010.
472. **Masao Nagase, Kojiro Tamaru, Keiichiro Nonaka, Shinichi Warisawa, Sunao Ishihara *and* Hiroshi Yamaguchi :** Direct Actuation of GaAs Membrane Resonator by Scanning Probe, *NTT Technical Review,* **Vol.8,** rp1-(7pp), 2010.
473. **Kaoru Ohya, MOHARA Naohide, Kensuke Inai, ITO Atsushi, NAKAMURA Hiroaki, UEDA Yoshio *and* TANABE Tetsuo :** Molecular Dynamics Study of Plasma Surface Interactions for Mixed Materials, *J. Plasma Fusion Res. SERIES,* **Vol.9,** 497-502, 2010.
474. **Hiroki Hibino, Hiroyuki Kageshima *and* Masao Nagase :** Epitaxial few-layer graphene: toward single crystal growth, *Journal of Physics D: Applied Physics,* **Vol.43,** *No.37,* 374005-(14pp), 2010.
475. **Kaoru Ohya *and* Kensuke Inai :** Hydrocarbon Redeposition on Plasma Facing Walls Intersecting Magnetic Field at Shallow Angles, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.49,** *No.9,* 096201-1-096201-7, 2010.
476. **Yusuke Ikawa, Yorihide Yuasa, Cheng-Yu Hu, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** 2D Device Simulation of AlGaN/GaN HFET Current Collapse Caused by Surface Negative Charge Injection, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E93-C,** *No.8,* 1218-1224, 2010.
477. **Cheng-Yu Hu, Katsutoshi Nakatani, Hiroji Kawai, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Buffer Layer Doping Concentration Measurement Using VT-VSUB Characteristics of GaN HEMT with p-GaN Substrate Layer, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E93-C,** *No.8,* 1234-1237, 2010.
478. **Kei Takashina, Masao Nagase, K Nishiguchi, Y Ono, H Omi, A Fujiwara, T Fujisawa *and* K Muraki :** Separately contacted monocrystalline silicon double-layer structure with an amorphous silicon dioxide barrier made by wafer bonding, *Semiconductor Science and Technology,* **Vol.25,** *No.12,* 125001-(4pp), 2010.
479. **Kensuke Inai, Yukihiro Tomita, Gakushi Kawamura *and* Kaoru Ohya :** A coupled EDDY/PIC/ELECTRAN simulation of erosion and deposition in gaps, *Fusion Engineering and Design,* **Vol.85,** *No.7-9,* 1416-1420, 2010.
480. **Kaoru Ohya, Naohide Mohara, Kensuke Inai, Atsushi Ito, Hiroaki Nakamura, Andreas Kirschner *and* Dimitry Borodin :** Molecular dynamics and dynamic Monte Carlo studies of mixed materials and their impact on plasma wall interactions, *Fusion Engineering and Design,* **Vol.85,** *No.7-9,* 1167-1172, 2010.
481. **Hayato Kawazome, Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Jun Kawata, Kenji Nishimura *and* Tetsuo Tanabe :** Calculation of D/XB Values of Hydrocarbon Molecules in Tokamak Edge Plasmas, *Plasma and Fusion Research,* **Vol.5,** S2073-1-S2073-5, 2010.
482. **Jin-Ping Ao :** Monolithic Integration of GaN-based LEDs, *Journal of Physics: Conference Series,* **Vol.276,** *No.1,* 012001-1-012001-4, 2011.
483. **Retsuo Kawakami, Niibe Masahito, Fukudome Toshiaki, Takeichi Atsushi, Inaoka Takeshi *and* Tominaga Kikuo :** Effect of DBD Air Plasma Treatment on TiO2 Thin Film Surfaces, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.50,** *No.1,* 01BE02-1-01BE02-5, 2011.
484. **Jin-Ping Ao, Katsutoshi Nakatani, Yuji Sogawa, Shiro Akamatsu, Young Hyun Kim, Takahiro Miyashita, Shin-ichi Motoyama *and* Yasuo Ohno :** GaN MOSFET with a gate SiO2 insulator deposited by silane-based plasma-enhanced chemical vapor deposition, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.8,** *No.2,* 457-460, 2011.
485. **Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Tominaga Kikuo, Niibe Masahito, Mukai Takashi, Takeichi Atsushi *and* Fukudome Toshiaki :** Etch-induced damage characteristics of n-GaN surfaces by capacitively coupled radio frequency He and Ar plasmas, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.8,** *No.2,* 441-443, 2011.
486. **Niibe Masahito, Maeda Yoshie, Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Tominaga Kikuo *and* Mukai Takashi :** Surface analysis of n-GaN crystal damaged by RF-plasma-etching with Ar, Kr, and Xe gases, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.8,** *No.2,* 435-437, 2011.
487. **Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** An EDDY/Particle-in-Cell Simulation of Erosion of Plasma Facing Walls Bombarded by a Collisional Plasma, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.50,** *No.2,* 026001-1-026001-7, 2011.
488. **Kaoru Ohya *and* Hideaki Kuwada :** Modeling of Electron Beam Charging of an Insulating Layer on a Silicon Substrate, *e-Journal of Surface Science and Nanotechnology,* **Vol.9,** 112-116, 2011.
489. **Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Tominaga Kikuo, Niibe Masahito, Mukai Takashi, Takeichi Atsushi *and* Fukudome Toshiaki :** Synergy Effect of Xenon Plasma Ions and Ultraviolet Lights on GaN Etch Surface Damage and Modification, *Transactions of the Materials Research Society of Japan,* **Vol.36,** *No.1,* 75-78, 2011.
490. **大宅 薫, Andreas Kirschner :** 国際連携による核融合炉実現を目指したプラズマ対向炉材料寿命評価コードの開発, *徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部研究報告, No.55,* 31-36, 2010年.
491. **Masao Nagase, Hiroki Hibino, Hiroyuki Kageshima *and* Hiroshi Yamaguchi :** Contact Conductance Measurement of Locally Suspended Graphene on SiC, *Applied Physics Express,* **Vol.3,** *No.4,* 045101-(3pp), 2010.
492. **Shinichi Tanabe, Yoshiaki Sekine, Hiroyuki Kageshima, Masao Nagase *and* Hiroki Hibino :** Half-Integer Quantum Hall Effect in Gate-Controlled Epitaxial Graphene Devices, *Applied Physics Express,* **Vol.3,** *No.7,* 075102-(3pp), 2010.
493. **Hiroyuki Kageshima, Hiroki Hibino, Masao Nagase, Yoshiaki Sekine *and* Hiroshi Yamaguchi :** Atomic Structure and Physical Properties of Epitaxial Graphene Islands Embedded in SiC(0001) Surfaces, *Applied Physics Express,* **Vol.3,** *No.11,* 115103-(3pp), 2010.
494. **日比野 浩樹, 影島 博之, 永瀬 雅夫 :** シリコンカーバイド上のグラフェン成長, --- 特集 材料基礎研究所最前線 ---, *NTT技術ジャーナル,* **Vol.22,** *No.6,* 18-21, 2010年6月.
495. **影島 博之, 日比野 浩樹, 永瀬 雅夫, 山口 浩司 :** SiC上エピタキシャルグラフェン成長の理論検討, *日本結晶成長学会誌,* **Vol.37,** 190-195, 2010年10月.
496. **日比野 浩樹, 影島 博之, 田邉 真一, 永瀬 雅夫, 水野 清義 :** SiC 上エピタキシャルグラフェンの成長と評価, *固体物理,* **Vol.45,** 645-655, 2010年11月.
497. **Kaoru Ohya, Takuya Yamanaka, Daiki Takami *and* Kensuke Inai :** Modeling of charging effects in scanning ion microscopes, *Proceedings of SPIE,* **Vol.7729,** 7729-24-(9pp), Monterey, May 2010.
498. **Kaoru Ohya :** Progress in Modeling Plasma-Material Interactions, *19th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* San Diego, California, USA, May 2010.
499. **Y. Higashizono, M. Sakamoto, K. Ogawa, K. Ozaki, S. Tsuru, R. Ohyama, I. Gouda, T. Shoji, N. Ashikawa, M. Tokitani, K. Tokunaga, S. Masuzaki, Kaoru Ohya, A. Sagara *and* K.N. Sato :** Plasma and Neutral Hydrogen Behavior near Plasma Facing Materials Based on Spectroscopic Measurement and Monte Carlo Simulation in the Compact PWI Simulator APSEDAS, *19th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* San Diego, May 2010.
500. **Daiji Kato, Takahiro Kenmotsu, Kaoru Ohya *and* Tetsuo Tanabe :** Linear Polarization of Photon Emissions from Reflected Neutrals of Atomic Hydrogen at High-Z First-Wall Surfaces, *19th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* San Diego, May 2010.
501. **H.G. Esser, Andreas Kirschner, D. Borodin, D. Matveev, Kaoru Ohya, O. Schmitz *and* V. Philipps :** Analysis of the Local Redeposition Behaviour of Carbon at the Main Walls in TEXTOR by CD4 Gas Injection and Quartz Microbalance Techniques, *19th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* San Diego, May 2010.
502. **M. Sakamoto, Y. Higashizono, K. Ozaki, K. Ogawa, A. Rusinov, N. Ashikawa, M. Tokitani, T. Shoji, S. Masuzaki, K. Tokunaga, Kaoru Ohya, A. Sagara, N. Yoshida *and* K.N. Sato :** Surface Modification of Tungsten and Its Impact of Deuterium Retention, *19th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* San Diego, May 2010.
503. **Qian Xu, Kaoru Ohya, Z.S. Yang, Kensuke Inai, R.J. Hong *and* G.-N. Luo :** Monte Carlo Simulation of Erosion and Deposition Behavior of SiC-coated Graphite Tiles in EAST, *19th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* San Diego, May 2010.
504. **Andreas Kirschner, A. Kreter, P. Wienhold, S. Brezinsek, A. Pospieszczyk, Ch. Schulz, U. Breuer, D. Borodin, M. Clever, A. Huber, D. Matveev, Kaoru Ohya, V. Philipps, U. Samm, O. Schmitz, B. Schweer, H. Stoschus *and* the TEXTOR Team :** Erosion and Deposition Studies on Plasma-Wetted and -Shadowed Areas by Means of Local Impurity Injection in TEXTOR, *19 th International Conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion devices,* San Diego, May 2010.
505. **Niibe Masahito, Maeda Yoshie, Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Tominaga Kikuo *and* Mukai Takashi :** Surface Analysis of n-GaN Crystal Damaged by RF-plasma-etching with Ar, Kr and Xe Gases, *The 37th International Symposium on Compound Semiconductors,* 42, Kagawa, May 2010.
506. **Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Tominaga Kikuo, Niibe Masahito, Mukai Takashi, Takeichi Atsushi *and* Fukudome Toshiaki :** Etch-induced Damage Characteristics of n-GaN Surfaces by Capacitively Coupled Radio Frequency He and Ar Plasmas, *The 37th International Symposium on Compound Semiconductors,* 41, Kagawa, May 2010.
507. **Hiroki Hibino, Hiroyuki Kageshima *and* Masao Nagase :** In-situ surface electron microscopy observations of growth and etching of epitaxial few-layer graphene on SiC, --- [Invited] ---, *International Workshop on "In situ characterization of near surface processes",* Eisenerz, Austria, May 2010.
508. **Jin-Ping Ao, Katsutoshi Nakatani, Yuji Sogawa, Young Hyun Kim, Takahiro Miyashita, Shin-ichi Motoyama *and* Yasuo Ohno :** GaN MOSFET with Gate SiO2 Deposited by Silane-Based PECVD, *The 37th International Symposium on Compound Semiconductors,* Takamatsu, May 2010.
509. **Katsushi Nishino, Yuusuke Sawai, Yuji Nariyuki, Takeshi Noda, Yoshiki Naoi, Shiro Sakai, Atsuyuki Fukano *and* Satoru Tanaka :** TEM Observation of Re-Grown GaN on Nano-Patterned GaN Template, *The 37th International Symposium on Compound Semiconductors,* FrP77, Takamatsu, Jun. 2010.
510. **Retsuo Kawakami, Niibe Masahito, Fukudome Toshiaki, Takeichi Atsushi, Inaoka Takeshi *and* Tominaga Kikuo :** Effect of DBD Air Plasma Treatment on TiO2 Thin Film Surfaces, *The Third International Symposium on Organic and Inorganic Electronic Materials and Related Nanotechnologies (EM-NANO2010),* Toyama, Jun. 2010.
511. **Y. Ono, Y. Miyazaki, S. Yabuuchi, Hiroyuki Kageshima, Masao Nagase, A. Fujiwara *and* E. Ota :** Significance of the Interface regarding Magnetic Properties of Mn-Nanosilicide in Silicon, *Asia-Pacific Conference on Semiconducting Silicides and Related Materials Science and Technology Towards Sustainable Optoelectronics (APAC-SILICIDE 2010), No.25-AM-IV-4,* Tsukuba, Japan, Jul. 2010.
512. **Hiroyuki Kageshima, Hiroki Hibino, Masao Nagase, Yoshiaki Sekine *and* Hiroshi Yamaguchi :** Atomic structure of epitaxial graphene islands on SiC(0001) surfaces and their magnetoelectric effects, *30th International Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS2010), No.TuD1-2,* Seoul, Korea, Jul. 2010.
513. **Yoshiki Naoi *and* Yoshifumi Nishio :** Current Challenges of the Double Degree Master Program in Electrical and Electronic Engineering, *Proceedings of the Fifth International Symposium on the Development of the Global Double Degree Program (GDDP),* 15, Tokushima, Aug. 2010.
514. **Fumiya Horie, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** High Temperature Growth of AlxCy by Chemical Vapor Deposition, *The 16th International Conference on Crystal Growth(ICCG-16),* Beijing, Aug. 2010.
515. **Masao Nagase, Hiroki Hibino, Hiroyuki Kageshima *and* Hiroshi Yamaguchi :** Contact conductance measurement of nano-membrane structure of graphene on SiC, *18th International Vacuum Congress (IVC-18)/International Conference on Nanoscience and Technology (ICN+T 2010)/14th International Conference on Surfaces Science (ICSS-14)/Vacuum and Surface Sciences Conference of Asia and Australia (VASSCAA-5), No.P1-EmP1-18,* Beijing, China, Aug. 2010.
516. **Hiroki Hibino, Hiroyuki Kageshima, Shinichi Tanabe, Masao Nagase, Seigi Mizuno *and* Satoru Tanaka :** Surface Electron Microscopy of Epitaxial Graphene, --- [Invited] ---, *Second International Symposium on the Science and Technology of Epitaxial Graphene (STEG2),* Amelia Island, Florida, USA, Sep. 2010.
517. **Mami Abe, Takahumi Amou, Kenji Kuramoto, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Effects of Substrate Conductivity on Open-Ring Resonator Wireless Interconnection, *2010 Asia-Pacific Radio Science Conference,* Toyama, Sep. 2010.
518. **Shinichi Tanabe, Yoshiaki Sekine, Hiroyuki Kageshima, Masao Nagase *and* Hiroki Hibino :** Observation of bandgap in epitaxial bilayer graphene field effect transistors, *2010 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2010),* Sendai, Japan, Sep. 2010.
519. **Jin-Ping Ao, Kensuke Takahashi, Naoki Shinohara, Naoki Niwa, Teruo Fujiwara *and* Yasuo Ohno :** S-parameter Analysis of GaN Schottky Diodes for Microwave Power Rectification, *2010 IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium,* Monterey, Oct. 2010.
520. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Naohide Mohara, Yohei Miyake, Andreas Kirschner, Dimitry Borodin, Doerner Russell, Yoshio Ueda *and* Tetsuo Tanabe :** Molecular Dynamics Study of Plasma Surface Interaction of Codeposited Materials, *23th IAEA Fusion Energy Conference, THD/P3-04,* Daejeon, Oct. 2010.
521. **Masataka Bando, Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Modeling of Impurity Transport in Edge Plasmas and Tritium Codeposition on Plasma Facing Walls in ITER, *9th International Conference on Tritium Science and Technology, 3P07-48,* Nara, Oct. 2010.
522. **Kaoru Ohya *and* Hideaki Kuwada :** Modeling of Electron Beam Charging of an Insulating Layer on Materials, *6th International Workshop on Nano-Scale Spectroscopy & Nanotechnology, P-23, October 25-29, 2010, Kobe Univ., Japan,* Kobe, Oct. 2010.
523. **Hiroki Hibino, Shinichi Tanabe, Hiroyuki Kageshima *and* Masao Nagase :** Growth, structure, and transport properties of epitaxial graphene on SiC, --- [Invited] ---, *International Symposium on Graphene Devices 2010 (ISGD2010),* Sendai, Japan, Oct. 2010.
524. **Masao Nagase, Hiroki Hibino, Hiroyuki Kageshima *and* Hiroshi Yamaguchi :** Electrical contact properties of few-layer graphene on SiC substrate, --- [Invited] ---, *International Symposium on Graphene Devices 2010 (ISGD2010),* Sendai, Japan, Oct. 2010.
525. **Hiroyuki Kageshima, Hiroki Hibino, Masao Nagase, Yoshiaki Sekine *and* Hiroshi Yamaguchi :** Theoretical study on functions of graphene, --- [Invited] ---, *International Symposium on Graphene Devices 2010 (ISGD2010),* Sendai, Japan, Oct. 2010.
526. **Jin-Ping Ao :** Monolithic Integration of GaN-based LEDs, *2nd Photonics and Optoelectronics Meetings (POEM2010),* Wuhan, Nov. 2010.
527. **永瀬 雅夫 :** 物性，評価技術, --- [招待講演] ---, *MNC技術セミナー「グラフェン」,* 北九州, 2010年11月.
528. **Retsuo Kawakami, Takeichi Atsushi, Niibe Masahito, Inaoka Takeshi *and* Tominaga Kikuo :** Capacitively Coupled Radio Frequency Helium Plasma Etch Damage to TiO2 Thin Film Surfaces, *Proceedings of International Symposium of Dry Process 2010,* 171-172, Tokyo, Nov. 2010.
529. **Hiroyuki Kageshima, Hiroki Hibino, Masao Nagase, Yoshiaki Sekine *and* Hiroshi Yamaguchi :** Theoretical study on growth, structure, and physical properties of graphene on SiC, --- [Invited] ---, *"Japan-Korea Symposium on Surface and Nanostructure 9th" (JKSSN9),* Sendai, Japan, Nov. 2010.
530. **Shinichi Tanabe, Yoshiaki Sekine, Hiroyuki Kageshima, Masao Nagase *and* Hiroki Hibino :** Electronic transport properties of top-gated monolayer and bilayer graphene devices on SiC, *The 2010 Fall Meeting of the Materials Research Society (MRS), No.B9.2,* Boston, USA, Dec. 2010.
531. **Masataka Bando *and* Kaoru Ohya :** Modeling of impurity release, transport and deposition on plasma facing components in ITER, *20th International Toki Conference, The Next Twenty Years in Plasma and Fusion Science, December 7-10, Toki, Gifu, Japan, P1-57,* Gifu, Dec. 2010.
532. **Mami Abe, Yuka Okuyama, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Misalignment Effects in Inter-Chip Wireless Connection with Open-Ring Resonators, *2010 Asia-Pacific Microwave Conference (APM C2010),* Yokohama, Dec. 2010.
533. **Yasuo Ohno :** Application of GaN Devices to Wireless Power Transmission, *2010 Asia-Pacific Microwave Conference (APM C2010),* Yokohama, Dec. 2010.
534. **Yohei Miyake *and* Kaoru Ohya :** Molecular dynamics study of plasma wall interactions of W and C containing Be impurity, *20th International Toki Conference, The Next Twenty Years in Plasma and Fusion Science, December 7-10, Toki, Gifu, Japan, P2-77,* Gifu, Dec. 2010.
535. **Hayato Kawazome, Kaoru Ohya *and* Jun Kawata :** Redeposition characteristics of heavy hydrocarbon molecules on a divertor plate, *20th International Toki Conference, The Next Twenty Years in Plasma and Fusion Science, December 7-10, Toki, Gifu, Japan, P2-78,* **Vol.6,** *No.1,* Dec. 2010.
536. **Yoshiaki Sekine, Hiroki Hibino, Katsuya Oguri, Tatsushi Akasaki, Hiroyuki Kageshima, Masao Nagase *and* Hiroshi Yamaguchi :** Surface-enhanced Raman spectroscopy of graphene grown on SiC, *The International Symposium on Nanoscale Transport and Technology (ISNTT2011), No.PWe-12,* Atsugi, Japan, Jan. 2011.
537. **Hiroyuki Kageshima, Hiroki Hibino, Masao Nagase, Yoshiaki Sekine *and* Hiroshi Yamaguchi :** Theoretical study on magnetoelectric effects of embedded graphene nanoribbons on SiC(0001) surface, *The International Symposium on Nanoscale Transport and Technology (ISNTT2011), No.PWe-10,* Atsugi, Japan, Jan. 2011.
538. **Hiroyuki Kageshima, Hiroki Hibino, Hiroshi Yamaguchi *and* Masao Nagase :** Theoretical study on epitaxial graphene growth on SiC(0001) surface, *2011 International Workshop on Dielectric Thin Films for Future Electron Devices: Science and Technology (IWDTF2011), No.P-24,* Tokyo, Japan, Jan. 2011.
539. **Niibe Masahito, Kotaka Takuya, Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Tominaga Kikuo *and* Mukai Takashi :** Damage Analysis of Plasma-etched n-GaN Crystal Surface by N-K Absorption Spectroscopy, *3rd International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials (ISPlasma2011),* Nagoya, Mar. 2011.
540. **西野 克志 :** 直接合成法によるa面GaNの結晶成長, *LED総合フォーラム,* P20, 2010年4月.
541. **高見 大気, 山中 卓也, 井内 健介, 大宅 薫 :** イオン衝撃による絶縁物の二次電子放出と帯電のシミュレーション, *日本顕微鏡学会第66回学術講演会,* 2010年5月.
542. **日下 一也, 富永 喜久雄 :** 電源の異なる二種類のスパッタリング法で堆積させた2層の窒化アルミニウム薄膜の残留応力測定, *第44回X線材料強度に関するシンポジウム講演論文集,* 105-109, 2010年7月.
543. **大森 悠丘, 丸尾 洋一, 村井 啓一郎, 富永 喜久雄, 森賀 俊広 :** 対向ターゲット式DCスパッタリング装置を用い電流比を変化させて作製したIZO薄膜の特性, *応用物理学会中国四国支部 日本物理学会中国支部・四国支部 日本物理教育学会中国四国支部 2010年度支部学術講演会,* 2010年7月.
544. **阿部 まみ, 敖 金平, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器無線接続における基板抵抗の影響, *第71回応用物理学会学術講演会,* 2010年9月.
545. **原内 健次, 細川 大志, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN横型ショットキーダイオードのSパラメータ解析, *第71回応用物理学会学術講演会,* 2010年9月.
546. **細川 大志, 原内 健次, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN横型ショットキーダイオードの二次元デバイスシミュレーション, *第71回応用物理学会学術講演会,* 2010年9月.
547. **川上 烈生, 新部 正人, 武市 敦, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** GaNの容量結合型RFヘリウムプラズマエッチダメージ, *第71回秋季応用物理学会学術講演会論文集, No.1,* 08-132, 2010年9月.
548. **新部 正人, 前田 佳恵, 川上 烈生, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** Ar, KrおよびXeガスを用いてRFプラズマエッチングしたn-GaN 結晶の表面分析, *第71回秋季応用物理学会学術講演会論文集, No.1,* 08-133, 2010年9月.
549. **原 航平, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** Taマスクを用いたMOCVD再成長GaNの表面モフォロジー改善, *第71回応用物理学会学術講演会,* 15p-C-8, 2010年9月.
550. **田邉 真一, 関根 佳明, 影島 博之, 永瀬 雅夫, 日比野 浩樹 :** 単層エピタキシャルグラフェンにおける半整数量子ホール効果の観測, *第71回応用物理学会学術講演会, No.16a-ZQ-11,* 2010年9月.
551. **影島 博之, 日比野 浩樹, 山口 浩司, 永瀬 雅夫 :** SiC上エピタキシャルグラフェンのステップ境界, *第71回応用物理学会学術講演会, No.16a-ZM-9,* 2010年9月.
552. **堀江 郁哉, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** MOCVD法によるAlC薄膜の成長, *第71回応用物理学会学術講演会,* 16a-ZT-11, 2010年9月.
553. **川上 烈生, 新部 正人, 武市 敦, 稲岡 武, 小西 将士, 森 祐太, 兒玉 宗久, 富永 喜久雄 :** TiO2光触媒へのDBDエアプラズマトリートメント効果, *平成22年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 20, 2010年9月.
554. **武市 敦, 川上 烈生, 新部 正人, 稲岡 武, 向井 考志, 小西 将士, 森 祐太, 兒玉 宗久, 富永 喜久雄 :** ヘリウムとアルゴンプラズマによる窒化ガリウムエッチングダメージ, *平成22年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 21, 2010年9月.
555. **川崎 晃一, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** MOCVD法によるSiおよびサファイア上へのGeC薄膜の成長, *平成22年度電気関係学会四国支部連合大会,* 11-2, 2010年9月.
556. **松本 将和, 福田 弘之, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** GaN系UV-LEDの偏光特性, *平成22年度電気関係学会四国支部連合大会,* 11-14, 2010年9月.
557. **楠 貴大, 沼島 明菜, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** ナノ微粒子技術を用いたGaN表面周期構造の作製, *平成22年度電気関係学会四国支部連合大会,* 11-17, 2010年9月.
558. **和田 祥吾, 直井 美貴, 酒井 士郎, 深野 敦之, 田中 覚 :** 金属マスクを施したサファイア表面周期構造へのGaN成長と評価, *平成22年度電気関係学会四国支部連合大会,* 11-18, 2010年9月.
559. **加藤 保洋, 中内 潤, 西野 克志, 月原 政志, 酒井 士郎 :** 昇華法によるバルクAlNの成長, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* 11-3, 2010年9月.
560. **高見 大気, 山中 卓也, 大宅 薫 :** イオンビーム照射による絶縁物薄膜の帯電と二次電子放出のシミュレーション, *第30回LSIテスティングシンポジウム会議録,* 41-46, 2010年11月.
561. **大宅 薫 :** ベリリウム堆積によるITERダイバータにおける損耗・再堆積のシミュレーション, *平成22年 PWI合同研究会(核融合科学研究所),* 2010年11月.
562. **大宅 薫, 三宅 洋平 :** ベリリウム混合層におけるプラズマ・壁相互作用の分子動力学シミュレーション, *第27回プラズマ・核融合学会年会，札幌，2010年11月30日∼12月3日，30P56,* 2010年11月.
563. **Kirschner Andreas, 大宅 薫, Borodin D., Matveev D., Galonska A., Brezinsek Sebastian, Esser H.G., Kreter A., Litnovsky A., Philipps V., Samm U., Wienhold P., Kawamura G., Tanabe T., Ueda Y. :** Simulation of material migration in tokamaks, *第27回プラズマ・核融合学会年会，札幌，2010年11月30日∼12月3日，02pB02,* 2010年12月.
564. **新部 正人, 小高 拓也, 川上 烈生, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** プラズマエッチングしたGaN結晶のN-K吸収測定によるダメージ解析II, *第24回日本放射光学会年会,* 2011年1月.
565. **原内 健次, 岩崎 裕一, 阿部 まみ, 敖 金平, 篠原 真毅, 外村 博史, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器接続によるマイクロ波無線電力伝送, *2011年電子情報通信学会総合大会,* 2011年3月.
566. **細川 大志, 黒田 健太郎, 井谷 祥之, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET 電流コラプスの回復過程測定, *第57回応用物理学関係連合講演会,* 2011年3月.
567. **関根 佳明, 日比野 浩樹, 小栗 克弥, 赤崎 達志, 影島 博之, 永瀬 雅夫, 山口 浩司 :** SiC 上グラフェンの表面増強ラマン散乱, *日本物理学会 第66回年次大会, No.26aTA-3,* 2011年3月.
568. **田邉 真一, 関根 佳明, 影島 博之, 永瀬 雅夫, 日比野 浩樹 :** エピタキシャルグラフェンの Hall 移動度評価, *第58回 応用物理学関係連合講演会, No.26p-KE-14,* 2011年3月.
569. **呉 龍錫, 岩本 篤, 西 勇輝, 船瀬 雄也, 湯浅 貴浩, 富田 卓朗, 永瀬 雅夫, 日比野 浩樹, 山口 浩司 :** ラマン分光法による 4H-SiC 上エピタキシャルグラフェンの膜質評価, *第58回 応用物理学関係連合講演会, No.26p-KE-17,* 2011年3月.
570. **影島 博之, 日比野 浩樹, 山口 浩司, 永瀬 雅夫 :** SiC(0001) 面上での S i 脱離とグラフェン形成, *第58回 応用物理学関係連合講演会, No.26p-BM-1,* 2011年3月.
571. **永瀬 雅夫 :** ナノプロセスと材料による新たなデバイスの創出, --- [招待講演] ---, *第58回 応用物理学関係連合講演会シンポジウム:異種機能集積化と応用物理~最先端多様分野の融合によって拓かれ る未来社会~, No.26p-BV-4,* 2011年3月.
572. **中野 由崇, 川上 烈生, 新部 正人, 武市 敦, 稲岡 武, 富永 喜久雄 :** GaN のプラズマエッチング損傷のフォトルミネッセンス評価, *第58回春季応用物理学会学術講演会, No.1,* 2011年3月.
573. **松本 将和, 福田 弘之, 直井 美貴, 酒井 士郎, 深野 敦之, 田中 覚 :** 表面・界面に周期構造を有するGaN系LEDの配向特性評価, *LED総合フォーラム,* 69, 2010年4月.
574. **川上 烈生, 福留 利章, 武市 敦, 稲岡 武, 富永 喜久雄 :** UV-LED光触媒反応によるクライマクテリック型果実の汎用型鮮度維持技術の開発研究, *LED総合フォーラム2010 in 徳島,* 89-92, 2010年4月.
575. **永瀬 雅夫 :** グラフェン研究の現状と新規材料としての可能性について, *CPC研究会,* 2010年6月.
576. **川上 烈生 :** LED光触媒酸化作用を用いた果実の汎用型鮮度保持技術の開発研究, *四国まるごと「食と健康」イノベーション2010∼四国の研究機関が集い「食と健康」リソースを発信∼,* 2010年8月.
577. **川上 烈生 :** 果実の汎用型鮮度維持装置(JST成果の一部としてLED光触媒装置の出展参加), *徳島ビジネスチャレンジメッセ2010,* 2010年10月.
578. **永瀬 雅夫 :** グラフェン材料開発の最前線, *学振・将来加工技術第136委員会 第11回研究会(合同),* 2010年11月.
579. **新部 正人, 小高 拓也, 川上 烈生, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** 希ガスプラズマでエッチングしたn-GaN結晶のNEXAFS測定によるダメージ解析, *2011先端技術セミナー，高度産業科学技術研究所主催,* 65, 2011年3月.
580. **永瀬 雅夫 :** グラフェンの作製と応用展開, --- 基礎から量産・実用化に向けた研究動向 ---, *情報機構セミナー,* 2011年3月.
581. **川上 烈生 :** 高周波キセノンプラズマによる自己無撞着な衝撃粒子エネルギー分布及び粒子束の解析, *平成22年度核融合科学研究所LHD数値解析システム利用共同研究報告書,* 日本, 2011年3月.
582. **川上 烈生 :** プラズマイオンと紫外光線のシナジー効果によるワイドギャップ半導体エッチングダメージの振舞い, *平成22年度先端工学教育研究プロジェクト,* 日本, 2011年3月.
583. **一樂 浩之, 笠谷 武司, 田中 義浩, 衣斐 八束, 福井 明, 川上 烈生, 稲岡 武 :** 果実殺菌のための紫外線/ラジカルジェットデバイスの開発研究, *財団法人 阿波銀行学術・文化振興財団,平成22年度(第15回)学術部門助成(地域共同研究助成,* 日本, 2011年3月.
584. **永瀬 雅夫, 他 :** ナノカーボンの応用と実用化, --- ―フラーレン,ナノチューブ,グラフェンを中心に― ---, 株式会社 シーエムシー出版, 東京, 2011年7月.
585. **Shinichi Tanabe, Yoshiaki Sekine, Hiroyuki Kageshima, Masao Nagase *and* Hiroki Hibino :** Electronic transport properties of top-gated monolayer and bilayer graphene devices on SiC, *Materials Research Society Symposia Proceedings,* **Vol.1283,** opl.2011.675-(6pp), 2011.
586. **Shinichi Tanabe, Yoshiaki Sekine, Hiroyuki Kageshima, Masao Nagase *and* Hiroki Hibino :** Observation of band gap in epitaxial bilayer graphene field effect transistors, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.50,** *No.4,* 04DN04-(4pp), 2011.
587. **Teruaki Takeuchi, Kosuke Tatsumura, Iwao Ohdomari, Takayoshi Shimura *and* Masao Nagase :** X-ray diffraction profiles of Si nanowires with trapezoidal cross-sections, *Physica B : Condensed Matter,* **Vol.406,** *No.13,* 2559-2564, 2011.
588. **Hiroyuki Kageshima, Hiroki Hibino, Masao Nagase, Yoshiaki Sekine *and* Hiroshi Yamaguchi :** Theoretical Study on Magnetoelectric and Thermoelectric Properties for Graphene Devices, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.50,** *No.7,* 070115-(5pp), 2011.
589. **Hayato Kawazome, Kaoru Ohya *and* Jun Kawata :** Redeposition Characteristics of Heavy Hydrocarbon Molecules on a Divertor Plate, *Plasma and Fusion Research,* **Vol.6,** 2405034-1-2405034-4, 2011.
590. **Qian Xu, Kaoru Ohya, Z.S. Yang, Kensuke Inai *and* G.-N. Luo :** Monte Carlo simulation of erosion and deposition behavior on SiC-coated graphite tiles in EAST, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.415,** *No.1, Supplement,* S153-S156, 2011.
591. **Andreas Kirschner, A. Kreter, P. Wienhold, S. Brezinsek, J.W. Coenen, H.G. Esser, A. Pospieszczyk, Ch. Schulz, U. Breuer, D. Borodin, M. Clever, R. Ding, A. Galoska, A. Huber, A. Litnovsky, D. Matveev, Kaoru Ohya, V. Philipps, U. Samm, O. Schmitz, B. Schweer, H. Stoschus *and* TEXTOR team :** Deposition and re-erosion studies by means of local impurity injection in TEXTOR, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.415,** *No.1, Supplement,* S239-S245, 2011.
592. **H.G. Esser, A. Kirschner, D. Borodin, D. Matveev, Kaoru Ohya, O. Schmitz *and* V. Philipps :** Analysis of the local re-deposition behavior of carbon at the main walls in TEXTOR by CD4 Gas injection and Quartz Microbalance techniques, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.415,** *No.1, Supplement,* S246-S249, 2011.
593. **Daiji Kato, Takahiro Kenmotsu, Kaoru Ohya *and* Tesuo Tanabe :** Linear polarization of photon emissions from reflected neutrals of atomic hydrogen at high-Z first wall surfaces, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.415,** *No.1, Supplemernt,* S1162-S1165, 2011.
594. **Retsuo Kawakami, Takeichi Atsushi, Niibe Masahito, Inaoka Takeshi *and* Tominaga Kikuo :** Damage Characteristics of TiO2 Thin Film Surfaces Etched by Capacitively Coupled Radio Frequency Helium Plasmas, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.50,** *No.8,* 08KD01-1-08KD01-5, 2011.
595. **Hiroyuki Kageshima, Hiroki Hibino, Hiroshi Yamaguchi *and* Masao Nagase :** Theoretical Study on Epitaxial Graphene Growth by Si Sublimation from SiC(0001) Surface, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.50,** *No.9,* 095601-(6pp), 2011.
596. **Shinichi Tanabe, Yoshiaki Sekine, Hiroyuki Kageshima, Masao Nagase *and* Hiroki Hibino :** Carrier transport mechanism in graphene on SiC(0001), *Physical Review B, Condensed Matter and Materials Physics,* **Vol.84,** *No.11,* 115458-(5pp), 2011.
597. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Mitsuo Inoue, Yukihiro Tomita, Gakushi Kawamura *and* Tetsuo Tanabe :** Toroidal and poloidal asymmetry in carbon deposition on gaps of plasma facing tiles, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.417,** *No.1-3,* 602-606, 2011.
598. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai, Yasuyuki Kikuhara, Naohide Mohara, Atsushi Ito, Hiroaki Nakamura *and* Tetsuo Tanabe :** Molecular dynamics study on hydrocarbon interaction with plasma facing walls, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.417,** *No.1-3,* 637-642, 2011.
599. **Y. Ono, Y. Miyazaki, S. Yabuuchi, Hiroyuki Kageshima, Masao Nagase, A. Fujiwara *and* E. Ohta :** Significance of the interface regarding magnetic properties of manganese nanosilicide in silicon, *Thin Solid Films,* **Vol.519,** *No.24,* 8505-8508, 2011.
600. **Masataka Bando, Kaoru Ohya *and* Kensuke Inai :** Modeling of Impurity Transport in Edge Plasmas and Tritium Codeposition on Plasma Facing Walls in ITER, *Fusion Science and Technology,* **Vol.60,** *No.4,* 1467-1470, 2011.
601. **Kaoru Ohya, Daiki Takami *and* Takuya Yamanaka :** Modeling of charging effect on ion induced secondary electron emission from nanostructured materials, *Journal of Vacuum Science and Technology. B, Nanotechnology & Microelectronics : Materials, Processing, Measurement, & Phenomena : JVST B,* **Vol.29,** *No.6,* 06F901-1-06F901-6, 2011.
602. **Kaoru Ohya *and* Andreas Kirschner :** Simulation of hydrogen retention and re-emission from tungsten exposed to divertor plasmas, *Physica Scripta,* **Vol.T145,** 014047(4pp), 2011.
603. **Andreas Kirschner, H.G. Esser, D. Matveev, O.Van Hoey, D. Borodin, A. Galonska, Kaoru Ohya, V. Philipps, A. Pospieszczyk, U. Samm, O. Schmitz, P. Wienhold *and* TEXTOR team :** Modelling of carbon deposition from CD4 injection in the far scrape-off layer of TEXTOR, *Physica Scripta,* **Vol.T145,** 014005(4pp), 2011.
604. **Cheng-Yu Hu, Daigo Kikuta, Masahiro Sugimoto, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** VT-VSUB Characterization of AlGaN/GaN HFET With p-Type Body Layer, *IEEE Transactions on Electron Devices,* **Vol.58,** *No.12,* 4265-4271, 2011.
605. **Nakano Yoshitaka, Retsuo Kawakami, Niibe Masahito, Takeichi Atsushi, Inaoka Takeshi *and* Tominaga Kikuo :** Photoluminescence Study of Damage Introduced in GaN by Ar- and Kr-Plasmas Etching, *Materials Research Society Symposia Proceedings,* **Vol.1396,** *No.mrsf11-1396-o07-36,* 1-6, 2011.
606. **Hiroyuki Kageshima, Hiroki Hibino, Masao Nagase, Yoshiaki Sekine *and* Hiroshi Yamaguchi :** Atomic structure of epitaxial graphene islands on SiC(0001) surfaces and their magnetoelectric effects, *AIP Conference Proceedings,* **Vol.1399,** 755-756, 2011.
607. **Niibe Masahito, Kotaka Takuya, Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Tominaga Kikuo *and* Mukai Takashi :** Damage Analysis of Plasma-etched n-GaN Crystal Surface by Nitrogen K-edge NEXAFS Spectroscopy, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.51,** *No.1,* 01AB02-1-01AB02-4, 2012.
608. **永瀬 雅夫 :** グラフェン研究の現状と新規材料としての可能性, *炭素材料の研究開発動向 2011,* 61-70, 2011年5月.
609. **酒井 士郎 :** 半導体発光デバイスの現状, *日本画像学会誌,* **Vol.191,** *No.3,* 238-245, 2011年6月.
610. **Kaoru Ohya :** Progress in modeling erosion and redeposition on plasma facing materials, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.415,** *No.1, Supplement,* S10-S18, Aug. 2011.
611. **Kaoru Ohya *and* Andreas Kirschner :** Simulation of Hydrogen Retention and Re-emission from Tungsten Exposed to Divertor Plasmas, *13th International Workshop on Plasma-Facing Materials and Components for Fusion Applications and 1st International Conference on Fusion Energy Materials Science,* May 2011.
612. **Andreas Kirschner, E.G. Esser, D. Matveev, O. VanHoey, D. Borodin, A. Galonska, Kaoru Ohya, V. Philipps, A. Pospieszczyk, U. Samm, O. Schmitz, P. Wienhold *and* team TEXTOR :** Modelling of carbon deposition from CD4 injection in the far Scrape-Off Layer of TEXTOR, *13th International Workshop on Plasma-Facing Materials and Components for Fusion Applications and 1st International Conference on Fusion Energy Materials Science,* May 2011.
613. **Kenji Harauchi, Yuichi Iwasaki, Mami Abe, Jin-Ping Ao, Naoki Shinohara, Hiroshi Tonomura *and* Yasuo Ohno :** Power Transmission through Insulating Plate Using Open-Ring Resonator Coupling and GaN Schottky Diode, *IEEE MTT-S International MicrowaveWorkshop Series (IMWS) on InnovativeWireless Power Transmission: Technologies, Systems, and Applications,* 33-36, Kyoto, May 2011.
614. **Y. Yoshida, K. Hara, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** MOCVD-GaN growth on separated GaN from sapphire using Tantalium, *Asia-Pacific Workshop on Widegap Semiconductors, No.We-P47,* 321-322, Toba( Mie, Japan), May 2011.
615. **Kaoru Ohya, Daiki Takami *and* Takuya Yamanaka :** Modeling of Charging Effect on Ion Induced Secondary Electron Emission from Nano-structured Materials, *55th International Conference on Electron, Ion and Photon Beam Technology & Nanofabrication,* Las Vegas, Jun. 2011.
616. **Yasuo Ohno *and* Jin-Ping Ao :** Microwave Power Transmission Using Open-ring Resonators Coupling and GaN SBD, *2011 Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices,* Daejeon, Jun. 2011.
617. **Retsuo Kawakami, Takeichi Atsushi, Niibe Masahito, Konishi Masashi, Mori Yuta, Kodama Munehisa, Kotaka Takuya, Inaoka Takeshi, Tominaga Kikuo *and* Mukai Takashi :** Capacitively Coupled Radio Frequency Nitrogen Plasma Etch Damage to n-Type Gallium Nitride, *Proceedings of 11th International Symposium of Sputtering & Plasma Processes,* 54-57, Kyoto, Jul. 2011.
618. **Takeichi Atsushi, Retsuo Kawakami, Niibe Masahito, Konishi Masashi, Mori Yuta, Kodama Munehisa, Kotaka Takuya, Inaoka Takeshi *and* Tominaga Kikuo :** Capacitively Coupled Radio Frequency Helium Plasma Treatment Effect on TiO2 Thin Film Surfaces, *Proceedings of 11th International Symposium of Sputtering & Plasma Processes,* 584-61, Kyoto, Jul. 2011.
619. **Kotaka Takuya, Niibe Masahito, Retsuo Kawakami, Inaoka Takeshi, Tominaga Kikuo *and* Mukai Takashi :** Damage analysis of gallium nitride crystals etched by He and Ar plasma, *Proceedings of 11th International Symposium of Sputtering & Plasma Processes,* 73-76, Kyoto, Jul. 2011.
620. **Jin-Ping Ao, Yoshiki Naoi *and* Yasuo Ohno :** Thermally Stable TiN Schottky Contact on AlGaN/GaN Heterostructure, *The 11th International Symposium on Sputtering & Plasma Processes,* Kyoto, Jul. 2011.
621. **Yasuo Ohno, Kentaro Kuroda, Yuka Ohmori, Taishi Hosokawa *and* Jin-Ping Ao :** Measurement of AlGaN/GaN HFET Current Collapse Recovery Process, *9th International Conference on Nitride Semiconductors,* Glasgow, Jul. 2011.
622. **Yoshiaki Sekine, Hiroki Hibino, Katsuya Oguri, Tatsushi Akasaki, Hiroyuki Kageshima, Masao Nagase *and* Hiroshi Yamaguchi :** Surface-enhanced Raman scattering of graphene on SiC, *The 6th International School and Conference on Spintronics and Quantum Infromation Technology (SPINTECH6), No.WP-86,* Matsue, Japan, Aug. 2011.
623. **Yuichi Iwasaki, Kenji Harauchi, Jin-Ping Ao, Naoki Shinohara, Hiroshi Tonomura *and* Yasuo Ohno :** Open-Ring Resonator Coupling with GaN SBD for Microwave Power Transmission, *9th Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Gifu, Aug. 2011.
624. **Yusuke Ikawa, Taishi Hosokawa, Yusuke Kio, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** 2D Device Simulation of AlGaN/GaN HFET Current Collapse Caused by Deep Levels in GaN Buffer Layer, *2011 International Conference on Solid State Devices and Materials,* Nagoya, Sep. 2011.
625. **Hiroyuki Kageshima, Hiroki Hibino, Hiroshi Yamaguchi *and* Masao Nagase :** Theory on Initial Stage of Epitaxial Graphene Growth on SiC(0001), *2011 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2011),* Nagoya, Japan, Sep. 2011.
626. **Kaoru Ohya *and* Yohei Miyake :** Molecular Dynamics Study of Hydrogen Interaction with Carbon and Beryllium Deposits, *15th International Conference on Fusion Reactor Materials,* 15-048, Oct. 2011.
627. **Kaoru Ohya, Masatsugu Ohashi *and* Masataka Bando :** Modeling of Long-Distance Transport of Carbon and Beryllium in an ITER edge plasma, *15th International Conference on Fusion Reactor Materials,* 15-170, Oct. 2011.
628. **O Ryongsok, Atsushi Iwamoto, Yuki Nishi, Yuya Funase, Takahiro Yuasa, Takuro Tomita, Masao Nagase, Hiroki Hibino *and* Hiroshi Yamaguchi :** Microscopic Raman mapping for epitaxial graphene on 4H-SiC (0001), *24th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2011),* **Vol.51,** *No.6,* Kyoto, Japan, Oct. 2011.
629. **Retsuo Kawakami, Niibe Masahito, Takeichi Atsushi, Mori Yuta, Konishi Masashi, Kotaka Takuya, Matsunaga Fumihiko, Takasaki Toshihide, Kitano Takanori, Miyazaki Takahiro, Inaoka Takeshi *and* Tominaga Kikuo :** Characteristics of TiO2 Thin Film Surfaces Treated by Dielectric Barrier Discharge Helium and Air Plasmas, *Proceedings of International Symposium of Dry Process 2011,* 75-76, Kyoto, Nov. 2011.
630. **Kaoru Ohya *and* Yoshio Soneda :** Simulation of Deuterium Retention in Tungsten Exposed to Divertor Plasmas, *21st International Toki Conference: Integration of Fusion Science and Technology for Steady State Operation, November 28-December 1, 2011, Toki, Japan,* **Vol.7,** P1-29, Nov. 2011.
631. **Nakano Yoshitaka, Retsuo Kawakami, Niibe Masahito, Takeichi Atsushi, Inaoka Takeshi *and* Tominaga Kikuo :** Photoluminescence Study of Plasma-Induced Etching Damages in GaN, *2011 Materials Research Society (MRS) Fall Meeting & Exhibit,* Boston, Dec. 2011.
632. **Kaoru Ohya :** Modeling plasma interactions with ITER wall materials, *IAEA Technical Meeting on Improving the Database for Physical and Chemical Sputtering, Mon-Tue 12-13 Dec 2011, IAEA Headquarters, Vienna, Austria,* Dec. 2011.
633. **Kaoru Ohya :** Molecular dynamics study of hydrogen and hydrocarbon interaction with carbon and beryllium deposits, *IAEA Technical Meeting on Ab Initio-Based Methods for Plasma-Material Interaction in Fusion Devices, Wed-Thu 14-15 December, IAEA Headquarters, Vienna, Austria,* Dec. 2011.
634. **Hiroyuki Kageshima, Hiroki Hibino, Hiroshi Yamaguchi *and* Masao Nagase :** Role of steps and edges in epitaxial graphene growth on SiC(0001), *International Symposium on Surface Science -Towards Nano-, Bio-, and Green Inovation-(ISSS-6), No.14amB-1-2,* Tokyo, Japan, Dec. 2011.
635. **Kaoru Ohya :** Introduction to impurity transport modelling and plasma-wall interaction, *Joint ICTP-IAEA Workshop on Fusion Plasma Modelling using Atomic and Molecular Data, Trieste-Italy, 23-27 January 2012,* Jan. 2012.
636. **Kaoru Ohya :** Further on kinetic modelling of near-wall plasma, *Joint ICTP-IAEA Workshop on Fusion Plasma Modelling using Atomic and Molecular Data, Trieste-Italy, 23-27 January 2012,* Jan. 2012.
637. **Shogo Wada, Fumiya Horie *and* Shiro Sakai :** Optimum temperature to grow nano-AlC on sapphire by metalorganic chemical vapor deposition, *4th Int. Symp. on Advanced Plasma Science and its Application for Nitride and Nanomaterls,* Mar. 2012.
638. **Qingpeng Wang, Kentaro Tamai, Takahiro Miyashita, Shin-ichi Motoyama, Dejun Wang, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Influence of Dry Recess Process on Enhancement-mod GaN MOSFET, *4th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Application for Nitrides and Nanomaterials,* Nagoya, Mar. 2012.
639. **Niibe Masahito, Kotaka Takuya, Retsuo Kawakami, Nakano Yoshitaka, Inaoka Takeshi, Tominaga Kikuo *and* Mukai Takashi :** Damage Analysis of n-GaN Crystals Etched with He and N2 Plasma, *4th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials (ISPlasma2012),* Nagoya, Mar. 2012.
640. **F. Horie, Y. Ohnishi, Y. Naoi, 酒井 士郎 :** Heterostructure Formation on AlC/Sapphire Substrate, *30th Electronic Materials Symposium,* Th2-16, 2011年6月.
641. **影島 博之, 日比野 浩樹, 山口 浩司, 永瀬 雅夫 :** SiC(0001)面上エピタキシャルグラ フェンの構造と形成 (招待講演), --- [招待講演] ---, *応用物理学会シリコンテクノロジー分科会第137回研究集会「ゲートスタッ ク技術の進展-半導体機能界面の特性評価を中心に」,* 2011年7月.
642. **日下 一也, 富永 喜久雄 :** 金属-セラミックス傾斜機能薄膜の金属界面層の残留応力測定, *第45回X線材料強度に関するシンポジウム講演論文集,* 111-114, 2011年7月.
643. **永瀬 雅夫 :** グラフェンの基礎と材料としての魅力, --- [招待講演] ---, *日本化学会 講演会「グラフェンの魅力∼基礎と応用の観点から」,* 2011年7月.
644. **川上 烈生, 新部 正人, 中野 由崇, 武市 敦, 小西 将士, 森 祐太, 小高 拓也, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** 容量性結合N2プラズマによるGaNエッチングダメージ, *第72回秋季応用物理学会学術講演会, No.1,* 08-109, 2011年8月.
645. **新部 正人, 小高 拓也, 川上 烈生, 中野 由崇, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** HeおよびArガスを用いてプラズマエッチングしたn-GaN結晶の表面ダメージ分析, *第72回秋季応用物理学会学術講演会, No.1,* 08-110, 2011年8月.
646. **中野 由崇, 川上 烈生, 新部 正人, 武市 敦, 稲岡 武, 富永 喜久雄 :** プラズマエッチング損傷GaNのフォトルミネッセンス評価, *第72回秋季応用物理学会学術講演会, No.1,* 08-111, 2011年8月.
647. **西 勇輝, 永瀬 雅夫, 日比野 浩樹, 影島 博之, 山口 浩司 :** グラフェンメンブレンの形状変化, *第72回 応用物理学会学術講演会, No.30p-E-6,* 2011年8月.
648. **細川 大志, 井川 裕介, 木尾 勇介, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET電流コラプス回復の温度依存性, *第72回応用物理学会学術講演会,* 2011年9月.
649. **岩崎 裕一, 原内 健次, 福居 和人, 敖 金平, 大野 泰夫 :** 電力伝送用オープンリング共振器無線接続の評価, *2011年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2011年9月.
650. **原内 健次, 岩崎 裕一, 林野 耕平, 敖 金平, 篠原 真毅, 外村 博史, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器とGaNショットキーダイオードを用いた無線電力伝送, *2011年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2011年9月.
651. **影島 博之, 日比野 浩樹, 山口 浩司, 永瀬 雅夫 :** S i C ( 0 0 0 1 )上エピタキシャルグラフェン成長におけるS i 脱離とC 吸着の効果の比較, *第72回 応用物理学会学術講演会, No.1p-ZF-4,* 2011年9月.
652. **岩本 篤, 呉 龍錫, 船瀬 雄也, 西 勇輝, 湯浅 貴浩, 富田 卓朗, 永瀬 雅夫, 関根 佳明, 日比野 浩樹, 山口 浩司 :** ラマン分光法によるSiC上グラフェンの内部応力解析, *第72回 応用物理学会学術講演会, No.1a-E-1,* 2011年9月.
653. **船瀬 雄也, 岩本 篤, 西 勇輝, 永瀬 雅夫, 日比野 浩樹, 山口 浩司 :** エピタキシャルグラフェンの摩擦力の層数依存評価, *第72回 応用物理学会学術講演会, No.1a-E-14,* 2011年9月.
654. **田邉 真一, 関根 佳明, 影島 博之, 永瀬 雅夫, 日比野 浩樹 :** 単層エピタキシャルグラフェンの特異な抵抗の温度依存性, *第72回 応用物理学会学術講演会, No.1p-E-5,* 2011年9月.
655. **永瀬 雅夫 :** 電子顕微鏡によるグラフェン観察, --- [招待講演] ---, *SCANTECH2011 第20回記念講演会「SEM過去から未来へ」,* 2011年9月.
656. **影島 博之, 日比野 浩樹, 山口 浩司, 永瀬 雅夫 :** トレンチモデルを用いた SiC(0001)上グラフェン成長の検討, *日本物理学会2011年秋季大会,* 2011年9月.
657. **川上 烈生, 武市 敦, 新部 正人, 森 祐太, 小西 将士, 小高 拓也, 稲岡 武, 富永 喜久雄 :** TiO2薄膜のHeプラズマエッチングダメージ, *平成23年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 38, 2011年9月.
658. **武市 敦, 川上 烈生, 新部 正人, 中野 由崇, 小西 将士, 森 祐太, 小高 拓也, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** Ar/Krプラズマイオンと紫外線のシナジー効果によるn-GaNエッチングダメージ, *平成23年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 39, 2011年9月.
659. **森 祐太, 川上 烈生, 新部 正人, 武市 敦, 小西 将士, 小高 拓也, 松永 史彦, 高崎 敏英, 北野 尊宣, 宮崎 隆弘, 稲岡 武, 富永 喜久雄 :** DBD He/Air プラズマトリートメントによるTiO2薄膜表面の分析, *平成23年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 40, 2011年9月.
660. **小西 将士, 川上 烈生, 新部 正人, 武市 敦, 森 祐太, 小高 拓也, 中野 由崇, 稲岡 武, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** 窒素プロセシングプラズマによるn-GaNエッチングダメージ, *平成23年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 41, 2011年9月.
661. **永瀬 雅夫 :** 新規カーボン材料グラフェンの基礎物性と応用可能性について, --- [招待講演] ---, *第14回若手フォーラム 『材料の微細化・微構造制御と新機能の発現』 ∼次世代につながるセラミックステクノロジー∼,* 2011年10月.
662. **永瀬 雅夫 :** SiC上グラフェンの物性評価技術, --- [招待講演] ---, *炭素材料学会10月セミナー 「1日でわかるグラフェン入門 -グラフェンの基礎から合成，評価まで-」,* 2011年10月.
663. **永瀬 雅夫 :** 集積化ナノプローブによる表面物性評価, --- [招待講演] ---, *第40回薄膜・表面物理基礎講座 『 ナノ材料研究者のための表面・界面の評価技術の基礎と動向』,* 2011年11月.
664. **谷本 勝, 酒井 士郎 :** SiO2マスクを用いたMOCVD-GaNの転位密度低減に関する研究, *電子情報通信学会技術研究報告 電子デバイス,* **Vol.111,** *No.290,* 15-18, 2011年11月.
665. **大西 裕也, 堀江 郁哉, 酒井 士郎 :** MOCVD法によるsapphire上への(Si)(Ga)AlC(P)薄膜の成長, *電子情報通信学会技術研究報告 電子デバイス,* **Vol.111,** *No.290,* 117-120, 2011年11月.
666. **永瀬 雅夫 :** グラフェンの物性とデバイス応用, --- [招待講演] ---, *応物九州支部オータムスクール 『 機能性薄膜とデバイス応用』,* 2011年11月.
667. **玉井 健太郎, 王 青鵬, 宮下 準弘, 本山 慎一, 王 徳君, 敖 金平, 大野 泰夫 :** GaN MOSFET 電気特性へのチャネルリセスエッチングの影響, *第59回応用物理学関係連合講演会,* 2012年3月.
668. **Qingpeng Wang, Kentaro Tamai, Takahiro Miyashita, Shin-ichi Motoyama, Dejun Wang, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Characterization of GaN MOSFETs on AlGaN/GaN Heterostructure, *第59回応用物理学関係連合講演会,* Mar. 2012.
669. **細川 大志, 井川 裕介, 木尾 勇介, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET電流コラプスの回復機構, *第59回応用物理学関係連合講演会,* 2012年3月.
670. **福居 和人, 竹内 太郎, 林野 耕平, 原内 健次, 岩崎 裕一, 敖 金平, 大野 泰夫 :** マイクロ波整流用GaN ショットキーダイオードの特性改善, *2012年電子情報通信学会総合大会,* 2012年3月.
671. **林野 耕平, 原内 健次, 岩崎 裕一, 福居 和人, 敖 金平, 大野 泰夫 :** GaNショットキーダイオードを用いたレクテナ回路の損失分析, *2011年電子情報通信学会総合大会,* 2012年3月.
672. **塩入 達明, 岩崎 祐一, 原内 健次, 福居 和人, 敖 金平, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器無線送電への水濡れの影響, *2011年電子情報通信学会総合大会,* 2012年3月.
673. **岩崎 裕一, 阿部 まみ, 原内 健次, 福居 和人, 敖 金平, 大野 泰夫 :** 60GHz帯チップ間伝送用オープンリング共振器無線接続の評価, *2011年電子情報通信学会総合大会,* 2012年3月.
674. **大西 裕也, 堀江 郁哉, 酒井 士郎 :** MOCVD法によるSi,Ga,P添加Al4C3薄膜の成長, *第59回応用物理学会関係連合講演会,* 2012年3月.
675. **呉 龍錫, 岩本 篤, 田尾 拓人, 井口 宗明, 奥村 俊夫, 杉村 晶史, 富田 卓朗, 永瀬 雅夫, 日比野 浩樹, 山口 浩司 :** ひずみによるラマンシフトを用いた SiC 上グラフェンの層数評価, *第59回 応用物理学関係連合講演会, No.16a-B2-4,* 2012年3月.
676. **田尾 拓人, 呉 龍錫, 岩本 篤, 井口 宗明, 奥村 俊夫, 杉村 晶史, 永瀬 雅夫, 日比野 浩樹 :** 4H-SiC(0001)上エピタキシャルグラフェンの 表面ラフネスと層数均一性との相関, *第59回 応用物理学関係連合講演会, No.17a-A3-4,* 2012年3月.
677. **Choi Yun Jeong, 藤本 拓生, 堀江 郁哉, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** Study of phosphorus incorporated DLC films grown by CVD technique, *第59回応用物理学関係連合講演会,* GP5, 2012年3月.
678. **中野 由崇, 中村 圭二, 新部 正人, 川上 烈生, 伊藤 慎祥, 小高 拓也, 稲岡 武, 富永 喜久雄 :** GaNのArプラズマエッチングへのUV 光照射効果, *第59回春季応用物理学会学術講演会, No.1,* 2012年3月.
679. **影島 博之, 日比野 浩樹, 山口 浩司, 永瀬 雅夫 :** SiC(0001)面上エピタキシャルグラ フェン成長の初期過程, *日本物理学会2012年春季第67回年次大会,* 2012年3月.
680. **川上 烈生, 武市 敦, 兒玉 宗久, 新居 厚子, 小倉 長夫, 小西 将士, 森 祐太, 稲岡 武, 富永 喜久雄 :** UV-LED光触媒酸化とプラズマジェット殺菌作用による果実の鮮度保持テクノロジーの研究開発, *LED総合フォーラム2011 in 徳島,* 105-106, 2011年6月.
681. **楠 貴大, 沼島 明菜, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** ナノ微粒子技術を用いたGaN表面周期構造の作製と高性能LED作製への応用検討, *LED総合フォーラム,* 103-104, 2011年6月.
682. **原内 健次, 岩崎 裕一, 林野 耕平, 敖 金平, 篠原 真毅, 外村 博史, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器とGaN SBDを用いたマイクロ波電力伝送, *第8回無線電力伝送時限研究専門委員会(通算36回)研究会,* 2011年10月.
683. **永瀬 雅夫 :** グラフェンとその応用, *学振・第133委員会 第211回 研究会,* 2011年10月.
684. **細川 大志, 井川 裕介, 木尾 勇介, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET電流コラプスの回復過程解析, *電子情報通信学会電子デバイス研究会,* 2011年11月.
685. **馬渕 良, 影山 達也, 下村 直行, 直井 美貴, 大来 雄二 :** 大学における技術者倫理教育に対する講義用Webページの活用, *電気学会研究会資料,* **Vol.FIE-11,** *No.3,* 23-28, 2011年12月.
686. **永瀬 雅夫 :** SiC上グラフェンの物性評価と応用技術について, *第105回黒鉛化合物研究会,* 2012年1月.
687. **原内 健次, 岩崎 裕一, 林野 耕平, 塩入 達明, 福居 和人, 敖 金平, 大野 泰夫, 篠原 真毅, 外村 博史 :** GaN SBDとオープンリング共振器を用いた非接触マイクロ波電力伝送, *第10回無線電力伝送時限研究専門委員会研究会,* 2012年3月.
688. **川上 烈生 :** 自己無撞着なアルゴンプラズマによる窒化ガリウムエッチングダメージの解析, *平成22年度核融合科学研究所LHD数値解析システム利用共同研究報告書,* 日本, 2012年3月.
689. **川上 烈生 :** 紫外線/OHラジカルジェット殺菌と可視光LED光触媒酸化還元作用による果実の鮮度保持テクノロジー開発, *平成23年度JST研究成果最適展開支援プログラムA-STEP, フィージビリティスタディ【FS】ステージ探索タイプ,* 日本, 2012年3月.
690. **日比野 浩樹, 永瀬 雅夫, 他 :** グラフェンが拓く材料の新領域, --- ∼物性・作製法から実用化まで∼ ---, エヌティーエス, 東京, 2012年6月.
691. **永瀬 雅夫, 他 :** 異種機能デバイス集積化技術の基礎と応用, --- ―MEMS, NEMS, センサ, CMOSLSIの融合― ---, 株式会社 シーエムシー出版, 東京, 2012年11月.
692. **Shigeki Matsuo, Lihe Yan, Jinhai Si, Takuro Tomita *and* Shuichi Hashimoto :** Reduction of Pulse-to-Pulse Fluctuation in Laser Pulse Energy using the Optical Kerr Effect, *Optics Letters,* **Vol.37,** *No.10,* 1646-1648, 2012.
693. **O Ryongsok, Atsushi Iwamoto, Yuki Nishi, Yuya Funase, Takahiro Yuasa, Takuro Tomita, Masao Nagase, Hiroki Hibino *and* Hiroshi Yamaguchi :** Microscopic Raman mapping of epitaxial graphene on 4H-SiC (0001), *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.51,** *No.6,* 06FD06-(5pp), 2012.
694. **Tatsuya Okada, Takuro Tomita, Shigeki Matsuo, Shuichi Hashimoto, Ryota Kashino *and* Takuto Ito :** Formation of Nanovoids in Femtosecond Laser-Irradiated Single Crystals of Silicon Carbide, *Materials Science Forum,* **Vol.725,** 19-22, 2012.
695. **Kaoru Ohya *and* Yoshio Soneda :** Simulation of Deuterium Retention in Tungsten Exposed to Divertor Plasmas, *Plasma and Fusion Research,* **Vol.7,** 2403083-1-2403083-4, 2012.
696. **Retsuo Kawakami, Niibe Masahito, Takeichi Atsushi, Mori Yuta, Konishi Masashi, Kotaka Takuya, Matsunaga Fumihiko, Takasaki Toshihide, Kitano Takanori, Miyazaki Takahiro, Inaoka Takeshi *and* Tominaga Kikuo :** Characteristics of TiO2 Thin Film Surfaces Treated by Helium and Air Dielectric Barrier Discharge Plasmas, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.51,** *No.8,* 08HB04-1-08HB04-6, 2012.
697. **王 青鹏, 江 滢, 敖 金平, 王 德君 :** GaN MOSFET 的设计制作及其表征, *电力电子技术,* **Vol.46,** *No.12,* 81-83, 2012年.
698. **Tianya Tan, Mitsuaki Tohno, Masakazu Matsumoto, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Electroluminescence orientation in InGaN/GaN LED on nano-patterned sapphire by MOCVD, *Journal of Wuhan University of Technology. Materials Science Edition,* **Vol.27,** *No.6,* 1137-1138, 2012.
699. **Takuro Tomita, Minoru Yamamoto, Noboru Hasegawa, Kota Terakawa, Yasuo Minami, Masaharu Nishikino, Masahiko Ishino, Takeshi Kaihori, Yoshihiro Ochi, Tetsuya Kawachi, Mitsuru Yamagiwa *and* Tohru Suemoto :** Experimental verification of femtosecond laser ablation schemes by time-resolved soft x-ray reflective imaging, *Optics Express,* **Vol.20,** *No.28,* 29329-29337, 2012.
700. **Jin-Ping Ao, Yoshiki Naoi *and* Yasuo Ohno :** Thermally stable TiN Schottky contact on AlGaN/GaN heterostructure, *Vacuum,* **Vol.87,** *No.1,* 150-154, 2013.
701. **Ying Jiang, Qingpeng Wang, Kentaro Tamai, Takahiro Miyashita, Shin-ichi Motoyama, Dejun Wang, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** GaN MOSFET with Boron Trichloride-Based Dry Recess Process, *Journal of Physics: Conference Series,* **Vol.441,** 012025, 2013.
702. **Retsuo Kawakami, Atsushi Takeichi, Masahito Niibe, Masashi Konishi, Yuta Mori, Takuya Kotaka, Takeshi Inaoka, Kikuo Tominaga *and* Takashi Mukai :** Capacitively Coupled Radio Frequency Nitrogen Plasma Etch Damage to N-Type Gallium Nitride, *Vacuum,* **Vol.87,** 136-140, 2013.
703. **Qingpeng Wang, Kentaro Tamai, Takahiro Miyashita, Shin-ichi Motoyama, Dejun Wang, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Influence of Dry Recess Process on Enhancement-Mode GaN Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistors, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.52,** *No.1,* 01AG02-1-01AG02-5, 2013.
704. **Niibe Masahito, Kotaka Takuya, Retsuo Kawakami, Nakano Yoshitaka, Inaoka Takeshi, Tominaga Kikuo *and* Mukai Takashi :** Damage Analysis of n-GaN Crystal Etched with He and N2 Plasmas, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.52,** 01AF04-1-01AF04-5, 2013.
705. **Yoshitaka Nakano, Keiji Nakamura, Masahito Niibe, Retsuo Kawakami, Noriyoshi Ito, Takuya Kotaka *and* Kikuo Tominaga :** Effect of UV Irradiation on Ar-Plasma Etching Characteristics of GaN, *ECS Journal of Solid State Science and Technology,* **Vol.2,** *No.3,* 110-113, 2013.
706. **Shigeki Matsuo, Yoshifumi Umeda, Takuro Tomita *and* Shuichi Hashimoto :** Laser-Scanning Direction Effect in Femtosecond Laser-Assisted Etching, *Journal of Laser Micro/Nanoengineering,* **Vol.8,** *No.1,* 35-38, 2013.
707. **Niibe Masahito, Sano Keiji, Kotaka Takuya, Retsuo Kawakami, Tominaga Kikuo *and* Nakano Yoshitaka :** Etching Damage and Its Recovery by Soft X-ray Irradiation Observed in Soft X-ray Absorption Spectra of TiO2 Thin Film, *Journal of Applied Physics,* **Vol.113,** *No.12,* 126101-1-126101-3, 2013.
708. **永瀬 雅夫 :** 高速高温アニール装置によるグラフェン形成, *''熱技術''30年の歩み,* 9-13, 2012年4月.
709. **富田 卓朗, 長谷川 登, 錦野 将元, 河内 哲哉, 末元 徹 :** 軟X線レーザープローブによるアブレーションダイナミクスのイメージング, *レーザー研究,* **Vol.40,** *No.8,* 592-597, 2012年8月.
710. **上田 良夫, 大宅 薫, 芦川 直子, 伊藤 篤史, 小野 忠良, 加藤 太治, 川島 寿人, 河村 学思, 剣持 貴弘, 斎藤 誠紀, 清水 勝宏, 高木 郁二, 高山 有道, 滝塚 知典, 田中 康規, 田辺 哲朗, 藤間 光徳, Tolstikhina IngaYu., 冨田 幸博, 仲野 友英, 中村 浩章, 中村 誠, 畑山 明聖, 星野 一生, 本間 裕貴, 吉田 雅史, 和田 元 :** 炉内トリチウム, *プラズマ・核融合学会誌 プロジェクトレビュー「核融合炉実現を目指したトリチウム研究の新展開」 第3章,* **Vol.88,** *No.9,* 484-502, 2012年9月.
711. **Kouhei Hayashino, Kenji Harauchi, Yuichi Iwasaki, Kazuhito Fukui, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Analysis of Loss Mechanism in Rectenna Circuit with GaN Schottky Barrier Diode, *2012 IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series (IMWS) on Innovative Wireless Power Transmission: Technologies, Systems, and Applications (IMWS-IWPT2012),* Kyoto, May 2012.
712. **Kazuhito Fukui, Taro Takeuchi, Kouhei Hayashino, Kenji Harauchi, Yuichi Iwasaki, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** T-shaped Anode GaN Schottky Barrier Diode for Microwave Power Rectification, *2012 IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series (IMWS) on Innovative Wireless Power Transmission: Technologies, Systems, and Applications (IMWS-IWPT2012),* 195-198, Kyoto, May 2012.
713. **Yuichi Iwasaki, Tatsuaki Shioiri, Kenji Harauchi, Kazuhito Fukui, Kouhei Hayashino, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Effects of Wetting to Wireless Power Transmission by Open-Ring Resonators Coupling, *2012 IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series (IMWS) on Innovative Wireless Power Transmission: Technologies, Systems, and Applications (IMWS-IWPT2012),* 97-100, Kyoto, May 2012.
714. **Dohyung Kim, Fumiya Horie, Yuya Ohnishi, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Characteristics of Si and P-doped Al4C3 by Metalorganic Vapor Phase Epitaxy, *The Sixteenth International Conference on Metal Organic Vapor Phase Epitaxy,* TuP-71, Busan, May 2012.
715. **Yun-Jeong Choi, Takunari Fujimoto, Fumiya Horie, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Growth of Diamond like Carbon Film with Phosphorus Incorporation Using CVD Technique, *The Sixteenth International Conference on Metal Organic Vapor Phase Epitaxy,* FrA2-2, Busan, May 2012.
716. **A. Kirschner, P. Wienhold, D. Borodin, C. Bjorkas, O.Van Hoey, D. Matveev, S. Brezinsek, A. Kreter, M. Laengner, Kaoru Ohya, V. Philipps, A. Pospieszczyk, U. Samm, B. Schweer *and* TEXTOR team :** Studies of impurity migration in TEXTOR by local tracer injection, *20th International Conference on Plasma Surface Interactions 2012, May 21-25, Aachen, Germany, P2-025,* **Vol.438,** S723-S726, May 2012.
717. **Q. Xu, Kaoru Ohya, Z.S. Yang, R. Ding *and* G.-N. Luo :** Simulation of deposition behavior in the tile gaps under ITER mixed plasma-facing materials conditions, *20th International Conference on Plasma Surface Interactions 2012, May 21-25, Aachen, Germany, P2-047,* May 2012.
718. **Hideyuki Watanabe, Takuro Tomita, Shinichi Nakashima, Yukako Katou *and* Shinichi Shikata :** Raman Scattering in Diamond Isotopical Superlattices, *The sixth international New Diamond and Nano Carbons Conference (NDNC 2012),* A2.5, San Juan, Puerto Rico, May 2012.
719. **Tetsuya Kawachi, Akira Sasaki, Masaharu Nishikino, Masahiko Ishino, Noboru Hasegawa, Takashi Imazono, Yoshihiro Ochi, Momoko Tanaka, Kota Terakawa, Ryota Takei, Yasuo Minami, Motoyoshi Baba, Takuro Tomita, Anatoly Faenov, Pikuz Tatiana, Pirozhhkov Alexander, Esirkepov Zh. Timur, Janulewicz Karol, Kim Min Chul, Stiel Holger, Masaki Kando, Sergei Bulanov, Koindo Kimihiro, Mitsuru Yamagiwa *and* Tohru Suemoto :** Source development of laser-driven plasma x-ray lasers, *5th AWCXR & ISSP International Workshop on Coherent Soft-X-ray Sciences,* 2.1, Chiba, Jun. 2012.
720. **Tohru Suemoto, Kota Terakawa, Ryota Takei, Yasuo Minami, Motoyoshi Baba, Takuro Tomita, Noboru Hasegawa, Masaharu Nishikino, Yoshihiro Ochi, Mitsuru Yamagiwa *and* Tetsuya Kawachi :** Observation of laser ablation dynamics by soft X-ray imaging and interferometry, *5th AWCXR & ISSP International Workshop on Coherent Soft-X-ray Sciences,* 2.6, Chiba, Jun. 2012.
721. **Noboru Hasegawa, Yoshihiro Ochi, Tetsuya Kawachi, Kota Terakawa, Ryota Takei, Yasuo Minami, Motoyoshi Baba, Takuro Tomita, Masaharu Nishikino, Takeshi Kaihori, Mitsuru Yamagiwa *and* Tohru Suemoto :** Development of the single shot soft x-ray interferometer for observation of the nanometer-scaled surface dynamics, *5th AWCXR & ISSP International Workshop on Coherent Soft-X-ray Sciences,* 5.3, Chiba, Jun. 2012.
722. **Takuro Tomita, Masaharu Nishikino, Noboru Hasegawa, Kota Terakawa, Yasuo Minami, Ryota Takei, Motoyoshi Baba, Takeshi Kaihori, Morita Toshimasa, Tetsuya Kawachi, Mitsuru Yamagiwa *and* Tohru Suemoto :** Single-shot soft x-ray reflective imaging of femtosecond laser ablation process on platinum, *5th AWCXR & ISSP International Workshop on Coherent Soft-X-ray Sciences,* 5.15, Chiba, Jun. 2012.
723. **Takuro Tomita, Minoru Yamamoto, Noboru Hasegawa, Masaharu Nishikino, Masahiko Ishino, Takeshi Kaihori, Yoshihiro Ochi, Tetsuya Kawachi, Mitsuru Yamagiwa, Ryota Takei, Yasuo Minami, Kota Terakawa *and* Tohru Suemoto :** Femtosecond laser ablation dynamics of platinum observed by soft x-ray reflective imaging, *The 2012 Ultrafast Phenomena Conference,* THU.PIII.13, Lausanne, Switzerland, Jul. 2012.
724. **Masao Nagase, Yuki Nishi, Teruki Isawa *and* Takuto Tao :** Conductive carbon nanoprobe fabricated by focused ion beam assisted chemical vapor deposition, *International Conference on Nanoscience + Technology 2012 (ICN+T2012/STM'12),* Paris, France, Jul. 2012.
725. **Hiroyuki Kageshima, Hiroki Hibino, Hiroshi Yamaguchi *and* Masao Nagase :** Role of Step in Initial Stage of Graphene Growth on SiC(0001), *International Conference on Physics of Semiconductors (ICPS2012), No.61.45,* Zurich, Swiss, Aug. 2012.
726. **Takeshi Ohshima, Manato Deki, Takahiro Makino, Naoya Iwamoto, Shinobu Onoda, Toshio Hirao, Kazutoshi Kojima, Takuro Tomita, Shigeki Matsuo *and* Shuichi Hashimoto :** Breakdown Voltage In Silicon Carbide Metal-Oxide-Semiconductor Devices Induced By Ion Beams, *22nd International Conference on the Application of Accelerators in Research and Industry,* **Vol.1525,** 654-658, Texas, Aug. 2012.
727. **Hideyuki Watanabe, Takuro Tomita, Shinichi Nakashima, Yukako Katou *and* Shinichi Shikata :** Raman Scattering from Optical Phonons in Isotopic 12C13C Diamond Superlattices, *Internatinal Conference on Electronic Materials,* B-7-P24-018, Yokohama, Sep. 2012.
728. **Yuichi Iwasaki, Mami Abe, Kouhei Hayashino, Kazuhito Fukui *and* Jin-Ping Ao :** 60 GHz Wireless Interconnection Using Electromagnetic Coupling of Open-Ring Resonators, *2012 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2012),* Kyoto, Sep. 2012.
729. **Ying Jiang, Qingpeng Wang, Kentaro Tamai, Takahiro Miyashita, Shin-ichi Motoyama, Dejun Wang, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** GaN MOSFET with Boron Trichloride-Based Dry Recess Process, *11th Asia Pacific Conference on Plasma Science and Technology and 25th Symposium on Plasma Science for Materials,* Kyoto, Oct. 2012.
730. **Retsuo Kawakami, Niibe Masahito, Nakano Yoshitaka, Konishi Masashi, Mori Yuta, Shirahama Tatsuo, Yamada Tetsuya *and* Tominaga Kikuo :** Characteristics of TiO2 Surfaces Etched by Capacitively Coupled Radio Frequency N2 and He Plasmas, *11th Asia-Pacific Conference on Plasma Science and Technology & 25th Symposium on Plasma Science fro Materials (11th APCPST & 25th SPSM),* 289, Kyoto, Oct. 2012.
731. **Takuro Tomita, Masaharu Nishikino, Noboru Hasegawa, Kota Terakawa, Yasuo Minami, Ryota Takei, Motoyoshi Baba, Takeshi Kaihori, Toshimasa Morita, Tetsuya Kawachi, Mitsuru Yamagiwa *and* Tohru Suemoto :** The reflective imaging of femtosecond laser ablation dynamics on platinum probed by plasma based soft x-ray laser, *11th Asia-Pacific Conference on Plasma Science and Technology and 25th Symposium on Plasma Science for Materials,* 478, Kyoto, Oct. 2012.
732. **Katsushi Nishino, Jun Nakauchi, Kotaro Hayashi *and* Masashi Tsukihara :** Self-Separation of Sublimation-Grown AlN with AlSiN Buffer Layer, *International Workshop on Nitride Semiconductors,* Sapporo, Oct. 2012.
733. **Yusuke Kio, Taishi Hosokawa, Yusuke Ikawa, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Analysis of AlGaNGaN HFET Current Collapse Recovery Process, *International Workshop on Nitride Semiconductors 2012,* Sapporo, Oct. 2012.
734. **Yasuo Ohno, Yusuke Kio, Yusuke Ikawa *and* Jin-Ping Ao :** Observation of Side-gating Effect in AlGaN/GaN HFETs, *International Workshop on Nitride Semiconductors 2012,* Sapporo, Oct. 2012.
735. **Nakano Yoshitaka, Nakamura Keiji, Niibe Masahito, Retsuo Kawakami, Ito Noriyoshi, Kotaka Takuya *and* Tominaga Kikuo :** Effect of UV Irraiation on Ar-Plasma Etching of GaN, *International Workshop on Nitride Semiconductors 2012 (IWN2012),* Sapporo, Oct. 2012.
736. **Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Theoritical analysis for lineraly polarized emission in UV-LED with subwavelength grating structure, *International Workshop on Nitride Semiconductor 2012,* MoP-OD-41, Sapporo, Oct. 2012.
737. **Dohyung Kim, Heesub Lee, Kazuya Yamazumi, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Fabrication of C-doped p-AlGaInN LED by the insertion of Al4C3, *International Workshop on Nitride Semiconductor 2012,* TuP-OD-1, Sapporo, Oct. 2012.
738. **Kaoru Ohya *and* Takuya Yamanaka :** Modeling Secondary Electron Emission from Nanostructured Materials in Helium Ion Microscope, *25th International Conference on Atomic Collisions in Solids, Tu-017,* 97, Kyoto, Oct. 2012.
739. **永瀬 雅夫 :** グラフェンの基礎物性と応用技術, --- [招待講演] ---, *Advance Metallization Conf. 2012, 22nd Asian Session (ADMETA Plus 2012): Tutorial,* 東京, 2012年10月.
740. **Jin-Ping Ao, Takauki Shiraishi, Liuan Li, Akinori Kishi *and* Yasuo Ohno :** Synthesis and Application of Metal Nitrides as Schottky Electrodes for Gallium Nitride Electron Devices, *the first international conference on emerging advanced nanomaterials (2012),* Brisbane, Oct. 2012.
741. **Retsuo Kawakami, Niibe Masahito, Takeuchi Hideo, Konishi Masashi, Mori Yuta, Shirahama Tatsuo, Yamada Tetsuya *and* Tominaga Kikuo :** SiC Surface Damage Originating from Synergy Effect of Ar Plasma Ion and Plasma-Induced Ultraviolet Light Irradiations, *25th International Conference on Atomic Collisions in Solids (ICACS-25),* 117, Kyoto, Oct. 2012.
742. **Niibe Masahito, Kotaka Takuya, Sano Keiji, Retsuo Kawakami, Tominaga Kikuo *and* Nakano Yoshitaka :** Etching Damage Analysis of TiO2 Thin Film with Soft X-Ray Absorption Spectroscopy, *25th International Conference on Atomic Collisions in Solids (ICACS-25),* 227, Kyoto, Oct. 2012.
743. **Retsuo Kawakami, Niibe Masahito, Nakano Yoshitaka, Konishi Masashi, Mori Yuta, Takeichi Atsushi, Tominaga Kikuo *and* Mukai Takashi :** Damage Characteristics of p-GaN Surfaces Etched by Capacitively Coupled Radio Frequency Argon Plasmas, *Proceedings of International Symposium of Dry Process 2012,* 133-134, Tokyo, Nov. 2012.
744. **Masatsugu Ohashi *and* Kaoru Ohya :** Modeling tritium retention in ITER plasma facing materials, *22nd International Toki Conference ""Cross-Validation of Experiment and Modeling for fusion and Astrophysical Plasmas", P1-15, November 19-22, 2012, Gifu, Japan,* Nov. 2012.
745. **Hiroyuki Nakata *and* Kaoru Ohya :** Modeling beryllium deposition on tungsten and its interaction with hydrogen, *22nd International Toki Conference "Cross-Validation of Experiment and Modeling for Fusion and Astrophysical Plasmas", P2-43, Novemver 19-22, 2012, Gifu, Japan,* Nov. 2012.
746. **YUICHI HIWASA, SHOTA IWAMOTO, KOTARO HAYASHI, Katsushi Nishino *and* MASASHI TSUKIHARA :** Self-separation of sublimation-grown AlN on rough SiC substrate, *5th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Application for Nitrides and Nanomaterials,* Jan. 2013.
747. **Ying Jiang, Qingpeng Wang, Kentaro Tamai, Satoko Shinkai, Takahiro Miyashita, Shin-Ichi Motoyama, Dejun Wang, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Device Isolation for GaN MOSFETs With Boron Ion Implantation, *5th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Application for Nitrides and Nanomaterials,* Nagoya, Jan. 2013.
748. **Liuan Li, Takayuki Shiraishi, Akinori Kishi, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Evaluation of a Gate-First process for AlGaN/GaN HFETs, *5th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Application for Nitrides and Nanomaterials,* Nagoya, Jan. 2013.
749. **Nakano Yoshitaka, Nakamura Keiji, Niibe Masahito, Retsuo Kawakami, Ito Noriyoshi, Kotaka Takuya *and* Tominaga Kikuo :** Effect of UV irradiation on Ar-Plasma etching characteristics of GaN, *5th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials (ISPlasma2013),* Nagoya, Jan. 2013.
750. **Yuusuke Takashima, Ryo Shimizu *and* Yoshiki Naoi :** Fabrication of subwavelength grating with high aspect ratio on GaN LED, *5th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials,* P3083B, Nagoya, Jan. 2013.
751. **Kaoru Ohya, Takuya Yamanaka *and* Jun Kawata :** Modeling ion-induced secondary electron emission in scanning ion microscopes, *2013 SPIE Advanced Lithography,* San Jose, Feb. 2013.
752. **Kaoru Ohya :** Modeling secondary electron emission in scanning ion microscopes, *Interdisciplinary Surface Science Conference, March 25-28, 2013,* Nottingham, UK, Mar. 2013.
753. **Yuya Ohnishi, Dohyung Kim *and* Shiro Sakai :** Growth of AlC on sapphire, Silicon and SiC substrates, *第31回電子材料シンポジウム,* We2-5, Jul. 2012.
754. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** サブ波長回折格子を用いたAlGaN系LEDの偏光選択特性, *応用物理学会 中国四国支部 2012年度 支部学術講演会, No.Ap-3,* 2012年7月.
755. **横田 洋輝, 植木 智之, 富田 卓朗, 岡田 達也 :** 円偏光フェムト秒レーザー照射による4H-SiC単結晶内部の欠陥形成, *2012年度支部学術講演会講演予稿集,* 16, 2012年7月.
756. **横田 洋輝, 植木 智之, 富田 卓朗, 岡田 達也 :** 4H-SiC単結晶内部における円偏光フェムト秒レーザ照射誘起欠陥, *日本金属学会中国四国支部第52回講演大会講演概要集,* 71, 2012年8月.
757. **白石 孝之, 李 柳暗, 岸 明徳, 敖 金平, 大野 泰夫 :** GaNデバイスにおけるゲート・ファースト・プロセスの検討, *第73回応用物理学会学術講演会,* 2012年9月.
758. **木尾 勇介, 井川 裕介, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETにおけるサイドゲート効果の観測, *第73回応用物理学会学術講演会,* 2012年9月.
759. **林野 耕平, 岩崎 裕一, 福居 和人, 敖 金平, 大野 泰夫 :** マイクロ波電力伝送用レクテナ回路の比較, *2011年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2012年9月.
760. **富田 卓朗, 錦野 将元, 長谷川 登, 南 康夫, 武井 亮太, 馬場 基芳, 寺川 康太, 海堀 岳史, 守田 利昌, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** 軟X線干渉計測と反射率計測で観るフェムト秒レーザーアブレーション, *第73 回応用物理学会学術講演会講演予稿集,* **Vol.73,** 140, 2012年9月.
761. **金 度亨, 李 熙燮, 山住 和也, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** AlxCy によるAlXGa1-xN 中への拡散, *第73回応用物理学会学術講演会,* 12p-H9-15, 2012年9月.
762. **李 熙燮, 金 度亨, 山住 和也, 酒井 士郎 :** AlCによるAlGaNへのp型ドーピング, *第73回応用物理学会学術講演会,* 12p-H9-16, 2012年9月.
763. **林 浩太郎, 中内 潤, 西野 克志, 月原 政志 :** AlSiN層を用いた昇華法成長AlNの剥離, *第73回応用物理学会学術講演会,* 12a-PB4-4, 2012年9月.
764. **新部 正人, 小高 拓也, 川上 烈生, 富永 喜久雄, 中野 由崇 :** 軟X線吸収分光法によるTiO2薄膜のエッチングダメージの解析, *第73回秋季応用物理学会学術講演会, No.1,* 08-088, 2012年9月.
765. **川上 烈生, 新部 正人, 中野 由崇, 小西 将士, 森 祐太, 小高 拓也, 白濱 達夫, 山田 哲也, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** 容量性結合アルゴンプラズマによるp-GaNエッチングダメージ, *第73回秋季応用物理学会学術講演会, No.1,* 08-085, 2012年9月.
766. **富田 卓朗, 尾崎 信彦, 菅野 智士, 江山 剛史, 高吉 翔大, 森田 健, 井須 俊郎 :** GaAs/AlGaAs多重量子井戸におけるフェムト秒レーザーアブレーション, *2012年秋季第73回応用物理学会学術講演会, No.12p-PA4-6,* 2012年9月.
767. **出来 真斗, 牧野 高紘, 岩本 直也, 小野田 忍, 富田 卓朗, 橋本 修一, 児島 一聡, 大島 武 :** イオン照射したSiC-MOS キャパシタにおける絶縁破壊電界のLET 依存性, *第73 回応用物理学会学術講演会講演予稿集,* **Vol.73,** 15-294, 2012年9月.
768. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** サブ波長回折格子による直線偏光UV-LEDの理論的解析, *第73回応用物理学会学術講演会,* **Vol.12a-PB4-27,** 2012年9月.
769. **影島 博之, 日比野 浩樹, 山口 浩司, 永瀬 雅夫 :** SiC(0001)面上第0層グラフェン成長初期過程とステップの役割, *第73回応用物理学会学術講演会(応物2012秋), No.13p-C1-8,* 2012年9月.
770. **奥村 俊夫, 田尾 拓人, 呉 龍錫, 中島 健志, 永瀬 雅夫 :** SiC上グラフェンの不均一成長メカニズム, *第73回応用物理学会学術講演会(応物2012秋), No.13p-C1-3,* 2012年9月.
771. **伊澤 輝記, 船瀬 雄也, 西 勇輝, 永瀬 雅夫 :** 走査型摩擦力顕微鏡を用いたナノ摩擦係数測定, *第73回応用物理学会学術講演会(応物2012秋), No.13p-F7-4,* 2012年9月.
772. **大宅 薫 :** 炉内トリチウム挙動と蓄積評価, *日本原子力学会「2012年秋の大会」2012年9月19-21日，広島大学東広島キャンパス，核融合工学部会セッション「核融合炉実現のためのトリチウム研究報告と新展開に向けた提案」,* 2012年9月.
773. **長谷川 登, 富田 卓朗, 錦野 将元, 南 康夫, 馬場 基芳, 武井 亮太, 寺川 康太, 海堀 岳史, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** 軟X線プローブによるフェムト秒レーザーアブレーション過程の直接観測, *日本物理学会秋季大会,* **Vol.67,** *No.4,* 834, 2012年9月.
774. **富田 卓朗, 錦野 将元, 長谷川 登, 南 康夫, 武井 亮太, 馬場 基芳, 寺川 康太, 海堀 岳史, 守田 利昌, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** 軟X線イメージングによる閾値特性を持ったアブレーションダイナミクスの観測, *日本物理学会秋季大会,* **Vol.67,** *No.4,* 834, 2012年9月.
775. **小西 将士, 川上 烈生, 新部 正人, 中野 由崇, 森 祐太, 小高 拓也, 白濱 達夫, 山田 哲也, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** p-GaNとn-GaNにおけるAr プラズマエッチングダメージ, *平成24年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 49, 2012年9月.
776. **川上 烈生, 新部 正人, 竹内 日出雄, 森 祐太, 小西 将士, 小高 拓也, 白濱 達夫, 山田 哲也, 富永 喜久雄 :** ArプラズマによるSiCエッチングダメージ, *平成24年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 50, 2012年9月.
777. **森 祐太, 川上 烈生, 新部 正人, 中野 由崇, 小西 将士, 小高 拓也, 白濱 達夫, 山田 哲也, 富永 喜久雄 :** 二酸化チタン配合フッ素樹脂へのDBDエアプラズマトリートメント, *平成24年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 52, 2012年9月.
778. **清水 亮, 髙島 祐介, 直井 美貴 :** SiO2サブ波長回折格子のLED応用に関する検討, *平成24年度電気関係学会四国支部連合大会,* 11-5, 2012年9月.
779. **九鬼 健, 横山 達也, 富田 卓朗, 直井 美貴 :** MOCVD法によるリン化ゲルマニウム結晶成長に関する研究, *第42回結晶成長国内会議(NCCG-42),* 10PS07, 2012年11月.
780. **藤本 拓生, Choi Yun Jeong, 富田 卓朗, 直井 美貴 :** リン添加による炭素系薄膜CVD成長に関する研究, *第42回結晶成長国内会議(NCCG-42),* 10PS08, 2012年11月.
781. **新部 正人, 小高 拓也, 川上 烈生, 竹内 日出雄 :** プラズマエッチングしたp-SiC結晶のダメージ解析, *第26回日本放射光学会年会 放射光科学合同シンポジウム,* 2013年1月.
782. **新部 正人, 佐野 桂治, 小高 拓也, 川上 烈生, 富永 喜久雄, 中野 由崇 :** 軟X線照射によるTiO2薄膜の乱れた構造の回復, *第26回日本放射光学会年会 放射光科学合同シンポジウム,* 2013年1月.
783. **錦野 将元, 長谷川 登, 富田 卓朗, 武井 亮太, 馬場 基芳, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** 軟X線レーザー干渉計測による白金のフェムト秒レーザーアブレーション, *レーザー学会第33回年次大会,* **Vol.33,** 2013年1月.
784. **長谷川 登, 富田 卓朗, 錦野 将元, 武井 亮太, 馬場 基芳, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** 軟X線レーザープローブによるフェムト秒レーザーアブレーション過程の時間分解計測, *レーザー学会第33回年次大会,* **Vol.33,** 2013年1月.
785. **久米 保奈美, 林野 耕平, 岩崎 裕一, 福井 和人, 敖 金平, 大野 泰夫 :** 高調波反射を遮断した GaN SBD レクテナ回路の特性, *2013年電子情報通信学会総合大会,* 2013年3月.
786. **林野 耕平, 久米 保奈美, 福居 和人, 岩崎 裕一, 敖 金平, 大野 泰夫 :** 高調波遮断フィルタを用いたGaN SBDレクテナ回路の反射抑制, *2013年電子情報通信学会総合大会,* 2013年3月.
787. **西野 克志, 日和佐 悠一, 岩元 翔太, 林 浩太郎, 月原 政志 :** 昇華法による荒れたSiC基板上へのAlN成長, *第60回応用物理学会春季学術講演会,* 2013年3月.
788. **呉 龍錫, 高村 真琴, 古川 一暁, 永瀬 雅夫, 日比野 浩樹 :** SiC上グラフェン架橋構造作製のための電解エッチング条件の 検討, *第60回応用物理学会春季学術講演会(応物2013春), No.27p-G12-6,* 2013年3月.
789. **長谷川 登, 富田 卓朗, 錦野 将元, 南 康夫, 馬場 基芳, 武井 亮太, 寺川 康太, 海堀 岳史, 平野 祐介, 守田 利昌, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** 軟X 線プローブによるフェムト秒レーザーアブレーション過程の直接観測 (II), *日本物理学会年次大会,* **Vol.68,** *No.4,* 987, 2013年3月.
790. **Choi Yun-Jeong, 富田 卓朗, 直井 美貴 :** Morphological change of carbon film surface through thermal annealing, *第60回応用物理学会春季学術講演会,* 28p-PB3-9, 2013年3月.
791. **髙島 祐介, 清水 亮, 直井 美貴 :** UV-LED上サブ波長回折格子の偏光特性評価, *第60回応用物理学会春季学術講演会,* 28p-PA1-33, 2013年3月.
792. **岩田 義之, 岩本 篤, 井口 宗明, 永瀬 雅夫 :** SiC上グラフェンのラマンスペクトル測定における基板効果の評価, *第60回応用物理学会春季学術講演会(応物2013春), No.28p-A6-8,* 2013年3月.
793. **Ying Jiang, Qingpeng Wang, Kentaro Tamai, Satoko Shinkai, Takahiro Miyashita, Shin-Ichi Motoyama, Dejun Wang, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Field Isolation of GaN MOSFET by Boron Ion Implantation, *第60回応用物理学関係連合講演会,* Mar. 2013.
794. **Qingpeng Wang, Ying Jiang, Kentaro Tamai, Takahiro Miyashita, Shin-ichi Motoyama, Dejun Wang, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Oxide Thickness Dependency on Threshold Voltage of GaN MOSFETs on AlGaN/GaN Heterostructure, *第60回応用物理学関係連合講演会,* Mar. 2013.
795. **木尾 勇介, 井川 祐介, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETサイドゲート効果における光照射・温度の影響, *第60回応用物理学関係連合講演会,* 2013年3月.
796. **友部 健, 三谷 武志, 中島 信一, 藤森 裕基, 富田 卓朗, 桑原 奈月, 西澤 伸一, 奥村 元 :** ラマン散乱測定および強度計算に基づく10H-SiC 積層構造の決定, *第60 回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集,* **Vol.60,** 15-246, 2013年3月.
797. **富田 卓朗, 錦野 将元, 長谷川 登, 南 康夫, 武井 亮太, 馬場 基芳, 海堀 岳史, 守田 利昌, 平野 祐介, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** 軟X 線レーザーを用いた金属におけるレーザーアブレーションダイナミクスの観測, *日本物理学会年次大会,* **Vol.68,** *No.4,* 824, 2013年3月.
798. **金 度亨, 李 熙燮, 山住 和也, 西野 克志, 酒井 士郎 :** 炭素(C)ドープAlGaN のP 型化のメカニズム, *第60 回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集,* 28p-PA1-29, 2013年3月.
799. **西 勇輝, 日比野 浩樹, 影島 博之, 山口 浩司, 永瀬 雅夫 :** SiC上グラフェンによる原子層スイッチ, *第60回応用物理学会春季学術講演会(応物2013春), No.29a-G7-10,* 2013年3月.
800. **新部 正人, 川上 烈生, 中野 由崇, 小西 将士, 森 祐太, 小高 拓也, 白濱 達夫, 山田 哲也, 富永 喜久雄, 向井 孝志 :** n-GaN表面のN2プラズマエッチングダメージ, *第60回春季応用物理学会学術講演会, No.1,* 2013年3月.
801. **佐野 桂治, 新部 正人, 小高 拓也, 川上 烈生, 富永 喜久雄, 中野 由崇 :** 軟X線照射によるTiO2薄膜のエッチングダメージの回復Ⅰ, *第60回春季応用物理学会学術講演会, No.1,* 2013年3月.
802. **新部 正人, 佐野 桂治, 小高 拓也, 川上 烈生, 富永 喜久雄, 中野 由崇 :** 軟X線照射によるTiO2薄膜のエッチングダメージの回復II, *第60回春季応用物理学会学術講演会, No.1,* 2013年3月.
803. **江山 剛史, 高吉 翔大, 富田 卓朗, 錦野 将元, 長谷川 登, 南 康夫, 武井 亮太, 馬場 基芳, 平野 祐介, 海堀 岳史, 守田 利昌, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** 軟X 線レーザーで観るフェムト秒レーザーアブレーション過程の物質依存性, *第60 回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集,* **Vol.60,** 04-276, 2013年3月.
804. **錦野 将元, 長谷川 登, 富田 卓朗, 南 康夫, 武井 亮太, 石野 雅彦, 寺川 康太, 江山 剛史, 高吉 翔大, 河内 哲哉, 山極 満, 馬場 基芳, 末元 徹 :** 軟X線レーザー干渉計による白金のフェムト秒レーザーアブレーション初期過程, *第60 回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集,* **Vol.60,** 04-277, 2013年3月.
805. **出来 真斗, 牧野 高紘, 富田 卓朗, 児島 一聡, 大島 武 :** 4H-SiC MOS キャパシタにおける絶縁破壊電界のLET および膜厚依存性, *第60回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集,* **Vol.60,** 15-266, 2013年3月.
806. **川上 烈生, 武市 敦, 髙月 成俊, 大塩 誠二, 小倉 長夫, 小西 将士, 森 祐太, 桜間 健太郎, 稲岡 武, 富永 喜久雄 :** UV/OHラジカルジェット殺菌と可視光LED光触媒酸化還元による果実の鮮度保持技術, *LED総合フォーラム2012 in 徳島,* 103-104, 2012年4月.
807. **髙島 祐介, 直井 美貴 :** 金を用いたサブ波長回折格子の偏光制御, *LED総合フォーラム2012in徳島,* P-19, 2012年4月.
808. **永瀬 雅夫 :** 高品質エピタキシャルグラフェン作製, *第12回 徳島大学研究者との集い,* 2012年6月.
809. **玉井 健太郎, 敖 金平, 菊田 大悟, 杉本 雅裕, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN MISHFETチャネル電子移動度の測定, *電子情報通信学会電子デバイス研究会,* 2012年7月.
810. **新部 正人, 佐野 桂治, 小高 拓也, 川上 烈生, 富永 喜久雄, 中野 由崇 :** エッチングしたTiO2薄膜の軟X線照射による乱れた構造の回復, *第48回X線分析討論会,* 2012年10月.
811. **小高 拓也, 新部 正人, 川上 烈生, 中野 由崇, 向井 孝志 :** N2プラズマによるGaNエッチングダメージの分析, *第48回X線分析討論会,* 2012年10月.
812. **髙島 祐介, 馬渕 良, 直井 美貴, 下村 直行, 大来 雄二 :** 技術者倫理科目におけるアンケートによる教育改善とTAの教育寄与, *電気学会研究会資料,* **Vol.FIE-12,** *No.3,* 41-46, 2012年12月.
813. **富田 卓朗 :** プラズマ軟X線レーザーを用いた白金におけるフェムト秒レーザーアブレーションダイナミクスの観測, *平成24年度核融合科学研究所共同研究「プラズマの素過程と分光診断の展望」研究会,* 2013年1月.
814. **永瀬 雅夫 :** 高品質単結晶単層グラフェンの作製技術, *徳島大学 新技術説明会,* 2013年2月.
815. **Liuan Li, Akinori Kishi, Takayuki Shiraishi, Ying Jiang, Qingpeng Wang, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Evaluation of a Gate-First Process for AlGaN/GaN Heterostructure Field-Effect Transistors, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.52,** *No.4,* 11NH01, 2013.
816. **Retsuo Kawakami, Niibe Masahito, Nakano Yoshitaka, Konishi Masashi, Mori Yuta, Takeichi Atsushi, Tominaga Kikuo *and* Mukai Takashi :** Comparison between Damage Characteristics of p- and n-GaN Surfaces Etched by Capacitively Coupled Radio Frequency Argon Plasmas, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.52,** 05EC05-1-05EC05-5, 2013.
817. **Retsuo Kawakami, Niibe Masahito, Nakano Yoshitaka, Konishi Masashi, Mori Yuta, Takeuchi Hideo, Shirahama Tatsuo, Yamada Tetsuya *and* Tominaga Kikuo :** Characteristics of TiO2 Surfaces Etched by Capacitively Coupled Radio Frequency N2 and He Plasmas, *Journal of Physics: Conference Series,* **Vol.441,** 012038-1-012038-6, 2013.
818. **Andreas Kirschner, P Wienhold, C Bjorkas, O VanHoey, D Matveev, S Brezinsek, A Kreter, M Laengner, Kaoru Ohya, V Philipps, A Pospieszczyk, U Samm, B Schweer *and* TEXTOR team :** Studies of impurity migration in TEXTOR by local tracer injection, *Journal of Nuclear Materials,* **Vol.438,** S723-S726, 2013.
819. **Yasuo Ohno, Yusuke Kio, Yusuke Ikawa *and* Jin-Ping Ao :** Observation of Side-Gating Effect in AlGaN/GaN Heterostructure Field Effect Transistors, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.52,** *No.7,* 08JN28, 2013.
820. **Retsuo Kawakami, Niibe Masahito, Nakano Yoshitaka, Shirahama Tatsuo, Yamada Tetsuya, Aoki Kazuma, Takabatake Mari, Tominaga Kikuo *and* Mukai Takashi :** Damage characteristics of n-GaN thin film surfaces etched by N2 plasmas, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.10,** *No.11,* 1553-1556, 2013.
821. **Kaoru Ohya *and* Takuya Yamanaka :** Modeling secondary electron emission from nanostructured materials in helium ion microscope, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms,* **Vol.315,** 295-299, 2013.
822. **Retsuo Kawakami, Niibe Masahito, Takeuchi Hideo, Konishi Masashi, Mori Yuta, Shirahama Tatsuo, Yamada Tetsuya *and* Tominaga Kikuo :** Surface Damage of 6H-SiC Originating from Argon Plasma Irradiation, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms,* **Vol.315,** 213-217, 2013.
823. **Shin-ichi Nakashima, Takuro Tomita, Natsuki Kuwahara, Takeshi Mitani, Ken Tomobe, Shin-ichi Nishizawa *and* Hajime Okumura :** Raman intensity profiles of zone-folded modes in SiC: Identification of stacking sequence of 10H-SiC, *Journal of Applied Physics,* **Vol.114,** *No.19,* 193510-1-193510-7, 2013.
824. **Hiroyuki Kageshima, Hiroki Hibino, Hiroshi Yamaguchi *and* Masao Nagase :** Stability and reactivity of steps in the initial stage of graphene growth on the SiC(0001) surface, *Physical Review B, Condensed Matter and Materials Physics,* **Vol.88,** *No.23,* 235405-(7pp), 2013.
825. **Dohyung Kim, Heesub Lee, Kazuya Yamazumi, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Fabrication of C-Doped p-AlGaInN Light-Emitting Diodes by the Insertion of Al4C3, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.52,** *No.8S,* 08JG18-1-08JG18-5, 2013.
826. **Kazutaka Niigata, Kazuhiro Narano, Yutaro Maeda *and* Jin-Ping Ao :** pH Sensor on AlGaN/GaN Heterostructure with High Al Mole Fraction, *Frontiers in Sensors (FS),* **Vol.2,** *No.1,* 10-12, 2014.
827. **Dohyung Kim, Yuya Onishi, Ryuji Oki *and* Shiro Sakai :** Photo-induced Current and Degradation in Al4C3/Al2O3 (0001) Grown by Metalorganic Chemical Vapor Deposition, *Thin Solid Films,* **Vol.557,** 216-221, 2014.
828. **Manato Deki, Takahiro Makino, Naoya Iwamoto, Shinobu Onoda, Kazutoshi Kojima, Takuro Tomita *and* Takeshi Ohshima :** Linear energy transfer dependence of single event gate rupture in SiC MOS capacitors, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms,* **Vol.319,** 75-78, 2014.
829. **Manato Deki, Tomoki Oka, Shodai Takayoshi, Yoshiki Naoi, Takahiro Makino, Takeshi Ohshima *and* Takuro Tomita :** Temperature Dependence of Electric Conductivities in Femtosecond Laser Modified Areas in Silicon Carbide, *Materials Science Forum,* **Vol.778-780,** 661-664, 2014.
830. **Manato Deki, Takahiro Makino, Kazutoshi Kojima, Takuro Tomita *and* Takeshi Ohshima :** Single Event Gate Rupture in SiC MOS Capacitors with Different Gate Oxide Thicknesses, *Materials Science Forum,* **Vol.778-780,** 440-443, 2014.
831. **Hiroyuki Kageshima, Hiroki Hibino, Hiroshi Yamaguchi *and* Masao Nagase :** Stability and Reactivity of [11-20] Step in Initial Stage of Epitaxial Graphene Growth on SiC(0001), *Materials Science Forum,* **Vol.778-780,** 1150-1153, 2014.
832. **Qingpeng Wang, Ying Jiang, Liuan Li, Dejun Wang, Yasuo Ohno *and* Jin-Ping Ao :** Characterization of GaN MOSFETs on AlGaN/GaN Heterostructure With Variation in Channel Dimensions, *IEEE Transactions on Electron Devices,* **Vol.61,** *No.2,* 498-504, 2014.
833. **Liuan Li, Akinori Kishi, Takayuki Shiraishi, Ying Jiang, Qingpeng Wang *and* Jin-Ping Ao :** Electrical properties of TiN on gallium nitride grown using different deposition conditions and annealing, *Journal of Vacuum Science & Technology A,* **Vol.32,** *No.2,* 02B116, 2014.
834. **Naoki Shinohara, Naoki Niwa, Kenji Takagi, Kenniti Hamamoto, Satoshi Ujigawa, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Microwave building as an application of wireless power transfer, *Wireless Power Transfer,* **Vol.1,** *No.1,* 1-9, 2014.
835. **永瀬 雅夫 :** グラフェン複合物性の機能デバイス化技術の研究, *徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部研究報告,* **Vol.58,** 13-21, 2013年.
836. **Masao Nagase, Hiroki Hibino, Hiroyuki Kageshima *and* Hiroshi Yamaguchi :** Graphene-Based Nano-Electro-Mechanical Switch with High On/Off Ratio, *Applied Physics Express,* **Vol.6,** *No.4,* 055101-(3pp), 2013.
837. **Katsushi Nishino, Jun Nakauchi, Kotaro Hayashi *and* Masashi Tsukihara :** Self-Separation of Sublimation-Grown AlN with AlSiN Buffer Layer, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.52,** 08JA07-1-08-JA07-2, 2013.
838. **Yao Yao, Zhiyuan He, Fan Yang, Zhen Shen, Jincheng Zhang, Yiqiang Ni, Jin Li, Shuo Wang, Guilin Zhou, Jian Zhong, Zhisheng Wu, Baijun Zhang, Jin-Ping Ao *and* Yang Liu :** Normally-off GaN recessed-gate MOSFET fabricated by selective area growth technique, *Applied Physics Express,* **Vol.7,** *No.1,* 016502, 2014.
839. **関根 佳明, 日比野 浩樹, 小栗 克也, 赤崎 達志, 影島 博之, 永瀬 雅夫, 佐々木 健一, 山口 浩司 :** SiC上グラフェンの表面増強ラマン散乱, *NTT技術ジャーナル,* **Vol.25,** *No.6,* 22-26, 2013年6月.
840. **富田 卓朗 :** 固体物性からみたレーザーアブレーション, --- 講座:レーザー生成プラズマの新しい温度，密度領域における物性とシミュレーション ---, *プラズマ・核融合学会誌,* **Vol.89,** *No.7,* 493-499, 2013年7月.
841. **Retsuo Kawakami, Konishi Masashi, Mori Yuta, Shirahama Tatsuo, Yamada Tetsuya, Tominaga Kikuo, Niibe Masahito, Nakano Yoshitaka *and* Mukai Takashi :** Damage Characteristics of n-GaN Thin Film Surfaces Etched by N2 Plasmas, *The 40th International Symposium on Compound Semiconductors,* Kobe, May 2013.
842. **Retsuo Kawakami, Niibe Masahito, Nakano Yoshitaka, Konishi Masashi, Shirahama Tatsuo, Tominaga Kikuo *and* Mukai Takashi :** Damage Characteristics of n-GaN Thin Film Surfaces Etched by Ultraviolet Light-Assisted Helium Plasmas, *The 4th International Symposium on Organic and Inorganic Electronic Materials and Related Nanotechnologies (EM-NANO2010),* Kanazawa, Jun. 2013.
843. **Yuya Ohnishi, Dohyung Kim *and* Shiro Sakai :** Photo-induced Current in AlC/ Sapphire Grown by Metalorganic Chemical Vapor Deposition, *6th Int. Symp. on Control of Semiconductor Interfaces,* P2-17, Fukuoka, Jul. 2013.
844. **Shigeki Matsuo, Keiji Oda *and* Yoshiki Naoi :** Three-Dimensional Micro Modification and Selective Etching of Crystalline Silicon Using 1.56-m, *The 10th Conference on Lasers and Electro-Optics Pacific Rim (CLEO-PR 2013),* Kyoto, Jul. 2013.
845. **Liuan Li, Akinori Kishi, Takayuki Shiraishi, Ying Jiang, Qingpeng Wang *and* Jin-Ping Ao :** Electrical property of TiN on gallium nitride under different sputtering conditions, *The 12th International Symposium on Sputtering & Plasma Processes,* Kyoto, Jul. 2013.
846. **Retsuo Kawakami, Niibe Masahito, Takeuchi Hideo, Shirahama Tatsuo, Konishi Masashi, Mori Yuta, Yamada Tetsuya *and* Tominaga Kikuo :** Damage Characteristics of 6H-SiC Surfaces Etched Using Capacitively-Coupled Helium Plasmas Driven by a Radio Frequency Power, *Proceedings of 12th International Symposium of Sputtering & Plasma Processes,* 255-258, Kyoto, Jul. 2013.
847. **Noboru Hasegawa, Takuro Tomita, Masaharu Nishikino, Yasuo Minami, Motoyoshi Baba, Ryota Takei, Takeshi Kaihori, Yusuke Hirano, Toshimasa Morita, Tetsuya Kawachi, Mitsuru Yamagiwa *and* Tohru Suemoto :** A study of the femto-second laser ablation process in metals by using a single shot soft x-ray laser probe, *The 12th Asia Pacific Physics Conference,* Chiba, Jul. 2013.
848. **Masaharu Nishikino, Noboru Hasegawa, Takuro Tomita, Yasuo Minami, Ryota Takei, Motoyoshi Baba, Takashi Eyama, Shodai Takayoshi, Tetsuya Kawachi, Mitsuru Yamagiwa *and* Tohru Suemoto :** (Invited) Observation of the nano-scale surface dynamics of femtosecond laser ablation by time-resolved soft x-ray imaging technique, *SPIE Optics + Photonics 2013,* 8849-13, San Diego, Aug. 2013.
849. **Qingpeng Wang, Ying Jiang, Takahiro Miyashita, Shin-ichi Motoyama, Liuan Li, Dejun Wang, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Process Dependency on Threshold Voltage of GaN MOSFETs on AlGaN/GaN Heterostructure, *10th Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Hakodate, Sep. 2013.
850. **Kaoru Ohya *and* Takuya Yamanaka :** Modeling secondary electron emission in scanning He ion microscope; comparison with scanning Ga ion and electron microscopes, *19th International Vacuum Congress, September 9 -13,* Paris, Sep. 2013.
851. **Takuto Tao, Toshio Okumura, Nakashima Takeshi, O Ryongsok *and* Masao Nagase :** Highly uniform mono-layer graphene on SiC, *5th International Conference on Recent Progress in Graphene Research 2013 (RPGR 2013), No.12a-P3-29,* Tokyo, Japan, Sep. 2013.
852. **Takashi Eyama, Takuro Tomita, Masaharu Nishikino, Noboru Hasegawa, Yasuo Minami, Ryota Takei, Motoyoshi Baba, Yusuke Hirano, Toshimasa Morita, Tetsuya Kawachi, Mitsuru Yamagiwa *and* Tohru Suemoto :** Femtosecond laser ablation process on platinum and gold observed by plasma-based soft x-ray laser, *The Eighth International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications,* 402, Nara, Sep. 2013.
853. **Masaharu Nishikino, Noboru Hasegawa, Takuro Tomita, Yasuo Minami, Ryota Takei, Motoyoshi Baba, Takashi Eyama, Shodai Takayoshi, Tetsuya Kawachi, Mitsuru Yamagiwa *and* Tohru Suemoto :** Observation of the surface dynamics of femtosecond laser ablation by time-resolved soft x-ray imaging techinique, *The Eighth International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications,* 401, Nara, Sep. 2013.
854. **Akinori Kishi, Yuki Itai, Liuan Li, Takayuki Shiraishi, Kazuhito Fukui, Qiang Liu, Yasuo Ohno *and* Jin-Ping Ao :** GaN Schottky Barrier Diodes with TiN Electrode for High Efficiency Microwave Power Rectification, *2013 International Conference on Solid State Devices and Materials,* Fukuoka, Sep. 2013.
855. **Yuusuke Takashima, Ryo Shimizu, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Optical characteristics of UV-LED with subwavelength grating, *The 18th Microoptics Conference,* H62, Tokyo, Sep. 2013.
856. **Shodai Takayoshi, Manato Deki, Yoshiki Naoi, Takahiro Makino, Takeshi Ohshima *and* Takuro Tomita :** Temperature Dependence of Electric Conductivities in Femtosecond Laser Modified Areas in Silicon Carbide, *The International Conference on Silicon CArbide and Related Materials,* Mo-P-29, Miyazaki, Sep. 2013.
857. **Kaoru Ohya *and* Takuya Yamanaka :** Modeling Secondary Electron Emission from Line Edge Patterns in Scanning Ion Microscopes, *26th International Microprocess and Nanotechnology Conference, 8P-11-11,* Sapporo, Nov. 2013.
858. **O Ryongsok, Takamura Makoto, Furukawa Kazuaki, Masao Nagase *and* Hiroki Hibino :** Effects of UV light on electrochemical wet etching of silicon carbide for suspended graphene fabrication, *26th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2013), No.8P-11-20,* Sapporo, Japan, Nov. 2013.
859. **Masao Nagase :** Nano-electrical and mechanical properties of graphene on SiC substrate, --- [Invited] ---, *Quantum Science Symposium ASIA-2013 Meeting,* Tokyo, Nov. 2013.
860. **Kaoru Ohya *and* Takehito Nagai :** Modeling Positive and Negative Charging of an Insulating Layer under KeV Electron Irradiation, *9th International Symposium on Atomic Level Characterizations for New Materials and Devices '13, 03P18, December 2-6,* 236-239, Hawaii, Dec. 2013.
861. **Kaoru Ohya *and* Takuya Yamanaka :** Modeling Ion Induced Secondary Electron Emission in Scanning Ion Microscopes, *9th International Symposium on Atomic Level Characterizations for New Materials and Devices '13, 05P35,* 573-575, Hawaii, Dec. 2013.
862. **Kazutaka Niigata, Kazuhiro Narano, Yutaro Maeda *and* Jin-Ping Ao :** pH Sensor on AlGaN/GaN Heterostructure with High Al Mole Fraction, *2013 International Workshop on Frontiers in Sensors,* Sanya, Dec. 2013.
863. **Takuro Tomita, Noboru Hasegawa, Masaharu Nishikino, Takashi Eyama, Yasuo Minami, Ryota Takei, Motoyoshi Baba, Takeshi Kaihori, Toshimasa Morita, Yusuke Hirano, Tetsuya Kawachi, Mitsuru Yamagiwa *and* Tohru Suemoto :** Observation of the transient state of the femtosecond laser ablation phenomena on various metals, *8th International Conference on Reactive Plasmas 31st Symposium on Plasma Processing,* 6P-PM-S14-P34, Fukuoka, Feb. 2014.
864. **Shiro Nagaoka, Hideo Horibe, Seiichi Tagawa *and* Jin-Ping Ao :** A Fundamental Study of the Electron Beam Lithography Beyond Sub 100nm Process and its Application, *Malaysia-Japan International Conference on Nanoscience, Nanotechnology and Nanoengineering 2014,* Shah Alam, Feb. 2014.
865. **SHUNSUKE NAKATA, Shiro Sakai *and* Heesub Lee :** InGaN on Ta-GaN on sapphire substarte switched to the alternative Si wafer, *6th Int. Symp. On Advanced Plasma Science and its Application for Nitrides and Nanomaterals (ISPlasma2014),* 06aP33, Nagoya, Mar. 2014.
866. **Kazutaka Niigata, Kazuhiro Narano, Yutaro Maeda *and* Jin-Ping Ao :** Temperature Dependence of pH Sensor on AlGaN/GaN Heterostructure, *6th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials / 7th International Conference on Plasma-Nano Technology & Science,* Nagoya, Mar. 2014.
867. **Mitsuaki Suda, Katsushi Nishino, Satoshi Kurai *and* Yoichi Yamada :** CL measurement of AlGaN grown on the off-oriented AlN substrate, *6th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials,* Mar. 2014.
868. **Ryo Shimizu, Yuusuke Takashima *and* Yoshiki Naoi :** Polarized Light Emission from Blue-LED with SiO2 Subwavelength Grating, *6th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials,* 06aP40, Nagoya, Mar. 2014.
869. **Niibe Masahito, Kotaka Takuya, Retsuo Kawakami, Nakano Yoshitaka *and* Mukai Takashi :** Damage Analysis of N2 Plasma-Etched n-GaN Crystal, *6th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials (ISPlasma2014),* Nagoya, Mar. 2014.
870. **小渕 圭一朗, 林 浩太郎, 西野 克志 :** 昇華法によるAlN成長における初期過程の検討, *日本結晶成長学会 ナノ構造・エピタキシャル成長分科会 第5回窒化物半導体結晶成長講演会,* FR17, 2013年6月.
871. **日和佐 悠一, 林 浩太郎, 西野 克志 :** 荒れた6H-SiC基板へ昇華法により成長したAlNの剥離機構, *日本結晶成長学会 ナノ構造・エピタキシャル成長分科会 第5回窒化物半導体結晶成長講演会,* FR18, 2013年6月.
872. **清水 亮, 髙島 祐介, 直井 美貴 :** 低屈折率差サブ波長回折格子を有するLEDからの発光特性, *応用物理学会 中国四国支部 2013年度 支部学術講演会,* Ap-11, 2013年7月.
873. **大宅 薫 :** 炉内プラズマ対向壁材料の損耗，輸送，再堆積と水素同位体蓄積のシミュレーション, *第8回QUEST研究会∼長時間運転での粒子バランスのモデリング∼,2013.7.29-30,九州大学応用力学研究所,* 2013年7月.
874. **大宅 薫 :** ヘリウムイオン顕微鏡の二次電子信号評価シミュレーション, *ナノテスティング学会 平成25年度 第1回先端計測技術研究会∼HIM及びSEMの画像形成及びシミュレータ技術の最新動向と課題∼,大阪大学東京オフィス,* 2013年8月.
875. **金 度亨, 沖 竜二, 酒井 士郎 :** Al4C3/Al2O3 (0001)の光誘起電流(PIC)の特性, *第74回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集,* 17p-P9-2, 2013年9月.
876. **影島 博之, 日比野 浩樹, 山口 浩司, 永瀬 雅夫 :** SiC(0001)面上第1層グラフェン成長初期過程とステップの役割, *第74回応用物理学会秋季学術講演会(応物2013秋), No.17p-B1-8,* 2013年9月.
877. **中島 健志, 奥村 俊夫, 田尾 拓人, 呉 龍錫, 井口 宗明, 永瀬 雅夫 :** 表面構造制御による均一単層グラフェン成長, *第74回応用物理学会秋季学術講演会(応物2013秋), No.17a-B1-10,* 2013年9月.
878. **川上 烈生, 新部 正人, 中野 由崇, 向井 孝志, 白濱 達夫, 山田 哲也, 青木 一馬, 仲 祐弥, 高畑 麻里, 大場 健太 :** 紫外光アシストHeプラズマによるn-GaN表面エッチングダメージ, *第74回秋季応用物理学会学術講演会,* 08-034, 2013年9月.
879. **新部 正人, 佐野 桂治, 川上 烈生, 富永 喜久雄, 中野 由崇 :** SXおよびUV照射によるTiO2薄膜のエッチングダメージの回復, *第74回秋季応用物理学会学術講演会, No.1,* 07-059, 2013年9月.
880. **佐野 桂治, 新部 正人, 川上 烈生, 富永 喜久雄, 中野 由崇 :** XASスペクトルに見られるTiO2薄膜のエッチングダメージ回復現象の条件評価, *第74回秋季応用物理学会学術講演会, No.1,* 06-113, 2013年9月.
881. **出来 真斗, 牧野 高紘, 富田 卓朗, 児島 一聡, 大島 武 :** SiC-MOSキャパシタにおけるシングルイベント破壊機構の検討, *第74回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集,* **Vol.74,** 15-190, 2013年9月.
882. **江山 剛史, 富田 卓朗, 錦野 将元, 長谷川 登, 南 康夫, 武井 亮太, 馬場 基芳, 大西 直文, 羽富 大起, 海堀 岳史, 守田 利昌, 平野 祐介, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** 軟X 線レーザーによる金及び白金におけるフェムト秒レーザーアブレーション過程の観測, *第74回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集,* **Vol.74,** 04-241, 2013年9月.
883. **福居 和人, 劉 強, 板井 勇樹, 岸 明徳, 敖 金平, 大野 泰夫 :** GaN SBDを用いたレクテナ回路の特性比較, *2013年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2013年9月.
884. **小林 慶祐, 田邉 真一, 田尾 拓人, 呉 龍錫, 奥村 俊夫, 中島 健志, 日比野 浩樹, 永瀬 雅夫 :** SiC上グラフェンにおける移動度の異方性, *第74回応用物理学会秋季学術講演会(応物2013秋), No.18a-B1-4,* 2013年9月.
885. **髙島 祐介, 清水 亮, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 低屈折率膜を有するサブ波長回折格子を実装したUV-LEDの偏光特性, *第74回応用物理学会秋季学術講演会,* 19p-B5-16, 2013年9月.
886. **板井 勇樹, 岸 明徳, 李 柳暗, 白石 孝之, 福居 和人, 劉 強, 敖 金平, 大野 泰夫 :** TiN電極を有するマイクロ波整流用GaNショットキーバリアダイオード, *第74回応用物理学会学術講演会,* 2013年9月.
887. **新潟 一宇, 逢坂 直也, 楢野 和宏, 敖 金平 :** AlGaN/GaN ヘテロ構造を用いたpHセンサの温度依存性, *第74回応用物理学会学術講演会,* 2013年9月.
888. **中田 駿介, 李 熙燮, 酒井 士郎 :** Ta(タンタル)を用いたGaN(窒化ガリウム)の剥離およびマスクの検討, *平成25年度 電気関係学会四国支部連合大会,* 11-6, 2013年9月.
889. **白濱 達夫, 川上 烈生, 新部 正人, 竹内 日出雄, 佐野 桂治 :** HeプラズマによるSiCエッチングダメージ, *平成25年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 38, 2013年9月.
890. **川上 烈生, 新部 正人, 中野 由崇, 向井 孝志, 白濱 達夫, 山田 哲也, 青木 一馬, 仲 祐弥, 高畑 麻里, 大場 健太 :** N2プラズマによるGaNエッチングダメージ, *平成25年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 39, 2013年9月.
891. **山田 哲也, 川上 烈生, 新部 正人, 中野 由崇, 佐野 桂治 :** 二酸化チタン配合フッ素樹脂へのDBDエアプラズマトリートメント, *平成25年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 40, 2013年9月.
892. **高畑 麻里, 川上 烈生, 板東 由季, 白濱 達夫, 大塩 誠二, 山路 諭, 播岡 好之, 吉田 雅彦, 荒巻 広至, 前田 鎮廣 :** LED光触媒システムによる果実の鮮度保持技術, *平成25年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 78, 2013年9月.
893. **井口 宗明, 中島 健志, 奥村 俊夫, 呉 龍錫, 永瀬 雅夫 :** 顕微ラマン分光法による SiC 上グラフェンの欠陥評価, *平成 25 年度 電気関係学会四国支部連合大会, No.11-9,* 2013年9月.
894. **沖 竜二, 金 度享, 川本 祐嗣, 酒井 士郎 :** Mg:AlC における光誘起電流, *平成25年度 電気関係学会四国支部連合大会,* 11-4, 2013年9月.
895. **北村 彩斗, Choi Yun Jeong, 直井 美貴 :** CxPy薄膜へのAl添加効果に関する研究, *平成25年度電気関係学会四国支部連合大会,* 11-5, 2013年9月.
896. **川上 烈生, 新部 正人, 中野 由崇, 松永 史彦, 山田 哲也, 仲 祐弥, 白濱 達夫, 青木 一馬, 高畑 麻里, 大場 健太 :** 窒素とヘリウムDBDプラズマ処理された酸化チタン薄膜の表面状態, *日本物理学会 2013年秋季大会, 第68巻, 第2号, 第4分冊,* 820, 2013年9月.
897. **江山 剛史, 富田 卓朗, 錦野 将元, 長谷川 登, 南 康夫, 武井 亮太, 馬場 基芳, 大西 直文, 羽富 大起, 海堀 岳史, 守田 利昌, 平野 祐介, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** 軟X線反射率イメージングによる金および白金におけるレーザーアブレーションダイナミクスの観測, *日本物理学会秋季大会,* **Vol.68,** 2013年9月.
898. **影島 博之, 日比野 浩樹, 山口 浩司, 永瀬 雅夫 :** SiC(0001)上0層グラフェン成長における表面形状の起源, *日本物理学会 2013年秋季大会, No.28aDK-7,* 2013年9月.
899. **長谷川 登, 錦野 将元, 海堀 岳史, 平野 祐介, 守田 利昌, 河内 哲哉, 山極 満, 富田 卓朗, 江山 剛史, 柿本 直也, 羽富 大起, 大西 直文, 南 康夫, 武井 亮太, 馬場 基芳, 末元 徹 :** ピコ秒からサブマイクロ秒時間領域における金属のフェムト秒レーザーアブレーションダイナミクスの観測, *日本物理学会秋季大会,* **Vol.68,** 827, 2013年9月.
900. **羽富 大起, 大西 直文, 錦野 将元, 長谷川 登, 富田 卓朗, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** Pt表面におけるフェムト秒レーザーアブレーション過程の分子動力学解析, *日本物理学会秋季大会,* **Vol.68,** 828, 2013年9月.
901. **大宅 薫, 永井 健仁 :** KeV電子ビーム照射による絶縁膜帯電のシミュレーション, *第33回ナノテスティングシンポジウム,2013年11月13-15日,千里ライフサイエンスセンター(豊中市),* 7-12, 2013年11月.
902. **山中 卓也, 大宅 薫 :** 走査イオン顕微鏡によるラインパターン計測のシミュレーション, *第33回ナノテスティングシンポジウム,2013年11月13-15日,* 19-23, 2013年11月.
903. **茶谷 洋光, 田尾 拓人, 奥村 俊夫, 中島 健志, 小林 慶祐, 永瀬 雅夫 :** 表面構造制御による均一単層グラフェン成長, *平成25年度応用物理学会九州支部学術講演会, No.30Ea-11,* 2013年11月.
904. **大宅 薫 :** プラズマ対向壁の損耗・再堆積のシミュレーション, *プラズマ・核融合学会九州・沖縄・山口支部第17回支部大会,平成25年12月21-22日,佐世保工業高等専門学校,* 69-71, 2013年12月.
905. **新部 正人, 小高 拓也, 平井 翔大, 川上 烈生, 中野 由崇, 向井 孝志 :** N-K吸収分光法を用いたn-GaN結晶のプラズマエッチングダメージの解析, *第27回日本放射光学会年会 放射光科学合同シンポジウム,* 2014年1月.
906. **佐野 桂治, 新部 正人, 川上 烈生, 中野 由崇 :** エッチングダメージの回復したTiO 2 薄膜のNEXAFS 評価, *第27回日本放射光学会年会 放射光科学合同シンポジウム,* 2014年1月.
907. **錦野 将元, 長谷川 登, 富田 卓朗, 江山 剛史, 柿本 直也, 羽富 大起, 大西 直文, 馬場 基芳, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** 軟X線レーザーによる金のフェムト秒レーザーアブレーション過程の観測, *レーザー学会創立40周年記念学術講演会 第34回年次大会,* **Vol.34,** 21aIII-9, 2014年1月.
908. **長谷川 登, 富田 卓朗, 錦野 将元, 武井 亮太, 馬場 基芳, 江山 剛史, 柿本 直也, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** 軟X線レーザープローブを用いた金属のフェムト秒レーザーアブレーション過程の時間分解計測, *レーザー学会創立40周年記念学術講演会 第34回年次大会,* **Vol.34,** 21aVIII-6, 2014年1月.
909. **大宅 薫 :** イオンビーム照射による固体表面の二次電子放出と帯電のシミュレーション, *ナノテスティング学会 第3回先端計測技術研究会∼イオン及び電子ビームの画像形成及びシミュレータ技術の最新動向と課題∼,大阪大学東京オフィス,* 2014年2月.
910. **清水 亮, 髙島 祐介, 直井 美貴 :** サブ波長回折格子形状のLED偏光特性に対する影響, *第61回応用物理学会春季学術講演会,* 17a-E13-2, 2014年3月.
911. **影島 博之, 日比野 浩樹, 山口 浩司, 永瀬 雅夫 :** SiC(0001) Si面上エピタキシャルグラフェン成長における[1-100]ステップの役割, *第61回応用物理学会春季学術講演会(応物2014春), No.18p-E2-2,* 2014年3月.
912. **永瀬 雅夫 :** SiC上単結晶グラフェンの成長とその物性評価, --- [招待講演] ---, *第61回応用物理学会春季学術講演会(応物2014春), No.18p-F7-5,* 2014年3月.
913. **佐野 桂治, 新部 正人, 川上 烈生, 中野 由崇 :** X線吸収分光法によるTiO2薄膜のエッチングダメージ評価, *第61回春季応用物理学会学術講演会, No.1,* 2014年3月.
914. **新部 正人, 平井 翔大, 川上 烈生, 白濱 達夫, 中野 由崇, 向井 孝志 :** UVアシストHeプラズマによりエッチングしたn-GaN結晶の表面ダメージの分析, *第61回春季応用物理学会学術講演会, No.1,* 2014年3月.
915. **呉 龍錫, 奥村 俊夫, 中島 健志, 有月 琢哉, 井口 宗明, 青木 翔, 小林 慶祐, 松本 卓也, 永瀬 雅夫 :** SiC上グラフェンのオゾン処理によるキャリア密度制御, *第61回応用物理学会春季学術講演会(応物2014春), No.19p-E2-7,* 2014年3月.
916. **井川 裕介, 李 根三, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETサイドゲート効果における光照射・温度の影響, *第61回応用物理学関係連合講演会,* 2014年3月.
917. **岡 知輝, 出来 真斗, 直井 美貴, 牧野 高紘, 大島 武, 富田 卓朗 :** SiCのフェムト秒レーザー改質部における電気伝導度の温度依存性, *第 61 回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集,* **Vol.61,** 04-262, 2014年3月.
918. **髙島 祐介, 南原 康亮, 清水 亮, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** Cr-サブ波長回折格子を用いた紫外域偏光制御の理論的検討, *第61回応用物理学会春季学術講演会,* 19a-F10-9, 2014年3月.
919. **茶谷 洋光, 奥村 俊夫, 伊澤 輝記, 井口 宗明, 中島 健志, 小林 慶祐, 呉 龍錫, 有月 琢哉, 松本 卓也, 前田 文彦, 日比野 浩樹, 永瀬 雅夫 :** グラフェン積層接合の電気特性, *第61回応用物理学会春季学術講演会(応物2014春), No.20a-E2-3,* 2014年3月.
920. **柿本 直也, 江山 剛史, 富田 卓朗, 長谷川 登, 錦野 将元, 南 康夫, 馬場 基芳, 海堀 岳史, 守田 利昌, 平野 祐介, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** 軟 X 線シャドウグラフを用いたナノ秒スケールにおける金のフェムト秒レーザーアブレーション過程の観測, *第 61 回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集,* **Vol.61,** 04-286, 2014年3月.
921. **長谷川 登, 錦野 将元, 富田 卓朗, 江山 剛史, 柿本 直也, 大西 直文, 羽富 大起, 伊藤 篤史, 南 康夫, 武井 亮太, 馬場 基芳, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** 軟X線レーザーを用いた金属表面のフェムト秒レーザーアブレーション過程の観測I, *日本物理学会年次大会,* **Vol.69,** 2014年3月.
922. **錦野 将元, 長谷川 登, 富田 卓朗, 江山 剛史, 柿本 直也, 大西 直文, 羽富 大起, 伊藤 篤史, 南 康夫, 武井 亮太, 馬場 基芳, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** 軟X線レーザーを用いた金属表面のフェムト秒レーザーアブレーション過程の観測II, *日本物理学会年次大会,* **Vol.69,** 2014年3月.
923. **富田 卓朗, 江山 剛史, 柿本 直也, 長谷川 登, 錦野 将元, 南 康夫, 武井 亮太, 馬場 基芳, 大西 直文, 羽富 大起, 海堀 岳史, 守田 利昌, 平野 祐介, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** 軟X線イメージングによる金属表面におけるアブレーション過程の観測, *日本物理学会年次大会,* **Vol.69,** *No.4,* 740, 2014年3月.
924. **山極 満, 長谷川 登, 錦野 将元, 富田 卓朗, 江山 剛史, 柿本 直也, 大西 直文, 羽富 大起, 伊藤 篤史, 南 康夫, 武井 亮太, 馬場 基芳, 河内 哲哉, 末元 徹 :** 軟X線レーザープローブを用いた，金属表面のフェムト秒レーザーアブレーション過程の観測, *日本物理学会年次大会,* **Vol.69,** *No.4,* 874, 2014年3月.
925. **江山 剛史, 柿本 直也, 富田 卓朗, 長谷川 登, 錦野 将元, 南 康夫, 武井 亮太, 馬場 基芳, 大西 直文, 羽富 大起, 海堀 岳史, 守田 利昌, 平野 祐介, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** 軟X線ニュートンリングとシャドウグラフを用いた金属表面のフェムト秒レーザーアブレーション過程の観測, *日本物理学会年次大会,* **Vol.69,** *No.4,* 875, 2014年3月.
926. **羽富 大起, 大西 直文, 錦野 将元, 長谷川 登, 富田 卓朗, 伊藤 篤史, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** フェムト秒レーザー照射に伴う金属表面剥離過程の分子動力学解析, *日本物理学会年次大会,* **Vol.69,** *No.4,* 875, 2014年3月.
927. **馬場 基芳, 錦野 将元, 長谷川 登, 富田 卓朗, 南 康夫, 武井 亮太, 山極 満, 河内 哲哉, 末元 徹 :** 斜入射型反射軟X線顕微鏡によるサブミクロン画像観察, *日本物理学会年次大会,* **Vol.69,** *No.4,* 875, 2014年3月.
928. **川上 烈生, 板東 由季, 白濱 達夫, 大塩 誠二, 山路 諭, 播岡 好之, 吉田 雅彦, 荒巻 広至, 前田 鎮廣 :** LED光触媒による果実の新規汎用型鮮度保持技術の開発研究, *LED総合フォーラム2013 in 徳島,* 77-78, 2013年4月.
929. **清水 亮, 髙島 祐介, 直井 美貴 :** 高屈折率差サブ波長回折格子のLED応用への検討, *LED総合フォーラム2013in徳島,* P-93, 2013年4月.
930. **永瀬 雅夫 :** 新炭素ナノ材料・グラフェンについて, *徳島大学工業会 東海支部 第33回支部総会,* 2013年7月.
931. **ケイ ショウシン, 王 青鵬, 江 瀅, 敖 金平 :** AlGaN/GaN ヘテロ構造上GaN MOSFETの移動度の評価, *2013年度応用物理学会中国四国支部若手半導体研究会,* 2013年7月.
932. **永瀬 雅夫 :** SiC昇華法による単結晶グラフェン作製技術, *第2回和歌山大・徳島大合同 光・ナノテクノロジー研究会,* 2013年8月.
933. **下村 直行, 直井 美貴, 橋爪 正樹 :** 初年度教育・導入教育としてのエンジニアリング入門教育の導入, *電気学会研究会資料,* **Vol.FIE-13,** *No.2,* 25-28, 2013年9月.
934. **永瀬 雅夫 :** グラフェンの極限デバイス応用への提案, *徳島県「ものづくり新技術展示商談会in HONDA」,* 2013年9月.
935. **新部 正人, 佐野 桂治, 川上 烈生, 中野 由崇 :** エッチングしたTiO2薄膜のTi-L NEXAFSに見られる乱れた構造の紫外線照射による回復, *第49回X線分析討論会,* 2013年9月.
936. **川上 烈生, 高畑 麻里, 白濱 達夫, 大塩 誠二, 山路 諭, 播岡 好之, 吉田 雅彦, 荒巻 広至, 前田 鎮廣 :** LED光触媒技術を用いた果実の鮮度保持効果, *第3回次世代ものづくり基盤技術産業展 TECH Biz EXPO 2013,* 2013年10月.
937. **川上 烈生, 高畑 麻里, 白濱 達夫, 大塩 誠二, 山路 諭, 播岡 好之, 吉田 雅彦, 荒巻 広至, 前田 鎮廣 :** LED光触媒技術を用いた果実の鮮度保持効果, *BioOpt Japan 2013,* 2013年10月.
938. **髙島 祐介, 清水 亮, 北村 彩人, 西野 克志, 直井 美貴, 下村 直行, 大来 雄二 :** 学習者の地域性に即した事例を用いた技術者倫理教育の学習効果, *電気学会研究会資料,* **Vol.FIE-13,** *No.3,* 31-35, 2013年12月.
939. **富田 卓朗 :** (invited) レーザーアブレーションダイナミクスのイメージング, *第9回励起ナノプロセス研究会,* A-4-1-A-4-6, 2013年12月.
940. **井川 裕介, 李 根三, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETサイドゲート効果の2次元デバイスシミュレーション, *電子情報通信学会電子デバイス研究会,* 2014年1月.
941. **永瀬 雅夫 :** エピタキシャルグラフェン作製技術の研究, *香川大学工学部 第9回先端工学研究発表会,* 2014年2月.
942. **永瀬 雅夫 :** 高品質単層エピタキシャルグラフェン作製技術, *産総研セミナー,* 2014年2月.
943. **富田 卓朗 :** 電気電子工学科における研究室教育, *工学教育シンポジウム2014,* 4, 2014年3月.
944. **Jin-Ping Ao :** Chapter 6: GaN MOSFET on AlGaN/GaN Heterostructure, Gallium Nitride: Structure, Thermal Properties and Applications, Nova Science Publishers, Hauppauge, Sep. 2014.
945. **Yasuhide Ohno, Kenzo Maehashi *and* Kazuhiko Matsumoto :** Chapter 2: Graphene Laser Irradiation CVD Growth, Springer Japan, Tokyo, Mar. 2015.
946. **Yasuhide Ohno, Kenzo Maehashi *and* Kazuhiko Matsumoto :** Chapter 3: Graphene Direct Growth on Si/SiO2 Substrates, Springer Japan, Tokyo, Mar. 2015.
947. **Yasuhide Ohno, Kenzo Maehashi *and* Kazuhiko Matsumoto :** Chapter 7: Graphene Biosensor, Springer Japan, Tokyo, Mar. 2015.
948. **Yasuhide Ohno, Takafumi Kamimura, Kenzo Maehashi, Koichi Inoue *and* Kazuhiko Matsumoto :** Chapter 10: Aligned Single-Walled Carbon Nanotube Growth on Patterned SiO2/Si Substrates, Springer Japan, Tokyo, Mar. 2015.
949. **Yasuhide Ohno, Kenzo Maehashi *and* Kazuhiko Matsumoto :** Chapter 12: Stochastic Resonance Effect on Carbon Nanotube Field-Effect Transistors, Springer Japan, Tokyo, Mar. 2015.
950. **Ying Jiang, Qingpeng Wang, Kentaro Tamai, Liuan Li, Satoko Shinkai, Takahiro Miyashita, Shin-ichi Motoyama, Dejun Wang, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Field isolation for GaN MOSFETs on AlGaN/GaN heterostructure with boron ion implantation, *Semiconductor Science and Technology,* **Vol.29,** *No.5,* 055002, 2014.
951. **Kaoru Ohya :** Simulation of secondary electron emission from a stepped surface in scanning ion microscopes, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.53,** *No.6S,* 06JB01-1-06JB01-5, 2014.
952. **Yuusuke Takashima, Ryo Shimizu, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Polarized emission characteristics of UV-LED with subwavelength grating, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.53,** *No.7,* 072101-1-072101-6, 2014.
953. **Takuro Tomita, Masaharu Nishikino, Noboru Hasegawa, Yasuo Minami, Ryota Takei, Motoyoshi Baba, Takashi Eyama, Shodai Takayoshi, Takeshi Kaihori, Toshimasa Morita, Yusuke Hirano, Tetsuya Kawachi, Mitsuru Yamagiwa *and* Tohru Suemoto :** Time-resolved soft x-ray imaging of femtosecond laser ablation processes on metals, *Journal of Laser Micro/Nanoengineering,* **Vol.9,** *No.2,* 137-142, 2014.
954. **Jin-Ping Ao, Takauki Shiraishi, Liuan Li, Akinori Kishi *and* Yasuo Ohno :** Synthesis and Application of Metal Nitrides as Schottky Electrodes for Gallium Nitride Electron Devices, *Science of Advanced Materials,* **Vol.6,** *No.7,* 1645-1649, 2014.
955. **Motoyoshi Baba, Masaharu Nishikino, Noboru Hasegawa, Takuro Tomita, Yasuo Minami, Ryota Takei, Mitsuru Yamagiwa, Tetsuya Kawachi *and* Tohru Suemoto :** Submicron scale image observation with a grazing incidence reflection-type single-shot soft X-ray microscope, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.53,** 080302-1-080302-4, 2014.
956. **関根 佳明, 日比野 浩樹, 小栗 克弥, 岩本 篤, 永瀬 雅夫, 影島 博之, 佐々木 健一, 赤崎 達志 :** 金微粒子によるSiC上グラフェンの表面増強ラマン散乱, *レーザー研究,* **Vol.42,** *No.8,* 652-657, 2014年.
957. **Kaoru Ohya :** Simulation of insulating-layer charging on a conductive substrate irradiated by ion and electron beams, *Journal of Vacuum Science and Technology. B, Nanotechnology & Microelectronics : Materials, Processing, Measurement, & Phenomena : JVST B,* **Vol.32,** *No.6,* 06FC01-1-06FC01-8, 2014.
958. **Qingpeng Wang, Ying Jiang, Takahiro Miyashita, Shin-ichi Motoyama, Liuan Li, Dejun Wang, Yasuo Ohno *and* Jin-Ping Ao :** Process dependency on threshold voltage of GaN MOSFET on AlGaN/GaN heterostructure, *Solid-State Electronics,* **Vol.99,** 59-64, 2014.
959. **Retsuo Kawakami, Masahito Niibe, Yoshitaka Nakano, Tatsuo Shirahama, Kazuma Aoki, Kenta Oba, Mari Takabatake *and* Takashi Mukai :** Damage Characteristics of n-GaN Thin Film Surfaces Etched by Ultraviolet Light-Assisted Helium Plasmas, *Thin Solid Films,* **Vol.570,** 81-86, 2014.
960. **Liuan Li, Ryosuke Nakamura, Qingpeng Wang, Ying Jiang *and* Jin-Ping Ao :** Synthesis of titanium nitride for self-aligned gate AlGaN/GaN heterostructure field-effect transistors, *Nanoscale Research Letters,* **Vol.9,** *No.1,* 590, 2014.
961. **Chen Miao-Gen, Keiji Nakamura, Qiu Yan-Qing, Daisuke Ogawa, Retsuo Kawakami, Masahito Niibe *and* Yoshitaka Nakano :** Optical and Electrical Investigation of Ar+-Irradiated GaN, *Applied Physics Express,* **Vol.7,** *No.11,* 111003-1-111003-3, 2014.
962. **Kazutaka Niigata, Kazuhiro Narano, Yutaro Maeda *and* Jin-Ping Ao :** Temperature dependence of sensing characteristics of a pH sensor fabricated on AlGaN/GaN heterostructure, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.53,** *No.11S,* 11RD01-1-11RD01-5, 2014.
963. **Yutaro Maeda, Kazutaka Niigata, Kazuhiro Narano, Lei Wang *and* Jin-Ping Ao :** Surface Dependence of pH Sensors on AlGaN/GaN Heterostructure, *ECS Transactions,* **Vol.61,** *No.19,* 65-71, 2014.
964. **Yusuke Ikawa, Keunsam Lee, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Two-dimensional device simulation of GaN/GaN heterojunction FET side-gating effect, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.53,** *No.11,* 114302, 2014.
965. **Liuan Li, Akinori Kishi, Qiang Liu, Yuki Itai, Ryota Fujihara, Yasuo Ohno *and* Jin-Ping Ao :** GaN Schottky Barrier Diode with TiN Electrode for Microwave Rectification, *IEEE Journal of the Electron Devices Society,* **Vol.2,** *No.6,* 168-173, 2014.
966. **Akira Fukuda, Daiju Terasawa, Yasuhide Ohno *and* Kazuhiko Matsumoto :** Effect of the Inert Gas Adsorption on the Bilayer Graphene to the Localized Electron Magnetotransport, *Journal of Physics: Conference Series,* **Vol.568,** *No.5,* 052009, 2014.
967. **Liuan Li, Yonggang Xu, Qingpeng Wang, Ryosuke Nakamura, Ying Jiang *and* Jin-Ping Ao :** Metal-oxide-semiconductor AlGaN/GaN heterostructure field-effect transistors using TiN/AlO stack gate layer deposited by reactive sputtering, *Semiconductor Science and Technology,* **Vol.30,** *No.1,* 015019, 2015.
968. **Shiro Nagaoka, Hideo Horibe, Jin-Ping Ao *and* Seiichi Tagawa :** A Fundamental Study of the Electron Beam Lithography Beyond Sub 100nm Process and its Application, *Advanced Materials Research,* **Vol.1109,** 617-625, 2015.
969. **O Ryong-Sok, Takamura Makoto, Furukawa Kazuaki, Masao Nagase *and* Hiroki Hibino :** Effects of UV light intensity on electrochemical wet etching of SiC for the fabrication of suspended graphene, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.54,** *No.3,* 036502-(5pp), 2015.
970. **N. A. Inogamov, V. V. Zhakhovsky, Noboru Hasegawa, Masaharu Nishikino, Mitsuru Yamagiwa, Masahiko Ishino, M. B. Agranat, S. I. Ashitkov, A. Ya. Faenov, V. A. Khokhlov, D. K. Ilnitsky, Yu. V. Petrov, K. P. Migdal, T. A. Pikuz, Shodai Takayoshi, Takashi Eyama, Naoya Kakimoto, Takuro Tomita, Motoyoshi Baba, Yasuo Minami, Tohru Suemoto *and* Tetsuya Kawachi :** Hydrodynamics driven by ultrashort laser pulse: simulations and the optical pump X ray probe experiment, *Applied Physics. B, Lasers and Optics,* **Vol.119,** 413-419, 2015.
971. **Retsuo Kawakami, Yoshitaka Nakano, Masahito Niibe, Tatsuo Shirahama *and* Takashi Mukai :** Electrical Investigation of Deep-Level Defects Introduced in AlGaN/GaN Heterostructures by CF4 Plasma Treatments, *ECS Solid State Letters,* **Vol.4,** *No.4,* 36-38, 2015.
972. **Qingpeng Wang, Jin-Ping Ao, Pangpang Wang, Ying Jiang, Liuan Li, Kazuya Kawaharada *and* Yang Liu :** GaN metal oxide semiconductor field-effect transistors on AlGaN/GaN heterostructure with recessed gate, *Frontiers of Materials Science,* **Vol.9,** *No.2,* 151-155, 2015.
973. **Tomoyuki Ueki, Kazuki Morimoto, Hiroki Yokota, Takuro Tomita *and* Tatsuya Okada :** Application of femtosecond laser irradiation to low-temperature diffusion at the Ni/SiC interface, *Applied Physics Express,* **Vol.8,** *No.2,* 026503-1-026503-4, 2015.
974. **Keisuke Kobayashi, Shinichi Tanabe, Takuto Tao, Toshio Okumura, Takeshi Nakashima, Takuya Aritsuki, Ryong-Sok O *and* Masao Nagase :** Resistivity anisotropy measured using four probes in epitaxial graphene on silicon carbide, *Applied Physics Express,* **Vol.8,** *No.2,* 036602-(3pp), 2015.
975. **Qingpeng Wang, Ying Jiang, Jiaqi Zhang, Liuan Li, Kazuya Kawaharada, Dejun Wang *and* Jin-Ping Ao :** Gate-first GaN MOSFET based on dry-etching-assisted non-annealing ohmic process, *Applied Physics Express,* **Vol.8,** *No.4,* 046501, 2015.
976. **永瀬 雅夫 :** 高品質単結晶グラフェンの作製技術, --- 大学発!次世代を担うR&D特集 ---, *月刊機能材料,* **Vol.34,** *No.5,* 28-35, 2014年5月.
977. **K. Yamazumi, D. Kim, M. Sekiguchi *and* Shiro Sakai :** C-Related p-Type Conduction in AlGaN and AlN, *LEDIA'14,* 24p-LEDp6-7, Apr. 2014.
978. **Takashi Eyama, Naoya Kakimoto, Takuro Tomita, Noboru Hasegawa, Masaharu Nishikino, Yasuo Minami, Ryota Takei, Motoyoshi Baba, Takeshi Kaihori, Toshimasa Morita, Yusuke Hirano, Tetsuya Kawachi, Mitsuru Yamagiwa *and* Tohru Suemoto :** Direct observation of femtosecond laser ablation on metals by plasma-based soft x-ray laser, *International conference on HIGH ENERGY DENSITY SCIENCES 2014,* HEDSp9-31, Yokohama, Apr. 2014.
979. **Liuan Li, Takayuki Shiraishi, Akinori Kishi, Ryosuke Nakamura *and* Jin-Ping Ao :** Synthesis of titanium nitride and aluminum oxide by reactive sputtering for GaN-based electron devices, *The 3rd International Symposium on Next-Generation Electronics,* Taoyuan, May 2014.
980. **Kazutaka Niigata, Kazuhiro Narano, Yutaro Maeda *and* Jin-Ping Ao :** Surface Dependence of pH Sensors on AlGaN/GaN Heterostructures, *The 225th Electrochemical Society Meeting,* Orlando, May 2014.
981. **Tetsuya Kawachi, Masaharu Nishikino, Akira Sasaki, Makoto Ishino, Noboru Hasegawa, Takashi Imazono, Pikuz Tatian, Anatoly Faenov, M. Magnitskiy, M. Maruyama, Takuro Tomita, Tohru Suemoto, Pirozhhkov Alexander, Sergei Bulanov, Hiromitsu Kiriyama, Mitsuru Yamagiwa, Masaki Kando, Mitsuru Yamagiwa, K. Kondo, P. Bolton *and* Yoshiaki Kato :** Progress and Prospects of Coherent X-ray Research using High Power Lasers in JAEA, *14th International Conference for X-Ray Lasers 2014,* Colorado, May 2014.
982. **Kaoru Ohya :** Charging Simulation of Insulating Layers on a Conducting Substrate Irradiated by Ion and Electron Beams, *58th International Cpnference on Electron, Ion and Photon beam Technology & Nanofabrication, P09-02, , May 27-30, 2014,* Washington, D.C., May 2014.
983. **Masaharu Nishikino, Noboru Hasegawa, Takashi Eyama, Naoya Kakimoto, Takuro Tomita, Daiki Hatomi, Naofumi Ohnishi, Atsushi M Ito, Yasuo Minami, Motoyoshi Baba, Tetsuya Kawachi, Mitsuru Yamagiwa *and* Tohru Suemoto :** Observation of Weakly Excited Ablation Dynamics with Femtosecond Laser by using Time-Resolved Soft X-ray Imaging Technique, *14th International Conference for X-Ray Lasers 2014,* Colorado, May 2014.
984. **Jin-Ping Ao :** Titanium Nitride and its Application on GaN-based Electron Devices, *2014 International Symposium on Single Crystal Diamond and its Electronics and the Fourth Chinese Vacuum Forum,* Xi'an, Jun. 2014.
985. **Shiro Sakai :** InGaAlN LED and C-related P-type Conductivity in AlGaN, *2014 International Symposium on Single Crystal Diamond Electronics (SCDE) and the Fourth Chinese Vacuum Forum (CVF),* Xi'an, Jun. 2014.
986. **Masao Nagase :** Epitaxial graphene grown by infrared rapid thermal annealing, --- [invited] ---, *The 6th IEEE International Nanoelectronics Conference (INEC2014),* Sapporo, Jul. 2014.
987. **Kageshima Hiroyuki, Hiroki Hibino, Hiroshi Yamaguchi *and* Masao Nagase :** Theoretical studies of graphene on SiC, --- [invited] ---, *The 6th IEEE International Nanoelectronics Conference (INEC2014),* Sapporo, Jul. 2014.
988. **Jin-Ping Ao, Qingpeng Wang, Ying Jiang, Liuan Li, Kazuya Kawaharada *and* Yang Liu :** GaN MOSFET on AlGaN/GaN Heterostructure with Recess Structure, *Energy, Materials and Nanotechnology, Open Access Week Meeting,* Chengdu, Aug. 2014.
989. **Jin-Ping Ao :** Development of Gallium Nitride Schottky Barrier Diode for Microwave Rectification, *Progress In Electromagnetics Research Symposium,* Guangzhou, Aug. 2014.
990. **Ryota Fujihara, Yuki Itai, Liuan Li, Qiang Liu, Yasuo Ohno *and* Jin-Ping Ao :** Temperature Dependence of TiN-Anode GaN Schottky Barrier Diode Characteristics for Microwave Power Rectification, *2014 International Conference on Solid State Devices and Materials,* Tsukuba, Sep. 2014.
991. **Kaoru Ohya, Emile.Van Veldhoven, Paul.F.A. Alkemade *and* Diederik.J. Maas :** Helium ion beam charging of an oxide layer on a silicon substrate: a comparison between observed and Monte Carlo-simulated results, *19th International Conference on Ion Beam Modification of Materials, PA21, Leuven, Belgium, September 14-19, 2014,* Sep. 2014.
992. **Takuya Yamanaka, Kaoru Ohya, Veldhoven Emile. Van, Alkemade F. Paul. A. *and* Maas Diederik. J. :** Modelling and observation of a trench pattern on a silicon substrate in helium ion microscope, *19th International Conference on Ion Beam Modification of Materials, PA22,* Leuven, Belgium, Sep. 2014.
993. **M. B. Agranat, S. I. Ashitkov, Motoyoshi Baba, Takashi Eyama, Anatoly Faenov, Noboru Hasegawa, Daiki Hatomi, D. K. Ilnitsky, N. A. Inorgamov, Tetsuya Kawachi, V. A. Khokhlov, Yasuo Minami, Masaharu Nishikino, Naofumi Ohnishi, Pikuz Tatian, V. V. Shepelev, Tohru Suemoto, Shodai Takayoshi, Ryota Takei, Takuro Tomita, Mitsuru Yamagiwa, V. V. Zhakhovsky *and* Yu V. Petrov :** Hydrodynamics driven by ultrashort laser pulse, *9th International Conference on Photo-Excited Processes and Applications,* 30, Matsue, Sep. 2014.
994. **Eizo Yanagita, Manato Deki, Yoshiki Naoi, Takahiro Makino, Takeshi Ohshima *and* Takuro Tomita :** Shallow impurity levels in femtosecond laser modified areas on semi insulating 6H-SiC, *9th International Conference on Photo-Excited Processes and Applications,* 111, Matsue, Sep. 2014.
995. **Naoya Kakimoto, Takashi Eyama, Takuro Tomita, Noboru Hasegawa, Masaharu Nishikino, Yasuo Minami, Ryota Takei, Motoyoshi Baba, Takeshi Kaihori, Toshimasa Morita, Yusuke Hirano, Tetsuya Kawachi, Mitsuru Yamagiwa *and* Tohru Suemoto :** Observation of femtosecond laser ablation process in nano-seconds region by soft x-ray shadow graph, *9th International Conference on Photo-Excited Processes and Applications,* 119, Matsue, Oct. 2014.
996. **Masao Nagase :** Graphene on SiC substrates fabricated by an infrared rapid thermal annealer, --- [invited] ---, *3rd International Conference on Nanotechnology (NANOCON 014),* Pune, India, Oct. 2014.
997. **Keiji Sano, Masahito Niibe, Retsuo Kawakami *and* Yoshitaka Nakano :** Spectral Recovery of Etching Damage of TiO2 Thin Films Observed in XAS Spectra, *The 7th International Symposium on Surface Science (ISSS-7),* Matsue, Nov. 2014.
998. **Kaoru Ohya :** Simulation Study of Crystalline Orientation Effect in Scanning Ion Microscope, *7th International Symposium on Surface Ecience, 4PN-96, Novemver 2-6, 2014,* Matsue, Nov. 2014.
999. **Masahito Niibe, Takuya Kotaka, Retsuo Kawakami, Yoshitaka Nakano *and* Takashi Mukai :** Damage Characteristics of n-GaN Crystal Etched with N2 Plasma by Soft X-ray Absorption Spectroscopy, *The 7th International Symposium on Surface Science (ISSS-7),* Matsue, Nov. 2014.
1000. **Shodai Hirai, Masahito Niibe, Tatsuo Shirahama, Retsuo Kawakami, Yoshitaka Nakano *and* Takashi Mukai :** Surface Analysis of Thick AlGaN Films Treated by Ar and CF4 Plasma Etching, *The 7th International Symposium on Surface Science (ISSS-7),* Matsue, Nov. 2014.
1001. **Masaharu Nishikino, Noboru Hasegawa, Takuro Tomita, Takashi Eyama, Naoya Kakimoto, Naofumi Ohnishi, Atsushi M. Ito, Motoyoshi Baba, Yasuo Minami, Tetsuya Kawachi, Mitsuru Yamagiwa *and* Tohru Suemoto :** Observation of Femtosecond Laser Ablation on Tungsten by using Soft X-ray Laser, *Plasma Conference 2014,* Niigata, Nov. 2014.
1002. **Noboru Hasegawa, Takuro Tomita, Masaharu Nishikino, Takashi Eyama, Naoya Kakimoto, Naofumi Ohnishi, Atsushi M. Ito, Motoyoshi Baba, Yasuo Minami, Tetsuya Kawachi, Mitsuru Yamagiwa *and* Tohru Suemoto :** A study of the femto-second laser ablation process in metals by using a soft x-ray laser probe, *Plasma Conference 2014,* Niigata, Nov. 2014.
1003. **Retsuo Kawakami, Masahito Niibe, Yoshitaka Nakano, Tatsuo Shirahama, Shodai Hirai *and* Takashi Mukai :** Morphological and Compositional Changes in AlGaN Surfaces Etched by RF Capacitively Coupled Carbon Tetrafluoride and Argon Plasmas, *Proceedings of International Symposium of Dry Process 2014,* 69-70, Tokyo, Nov. 2014.
1004. **Masahito Niibe, Takuya Kotaka, Retsuo Kawakami, Yoshitaka Nakano *and* Takashi Mukai :** Etching Damage Analysis of n-GaN Crystals Etched with N2-Plasma Using Soft X-Ray Absorption Spectroscopy, *Proceedings of International Symposium of Dry Process 2014,* 75-76, Tokyo, Nov. 2014.
1005. **Jin-Ping Ao :** Development of Gallium Nitride Electron Devices for Microwave and Milimeterwave Application, *2014 international forum on development strategy of the third generation semiconductors,* Dongguan, Dec. 2014.
1006. **Hiroshi Fukunaga, Shiro Sakai, Masataka Muguruma, S. Nohda, M. Kimura *and* Y. Muramoto :** A Novel Method to Generate Different Wavelength of InGaN-LED in the Same Wafer, *10th International Symposium on Semiconductor Light Emitting Devices,* Th-O63, Taiwan, Dec. 2014.
1007. **Kaoru Ohya :** Damage simulation of EUV-multilayered mask under focused ion beam irradiation, *SPIE Advanced Lithography 9422-87, 22-26 February 2015,* San Jose, Feb. 2015.
1008. **H. Fukunaga, M. Muguruma, Shiro Sakai, S. Nohda, M. Kimura *and* Y. Muramoto :** A Temperature Gradient Method in InGaN/GaN LEDs Manufacturing, *International Forum on Advanced Technologies,* 20, Tokushima, Mar. 2015.
1009. **Jiaqi Zhang, Qingpeng Wang, Kazuya Kawaharada, Huichao Zhu *and* Jin-Ping Ao :** Effect of Annealing and Temperature on the Performance of Self-Aligned Gate AlGaN/GaN HFETs, *7th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials / 8th International Conference on Plasma-Nano Technology & Science,* Nagoya, Mar. 2015.
1010. **Yoshitaka Nakano, Chen Miao-Gen, Daisuke Ogawa, Keiji Nakamura, Retsuo Kawakami *and* Masahito Niibe :** Generation Behavior of Deep-Level Defects in Ar+-Irradiated GaN, *7th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials (ISPlasma2015) and 8th Interational Conference on Plasma-Nano Technology & Science (IC-PLANTS2015),* Nagoya, Mar. 2015.
1011. **Yuusuke Takashima, Ryo Shimizu, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Improvement of Polarization Characteristics of UV-LED by Using Sub-Wavelength Grating with Low Index Underlayer, *7th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials,* B1-O-11, Nagoya, Mar. 2015.
1012. **中村 亮介, 白石 孝之, 福村 卓哉, 李 柳暗, 敖 金平 :** セルフアラインゲート構造を有するAlGaN/GaN HFETの試作, *2014年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* 2014年7月.
1013. **森本 和樹, 植木 智之, 富田 卓朗, 岡田 達也 :** Ni/SiC界面へのフェムト秒レーザ照射と低温アニールに伴う変化, *2014年度 応用物理・物理系学会中国四国支部 講演予稿集,* 62, 2014年7月.
1014. **髙島 祐介, 清水 亮, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 多層サブ波長回折格子を有するLEDの偏光特性, *2014年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* Ea-6, 2014年7月.
1015. **高吉 翔大, 西野 克志 :** 昇華法におけるAlN結晶成長速度の向上に関する検討, *2014年度 応用物理・物理系学会中国四国支部 合同学術講演会,* 2014年7月.
1016. **森本 和樹, 植木 智之, 富田 卓朗, 岡田 達也 :** fsレーザ照射によるSiC中へのひずみ導入と低温アニールに伴うNi拡散, *日本金属学会中国四国支部第54回講演大会 講演概要集,* 6, 2014年8月.
1017. **大宅 薫 :** シミュレーションによるイオン顕微鏡の二次電子像コントラストの理解, *ナノテスティング学会 第4回先端計測技術研究会∼イオン及び電子ビームのシミュレーション技術と二次電子放出効率測定技術∼,大阪大学東京オフィス,* 2014年8月.
1018. **Qiang Liu, Liuan Li, Ryota Fujihara, Yuki Itai, Yasuo Ohno *and* Jin-Ping Ao :** Size Dependence of GaN Schottky Barrier Diode Characteristics for Microwave Power Rectification, *平成26年度電気関係学会四国支部連合大会,* Sep. 2014.
1019. **藤原 諒太, 劉 強, 李 柳暗, 板井 勇樹, 大野 泰夫, 敖 金平 :** マイクロ波無線電力伝送用GaNショットキーダイオード, *2014年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2014年9月.
1020. **藤原 諒太, 板井 勇樹, 劉 強, 李 柳暗, 大野 泰夫, 敖 金平 :** TiN 電極マイクロ波整流用 GaN SBD の温度特性, *第75回応用物理学会学術講演会,* 2014年9月.
1021. **江山 剛史, 柿本 直也, 富田 卓朗, 長谷川 登, 錦野 将元, 南 康夫, 馬場 基芳, 大西 直文, 伊藤 篤史, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** タングステンにおけるフェムト秒レーザーアブレーション過程の軟X線プローブ光を用いた観測, *日本物理学会秋季大会,* **Vol.69,** *No.2,* 673, 2014年9月.
1022. **川上 烈生, 新部 正人, 中野 由崇, 白濱 達夫, 向井 孝志 :** 対向ターゲットを用いたDCプラズマスパッタリングによる酸化チタン薄膜の生成, *平成26年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 40, 2014年9月.
1023. **白濱 達夫, 川上 烈生, 新部 正人, 中野 由崇, 平井 翔大, 向井 孝志 :** CF4プラズマとAlGaN表面との相互作用, *平成26年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 41, 2014年9月.
1024. **福永 寛, 酒井 士郎 :** 基板の裏面を加工及び追加したInGaN系LED, *電気関係学会四国支部連合大会,* 11-2, 2014年9月.
1025. **堰口 正啓, 金 度亨, 沖 竜二, 酒井 士郎 :** AlC拡散によるAlGaN表面の変化, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* 11-1, 2014年9月.
1026. **北村 彩斗, 直井 美貴 :** AlxCyPz 薄膜の表面モフォロジーとその物性評価, *平成26年度電気関係学会四国支部連合大会,* 11-3, 2014年9月.
1027. **出来 真斗, 牧野 高紘, 富田 卓朗, 児島 一聡, 大島 武 :** イオン照射を行った4H-SiC MOSFETにおける絶縁破壊電界, *第75 回応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集,* **Vol.75,** 15-226, 2014年9月.
1028. **森本 和樹, 植木 智之, 富田 卓朗, 岡田 達也 :** Ni/SiC 界面へのフェムト秒レーザ照射と低温アニールによるNi 拡散の促進, *第75 回応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集,* **Vol.75,** 03-224, 2014年9月.
1029. **近藤 健太, 柳田 栄造, 板東 洋太, 出来 真斗, 岡田 達也, 富田 卓朗 :** フェムト秒レーザー照射によるNi/SiC 界面反応の物性解析, *第75 回応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集,* **Vol.75,** 03-225, 2014年9月.
1030. **柳田 栄造, 近藤 健太, 板東 洋太, 出来 真斗, 牧野 高紘, 大島 武, 直井 美貴, 富田 卓朗 :** SiC のフェムト秒レーザー改質部における電気伝導機構, *第75 回応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集,* **Vol.75,** 03-226, 2014年9月.
1031. **柿本 直也, 江山 剛史, 富田 卓朗, 長谷川 登, 錦野 将元, 南 康夫, 馬場 基芳, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** 軟X 線シャドウグラフを用いた金における フェムト秒レーザーアブレーション過程のフルエンス依存性, *第75 回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集,* **Vol.75,** 03-227, 2014年9月.
1032. **有月 琢哉, 奥村 俊夫, 呉 龍錫, 中島 健志, 小林 慶祐, 永瀬 雅夫 :** デバイス化プロセスにおける SiC 上グラフェン電子物性変調, *第75回応用物理学会秋季学術講演会(応物2014秋), No.17p-B1-4,* 2014年9月.
1033. **泰地 耕作, 奥村 俊夫, 中島 健志, 永瀬 雅夫 :** SiC 上グラフェン表面電位の環境雰囲気効果に関する研究, *第75回応用物理学会秋季学術講演会(応物2014秋), No.17p-B1-5,* 2014年9月.
1034. **新部 正人, 川上 烈生, 中野 由崇, 向井 孝志, 白濱 達夫, 平井 翔大 :** CF4とArプラズマでエッチングしたAlGaN表面ダメージ, *第75回秋季応用物理学会学術講演会,* 2014年9月.
1035. **青木 翔, 呉 龍錫, 井口 宗明, 中島 健志, 永瀬 雅夫 :** SiC 上グラフェンのラマンスペクトルにおける表面成分抽出, *第75回応用物理学会秋季学術講演会(応物2014秋), No.18p-B1-9,* 2014年9月.
1036. **関根 佳明, 日比野 浩樹, 小栗 克弥, 岩本 篤, 永瀬 雅夫, 影島 博之, 赤崎 達志 :** 金微粒子によるSiC上グラフェンの表面増強ラマン散乱, *第75回応用物理学会秋季学術講演会(応物2014秋), No.18p-B1-12,* 2014年9月.
1037. **中野 由崇, 中村 圭二, 新部 正人, 川上 烈生 :** A+イオン照射したHVPE-GaN膜の電気的評価, *第75回秋季応用物理学会学術講演会,* 2014年9月.
1038. **影島 博之(島根大学), 日比野 浩樹, 山口 浩司, 永瀬 雅夫 :** SiC(0001) Si 面上第一層目グラフェン成長における [1-100]ステップの役割, *第75回応用物理学会秋季学術講演会(応物2014秋), No.19p-B3-3,* 2014年9月.
1039. **髙島 祐介, 清水 亮, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** サブ波長金属回折格子の紫外域偏光特性の理論検討, *第75 回応用物理学会秋季学術講演会,* **Vol.75,** 19p-C1-10, 2014年9月.
1040. **川本 祐介, 酒井 士郎 :** 陽極酸化によるAlGaInN-LEDの光取り出し効率の向上, *電子情報通信学会ソサイエティ大会講演論文集,* c-4-33, 2014年9月.
1041. **森本 和樹, 植木 智之, 富田 卓朗, 岡田 達也 :** Ni/SiC界面へのfsレーザ照射によるひずみ導入と低温アニール, *日本金属学会2014年秋期講演大会,* 213, 2014年9月.
1042. **清水 亮, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** サブ波長周期構造を有する窒化物系LED の 発光特性, *日本光学会年次学術講演会Optics & Photonics Japan 2014,* 6pP11, 2014年11月.
1043. **大宅 薫 :** 集束イオンビームによる多層膜の照射ダメージのシミュレーション, *第34回ナノテスティングシンポジウム，豊中市，2014年11月12~14日,* 177-181, 2014年11月.
1044. **出来 真斗, 近藤 健太, 柳田 栄造, 板東 洋太, 森本 和樹, 岡田 達也, 富田 卓朗 :** フェムト秒レーザー支援アニールによるNi/SiC界面の低温シリサイド化, *応用物理学会 先進パワー半導体分科会 第1回講演会,* 114, 2014年11月.
1045. **佐野 桂治, 新部 正人, 川上 烈生, 中野 由崇 :** X線吸収分光法を用いたTiO2薄膜のプラズマダメージ評価, *第28回日本放射光学会年会 放射光科学合同シンポジウム,* 2015年1月.
1046. **平井 翔大, 新部 正人, 川上 烈生, 白濱 達夫, 中野 由崇, 向井 孝志 :** ArとCF4プラズマで処理したAlGaN膜の表面分析, *第28回日本放射光学会年会 放射光科学合同シンポジウム,* 2015年1月.
1047. **大宅 薫 :** イオンビームによる照射ダメージのダイナミックモンテカルロシミュレーション, *ナノテスティング学会 第5回先端計測技術研究会∼イオン及び電子ビームのシミュレーション技術と実験結果との比較∼,大阪大学東京オフィス,* 2015年1月.
1048. **大宅 薫 :** 電子・イオン照射による固体の二次電子放出, *日本学術振興会「荷電粒子ビームの工業への応用第132委員会」 第4回荷電粒子ビーム基礎講座, 産業技術総合研究所 臨海副都心センター,* 12-19, 2015年2月.
1049. **佐野 桂治, 新部 正人, 川上 烈生, 中野 由崇 :** 軟X線照射によるTiO2超微粒子のNEXAFSスペクトル形状の回復, *第62回春季応用物理学会学術講演会, No.1,* 2015年3月.
1050. **井筒 類, 江山 剛史, 柿本 直也, 富田 卓朗, 長谷川 登, 錦野 将元, 南 康夫, 馬場 基芳, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** フェムト秒レーザーアブレーションにおけるタングステン剥離薄膜形状の局所強度依存性, *第62 回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集,* **Vol.62,** 04-078, 2015年3月.
1051. **小田 達也, 小林 慶祐, 有月 琢哉, 青木 翔, 永濵 拓也, 永瀬 雅夫 :** HSQ 塗布による SiC 上グラフェンのキャリア濃度変化, *第62回応用物理学会春季学術講演会(応物2015春), No.12a-D7-8,* 2015年3月.
1052. **髙島 祐介, 田邊 聖人, 清水 亮, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** Siサブ波長回折格子/SiO2膜/LED構造を有する窒化物系偏光LED, *第62回応用物理学会春季学術講演会,* 13p-B1-7, 2015年3月.
1053. **中野 由崇, 髙木 健司, 小川 大輔, 中村 圭二, 新部 正人, 川上 烈生 :** Ar+イオン照射したMOCVD-GaN:Si膜の電気的評価, *第62回春季応用物理学会学術講演会, No.1,* 2015年3月.
1054. **中野 由崇, 川上 烈生, 新部 正人, 髙木 健司, 白濱 達夫, 向井 孝志 :** CF4プラズマ処理したAlGaN/GaNヘテロ構造の電気的評価, *第62回春季応用物理学会学術講演会, No.1,* 2015年3月.
1055. **Ying Wang, Lin-An Yang, Jin-Ping Ao, Zhi-Zhe Wang *and* Yue Hao :** Thermal analysis on a vertical GaN Gunn diode, *第62回応用物理学関係連合講演会,* Mar. 2015.
1056. **柿本 直也, 江山 剛史, 井筒 類, 富田 卓朗, 長谷川 登, 錦野 将元, 南 康夫, 馬場 基芳, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** 軟X線シャドウグラフを用いたフェムト秒レーザー照射によるタングステンの剥離薄膜形状の観測, *日本物理学会第70回年次大会(2015年)概要集,* **Vol.70,** 1506, 2015年3月.
1057. **江山 剛史, 柿本 直也, 井筒 類, 富田 卓朗, 長谷川 登, 錦野 将元, 南 康夫, 馬場 基芳, 河内 哲哉, 山極 満, 末元 徹 :** 金属のフェムト秒レーザーアブレーション過程における剥離形状と照射強度分布の相関, *日本物理学会第70回年次大会(2015年)概要集,* **Vol.70,** 2616, 2015年3月.
1058. **楢野 和宏, 前田 裕太郎, 新潟 一宇, 王 磊, 敖 金平 :** AlGaN/GaNヘテロ構造を用いたpHセンサへの表面処理の影響, *2014年度応用物理学会中国四国支部若手半導体研究会,* 2014年7月.
1059. **敖 金平 :** AlGaN/GaNヘテロ構造上pHセンサの研究, *第14回エンジニアリングフェスティバル,* 2014年9月.
1060. **Masao Nagase :** Graphene on SiC substrate fabricated by infrared rapid thermal annealer, --- [Invited] ---, *India-Japan workshop on "Nanotechnology: Synthesis & Sensing Applications",* Oct. 2014.
1061. **Takuro Tomita :** (invited) Single-shot soft x-ray imaging for the understanding of femtosecond-laser induced nano-periodic structure formation process, *The 15th Symposium on Advanced Photon Research,* Nov. 2014.
1062. **髙島 祐介, 清水 亮, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 多層サブ波長回折格子を用いた窒化物系直線偏光LED, *信学技報,* **Vol.114,** *No.338,* 69-72, 2014年11月.
1063. **大来 雄二, 札野 順, 下村 直行, 西野 克志 :** 電気学会の新事例集を用いた技術者倫理教育実践, *電気学会研究会資料,* **Vol.FIE-14,** *No.3,* 43-48, 2014年12月.
1064. **髙島 祐介, 田邊 聖人, 佐竹 正行, 町田 優奈, 清水 亮, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 有限時間領域差分法による紫外域の多層サブ波長回折格子偏光特性の理論的検討, *LED総合フォーラム2014-2015in徳島,* P-3, 2015年1月.
1065. **町田 優奈, 髙島 祐介, 清水 亮, 田邊 聖人, 佐竹 正行, 直井 美貴 :** サブ波長金属回折格子を用いた紫外域偏光制御における材料及び構造設計指針の理論検討, *LED総合フォーラム2014-2015in徳島,* P-4, 2015年1月.
1066. **川上 烈生, 宮脇 克行, 玉谷 元, 榎木 一史, 白濱 達夫, 大塩 誠二, 山路 諭, 吉田 雅彦, 前田 鎮廣 :** 鮮度保持のためのLED光触媒技術に関する研究, *LED総合フォーラム2014-2015 in 徳島,* 137-140, 2015年1月.
1067. **永瀬 雅夫 :** SiC上グラフェンのナノ物性評価, *JSM SPM分科会・RIIFセミナー-グリーンエレクトロニクス材料・デバイスのSPM解析技術-,* 2015年3月.
1068. **永瀬 雅夫, 他 :** グラフェンの機能と応用展望, --- 普及版 ---, 株式会社 シーエムシー出版, 東京, 2015年9月.
1069. **Keiji Sano, Masahito Niibe, Retsuo Kawakami *and* Yoshitaka Nakano :** Recovery of X-ray Absorption Spectral Profile in Etched TiO2 Thin Films, *Journal of Vacuum Science & Technology A,* **Vol.33,** *No.3,* 031403-1-031403-4, 2015.
1070. **Fan Yang, A.A. Taskin, Satoshi Sasaki, Kouji Segawa, Yasuhide Ohno, Kazuhiko Matsumoto *and* Yoichi Ando :** Dual-Gated Topological Insulator Thin-Film Device for Efficient Fermi-Level Tuning, *ACS Nano,* **Vol.9,** *No.4,* 4050-4055, 2015.
1071. **Manato Deki, Takahiro Makino, Kazutoshi Kojima, Takuro Tomita *and* Takeshi Ohshima :** Instability of Critical Electric Field in Gate Oxide Film of Heavy Ion Irradiated SiC MOSFETs, *Materials Science Forum,* **Vol.821-823,** 673-676, 2015.
1072. **Qingpeng Wang, Ying Jiang, Jiaqi Zhang, Kazuya Kawaharada, Liuan Li, Dejun Wang *and* Jin-Ping Ao :** Effects of recess process and surface treatment on the threshold voltage of GaN MOSFETs fabricated on a AlGaN/GaN heterostructure, *Semiconductor Science and Technology,* **Vol.30,** *No.6,* 065004-1-065004-6, 2015.
1073. **Ying Wang, Lin-An Yang, Zhi-Zhe Wang, Jin-Ping Ao *and* Yue Hao :** The enhancement of the output characteristics in the GaN based multiple-channel planar Gunn diode, *Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science,* **Vol.213,** *No.5,* 1252-1258, 2015.
1074. **Masatoshi Nakamura, Yasushi Kanai, Yasuhide Ohno, Kenzo Maehashi, Koichi Inoue *and* Kazuhiko Matsumoto :** Graphene-FET-based gas sensor properties depending on substrate surface conditions, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.54,** *No.6S1,* 06FF11, 2015.
1075. **Yoshitaka Nakano, Daisuke Ogawa, Keiji Nakamura, Retsuo Kawakami *and* Masahito Niibe :** Ar+-Irradiation-Induced Damage in Hydride Vapor-Phase Epitaxy GaN Films, *Journal of Vacuum Science & Technology A,* **Vol.33,** 043002-1-043002-5, 2015.
1076. **Retsuo Kawakami, Masahito Niibe, Yoshitaka Nakano, Tatsuo Shirahama, Shodai Hirai *and* Takashi Mukai :** Comparison between AlGaN Surfaces Etched by Carbon Tetrafluoride and Argon Plasmas: Effect of the Fluorine Impurities Incorporated in the Surface, *Vacuum,* **Vol.119,** 264-269, 2015.
1077. **Yuusuke Takashima, Ryo Shimizu, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Influence of low-contrast subwavelength grating shape on polarization characteristics of GaN-based light-emitting diode emissions, *Optical Engineering,* **Vol.54,** *No.6,* 067112-1-067112-5, 2015.
1078. **Qingpeng Wang, Ying Jiang, Jiaqi Zhang, Kazuya Kawaharada, Liuan Li, Dejun Wang *and* Jin-Ping Ao :** A self-aligned gate GaN MOSFET using an ICP-assisted low-temperature Ohmic process, *Semiconductor Science and Technology,* **Vol.30,** *No.7,* 075003-1-075003-5, 2015.
1079. **Yun Jeong Choi, Yoshiki Naoi *and* Takuro Tomita :** Self-organization of highly ordered honeycomb buckling patterns in crystalline thin films, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.54,** *No.10,* 105502-1-105502-5, 2015.
1080. **Ying Jiang, Qingpeng Wang, Fuzhe Zhang, Liuan Li, Deqiu Zhou, Yang Liu, Dejun Wang *and* Jin-Ping Ao :** Reduction of leakage current by O2plasma treatment for deviceisolation of AlGaN/GaN heterojunction field-effect transistors, *Applied Surface Science,* **Vol.351,** 1155-1160, 2015.
1081. **Ying Wang, Lin-An Yang, Zhi-Zhe Wang, Jin-Ping Ao *and* Yue Hao :** The modulation of multi-domain and harmonic wave in GaN planar Gunn diode by recess layer, *Semiconductor Science and Technology,* **Vol.31,** *No.2,* 025001, 2015.
1082. **Shohdai Hirai, Masahito Niibe, Retsuo Kawakami, Tatsuo Shirahama, Yoshitaka Nakano *and* Takashi Mukai :** Surface Analysis of AlGaN Treated with CF4 and Ar Plasma Etching, *e-Journal of Surface Science and Nanotechnology,* **Vol.13,** 481-487, 2015.
1083. **Yusuke Takidani, Kazuki Morimoto, Kenta Kondo, Tomoyuki Ueki, Takuro Tomita, Yasuhiro Tanaka *and* Tatsuya Okada :** Low-Temperature Diffusion at Ni/SiC Interface with the Aid of Femtosecond Laser-Induced Strain, *Journal of Laser Micro/Nanoengineering,* **Vol.10,** *No.3,* 314-319, 2015.
1084. **Masahito Niibe, Takuya Kotaka, Retsuo Kawakami, Yoshitaka Nakano *and* Takashi Mukai :** Damage Characteristics of n-GaN Crystal Etched with N2 Plasma by Soft X-Ray Absorption Spectroscopy, *e-Journal of Surface Science and Nanotechnology,* **Vol.14,** 9-13, 2016.
1085. **Naoya Kakimoto, Takashi Eyama, Rui Izutsu *and* Takuro Tomita :** The Shape of The Exfoliated Surface during Femtosecond Laser Ablation, *Journal of Laser Micro/Nanoengineering,* **Vol.11,** *No.1,* 91-94, 2016.
1086. **Ying Jiang, Qingpeng Wang, Fuzhe Zhang, Liuan Li, Satoko Shinkai, Dejun Wang *and* Jin-Ping Ao :** Device Isolation Using Field Implantation for GaN MOSFETs, *Semiconductor Science and Technology,* **Vol.31,** *No.3,* 035019, 2016.
1087. **Jiaqi Zhang, Lei Wang, Qingpeng Wang, Ying Jiang, Liuan Li, Huichao Zhu *and* Jin-Ping Ao :** Plasma-assisted ohmic contact for AlGaN/GaN heterostructure field-effect transistors, *Semiconductor Science and Technology,* **Vol.31,** 035015, 2016.
1088. **Liuan Li, Jiaqi Zhang, Yang Liu *and* Jin-Ping Ao :** Evaluation of a gate-first process for AlGaN/GaN MOS-HFETs with low ohmic annealing temperature, *Chinese Physics B,* **Vol.25,** *No.3,* 038503, 2016.
1089. **Liuan Li, Xinzhi Wang, Yang Liu *and* Jin-Ping Ao :** NiO/GaN heterojunction diode deposited through magnetron reactive sputtering, *Journal of Vacuum Science & Technology A,* **Vol.34,** *No.2,* 02D104, 2016.
1090. **永瀬 雅夫 :** 高品質グラフェン作製技術の研究, *徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部研究報告,* **Vol.60,** 1-10, 2015年.
1091. **永瀬 雅夫 :** 各種顕微鏡法によるSiC上グラフェンの観察, *THE HITACHI SCIENTIFIC INSTRUMENT NEWS,* **Vol.58,** *No.2,* 5027-5034, 2015年9月.
1092. **松下 俊雄, 川上 烈生 :** UV-LED光触媒技術と鮮度保持への応用, *電気計算,* **Vol.10,** 30-33, 2015年9月.
1093. **H. Fukunaga, Shiro Sakai, S. Noda, M. Kimura *and* Y. Muramoto :** A Temperature Gradient Method Applied to Visible or Near-Ultraviolet InGaN/GaN LEDs, *7th Asia-Pacific Workshop on Widegap Semiconductors,* TTUP2-24, Seoul, May 2015.
1094. **Jin-Ping Ao :** Synthesis and Application of TiN for GaN Devices, *International Forum on Advanced Functional Materials and Polymer Materials,* Qingdao, May 2015.
1095. **Jin-Ping Ao :** Enhancement-mode GaN MOSFETs on AlGaN/GaN Heterostructure, *2015 International Symposium on Single Crystal Diamond and its Electronics,* Xi'an, Jun. 2015.
1096. **Retsuo Kawakami, Masahito Niibe, Yoshitaka Nakano *and* Takashi Mukai :** Comparison between Surface Characteristics of Titanium Oxide Thin Films Treated with N2 Dielectric Barrier Discharge Plasma and Annealed in N2 Gas, *Proceedings of 13th International Symposium of Sputtering & Plasma Processes,* 63-66, Kyoto, Jul. 2015.
1097. **Liuan Li, Yuki Itai, Xinzhi Wang *and* Jin-Ping Ao :** NiO/GaN heterojunction diodes deposited by magnetron reactive sputtering, *The 13th International Symposium on Sputtering & Plasma Processes,* Kyoto, Jul. 2015.
1098. **Shiro Sakai :** AlGaInN blue to UV LEDs and detectors, *2015 International Conference on Optoelectronics and Microelectronics,* 2, Jul. 2015.
1099. **Shiro Sakai :** AlGaInN blue to UV LEDs and detectors, *2015 International Conference on Optoelectronics and Microelectronics,* 2, Jul. 2015.
1100. **Fuzhe Zhang, Ying Jiang, Qingpeng Wang, Satoko Shinkai *and* Jin-Ping Ao :** Device Isolation for GaN MOSFET Using Boron Ion Implantation, *the 11th International Conference on Nitride Semiconductors,* Beijing, Aug. 2015.
1101. **Liuan Li, Jiaqi Zhang, Yang Liu *and* Jin-Ping Ao :** Gate First Metal-Oxide-Semiconductor AlGaN/GaN HFETs Fabricated with a Low Temperature Ohmic Process, *the 11th International Conference on Nitride Semiconductors,* Beijing, Aug. 2015.
1102. **Yoshitaka Nakano, Retsuo Kawakami, Masahito Niibe, Tatsuo Shirahama *and* Takashi Mukai :** A Relation between Pinch-Off Voltages and Deep-Level Defects in AlGaN/GaN Hetero-Structures Treated by CF4 Plasma, *11th International Conference on Nitride Semiconductors (ICNS-11),* Beijing, Sep. 2015.
1103. **Alkemade F. P. A., Takuya Yamanaka, Veldhoven E. van, Maas D. J. *and* Kaoru Ohya :** Imaging and model simulation of trenches on a silicon surface in helium ion microscopy, *41st Micro and Nano Engineering, Wed-B7-c1,* The Hague, The Netherlands, Sep. 2015.
1104. **Kaoru Ohya :** Molecular dynamics study of crystalline orientation effect in scanning ion microscopes, *SPIE Scanning Microscopies 2015, September 29-October 1, 2015, Monterey, USA, 9636-7,* Monterey, Sep. 2015.
1105. **Lei Wang, Jiaqi Zhang, Qingpeng Wang, Yutaro Maeda *and* Jin-Ping Ao :** Investigation on recess processing on AlGaN/GaN heterostructure field-effect transistors, *The 37th International Symposium on Dry Process,* Hyogo Prefecture, Nov. 2015.
1106. **Retsuo Kawakami, Masahito Niibe, Yoshitaka Nakano, Chisato Azuma *and* Takashi Mukai :** Anatase TiO2 Thin Films Grown by Facing-Target Reactive Sputtering and Its Impact on Photocatalytic Activity, *Proceedings of International Symposium of Dry Process 2015,* 125-126, Awaji, Nov. 2015.
1107. **H. Fukunaga, Shiro Sakai, S. Noda, M. Kimura *and* Y. Muramoto :** A Temperature Gradient Method Applied to Visible or Near-Ultraviolet InGaN/GaN LEDs, *6th International Symposium on Growth of III-Nitrides (ISGN-6),* Tu-A49, Hamamatsu, Nov. 2015.
1108. **Aritsuki Takuya, Nakashima Takeshi, Kobayashi Keisuke, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** High quality graphene on SiC formed by the surface structure control technique, *28th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2015), No.12P-7-16,* Toyama, Japan, Nov. 2015.
1109. **Yasuhide Ohno, Masao Nagase *and* Matsumoto Kazuhiko :** Top-gated graphene field-effect transistors by low-temperature synthesized SiNx insulator on SiC substrates, *28th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2015), No.12P-7-28,* Toyama, Japan, Nov. 2015.
1110. **Yoshizumi D., Nishiguchi K., Yoshiaki Sekine, Furukawa K., Fujiwara A. *and* Masao Nagase :** Electron emission using multilayered-graphene/SiO2/Si heterodevice driven with low-voltage supply in low vacuum, *28th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2015), No.13P-11-104L,* Toyama, Japan, Nov. 2015.
1111. **Yuusuke Takashima, Masato Tanabe, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Theoretical investigation for the polarization in control in UV wavelength region by using eigen mode within subwavelength grating, *10th International Conference on Optics-photonics Design and Fabrication,* 1S2-08, Weingarten, Mar. 2016.
1112. **Tong zhang, Liuan Li, Lei Wang *and* Jin-Ping Ao :** Metal-oxide-semiconductor AlGaN/GaN heterostructure field-effect transistors using TiN/HfON stack gate layer deposited by reactive sputtering, *8th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials / 9th International Conference on Plasma-Nano Technology & Science,* Nagoya, Mar. 2016.
1113. **Hisatomo Matsumura, Shin-ichiro Yanagiya, Nobuo Goto, Hiroki Kishikawa, Masao Nagase, Akihiro Furube *and* Hsu Shih-Hsiang :** SERS study of gold nanoparticles deposited on graphene epitaxially grown on SiC, *International Forum on Advanced Technologies (IFAT2016), Tokushima,* **Vol.P2-20,** Tokushima, Mar. 2016.
1114. **Liangchiun Chao, Chi-Chao Ye *and* Jin-Ping Ao :** Photosensing properties of ZnO nanostructure, *2nd International Forum on Advanced Technologies,* Tokushima, Mar. 2016.
1115. **Li Meng, Jingwen Zhang, Jin-Ping Ao *and* Xun Hou :** Size-Tunable Self-assembled ZnO Quantum Dots on 4H-SiC Substrates, *2nd International Forum on Advanced Technologies,* Tokushima, Mar. 2016.
1116. **Tian Xie, Yuyu Bu, Liang-Chiun Chao *and* Jin-Ping Ao :** Fabrication of Cu2O thin films by reactive magnetron sputtering for photoelectrochemical water splitting, *2nd International Forum on Advanced Technologies,* Tokushima, Mar. 2016.
1117. **Chun-Chi Chang, Yu-Ling Huang, Jin-Ping Ao *and* Liang-Chiun Chao :** Characterization of AgxO and Al:AgxO thin films prepared by reactive ion beam sputter deposition, *2nd International Forum on Advanced Technologies,* Tokushima, Mar. 2016.
1118. **Yuyu Bu, Weibing Li *and* Jin-Ping Ao :** Fabrication of Large-scaled Multilayer C3N4 Ultrathin Flake by Mechanical Grind Method with Enhanced Photocatalysis Performance, *10th International Conference on New Diamond and Nano Carbons,* Xi'an, Mar. 2016.
1119. **荒木 佑馬, 竹平 徳崇, 新部 正人, 川上 烈生 :** 酸化チタン薄膜表面への酸素プラズマ処理による効果, *応用物理学会関西支部平成27年度第1回講演会,* 2015年6月.
1120. **川上 烈生, 新部 正人, 中野 由崇, 東 知里, 向井 孝志 :** 対向ターゲット式スパッタ法により作製した酸化チタン薄膜の光触媒特性, *2015年度応用物理・物理系学会 中国四国支部合同学術講演会,* 116, 2015年8月.
1121. **板東 洋太, 直井 美貴, 富田 卓朗 :** SiC基板への回路描画を目指したフェムト秒レーザー改質, *2015年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* Ga-3, 2015年8月.
1122. **佐竹 正行, 髙島 祐介, 清水 亮, 田邊 聖人, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** サブ波長回折格子を用いた窒化物系LEDの配向特性評価, *2015年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* Ga-4, 2015年8月.
1123. **田邊 聖人, 髙島 祐介, 清水 亮, 佐竹 正行, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** サブ波長回折格子内固有モード共鳴を用いた紫外光偏光制御, *2015年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* Ga-5, 2015年8月.
1124. **六車 正哉, 酒井 士郎, 納田 卓, 木村 真大, 村本 宜彦 :** トンネル接合を用いたInGaN/GaN 多波長LED, *2015年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* 16, 2015年8月.
1125. **井筒 類, 柿本 直也, 富田 卓朗 :** 軟X線シャドウグラフを用いたタングステンにおけるアブレーション過程の観測, *2015年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* Ga-1, 2015年8月.
1126. **柿本 直也, 井筒 類, 富田 卓朗 :** 軟X線干渉計測を用いたタングステンにおけるアブレーション過程の観測, *2015年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* Ga-2, 2015年8月.
1127. **山元 佑基, 西野 克志 :** 昇華法AlN結晶成長におけるTaマスクの効果, *2015年度 応用物理・物理系学会中国四国支部 合同学術講演会,* Ca-1, 2015年8月.
1128. **鈴木 雄大, 西野 克志 :** MOCVD法AlGaN成長における昇華法AlN基板処理方法の検討, *2015年度 応用物理・物理系学会中国四国支部 合同学術講演会,* Da-6, 2015年8月.
1129. **滝谷 悠介, 近藤 健太, 植木 智之, 田中 康弘, 富田 卓朗, 岡田 達也 :** Ni/SiC界面におけるフェムト秒レーザ照射誘起ひずみを応用した低温拡散, *日本金属学会中国四国支部第55回講演大会講演概要集,* 52, 2015年8月.
1130. **髙島 祐介, 田邊 聖人, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 固有モード複素分散関係を用いたサブ波長回折格子の紫外域偏光特性, *第76回応用物理学会秋季学術講演会,* **Vol.75,** 13a-2A-5, 2015年9月.
1131. **滝谷 悠介, 近藤 健太, 植木 智之, 田中 康弘, 富田 卓朗, 岡田 達也 :** フェムト秒レーザー照射によるNi/SiC界面へのひずみ導入と低温アニール, *第76回応用物理学会秋季学術講演会,* 13p-2F-10, 2015年9月.
1132. **柿本 直也, 井筒 類, 富田 卓朗 :** タングステンにおけるアブレーション過程のフルエンス依存性, *第76回応用物理学会秋季学術講演会,* **Vol.76,** 13p-2F-1, 2015年9月.
1133. **新部 正人, 川上 烈生, 中野 由崇, 竹平 徳崇, 平井 翔大, 荒木 佑馬, 東 知里, 向井 孝志 :** 紫外光アシストCF4プラズマでエッチンングされたAlGaN表面分析, *第76回秋季応用物理学会学術講演会,* 2015年9月.
1134. **新部 正人, 荒木 佑馬, 竹平 徳崇, 川上 烈生, 中野 由崇, 東 知里 :** 酸化チタン薄膜表面への酸素プラズマ照射効果, *第76回秋季応用物理学会学術講演会,* 2015年9月.
1135. **永濱 拓也, 小林 慶祐, 有月 琢哉, 高嶋 和也, 青木 翔, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** 雰囲気制御による SiC 上グラフェンの抵抗値変化, *第76回応用物理学会秋季学術講演会(応物2015秋), No.15a-2T-9,* 2015年9月.
1136. **大野 恭秀, 永瀬 雅夫, 松本 和彦 :** Cat-CVD 法による SiNx 絶縁膜を用いた SiC グラフェン FET の作製, *第76回応用物理学会秋季学術講演会(応物2015秋), No.15a-2T-1,* 2015年9月.
1137. **滝谷 悠介, 近藤 健太, 植木 智之, 田中 康弘, 富田 卓朗, 岡田 達也 :** Ni/SiC界面におけるフェムト秒レーザ照射誘起ひずみ及び低温アニールによるNiシリサイド形成, *日本金属学会2015年秋期講演大会(第157回)概要集,* 80, 2015年9月.
1138. **川上 烈生, 新部 正人, 中野 由崇, 東 知里, 向井 孝志 :** CF4とArプラズマで処理したAlGaN/GaNの電気特性, *平成27年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 43, 2015年9月.
1139. **川西 洋平, 酒井 士郎 :** MOCVDを用いたGaN/SapphireへのGeドーピング, *電気関係学会四国支部合同学術講演会,* 2015年9月.
1140. **髙島 祐介, 岡本 裕, 田邉 聖人, 佐竹 正行, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** サブ波長周期構造の電極を有する窒化物系UV-LEDの発光特性, *日本光学会年次学術講演会Optics & Photonics Japan 2015,* 29pC10, 2015年10月.
1141. **滝谷 悠介, 近藤 健太, 直井 美貴, 富田 卓朗, 岡田 達也 :** レーザー支援アニールによるNi/SiC界面でのニッケルシリサイド形成及び炭素拡散, *公益社団法人 応用物理学会 先進パワー半導体分科会 第2回講演会,* **Vol.2,** 148, 2015年11月.
1142. **平井 翔大, 新部 正人, 川上 烈生, 竹平 徳崇, 中野 由崇, 向井 孝志 :** CF4とArプラズマで処理したAlGaN膜の表面分析, *第29回日本放射光学会年会 放射光科学合同シンポジウム,* 2016年1月.
1143. **荒木 佑馬, 新部 正人, 川上 烈生, 竹平 徳崇, 中野 由崇 :** TiO2薄膜のプラズマ処理試料のXPS法による組成と触媒活性の相関II, *第29回日本放射光学会年会 放射光科学合同シンポジウム,* 2016年1月.
1144. **中野 由崇, 坂井 佑輔, 新部 正人, 川上 烈生 :** CF4プラズマ処理したn-GaN 膜の電気的評価, *第63回春季応用物理学会学術講演会, No.1,* 2016年3月.
1145. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** ナノ周期構造中の固有モード共鳴を用いた高感度屈折率検出, *第63回応用物理学会春季学術講演会,* 21p-P1-8, 2016年3月.
1146. **松村 尚知, 柳谷 伸一郎, 古部 昭広, 岸川 博紀, 後藤 信夫, 永瀬 雅夫 :** SiC 上グラフェンに堆積した金ナノ粒子の SERS 効果, *第63回応用物理学会春季学術講演会(応物2016春), No.21p-P1-12,* 2016年3月.
1147. **楊 順涵, 有月 琢哉, 高嶋 和也, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** ロジウム - 二硫化モリブデン - グラフェンヘテロ接合の電気特性に関する研究, *第63回応用物理学会春季学術講演会(応物2016春), No.22a-S011-10,* 2016年3月.
1148. **中村 晃大, 有月 琢哉, 高嶋 和也, 永濱 拓也, 北岡 誠, 永瀬 雅夫, 大野 恭秀 :** エピタキシャルグラフェン上の吸着水層, *第63回応用物理学会春季学術講演会(応物2016春), No.22a-S011-13,* 2016年3月.
1149. **王 磊, 張 家琦, 王 青鵬, 前田 裕太郎, 敖 金平 :** ICP処理を用いたAlGaN/GaN HFETの低温オーミックコンタクトの研究, *2015年度応用物理学会中国四国支部若手半導体研究会,* 2015年8月.
1150. **前田 裕太郎, 王 磊, 敖 金平 :** AlGaN/GaN ヘテロ構造を用いたpHセンサの表面依存性, *2015年度応用物理学会中国四国支部若手半導体研究会,* 2015年8月.
1151. **後藤 和也, 矢木 健策, 敖 金平 :** セルフアラインゲート構造を有するサブミクロンAlGaN/GaN HFETの試作と評価, *2015年度応用物理学会中国四国支部若手半導体研究会,* 2015年8月.
1152. **Tong Zhang, Liuan Li, Lei Wang *and* Jin-Ping Ao :** Characterization of NiO synthesized by reactive sputtering, *2015年度応用物理学会中国四国支部若手半導体研究会,* Aug. 2015.
1153. **Ryota Fujihara, Keiko Hamaguchi, Yasuo Ohno *and* Jin-Ping Ao :** Characteristics of GaN Schottky barrier diode on Si substrate for microwave power rectification, *2015年度応用物理学会中国四国支部若手半導体研究会,* Aug. 2015.
1154. **Fuzhe Zhang, Ying Jiang, Qingpeng Wang, Satoko Shinkai *and* Jin-Ping Ao :** Device isolation for GaN MOSFETs with boron ion implantation, *2015年度応用物理学会中国四国支部若手半導体研究会,* Aug. 2015.
1155. **富田 卓朗 :** (invited)フェムト秒レーザー照射による SiC 上へのオーミック電極作製の可能性, *中四国支部 第54回材質制御研究会 -材料と光科学の接点-,* 2015年9月.
1156. **荒木 佑馬, 新部 正人, 川上 烈生, 竹平 徳崇, 中野 由崇 :** TiO2薄膜のプラズマ処理試料のXPS法による組成と触媒活性の相関, *第51回X線分析討論会,* 2015年10月.
1157. **川上 烈生, 宮脇 克行, 玉谷 元, 東 知里, 宇野 久史, 大塩 誠二, 山路 諭, 吉田 雅彦, 大西 和男, 大野 民之助, 松下 俊雄 :** LED光触媒に基づく鮮度保持技術のスケールアップ化, *LED総合フォーラム2015 in 徳島,* 117-120, 2015年12月.
1158. **Aritsuki Takuya, Nakashima Takeshi, Kobayashi Keisuke, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Epitaxial graphene on SiC formed by the surface structure control technique, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.55,** *No.6,* 06GF03-(4pp), 2016.
1159. **Susumu Iida, Kaoru Ohya, Ryoichi Hirano *and* Hidehiro Watanabe :** An analysis of the impact of native oxide, surface contamination and material density on total electron yield in the absence of surface charging effects, *Applied Surface Science,* **Vol.384,** 244-250, 2016.
1160. **Yasuhide Ohno, Yasushi Kanai, Yuki Mori, Masao Nagase *and* Kazuhiko Matsumoto :** Top-gated graphene field-effect transistors by low-temperature synthesized SiNx insulator on SiC substrates, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.55,** *No.6S1,* 06GF09, 2016.
1161. **Z. Shen, L. He, Jin-Ping Ao, B.J. Zhang *and* Y. Liu :** Investigation of O3-Al2O3/H2O-Al2O3 dielectric bilayer deposited by atomic-layer deposition for GaN MOS capacitors, *Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science,* **Vol.213,** *No.10,* 2693-2698, 2016.
1162. **Hisatomo Matsumura, Shin-ichiro Yanagiya, Masao Nagase, Hiroki Kishikawa *and* Nobuo Goto :** Microscopic Raman Study of Graphene on 4H-SiC Two-Dimensionally Enhanced by Surface Roughness and Gold Nanoparticles, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.55,** *No.6S1,* 06GL05, 2016.
1163. **Yuyu Bu, Zhiwei Chen, Tian Xie, Weibing Li *and* Jin-Ping Ao :** Fabrication of C3N4 ultrathin flakes by mechanical grind method with enhanced photocatalysis and photoelectrochemical performance, *RSC Advances,* **Vol.6,** 47813-47819, 2016.
1164. **Yuusuke Takashima, Masato Tanabe, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Highly polarized emission from a GaN-based ultraviolet light-emitting diode using a Si-subwavelength grating on a SiO2 underlayer, *Optics Communications,* **Vol.369,** 38-43, 2016.
1165. **Jiaqi Zhang, Lei Wang, Qingpeng Wang, Ying Jiang, Liuan Li, Huichao Zhu *and* Jin-Ping Ao :** Self-Aligned-Gate AlGaN/GaN Heterostructure Field-Effect Transistors with Titanium Nitride Gate, *Chinese Physics B,* **Vol.25,** *No.8,* 087308, 2016.
1166. **Taniguchi Yoshiaki, Miki Tsubasa, Mitsuno Takanori, Yasuhide Ohno, Masao Nagase, Keiji Minagawa *and* Mikito Yasuzawa :** Fabrication of hydrophilic graphene film by molecular functionalization, *Physica Status Solidi (B) Basic Solid State Physics : PSS,* **Vol.254,** *No.2,* 1600524-(4pp), 2016.
1167. **Tong Zhang, Liuan Li *and* Jin-Ping Ao :** Temperature-dependent electrical transport characteristics of a NiO/GaN heterojunction diode, *Surfaces and Interfaces,* **Vol.5,** 15-18, 2016.
1168. **Tatsuya Okada, Takuro Tomita, Tomoyuki Ueki, Yuki Masai, Yota Bando *and* Yasuhiro Tanaka :** Femtosecond laser-induced modification at aluminum/diamond interface, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.56,** *No.2,* 026601-1-026601-5, 2017.
1169. **Masaharu Nishikino, Noboru Hasegawa, Takuro Tomita, Yasuo Minami, Takashi Eyama, Naoya Kakimoto, Rui Izutsu, Motoyoshi Baba, Tetsuya Kawachi *and* Tohru Suemoto :** Formation of x-ray Newton's rings from nano-scale spallation shells of metals in laser ablation, *AIP Advances,* **Vol.7,** *No.1,* 015311-1-015311-5, 2017.
1170. **Yuusuke Takashima, Masato Tanabe, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Theoretical investigation of polarization control in ultraviolet wavelength region using eigenmode within subwavelength grating, *Optical Review,* **Vol.24,** *No.1,* 80-86, 2017.
1171. **Retsuo Kawakami, Masahito Niibe, Yoshitaka Nakano *and* Takashi Mukai :** AlGaN Surfaces Etched by CF4 Plasma with and without the Assistance of Near-Ultraviolet Irradiation, *Vacuum,* **Vol.136,** 28-35, 2017.
1172. **Yuyu Bu *and* Jin-Ping Ao :** A Review on Photoelectrochemical Cathodic Protection Semiconductor Thin Films for Metals, *Green Energy & Environment,* **Vol.2,** *No.4,* 331-362, 2017.
1173. **Lei Wang, Jiaqi Zhang, Liuan Li, Yutaro Maeda *and* Jin-Ping Ao :** Plasma-assisted surface treatment for low-temperature annealed ohmic contact on AlGaN/GaN heterostructure field-effect transistors, *Chinese Physics B,* **Vol.26,** *No.3,* 037201, 2017.
1174. **Lei Wang, Yuyu Bu *and* Jin-Ping Ao :** Effect of oxygen plasma treatment on the performance of AlGaN/GaN ion-sensitive eld-effect transistors, *Diamond and Related Materials,* **Vol.73,** *No.3,* 1-6, 2017.
1175. **D. Terasawa, A. Fukuda, A. Fujimoto, Yasuhide Ohno, Y. Kanai *and* K. Matsumoto :** Relationship between conductance fluctuation and weak localization in graphene, *Physical Review B,* **Vol.95,** *No.12,* 125427, 2017.
1176. **Wang Lei, Bu Yuyu, Li Liuan *and* Jin-Ping Ao :** pH sensitivity of AlGaN/GaN heterostructure ion-sensitive field-effect transistors with thermal oxidation treatment, *Applied Surface Science,* **Vol.411,** 144-148, 2017.
1177. **Nishiguchi Katsuhiko, Yoshizumi Daisuke, Sekine Yoshiaki, Furukawa Kazuaki, Fujiwara Akira *and* Masao Nagase :** Planar cold cathode based on a multilayer-graphene/SiO2/Si heterodevice, *Applied Physics Express,* **Vol.9,** *No.10,* 105101-(4pp), 2016.
1178. **Zhangcheng Liu, Jin-Ping Ao, Fengnan Li, Wei Wang, Jingjing Wang, Jinwen Zhang *and* Hong-Xing Wang :** Fabrication of three dimensional diamond ultraviolet photodetector through down-top method, *Applied Physics Letters,* **Vol.109,** 153507, 2016.
1179. **Zhangcheng Liu, Jin-Ping Ao, Fengnan Li, Wei Wang, Jingjing Wang, Jingwen Zhang *and* Hong-Xing Wang :** Photoelectrical characteristics of ultrathin TiO2/diamond photodetector, *Materials Letters,* **Vol.188,** *No.2,* 52-54, 2017.
1180. **Masao Nagase :** Observation of graphene on SiC using various types of microscopy, *THE HITACHI SCIENTIFIC INSTRUMENT NEWS,* **Vol.7,** 8-16, Sep. 2016.
1181. **Shiro Sakai :** InGaAlN Multi-wavelength LEDs, *2016 10th Int. Conf. on New Diamond and Nano Carbons,* 180, Xi'an, May 2016.
1182. **Taofei Pu, Fuzhe Zhang *and* Jin-Ping Ao :** Effect of Oxidation Treatment on Threshold Voltage of GaN MOSFETs Fabricated on AlGaN/GaN Heterostructure, *10th International Conference on New Diamond and Nano Carbons,* Xi'an, May 2016.
1183. **Xinke Liu, Jin-Ping Ao, Jiazhu He, Jianfeng Wang, Wenjie Yu *and* Ke Xu :** 1200 V GaN Schottky Barrier Diode on 2'' Free-Standing Wafer using a CMOS-Compatible Gold-Free Process, *10th International Conference on New Diamond and Nano Carbons,* Xi'an, May 2016.
1184. **Lei Wang, Yutaro Maeda, Yuyu Bu *and* Jin-Ping Ao :** Effect of UV/Ozone and Oxygen Plasma Treatment on AlGaN surface of AlGaN/GaN Ion-Sensitive Field-Effect Transistor, *10th International Conference on New Diamond and Nano Carbons,* Xi'an, May 2016.
1185. **Shiro Sakai :** AlGaInN LEDs with a Temperature Gradient Method, *BIT's 5th annual world congress of advanced materials-2016,* 164, Chongqing, Jun. 2016.
1186. **Kaoru Ohya :** Modelling secondary electron emission from nanostructured materials in scanning ion microscopes: some interesting similarities and differences from scanning electron microscopes, *1st International Conference on Helium Ion Microscopy and Emerging Focused Ion Beam Technologies, Keynote A1, 8-10 June 2016,* Luxemburg City, Jun. 2016.
1187. **Kaoru Ohya :** Simulation of Ion Backscattering and Secondary Electron Emission from Crystal Surfaces Irradiated with Focused Ion Beams, *1st International Conference on Helium Ion Microscopy and Emerging Focused Ion Beam Technologies, P20, 8-10 June 2016,* Luxemburg City, Jun. 2016.
1188. **Masao Nagase :** Single-crystal graphene growth on SiC by infrared rapid thermal annealing, --- [invited] ---, *2016 Collaborative Conference on 3D and Materials Research(CC3DMR),* inchon, Korea, Jun. 2016.
1189. **Yoshitaka Nakano, Masahito Niibe *and* Retsuo Kawakami :** Electrical Damage Investigation of n-GaN Films Treated by CF4 Plasma, *Proceedings of the 43rd International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS2016),* MoP-ISCS-LN-4\_1-MoP-ISCS-LN-4\_2, Toyama, Jun. 2016.
1190. **Retsuo Kawakami, Masahito Niibe, Yoshitaka Nakano *and* Takashi Mukai :** Effect of Ultraviolet Light-Assisted CF4 Plasma Irradiation on AlGaN Thin Film Surface, *Proceedings of the 43rd International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS2016),* MoP-ISCS-096\_1-MoP-ISCS-096\_2, Toyama, Jun. 2016.
1191. **Yasushi Kanai, Takashi Ikuta, Takao Ono, Yasuhide Ohno, Kenzo Maehashi, Koichi Inoue *and* Kazuhiko Matsumoto :** Detection Kondo effect in Graphene Quantum Dots, *The 43rd International Symposium on Compound Semiconductor,* 7528502, Jun. 2016.
1192. **Yoshiaki Taniguchi, Tsubasa Miki, Takanori Mitsuno, Yasuhide Ohno, Masao Nagase, Keiji Minagawa *and* Mikito Yasuzawa :** Hydrophilic Graphene Film by Molecular Functionalization, *The 43rd International Symposium on Compound Semiconductor,* Jun. 2016.
1193. **Takanori Mitsuno, Yoshiaki Taniguchi, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Intrinsic pH Sensitivity of Graphene Field-Effect Transistors, *The 43rd International Symposium on Compound Semiconductor,* Jun. 2016.
1194. **Takao Ono, Yasushi Kanai, Yasuhide Ohno, Kenzo Maehashi, Koichi Inoue *and* Kazuhiko Matsumoto :** An Application of Graphene Field Effect Transistor to Enzymatic Assay, *The 43rd International Symposium on Compound Semiconductor,* Jun. 2016.
1195. **Yuusuke Takashima, Masato Tanabe *and* Yoshiki Naoi :** Highly polarized ultraviolet light control using Ge subwavelength grating, *The 2016 Asian Conference on Nanoscience and Nanotechnology,* 1P-011, Sapporo, Oct. 2016.
1196. **Jin-Ping Ao, Tian Xie, Tong Zhang, Junshuai Xue *and* Yuyu Bu :** Synthesis and Applications of P-type Metal Oxides by Reactive Magnetron Sputtering, *12th IUPAC International Conference on Novel Materials and their Synthesis (NMS-XII),* Changsha, Oct. 2016.
1197. **Lei Wang, Jiaqi Zhang, Liuan Li, Junshuai Xue *and* Jin-Ping Ao :** Plasma-assisted low-temperature annealed ohmic process on AlGaN/GaN heterostructure field-effect transistors, *International Forum on Wide Bandgap Semiconductors China (IFWS 2016),* Beijing, Oct. 2016.
1198. **Taniguchi Yoshiaki, Miki Tsubasa, Mitsuno Takanori, Yasuhide Ohno, Masao Nagase, Keiji Minagawa *and* Mikito Yasuzawa :** Protein adsorption characteristics on bare and phosphorylcholine-modified graphene films on SiC substrate, *29th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2016), No.11P-11-16,* Kyoto, Japan, Nov. 2016.
1199. **Kitaoka Makoto, Nagahama Takuya, Nakamura Kohta, Takashima Kazuya, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Carrier doping effect of humidity for single-crystal graphene on SiC, *29th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2016), No.11P-11-24,* Kyoto, Japan, Nov. 2016.
1200. **Yoshitaka Nakano, Masahito Niibe *and* Retsuo Kawakami :** Electrical damage in n-GaN films treated by CF4 plasma, *Proceedings of International Symposium of Dry Process 2016,* 73-74, Sapporo, Nov. 2016.
1201. **Yasuhide Ohno, Takanori Mitsuno, Yoshiaki Taniguchi *and* Masao Nagase :** Intrinsic ion sensitivity of graphene field-effect transistors, *2016 Workshop on Innovative Nanoscale Devices and Systems,* Dec. 2016.
1202. **Jin-Ping Ao, Naoto Okada, Taofei Pu, Hiroko Itoh *and* Yasuo Ohno :** GaN SBDs on Silicon Substrate for Microwave Power Rectification, *2016 Asia Wireless Power Transfer Workshop,* Chengdu, Dec. 2016.
1203. **Yasuo OHNO, Hiroko ITOH *and* Jin-Ping Ao :** Reflection Control in Microwave Rectenna Using Integrated GaN SBD Configuration, *2016 Asia Wireless Power Transfer Workshop,* Chengdu, Dec. 2016.
1204. **Taofei Pu, Tong Zhang, Lei Wang, Qian Huang *and* Jin-Ping Ao :** Enhancement-Mode GaN-Based High Electron Mobility Transistors With a Blocking Layer, *9th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials / 10th International Conference on Plasma-Nano Technology & Science,* Mar. 2017.
1205. **Yoshitaka Nakano, Masahito Niibe *and* Retsuo Kawakami :** Damage Introduced into n-GaN Films by CF4 Plasma Treatments, *9th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials (ISPlasma2017) and 10th Interational Conference on Plasma-Nano Technology & Science (IC-PLANTS2017),* Aichi, Mar. 2017.
1206. **Masaharu Nishikino, Noboru Hasegawa, Takuro Tomita, Yasuo Minami, Takashi Eyama, Naoya Kakimoto, Rui Izutsu, Motoyoshi Baba, Tetsuya Kawachi *and* Tohru Suemoto :** Observation of fs-laser spallative ablation using soft X-ray laser probe, *Proceedings of SPIE,* **Vol.10091,** 100910O-1-100910O-5, San Francisco, Mar. 2017.
1207. **草葉 啓太, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** サブ波長格子/導波構造による二波長帯紫外光検出器の開発, *2016年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* Bp-10, 2016年7月.
1208. **岡本 裕, 髙島 祐介, 佐竹 正行, 田邉 聖人, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 高透過ストライプ状p型電極を用いたUV-LEDの光取り出し制御, *2016年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* Bp-11, 2016年7月.
1209. **橋本 拓哉, 植木 智之, 田中 康弘, 富田 卓朗, 岡田 達也 :** SiC単結晶上に電子ビーム蒸着したニッケル薄膜の双晶化, *2016年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会講演概要集,* 26, 2016年7月.
1210. **政井 勇輝, 植木 智之, 田中 康弘, 富田 卓朗, 岡田 達也 :** Al/ダイヤモンド単結晶界面へのフェムト秒レーザ照射に伴う微細周期構造形成, *2016年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会講演概要集,* 27, 2016年7月.
1211. **板東 洋太, 竹中 一将, 滝谷 悠介, 田中 康弘, 中島 信一, 岡田 達也, 富田 卓朗 :** 極薄SiCにおけるラマンスペクトルの極性面依存性, *2016年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会講演概要集,* 44, 2016年7月.
1212. **橋本 竜治, 鈴木 雄大, 西野 克志 :** 昇華法AlN基板上へのMOCVD法によるAlGaN結晶の成長, *2016年度 応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* 86, 2016年7月.
1213. **梨子木 清人, 西野 克志 :** 6H-SiC基板上へのAlNバルク結晶成長, *2016年度 応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* 87, 2016年7月.
1214. **多喜川 直也, 西野 克志 :** 剥離AlNを種結晶として用いた昇華法AlN成長, *2016年度 応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* 88, 2016年7月.
1215. **森本 征士, 有月 琢哉, 青木 翔, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** 顕微ラマン分光法による SiC 上グラフェンの応力とキャリア密度の面内分布評価, *第77回応用物理学会秋季学術講演会(応物2016秋), No.13a-A32-3,* 2016年9月.
1216. **山田 祐輔, 有月 琢哉, 高嶋 和也, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** 走査プローブ顕微鏡を用いた SiC 上グラフェンの実効ヤング率計測, *第77回応用物理学会秋季学術講演会(応物2016秋), No.13a-A32-4,* 2016年9月.
1217. **平田 朋也, 酒井 士郎, 納田 卓, 木村 真大, 村本 宜彦 :** 中間板を用いたMOCVD-InGaN/GaN 四波長LED, *第77回 応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集,* 14a-A21-2, 2016年9月.
1218. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** サブ波長構造中の固有モード波数分散関係を用いた屈折率検出の高感度化, *第77回応用物理学会秋季学術講演会,* 15a-P5-14, 2016年9月.
1219. **新部 正人, 川上 烈生, 中野 由崇, 田中 良, 荒木 佑馬, 東 知里, 向井 孝志 :** AlGaN 表面特性への酸素プラズマ照射効果, *第77回秋季応用物理学会学術講演会,* 2016年9月.
1220. **北岡 誠, 永濱 拓也, 中村 晃大, 有月 琢哉, 高嶋 和也, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** SiC 上グラフェンの水脱離による導電率変化, *第77回応用物理学会秋季学術講演会(応物2016秋), No.15p-A33-2,* 2016年9月.
1221. **大野 恭秀, 光野 琢仁, 谷口 嘉昭, 永瀬 雅夫 :** グラフェン本来のイオンセンシング特性, *第77回応用物理学会秋季学術講演会(応物2016秋), No.15p-A33-10,* 2016年9月.
1222. **川西 洋平, 酒井 士郎 :** MOCVDを用いた，GeドープAlGaNの成長, *第77回 応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集,* 16a-P5-26, 2016年9月.
1223. **川上 烈生, 新部 正人, 中野 由崇, 東 知里, 向井 孝志 :** 紫外線照射下でのCF4 プラズマエッチングによるAlGaN表面ダメージ, *平成28年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 44, 2016年9月.
1224. **北岡 誠, 永濱 拓也, 中村 晃大, 有月 琢哉, 高嶋 和也, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** SiC 上グラフェンのシート抵抗の湿度依存性, *第8回集積化MEMSシンボジウム, No.25pm4-PM-016,* 2016年10月.
1225. **谷口 嘉昭, 三木 翼, 光野 琢仁, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫, 南川 慶二, 安澤 幹人 :** 新規合成分子を用いた表面修飾による単結晶グラフェンの親水化, *第8回集積化MEMSシンボジウム, No.25pm4-PM-017,* 2016年10月.
1226. **田邉 聖人, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 紫外域偏光制御におけるナノ周期構造の形状依存, *日本光学会年次学術講演会Optics & Photonics Japan 2016,* 1pP4, 2016年11月.
1227. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 高屈折率差サブ波長周期構造を用いた広範囲な屈折率に対する高感度屈折率検出, *日本光学会年次学術講演会Optics & Photonics Japan 2016,* 1pP15, 2016年11月.
1228. **佐竹 正行, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 表面実装サブ波長周期構造中の固有モードを用いた窒化物系 LED の放射パターン制御, *日本光学会年次学術講演会Optics & Photonics Japan 2016,* 1pP16, 2016年11月.
1229. **谷口 嘉昭, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** SiC上グラフェンのタンパク質吸着特性, --- ∼分子修飾による高性能バイオセンサの実現に向けて∼ ---, *サイエンスプラザ2016, No.52,* 2016年11月.
1230. **中野 由崇, 新部 正人, 川上 烈生 :** CF4プラズマ処理したn-GaN膜の電気的ダメージ, *2016 真空・表面科学合同講演会，第36回表面科学学術講演会・第57回真空に関する連合講演会, No.1,* 2016年11月.
1231. **板東 洋太, 滝谷 悠介, 田中 康弘, 中島 信一, 岡田 達也, 富田 卓朗 :** 極薄SiCにおけるラマンスペクトルの極性面及び膜厚依存性, *第27回光物性研究会論文集,* **Vol.27,** 19-22, 2016年12月.
1232. **大宅 薫 :** He, Ne, Gaイオンチャネリングへの照射ダメージ効果, *ナノテスティング学会 第9回先端計測技術研究会, 金沢工業大学大学院虎ノ門キャンパス,* 2016年12月.
1233. **田中 良, 新部 正人, 川上 烈生, 中野 由崇, 向井 孝志 :** 酸素および窒素プラズマ処理したAlGaN膜の表面分析, *第30回日本放射光学会年会 放射光科学合同シンポジウム,* 2017年1月.
1234. **荒木 佑馬, 新部 正人, 川上 烈生, 竹平 徳崇, 中野 由崇 :** TiO2薄膜のプラズマ処理試料のXPS法による組成と触媒活性の相関III, *第30回日本放射光学会年会 放射光科学合同シンポジウム,* 2017年1月.
1235. **井筒 類, 近藤 恭介, 富田 卓朗 :** Linnik干渉計を用いたホウケイ酸ガラスにおけるフェムト秒レーザーアブレーション過程の観測, *レーザー学会学術講演会 第37回年次大会,* **Vol.37,** 20, 2017年1月.
1236. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** サブ波長周期構造を用いた垂直入射型屈折率高感度検出, *第64回応用物理学会春季学術講演会,* 14a-F202-8, 2017年3月.
1237. **井筒 類, 近藤 恭介, 富田 卓朗 :** 透明固体材料における干渉計測によるフェムト秒レーザーアブレーション過程の観測, *第64回応用物理学会春季学術講演会,* 14p-512-2, 2017年3月.
1238. **山崎 勇輝, 川上 博貴, 直井 美貴, 富田 卓朗 :** フェムト秒レーザーアニールによるp-GaN上へのNi/Auオーミック電極作製, *第64回応用物理学会春季学術講演会,* 15a-512-7, 2017年3月.
1239. **川上 博貴, 直井 美貴, 富田 卓朗 :** フェムト秒レーザー支援アニールによるSiC上へのNi電極作製, *第64回応用物理学会春季学術講演会,* 15a-512-8, 2017年3月.
1240. **朴 理博, 永瀬 雅夫, 大野 恭秀 :** 集束イオンビームを用いたステンシルリソグラフィ技術のための Sub10nm パターンの作製, *第64回応用物理学会春季学術講演会(応物2017春), No.15a-304-2,* 2017年3月.
1241. **北岡 誠, 永濱 拓也, 中村 晃大, 有月 琢哉, 高嶋 和也, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** SiC 上グラフェンの水吸着によるキャリア密度変化, *第64回応用物理学会春季学術講演会(応物2017春), No.15a-B6-6,* 15-084-(1pp), 2017年3月.
1242. **谷口 嘉昭, 三木 翼, 光野 琢仁, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫, 南川 慶二, 安澤 幹人 :** 分子修飾機能化による SiC 上グラフェンの非特異吸着の抑制, *第64回応用物理学会春季学術講演会(応物2017春), No.15a-B6-7,* 15-085-(1pp), 2017年3月.
1243. **草葉 啓太, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** サブ波長格子/導波構造を有する二波長帯紫外光検出, *第64回応用物理学会春季学術講演会,* 16p-P13-9, 2017年3月.
1244. **礒合 俊輔, 安澤 幹人, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** SiC 上グラフェンの電気特性評価, *電気化学会第84回大会,* 2017年3月.
1245. **川上 博貴, 近藤 健太, 直井 美貴, 富田 卓朗 :** 連続波レーザーアニールによるSiC上へのNi電極作製と評価, *第35回電子材料シンポジウム,* **Vol.114,** *No.338,* Fr1-5, 2016年7月.
1246. **荒木 佑馬, 新部 正人, 川上 烈生, 竹平 徳崇, 中野 由崇 :** 酸素プラズマ処理したTiO2薄膜のXPSおよびNEXAFS法による組成・ダメージと触媒活性の相関, *第52回X線分析討論会,* 2016年10月.
1247. **岡本 裕, 髙島 祐介, 直井 美貴 :** サブ波長周期構造電極を有する低光損失偏光UV-LEDの理論的検討, *LED総合フォーラム2016in徳島,* P-3, 2016年12月.
1248. **佐竹 正行, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** FDTD法を用いたサブ波長周期構造によるLED放射パターンの理論的検討, *LED総合フォーラム2016in徳島,* P-4, 2016年12月.
1249. **原口 雅宣, 木内 陽介, 北田 貴弘, 永瀬 雅夫, 安井 武史, 宮脇 克行, 髙橋 章, 岡久 稔也 :** LEDライフイノベーション総合プラットフォーム推進事業におけるテラヘルツLED応用基盤技術に関する取り組み, *LED総合フォーラム2016in徳島 論文集,* 201-202, 2016年12月.
1250. **川上 烈生, 宮脇 克行, 白井 昭博, 東 知里, 冨士本 賢吾, 大塩 誠二, 山路 諭, 吉田 雅彦, 大西 和男, 大野 民之助, 松下 俊雄 :** LED光触媒ナノ粒子を使った鮮度保持技術の開発, *LED総合フォーラム2016 in 徳島,* 157-160, 2016年12月.
1251. **富田 卓朗 :** (invited) フェムト秒レーザー照射を用いた原子拡散の新展開, *第12回励起ナノプロセス研究会,* 2017年3月.
1252. **永瀬 雅夫, 他 :** ナノカーボンの応用と実用化, --- ―フラーレン,ナノチューブ,グラフェンを中心に― <普及版> ---, 株式会社 シーエムシー出版, 東京, 2017年10月.
1253. **Yuyu Bu, Jing Tian, Zhiwei Chen, Fenghui Tian *and* Jin-Ping Ao :** Optimization of the photoelectrochemical performance of Mo-doped BiVO4 photoanode by controlling the metal-oxygen bonds state on (020) facet, *Advanced Materials Interfaces,* **Vol.4,** *No.10,* 1601235-1-1601235-9, 2017.
1254. **Kitaoka Makoto, Nagahama Takuya, Nakamura Kohta, Aritsuki Takuya, Takashima Kazuya, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Carrier doping effect of humidity for single-crystal graphene on SiC, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.56,** *No.8,* 085102-(4pp), 2017.
1255. **Takuro Tomita, Manato Deki, Eizo Yanagita, Yota Bando, Yoshiki Naoi, Takahiro Makino *and* Takeshi Ohshima :** Femtosecond-Laser-Induced Defects on Silicon Carbide Probed by Electrical Conductivity, *Journal of Laser Micro/Nanoengineering,* **Vol.12,** *No.2,* 72-75, 2017.
1256. **Yuusuke Takashima, Masato Tanabe, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Ultraviolet polarizer with a Ge subwavelength grating, *Applied Optics,* **Vol.56,** *No.29,* 8224-8229, 2017.
1257. **Yoshitaka Nakano, Retsuo Kawakami *and* Masahito Niibe :** Generation of Electrical Damage in n-GaN Films Following Treatment in a CF4 Plasma, *Applied Physics Express,* **Vol.10,** 116201-1-116201-4, 2017.
1258. **Tatsuya Okada, Takuro Tomita, Tomoyuki Ueki, Yuki Masai, Yota Bando *and* Yasuhiro Tanaka :** Femtosecond-laser-induced modifications on the surface of a single-crystalline diamond, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.56,** *No.11,* 112701-1-112701-5, 2017.
1259. **Ruiling Wang, Tian Xie, Zhiyong Sun, Taofei Pu *and* Jin-Ping Ao :** Graphene quantum dot modified g-C3N4 for enhanced photocatalytic oxidation of ammonia performance, *RSC Advances,* **Vol.7,** *No.81,* 51687-51694, 2017.
1260. **Retsuo Kawakami, Masahito Niibe, Yoshitaka Nakano, Ryo Tanaka, Chisato Azuma *and* Takashi Mukai :** Characteristics of N2 and O2 Plasma-Induced Damages on AlGaN Thin Film Surfaces, *Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science,* **Vol.214,** *No.11,* 1700393-1-1700393-7, 2017.
1261. **Mitsuno Takanori, Taniguchi Yoshiaki, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Ion sensitivity of large-area epitaxial graphene film on SiC substrate, *Applied Physics Letters,* **Vol.111,** 213103-(4pp), 2017.
1262. **Chen Ching-Hsiu, Huang Yu-Ling, Huang Kai, Ayalew Assamen Ejigu, Chao Liang-Chiun *and* Jin-Ping Ao :** Controlled oxidation state of silver oxide thin films deposited by an integrated anode layer ion source ion beam sputter module, *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms,* **Vol.412,** 41-45, 2017.
1263. **Nguyen Thanh Tung, Phan Trong Tue, Truong Ngoc Thi Lien, Yasuhide Ohno, Kenzo Maehashi, Kazuhiko Matsumoto, Koichi Nishigaki, Manish Biyani *and* Yuzuru Takamura :** Peptide aptamer-modified single-walled carbon nanotube-based transistors for high-performance biosensors, *Scientific Reports,* **Vol.7,** *No.1,* 17881, 2017.
1264. **Yuyu Bu, Zhuoyuan Chen, Jin-Ping Ao, Jian Hou *and* Mingxian Sun :** Study of the photoelectrochemical cathodic protection mechanism for steel based on the SrTiO3-TiO2 composite, *Journal of Alloys and Compounds,* **Vol.730,** 1214-1224, 2018.
1265. **Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** High-sensitivity refractive index sensor with normal incident geometry using a subwavelength grating operating near the ultraviolet wavelength, *Sensors and Actuators B: Chemical,* **Vol.255,** *No.2,* 1711-1715, 2018.
1266. **Tian Xie, Tao Zheng, Ruiling Wang, Yuyu Bu *and* Jin-Ping Ao :** Fabrication of CuOx thin-film photocathodes by magnetron reactive sputtering for photoelectrochemical water reduction, *Green Energy & Environment,* **Vol.3,** *No.3,* 239-246, 2018.
1267. **Liuan Li, Zhangcheng Liu, Lei Wang, Baijun zhang, Yang Liu *and* Jin-Ping Ao :** Self-powered GaN ultraviolet photodetectors with p-NiO electrode grown by thermal oxidation, *Materials Science in Semiconductor Processing,* **Vol.76,** 61-64, 2018.
1268. **Retsuo Kawakami, Masahito Niibe, Yoshitaka Nakano, Yuma Araki, Yuki Yoshitani, Chisato Azuma *and* Takashi Mukai :** Characteristics of TiO2 Thin Films Surfaces Treated by O2 Plasma in Dielectric Barrier Discharge with the Assistance of External Heating, *Vacuum,* **Vol.152,** 265-271, 2018.
1269. **永瀬 雅夫 :** グラフェン基板上への異種機能集積化について, --- 特集/Heterogeneous Integration ---, *エレクトロニクス実装学会誌,* **Vol.20,** *No.6,* 382-386, 2017年.
1270. **Tatsuya Okada, Takuro Tomita, Tomoyuki Ueki, Takuya Hashimoto, Hiroki Kawakami, Yuki Fuchikami, Hiromu Hisazawa *and* Yasuhiro Tanaka :** Low-temperature diffusion assisted by femtosecond laser-induced modifications at Ni/SiC interface, *Applied Physics Express,* **Vol.11,** *No.1,* 016502-1-016502-4, 2018.
1271. **Li Chao, Huang Zhonghui, Wang Jianfeng, Xu Ke, Jin-Ping Ao *and* Liu Xinke :** Vertical GaN Schottky barrier diodes with record high current Ion/Ioff Ratio (~2.3×1010) on free-standing GaN wafer, *Materials Research Society (MRS) Spring Meeting,* Arizona, USA, Apr. 2017.
1272. **Jin-Ping Ao, Lei Wang, Yuyu Bu *and* Liu Xinke :** Development of AlGaN/GaN Ion-Sensitive Field-Effect Transistors, *2017 International Symposium on Single Crystal Diamond and its Electronics,* Xian, China, Jun. 2017.
1273. **Shiro Sakai :** Multi-wavelength AlGaInN-LEDs, *Collaborative Conference on Materials Research,* 422, Jeju island, South Korea, Jun. 2017.
1274. **Masao Nagase :** Epitaxial graphene on SiC for new functional devices, --- [invited] ---, *Collaborative Conference on Materials Research (CCMR) 2017,* Jeju, Korea, Jun. 2017.
1275. **Masao Nagase :** Single-Crystal graphene on SiC substrate: growth and applications, --- [invited] ---, *2017 Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices (AWAD),* Gyeongju, Korea, Jul. 2017.
1276. **Retsuo Kawakami, Kengo Fujimoto, Masahito Niibe, Yuma Araki, Yoshitaka Nakano *and* Takashi Mukai :** TiO2 Thin Film Surfaces Treated by O2 Plasma in Dielectric Barrier Discharge with Assistance of Heat Treatment, *Proceedings of 14th International Symposium of Sputtering & Plasma Processes,* 274-277, Kanazawa, Jul. 2017.
1277. **Masao Nagase :** Large-scale epitaxial graphene fabricated by high-temperature graphitization of SiC substrate, --- [Plenary] ---, *International Conference on Advanced Materials Development & Performance (AMDP) 2017,* Pune, India, Jul. 2017.
1278. **Tsuyoshi Tsuda, Mikito Yasuzawa, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Electrical characteristic evaluation of Graphene on SiC, *International Conference on Advanced Materials Development and Performance 2017,* Pune, Jul. 2017.
1279. **Yoshitaka Nakano, Retsuo Kawakami *and* Masahito Niibe :** Generation Behavior of Electrical Damage Introduced into n-GaN Films by CF4 Plasma Treatments, *29th International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS),* Matsue, Aug. 2017.
1280. **Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Normal incident type detection of the refractive index using subwavelength grating at violet wavelength, *The 24th Congress of the International Comission for Optics,* Th1G-07, Tokyo, Aug. 2017.
1281. **Yoshiaki Taniguchi, Tsubasa Milki, Yasuhide Ohno, Masao Nagase, Yukihiro Arakawa, Yasushi Imada, Keiji Minagawa *and* Mikito Yasuzawa :** Intrinsic response of protein adsorption to graphene film on SiC substrate, *Proceedings of 2017 International Conference on Solid State Devices and Materials,* Sep. 2017.
1282. **Jin-Ping Ao :** Demonstration of AlGaN/GaN Ion-Sensitive Field-Effect Transistors by Surface Modification, *The 8th Asia-Pacific Workshop on Widegap Semiconductors,* Sep. 2017.
1283. **Qian Huang, Taofei Pu, Jincheng Zhang, Yue Hao *and* Jin-Ping Ao :** Enhancement-mode GaN HEMTs with p-GaN cap layer and i-GaN blocking layer, *The 8th Asia-Pacific Workshop on Widegap Semiconductors,* Sep. 2017.
1284. **Xinke Liu, Hong Gu, Kuilong Li, Lunchun Guo, Jianfeng Wang, Hao-Chung Kuo, Ke Xu *and* Jin-Ping Ao :** AlGaN/GaN hign electron mobility transistors on free-standing wafer, *The 8th Asia-Pacific Workshop on Widegap Semiconductors,* Qingdao, China, Sep. 2017.
1285. **Y. Y. Bu, R. L. Wang, T. Xie, Y. P. Zhang *and* Jin-Ping Ao :** Defect modified photoanodes for photoelectrocatalytic water splitting, *13th IUPAC International Conference on Novel Materials and their Synthesis (NMS-XII),* Oct. 2017.
1286. **Masahito Niibe, Ryo Tanaka, Retsuo Kawakami, Yoshitaka Nakano *and* Takashi Mukai :** Surface Structure Analysis of AlGaN Thin Films Damaged by Oxygen and Nitrogen Plasmas, *The 8th International Symposium on Surface Science (ISSS-8),* Tsukuba, Oct. 2017.
1287. **Hiroyuki Katayama, Yuki Yamasaki, Hiroki Kawakami, Yoshiki Naoi *and* Takuro Tomita :** Annealing of Ni/Au electrode on p-GaN by femtosecond laser irradiation, *International Workshop on UV Materials and Devices 2017,* We-P3, Fukuoka, Nov. 2017.
1288. **Hiroki Kawakami, Yoshiki Naoi *and* Takuro Tomita :** Formation of Ni ohmic electrode on SiC by femtosecond laser irradiation associated with thermal annealing, *International Workshop on UV Materials and Devices 2017,* We-P5, Fukuoka, Nov. 2017.
1289. **Yu Okamoto, Yuusuke Takashima *and* Yoshiki Naoi :** Characterization of polarized ultraviolet light emitting diode by using subwavelength grating electrode, *International Workshop on UV Materials and Devices 2017,* We-18, Fukuoka, Nov. 2017.
1290. **Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Magnetic field sensing by bi-layer Ni-based subwavelength periodic structure operating visible wavelength region, *The 22nd Microoptics Conference,* 256-257, Tokyo, Nov. 2017.
1291. **Kitaoka Makoto, Nakamura Kota, Teratani Hitoshi, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Water adsorption and desorption for graphene on SiC, *International Symposium on Epitaxial Graphene 2017 (ISEG-2017), No.P6,* 44, Nagoya, Japan, Nov. 2017.
1292. **Yasuhide Ohno, Yoshiaki Taniguchi *and* Masao Nagase :** Electrical characteristics of positively and negatively charged protein adsorption to epitaxial graphene film on SiC substrate, *Proceedings of 2017 Workshop on Innovative Nanoscale Devices and Systems,* Nov. 2017.
1293. **Tian Xie, Ruiling Wang, Yuyu Bu *and* Jin-Ping Ao :** Fabrication and Photoelectrochemical Evaluation of CuxO Thin Film Photocathodes Grown by Magnetron Reactive Sputtering, *10th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials / 11th International Conference on Plasma-Nano Technology & Science,* Mar. 2018.
1294. **Ruiling Wang, Yuyu Bu, Tian Xie *and* Jin-Ping Ao :** Photoelectrochemical Performance of BiVO4-based Photoanodes with A Z-scheme, *10th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials / 11th International Conference on Plasma-Nano Technology & Science,* Mar. 2018.
1295. **Ryo Hiramura *and* Katsushi Nishino :** Crystal Growth of Gallium Oxide by Direct Synthesis Method, *4th International Forum on Advanced Technologies,* Tokushima, Mar. 2018.
1296. **Takaya Shimada *and* Katsushi Nishino :** Characterization of dislocations in sublimation-grown AlN crystals, *4th International Forum on Advanced Technologies,* Tokushima, Mar. 2018.
1297. **永瀬 雅夫 :** SiC上グラフェンの 各種顕微鏡法による 観察・評価, --- [招待講演] ---, *第32回 材料解析テクノフォーラム,* 2017年7月.
1298. **木村 幸将, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** SiCグラフェン積層構造における電気特性の角度依存性, *第8回集積化 MEMS 技術研究ワークショップ, No.P1,* 2017年7月.
1299. **森高 恭平, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** イオン性ゲルを用いたSiC上グラフェンデバイスの特性評価, *第8回集積化 MEMS 技術研究ワークショップ, No.P8,* 2017年7月.
1300. **草葉 啓太, 髙島 祐介, 直井 美貴, 原口 雅宣 :** 導波構造上にサブ波長周期構造を実装した可視域二波長帯光検出器の開発, *2017年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* Ep-5, 2017年7月.
1301. **二村 大, 川上 博貴, 植木 智之, 富田 卓朗, 岡田 達也, 田中 康弘 :** ダイヤモンド単結晶表面におけるフェムト秒レーザ照射誘起改質, *2017年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会講演概要集,* 55, 2017年7月.
1302. **谷口 嘉昭, 三木 翼, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫, 荒川 幸弘, 今田 泰嗣, 南川 慶二, 安澤 幹人 :** ホスホリルコリン修飾によるグラフェン表面のタンパク質吸着抑制, *電子デバイス研究会(ED),* 13, 2017年8月.
1303. **二村 大, 川上 博貴, 植木 智之, 富田 卓朗, 岡田 達也, 田中 康弘 :** ダイヤモンド単結晶表面へのフェムト秒レーザ照射による改質導入, *日本金属学会第57回中国四国支部講演大会講演概要集,* A21, 2017年8月.
1304. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 2層Niサブ波長周期構造を用いた微小磁場検出, *第78回応用物理学会秋季学術講演会,* 6p-PA3-12, 2017年9月.
1305. **松井 一史, 中村 晃大, 北岡 誠, 谷口 嘉昭, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** ケルビンフォース顕微鏡を用いた SiC 上グラフェン構造水層の観察, *第78回応用物理学会秋季学術講演会(応物2017秋), No.7p-C16-14,* 15-165-(1pp), 2017年9月.
1306. **二村 大, 川上 博貴, 植木 智之, 富田 卓朗, 岡田 達也, 田中 康弘 :** フェムト秒レーザ照射によるダイヤモンド単結晶表面への改質導入とアニールに伴う変化, *第78回応用物理学会秋季学術講演会,* 7p-S45-12, 2017年9月.
1307. **川上 博貴, 直井 美貴, 富田 卓朗 :** フェムト秒レーザー照射により作製したSiC上Ni電極の電気特性評価, *第78回応用物理学会秋季学術講演会,* 8a-A410-2, 2017年9月.
1308. **杉岡 賢人, 谷口 嘉昭, 三木 翼, 田原 雅章, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫, 荒川 幸弘, 南川 慶二, 今田 泰嗣, 安澤 幹人 :** SiC グラフェンを用いた親水化処理における修飾分子依存性, *第78回応用物理学会秋季学術講演会(応物2017秋), No.8a-C16-16,* 15-186-(1pp), 2017年9月.
1309. **川上 烈生, 新部 正人, 中野 由崇, 芳谷 勇樹, 東 知里, 向井 孝志 :** 光触媒TiO2薄膜への加熱を伴うO2 DBDプラズマ処理効果, *平成29年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 42, 2017年9月.
1310. **草葉 啓太, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** サブ波長周期構造を利用した光導波路モー ド共鳴による可視域二波長帯光検出, *日本光学会年次学術講演会Optics & Photonics Japan 2017,* 1pP2, 2017年11月.
1311. **岡本 裕, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** サブ波長周期金属ストライプ電極を用いた 偏光 UV-LED, *日本光学会年次学術講演会Optics & Photonics Japan 2017,* 1pP3, 2017年11月.
1312. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** Ni ナノ回折格子を用いた垂直入射型微小磁場検出, *日本光学会年次学術講演会Optics & Photonics Japan 2017,* 1pP4, 2017年11月.
1313. **川上 博貴, 直井 美貴, 富田 卓朗 :** SiC と金属の界面におけるフェムト秒レーザー照射支援アニール, *先進パワー半導体分科会第4回講演会,* IIB-8, 2017年11月.
1314. **竹中 一将, 板東 洋太, 滝谷 悠介, 山口 誠, 田中 康弘, 中島 信一, 岡田 達也, 富田 卓朗 :** サブミクロン厚SiCにおける極性面に依存したラマンスペクトル, *先進パワー半導体分科会第4回講演会,* IIA-20, 2017年11月.
1315. **谷口 嘉昭, 三木 翼, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫, 荒川 幸弘, 今田 泰嗣, 南川 慶二, 安澤 幹人 :** ホスホリルコリン修飾グラフェンのタンパク質吸着特性, *第9回「集積化MEMSシンボジウム」,* 02am2-B-2-(3pp), 2017年11月.
1316. **竹中 一将, 板東 洋太, 滝谷 悠介, 山口 誠, 田中 康弘, 中島 信一, 岡田 達也, 富田 卓朗 :** SiCのサブミクロン厚領域におけるラマンスペクトルの数値計算, *第28回光物性研究会,* IIA-68, 2017年12月.
1317. **谷口 嘉昭, 三木 翼, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫, 荒川 幸弘, 今田 泰嗣, 南川 慶二, 安澤 幹人 :** 分子修飾技術を用いたグラフェン表面のタンパク質吸着抑制, *平成 29 年度第 4 回半導体エレクトロニクス部門委員会・講演会,* P10-(4pp), 2018年1月.
1318. **河村 祐輔, 森本 征士, 北岡 誠, 田原 雅章, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** 顕微ラマン分光法による機能化 iC 上グラフェンの応力とキャリア密度の定量評価, *平成 29 年度第1回半導体エレクトロニクス部門委員会・講演会,* P9-(4pp), 2018年1月.
1319. **田原 雅章, 河村 祐輔, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** SiC 上グラフェン高品質化に向けたグラフェン成長過程の解明, *平成 29 年度第1回半導体エレクトロニクス部門委員会・講演会,* P8-(4pp), 2018年1月.
1320. **永瀬 雅夫 :** SiC 上グラフェンのデバイス応用, --- [招待講演] ---, *平成 29 年度第1回半導体エレクトロニクス部門委員会・講演会,* I-2-(), 2018年1月.
1321. **寺谷 仁志, 北岡 誠, 松井 一史, 田原 雅章, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** SiC 上グラフェンへの水ドーピング効果の評価, *第65回応用物理学会春季学術講演会(応物2018春), No.17a-C202-7,* 15-007-(1pp), 2018年3月.
1322. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** Ag/Niサブ波長周期構造による垂直入射型磁場センサーの高感度化, *第65回応用物理学会春季学術講演会,* 18p-P9-20, 2018年3月.
1323. **草葉 啓太, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** サブ波長周期構造/導波構造を用いた垂直光入射系屈折率検知, *第65回応用物理学会春季学術講演会,* 18p-P9-21, 2018年3月.
1324. **Du Jiyao, Kimura Yukinobu, Tahara Masaaki, Matsui Kazushi, Teratani Hitoshi, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Vertically stacked graphene tunneling junction with insulative water layer, *第65回応用物理学会春季学術講演会(応物2018春), No.18a-C202-11,* 15-058-(1pp), Mar. 2018.
1325. **谷口 嘉昭, 三木 翼, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫, 荒川 幸弘, 今田 泰嗣, 南川 慶二, 安澤 幹人 :** イミノビオチン修飾グラフェンによるアビジン吸着特性の pH 制御, *第65回応用物理学会春季学術講演会(応物2018春), No.18a-C202-10,* 15-057-(1pp), 2018年3月.
1326. **竹中 一将, 板東 洋太, 滝谷 悠介, 山口 誠, 田中 康弘, 中島 信一, 岡田 達也, 富田 卓朗 :** サブミクロン厚4H-SiCにおけるラマンスペクトルの極性面依存性, *第65回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集,* 18p-B203-17, 2018年3月.
1327. **星 泰暉, 李 小波, 敖 金平 :** NiN電極有するマイクロ波整流用GaNショットキーバリアダイオード, *第65回応用物理学会春季学術講演会,* 2018年3月.
1328. **片山 裕之, 川上 博貴, 今垣 諒彌, 橋本 拓哉, 山口 誠, 田中 康弘, 直井 美貴, 岡田 達也, 富田 卓朗 :** p-GaN上オーミック電極形成のためのフェムト秒レーザー照射方法の検討, *第65回応用物理学会春季学術講演会,* 19p-A404-11, 2018年3月.
1329. **渕上 裕暉, 橋本 拓哉, 川上 博貴, 植木 智之, 富田 卓朗, 岡田 達也, 田中 康弘 :** フェムト秒レーザ誘起改質を応用したNi/SiC界面における低温拡散, *第65回応用物理学会春季学術講演会講演予稿集,* 19p-A404-9, 2018年3月.
1330. **川上 博貴, 直井 美貴, 富田 卓朗 :** ホール測定によるNi/SiC界面に形成されたフェムト秒レーザー改質層の電気特性評価, *第65回応用物理学会春季学術講演会,* 20a-P1-4, 2018年3月.
1331. **宮本 美佑, 富田 卓朗 :** 走査型電子顕微鏡内でのフェムト秒レーザー光照射光学系の構築, *第65回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集,* 20a-P1-2, 2018年3月.
1332. **矢木 健策, 後藤 和也, 敖 金平 :** 低温オーミックプロセスを用いた AlGaN/GaN HFET に関する研究, *2017年度応用物理学会中国市国支部若手半導体研究会,* 2017年8月.
1333. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** Niサブ波長周期構造を用いた垂直入射型高感度磁場センサー, *日本光学会ナノオプティクス研究グループ 第24回研究討論会,* 2017年12月.
1334. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** Ni ナノ周期構造を用いた垂直光入射配置型磁場センサーの開発, *日本材料学会平成29 年度第 4 回半導体エレクトロニクス部門委員会第1 回講演会,* P5, 2018年1月.
1335. **髙島 祐介, 草葉 啓太, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** サブ波長回折格子/LED構造を用いた 垂直入射による高感度屈折率検出の理論的検討, *LED総合フォーラム2018in徳島,* P-6, 2018年2月.
1336. **川上 烈生, 宮脇 克行, 白井 昭博, 東 知里, 芳谷 勇樹, 吉岡 誠人, 南 雄也, 山路 諭, 吉田 雅彦, 大西 和男, 大野 民之助 :** LED照射下での光触媒ナノ複合材の鮮度保持機能, *LED総合フォーラム2018 in 徳島,* 125-126, 2018年2月.
1337. **原口 雅宣, 北田 貴弘, 永瀬 雅夫, 安井 武史, 木内 陽介, 宮脇 克行, 髙橋 章, 岡久 稔也 :** LEDライフイノベーション総合プラットフォーム推進事業におけるテラヘルツLED応用基盤技術に関する取り組み, *LED総合フォーラム2018in徳島,* P-2, 2018年2月.
1338. **Masao Nagase :** Functionalization of graphene on SiC by deionized water treatment, *平成29年度 共同プロジェクト研究発表会, No.P19,* Feb. 2018.
1339. **富田 卓朗 :** [invited] フェムト秒レーザー照射による半導体デバイス作製にむけて, *第十一回紀州吉宗セミナー,* 2018年3月.
1340. **Takuya Kawata, Takao Ono, Yasushi Kanai, Yasuhide Ohno, Kenzo Maehashi, Koichi Inoue *and* Kazuhiko Matsumoto :** Improved sensitivity of a graphene FET biosensor using porphyrin linkers, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.57,** *No.6,* 065103, 2018.
1341. **Taofei Pu, Qian Huang, Tong Zhang, Jiang Huang, Xiaomin Li, Liuan Li, Xiaobo Li, Lei Wang *and* Jin-Ping Ao :** Normally-off AlGaN/GaN heterostructure junction field-effect transistors with blocking layers, *Superlattices and Microstructures,* **Vol.120,** 448-453, 2018.
1342. **Hiroki Kawakami, Yoshiki Naoi *and* Takuro Tomita :** Femtosecond laser-assisted thermal annealing of Ni electrode on SiC substrate, *AIP Advances,* **Vol.8,** *No.6,* 065204-1-065204-5, 2018.
1343. **Ruiling Wang, Tian Xie, Tong Zhang, Taofei Pu, Yuyu Bu *and* Jin-Ping Ao :** Fabrication of FTOBiVO4WWO3 photoanode for improving photoelectrochemical performance: based on the Z-scheme electron transfer mechanism, *Journal of Materials Chemistry. A, Materials for Energy and Sustainability,* **Vol.6,** 12956-12961, 2018.
1344. **Tong Zhang, Taofei Pu, Tian Xie, Liuan Li, Yuyu Bu, Xiao Wang *and* Jin-Ping Ao :** Synthesis of thermally stable HfOxNy as gate dielectric for AlGaN/GaN heterostructure field-effect transistors, *Chinese Physics B,* **Vol.27,** *No.7,* 078503-1-078503-5, 2018.
1345. **Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Highly sensitive magnetic field sensor with normal-incidence geometry using Ni-based bilayer subwavelength periodic structure operating in visible-wavelength region, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.57,** *No.8S2,* 08PE01-1-08PE01-5, 2018.
1346. **Tong Zhang, Lei Wang, Xiaobo Li, Yuyu Bu, Taofei Pu, Ruiling Wang, Liuan Li *and* Jin-Ping Ao :** Positive threshold voltage shift in AlGaN/GaN HEMTs with p-type NiO gate synthesized by magnetron reactive sputtering, *Applied Surface Science,* **Vol.462,** 799-803, 2018.
1347. **Rupesh Singh, Toshio Kawahara, Yuhsuke Ohmi, Yasuhide Ohno, Kenzo Maehashi, Kazuhiko Matsumoto, Kazumasa Okamoto, Risa Utsunomiya *and* Masamichi Yoshimura :** Effects of low temperature buffer on carbon nano walls growth, *Materials Today. Communications,* **Vol.17,** 94-99, 2018.
1348. **Tatsuya Okada, Takuro Tomita, Tomoyuki Ueki, Takuya Hashimoto, Yuki Fuchikami, Hiroyuki Katayama, Hiromu Hisazawa *and* Yasuhiro Tanaka :** Femtosecond-laser-induced modifications on a 4H-SiC surface and their application to low-temperature diffusion at the Ni/SiC interface, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.57,** *No.11,* 116501-1-116501-7, 2018.
1349. **Liuan Li, Jia Chen, Xin Gu, Xiaobo Li, Taofei Pu *and* Jin-Ping Ao :** Temperature sensor using thermally stable TiN anode GaN Schottky barrier diode for high power device applications, *Superlattices and Microstructures,* **Vol.123,** 274-279, 2018.
1350. **Hongwei Wang, Wenqiang Zheng, Weibing Li, FengHui Tian, Shaoping Kuang, Yuyu Bu *and* Jin-Ping Ao :** Control the energy band potential of ZnMgO solid solution withenhanced photocatalytic hydrogen evolution capacity, *Applied Catalysis B: Environmental,* **Vol.217,** 523-529, 2018.
1351. **Tian Xie, Tao Zheng *and* Jin-Ping Ao :** Synthesis of copper oxide by reactive magnetron sputtering for photoelectrochemical water splitting, *Advances in Engineering Research,* **Vol.170,** 1055-1061, 2018.
1352. **Yue Yin, Fang Ren, Yunyu Wang, Zhiqiang Liu, Jin-Ping Ao, Meng Liang, Tongbo Wei, Guodong Yuan, Haiyan Ou, Jianchang Yan, Xiaoyan Yi, Junxi Wang *and* Jinmin Li :** Direct van der Waals Epitaxy of Crack-Free AlN Thin Film on Epitaxial WS2, *Materials,* **Vol.11,** 2464-1-2464-9, 2018.
1353. **Zhangcheng Liu, Dan Zhao, Jin-Ping Ao, Wei Wang, Xiaohui Chang, Yanfeng Wang, Jiao Fu *and* Hong-Xing Wang :** Enhanced ultraviolet photoresponse of diamond photodetector using patterned diamond film and two-step growth process, *Materials Science in Semiconductor Processing,* **Vol.89,** 110-115, 2019.
1354. **Retsuo Kawakami, Masahito Niibe, Yoshitaka Nakano, Shin-ichiro Yanagiya, Yuki Yoshitani, Chisato Azuma *and* Takashi Mukai :** Effects of Ultraviolet Wavelength and Intensity on AlGaN Thin Film Surfaces Irradiated Simultaneously with CF4 Plasma and Ultraviolet, *Vacuum,* **Vol.159,** 45-50, 2019.
1355. **Hengyu Xu, Caiping Wan, Ling Sang *and* Jin-Ping Ao :** Influence on curvature induced stress to the flatband voltage and interface density of 4H-SiC MOS structure, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.505,** 59-61, 2019.
1356. **Daiju Terasawa, Akira Fukuda, Akira Fujimoto, Yasuhide Ohno, Yasushi Kanai *and* Kazuhiko Matsumoto :** Universal Conductance Fluctuation Due to Development of Weak Localization in Monolayer Graphene, *Physica Status Solidi (B) Basic Solid State Physics : PSS,* **Vol.256,** *No.6,* 1800515, 2019.
1357. **Tian Xie, Tao Zheng, Ruiling Wang, Taofei Pu, Xiaobo Li, Yuyu Bu *and* Jin-Ping Ao :** A promising CuOx/WO3 pn heterojunction thin-film photocathode fabricated by magnetron reactive sputtering, *International Journal of Hydrogen Energy,* **Vol.44,** *No.8,* 4062-4071, 2019.
1358. **Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Optical magnetic field sensor based on guided mode resonance with Ni subwavelength grating/ waveguide structure, *Proceedings of SPIE,* **Vol.10928,** 109281S-1-109281S-8, 2019.
1359. **Zhangcheng Liu, Dan Zhao, Jin-Ping Ao, Xiaohui Chang, Yanfeng Wang, Jiao Fu, Minghui Zhang *and* Hong-Xing Wang :** Responsivity improvement of Ti-diamond-Ti structure UV photodetector through photocurrent gain, *Optics Express,* **Vol.26,** *No.13,* 17092-17098, 2018.
1360. **Taofei Pu, Xiao Wang, Qian Huang, Tong Zhang, Xiaobo Li, Liuan Li *and* Jin-Ping Ao :** Normally-Off AlGaN/GaN Heterojunction Metal-Insulator-Semiconductor Field-Effect Transistors with Gate-First Process, *IEEE Electron Device Letters,* **Vol.40,** *No.2,* 185-188, 2019.
1361. **川上 烈生, 白井 昭博 :** 医療・食品・環境分野で注目される抗菌技術:光触媒による殺菌と食品鮮度保持, *日本防菌防黴学会誌,* **Vol.46,** *No.7,* 321-327, 2018年7月.
1362. **Taofei Pu, Xiaobo Li, Yuyu Bu, Zhitao Chen *and* Jin-Ping Ao :** GaN Schottky Barrier Diodes for Microwave Power Transmission, *The fifth IEEE MTT-S International Wireless Symposium (IEEE IWS'2018),* May 2018.
1363. **Zhangcheng Liu, Dan Zhao, Jin-Ping Ao, Xiaohui Chang, Yanfeng Wang, Jiao Fu, Minghui Zhang *and* Hong-Xing Wang :** Responsivity Improvement of Diamond UV Photodetector with Novel Device Design, *2018 International New Diamond and Nano Carbons Conference,* Flagstaff, May 2018.
1364. **Zhangcheng Liu, Dan Zhao, Jin-Ping Ao, Wei Wang *and* Hongxing Wang :** Structured TiO2/Diamond Photodetector with Photon-induced Negative Photoconductive Phenomenon, *2018 International Symposium on Single Crystal Diamond and Electronics,* Xi'an, May 2018.
1365. **Zhangcheng Liu, Dan Zhao, Tai Min, Jin-Ping Ao *and* Hong-Xing Wang :** Structure design for diamond UV photodetector-Three dimensional diamond UV detector and p-i-n photodiode, *Structure design for diamond UV photodetector-Three dimensional diamond UV detector and p-i-n photodiode,* Xian, China, Jun. 2018.
1366. **Jin-Ping Ao :** Development of AlGaN/GaN Ion-Sensitive Field-Effect Transistors for Chemical Sensing, *The 5th International Symposium on Single Crystal Diamond and Electronics,* Jun. 2018.
1367. **Zhipeng Luo, Fazhan Zhao, Shihai Wang, Caiping Wan, Hengyu Xu *and* Jin-Ping Ao :** 4H-SiC MOS Capacitor C-V Curve Shift Caused by ArF Excimer Laser Light Irradiation, *The 5th International Symposium on Single Crystal Diamond and Electronics,* Xi'an, Jun. 2018.
1368. **Hiroyuki Katayama, Hiroki Kawakami, Yasuhiro Tanaka, Yoshiki Naoi, Tatsuya Okada *and* Takuro Tomita :** Femtosecond laser irradiation for the low contact resistance electrode fabrication on p-type gallium nitride, *19th International Symposium on Laser Precision Microfabrication (LPM 2018),* 57, Edinburgh, Jun. 2018.
1369. **Xiaobo Li, Tong Zhang, Taofei Pu, Taiki Hoshi, Tian Xie, Xianjie Li *and* Jin-Ping Ao :** GaN Schottky Barrier Diode with Nickel Nitride Electrode, *The 2018 Asia-Pacific Conference on Silicon Carbide and Related Materials (APCSCRM2018),* Beijing, Jul. 2018.
1370. **Taofei Pu, Xiao Wang, Qian Huang, Xiaobo Li, Yuyu Bu *and* Jin-Ping Ao :** Development of E-Mode AlGaN/GaN HJFETs, *2018 Asia-Pacific Conference on Silicon Carbide and Related Materials (APCSCRM2018),* Beijing, Jul. 2018.
1371. **Xie Tian, Zheng Tao *and* Jin-Ping Ao :** Synthesis of copper oxide by reactive magnetron sputtering for photoelectrochemical water splitting, *The 2018 8th International Conference on Advanced Engineering Materials and Technology (ICAEMT 2018),* Shenzhen, Jul. 2018.
1372. **Shigeki Fujiwara Joseph Luke, K Tachihara, S Mori, 大塚 良, T Yamamoto, Satoru Eguchi, Kazumi Takaishi, I Toyoguchi, Jin-Ping Ao *and* Hiroshi Kitahata :** Influence of PTS stopcock status on the natural frequency of blood pressure‒transducer kits, *Joint Conference of IFDAS2018-FADAS2018-JDSA46,* Nara, Oct. 2018.
1373. **Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Refractive Index Sensor Using Subwavelength Grating on Waveguide with Normal Incident Configuration, *The 23rd Microoptics Conference,* P-18, Taipei, Oct. 2018.
1374. **Toshihiko Takahata, Shin-ichiro Yanagiya, Yuuki Yoshitani, Retsuo Kawakami *and* Akihiro Furube :** High optical absorbance multilayer film of titanium dioxide and gold, *23rd MicroOptics Conference (MOC2018), Taipei, No.P-80,* Taipei, Oct. 2018.
1375. **Xiaobo Li, Taofei Pu, Taiki Hoshi, Tian Xie, Liuan Li, Xianjie Li, Shigeki Fujiwara Joseph Luke, Hiroshi Kitahata *and* Jin-Ping Ao :** Synthesis of nickel nitride electrodes for application on gallium nitride Schottky contact, *14th IUPAC International Conference on Novel Materials and their Synthesis,* Guangzhou, Oct. 2018.
1376. **Masaki Kuzuo, Kazushi Matsui, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Mechanical Properties of Structured Water Layer on Epitaxial Graphene, *ACSIN-14 & ICSPM26, No.22P032,* 42-(0.5pp), Sendai International Center, Sendai, Japan, Oct. 2018.
1377. **Jin-Ping Ao, Xiaobo Li, Taofei Pu, Taiki Hoshi, Tian Xie, Liuan Li, Xianjie Li, Shigeki Fujiwara Joseph Luke *and* Hiroshi Kitahata :** Gallium Nitride RF Schottky Barrier Diodes for Microwave Wireless Power Transmission, *2018 International Forum on Wide Bandgap Semiconductors,* Shenzhen, Oct. 2018.
1378. **Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Guided mode resonance based magnetic field sensor including Ni nano-grating, *2018 Joint Symposia on Optics,* 31aCJ5, Tokyo, Oct. 2018.
1379. **Xiaobo Li, Taofei Pu, Taiki Hoshi, Tian Xie, Liuan Li, Xianjie Li, Shigeki Fujiwara Joseph Luke, Hiroshi Kitahata *and* Jin-Ping Ao :** Nickel Nitride Gate AlGaN/GaN HFETs with Low Gate Leakage Current, *2018 International Workshop on Nitride Semiconductors,* Kanazawa, Nov. 2018.
1380. **Hiroyuki Katayama, Yoshiki Naoi, Tatsuya Okada, Yasuhiro Tanaka *and* Takuro Tomita :** Study of ohmic contact electrode on p-GaN using moderate crystal damage effect induced by femtosecond laser irradiation technique, *International Workshop on Nitride Semiconductors 2018,* ThP-ED-6, Kanazawa, Nov. 2018.
1381. **Retsuo Kawakami, Yoshitani Yuki, Mitani Kimiaki, Takami Naoki, Koide Hirofumi, Sugimoto Norihiro, Niibe Masahito, Nakano Yoshitaka, Azuma Chisato *and* Mukai Takashi :** Hydrophilic Modification of Polypropylene Film Surfaces Treated by Atmospheric-Pressure Air Plasma Jet, *Proceedings of International Symposium of Dry Process 2018,* 253-254, Nagoya, Nov. 2018.
1382. **Yoshitani Yuki, Retsuo Kawakami, Koide Hirofumi, Takami Naoki, Niibe Masahito, Nakano Yoshitaka, Azuma Chisato *and* Mukai Takashi :** Effect of Atmospheric-Pressure O2 Plasma-Assisted Annealing on Photocatalytic Activity of TiO2 Nanoparticles, *Proceedings of International Symposium of Dry Process 2018,* 255-256, Nagoya, Nov. 2018.
1383. **Taniguchi Yoshiaki, Miki Tsubasa, Yasuhide Ohno, Masao Nagase, Yukihiro Arakawa *and* Mikito Yasuzawa :** Observation of the interaction between avidin and iminobiotin using graphene FET on SiC substrate, *31th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2018), No.16P-11-3,* Sapporo, Japan, Nov. 2018.
1384. **Du Jiyao, Kimura Yukinobu, Tahara Masaaki, Matsui Kazushi, Teratani Hitoshi, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Vertically stacked graphene tunnel junction with ultrathin water layer barrier, *31th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2018), No.16P-11-27,* Sapporo, Japan, Nov. 2018.
1385. **Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Dual-wavelengths Filter Operating at Visible Wavelength Region using Subwavelength Grating on Waveguide Structure, *11th International Conference on Optics-photonics Design and Fabrication,* 28PSa-24, Hiroshima, Nov. 2018.
1386. **Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Optical magnetic field sensor based on guided mode resonance with Ni subwavelength grating/ waveguide structure, *SPIE Photonics West 2019,* 10928-64, San Francisco, Feb. 2019.
1387. **Ono Ryosuke, Masashi Kurashina, Mikito Yasuzawa, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Fabrication of Nanopillars Using Focus Ion Beam-Chemical Vapor Deposition Method, *5th International Forum on Advanced Technologies,* Taipei, Mar. 2019.
1388. **森岩 晃平, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** Niナノ周期構造/SiO2/Ag薄膜系を用いた磁場検出, *2018年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* Ga-3, 2018年8月.
1389. **杉 峻平, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 非線形光学効果によるナノ周期構造透過光制御, *2018年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* Ga-4, 2018年8月.
1390. **渕上 裕暉, 植木 智之, 富田 卓朗, 久澤 大夢, 岡田 達也, 田中 康弘 :** 4H-SiC表面へのフェムト秒レーザ照射改質導入によるNi/SiC界面反応の促進, *2018年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会講演予稿集,* 4, 2018年8月.
1391. **今垣 諒彌, 植木 智之, 富田 卓朗, 久澤 大夢, 岡田 達也, 田中 康弘 :** フェムト秒レーザ照射改質を導入したダイヤモンド表面へのTi蒸着, *2018年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* 5, 2018年8月.
1392. **今垣 諒彌, 植木 智之, 富田 卓朗, 久澤 大夢, 岡田 達也, 田中 康弘 :** ダイヤモンド表面へのフェムト秒レーザ照射改質の導入によるTi/ダイヤモンド界面反応, *日本金属学会中国四国支部第58回講演大会講演概要集,* 25, 2018年8月.
1393. **渕上 裕暉, 植木 智之, 富田 卓朗, 久澤 大夢, 岡田 達也, 田中 康弘 :** フェムト秒レーザ照射改質の導入によるNi/SiC界面のNiシリサイド形成, *日本金属学会中国四国支部第58回講演大会講演概要集,* 26, 2018年8月.
1394. **富田 卓朗, 竹中 一将, 板東 洋太, 滝谷 悠介, 山口 誠, 田中 康弘, 中島 信一, 岡田 達也 :** 表面局在した格子振動に由来するSiCのラマンスペクトル, *日本物理学会2018年秋季大会,* 11aPS36, 2018年9月.
1395. **枝澤 光希, 浦西 将, 富田 卓朗, 西野 克志 :** AlN結晶のアニール処理による機械的ダメージの回復評価, *第79回応用物理学会秋季学術講演会,* 19p-PA4-1, 2018年9月.
1396. **市村 佑太, 西野 克志 :** 直接合成法によるβ-Ga2O3の結晶成長, *第79回応用物理学会秋季学術講演会,* 19p-PB8-18, 2018年9月.
1397. **高畑 敏彦, 芳谷 勇樹, 柳谷 伸一郎, 川上 烈生, 古部 昭広 :** 酸化チタンと金による高吸収MIM膜の作製と光学特性評価, *第79回応用物理学会秋季学術講演会,* 19p-PA7-22, 2018年9月.
1398. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** サブ波長回折格子/導波路複合構造による二波長フィルター, *第79回応用物理学会秋季学術講演会,* 20p-224A-7, 2018年9月.
1399. **秋山 大宇, 谷口 嘉昭, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** SiC 上グラフェンのタンパク質吸着特性における pH 依存性, *第79回応用物理学会秋季学術講演会(応物2018秋), No.20p-311-2,* 15-184-(1pp), 2018年9月.
1400. **谷口 嘉昭, 高村 真琴, 谷保 芳孝, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** p 型 SiC 上グラフェンのタンパク質吸着特性, *第79回応用物理学会秋季学術講演会(応物2018秋), No.20p-311-3,* 15-185-(1pp), 2018年9月.
1401. **小野 尭生, 谷口 嘉昭, 牛場 翔太, 金井 康, 前橋 兼三, 井上 恒一, 渡邊 洋平, 中北 愼一, 鈴木 康夫, 河原 敏男, 木村 雅彦, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫, 松本 和彦 :** SiC 上グラフェンの糖鎖機能化によるインフルエンザウイルス検出, *第79回応用物理学会秋季学術講演会(応物2018秋), No.20p-311-4,* 15-186-(1pp), 2018年9月.
1402. **葛尾 理樹, 山田 祐輔, 松井 一史, 谷口 嘉昭, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** エピタキシャルグラフェン上構造水層の機械特性, *第79回応用物理学会秋季学術講演会(応物2018秋), No.21a-311-14,* 15-216-(1pp), 2018年9月.
1403. **川上 烈生, 芳谷 勇樹, 新部 正人, 中野 由崇, 東 知里, 向井 孝志 :** AlGaN薄膜表面へのCF4プラズマ処理中に及ぼす紫外光同時照射効果, *平成30年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 26, 2018年9月.
1404. **芳谷 勇樹, 川上 烈生, 小出 洋史, 髙見 直樹, 杉本 典優, 見谷 皇章, 新部 正人, 中野 由崇, 東 知里, 向井 孝志 :** アナターゼ型TiO2 ナノ粒子への加熱を伴うO2誘電体バリア放電プラズマ処理効果, *平成30年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 25, 2018年9月.
1405. **内藤 友紀, 西野 克志 :** 真空蒸着法による p 型 Si 基板上への BaSi2 膜作製の検討, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* 11-12, 2018年9月.
1406. **瀬尾 翔輝, 西野 克志 :** AlN 結晶成長における基板表面酸化膜除去の効果, *電気関係学会四国支部連合大会講演論文集,* 11-13, 2018年9月.
1407. **川越 悠斗, 谷口 嘉昭, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** グラフェン FET 特性の緩衝液濃度依存性, *第10回「集積化MEMSシンボジウム」,* 30pm2-A-3-(3pp), 2018年10月.
1408. **越智 柊太, 寺谷 仁志, 北岡 誠, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** SiC上グラフェンの高感度ガス応答, *第10回「集積化MEMSシンボジウム」,* 31pm2-C-2-(3pp), 2018年10月.
1409. **谷口 嘉昭, 三木 翼, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫, 荒川 幸弘, 安澤 幹人 :** SiC 上グラフェンFETを用いたアビジン-イミノビオチン相互作用の観測, *第10回「集積化MEMSシンボジウム」,* 01am2-C-1-(3pp), 2018年11月.
1410. **割石 大道, 葛尾 理樹, 谷口 嘉昭, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** 溶液中におけるSiC上グラフェンFETのドリフト評価, *第10回「集積化MEMSシンボジウム」,* 01am2-C-5-(3pp), 2018年11月.
1411. **山添 直里, 大坂 勇貴, 谷口 嘉昭, 永瀬 雅夫, 大野 恭秀, 岡本 敏弘, 原口 雅宣 :** 金ナノ粒子のプラズモン加熱を用いた穴あきグラフェンの作製, *レーザー学会学術講演会第39回年次大会, No.14-6,* 2019年1月.
1412. **水尾 優作, 渕上 裕暉, 富田 卓朗, 久澤 大夢, 岡田 達也 :** フェムト秒レーザ照射誘起改質を応用したNi/SiC界面における電極形成, *2019年 第66回 応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集,* 9a-W631-2, 2019年3月.
1413. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** アニール処理によるNiナノ粒子を用いた微小磁場検出, *第66回応用物理学会春季学術講演会,* 10a-W621-13, 2019年3月.
1414. **片山 裕之, 直井 美貴, 岡田 達也, 田中 康弘, 富田 卓朗 :** フェムト秒レーザー照射による結晶改質がp-GaNへのオーミックコンタクトに与える影響, *第66回応用物理学会春季学術講演会,* 10a-W631-12, 2019年3月.
1415. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 低アスペクト比Geサブ波長格子中を用いた可視域偏光フィルター, *第66回応用物理学会春季学術講演会,* 11p-PB1-19, 2019年3月.
1416. **藤原 茂樹, 敖 金平, 大塚 良, 山本 剛士, 江口 覚, 高石 和美, 北畑 洋 :** ワイヤレス給電式医療機器の作成と臨床応用に向けた試み, *第33 回中国・四国歯科麻酔研究会,* 2018年9月.
1417. **永瀬 雅夫, 大野 恭秀 :** 大面積単結晶グラフェン膜の合成とデバイス応用, *計量計測展2018,* **Vol.M-34-18,** 2018年9月.
1418. **永瀬 雅夫, 大野 恭秀, 安澤 幹人 :** 集束イオンビーム技術によるナノ電極プローブの開発, *社会産業理工学研究交流会2018, No.No.27,* 2018年9月.
1419. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 磁性体ナノ構造を用いた導波路共鳴磁場センサー, *日本光学会ナノオプティクス研究グループ 第25回研究討論会,* P06, 2018年11月.
1420. **Masao Nagase :** Single-crystal graphene on SiC for electronic devices, *平成30年度 共同プロジェクト研究発表会, No.P16,* Feb. 2019.
1421. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** サブ波長周期電極構造を用いた発光ダイオードの配光特性制御の理論的検討, *LED総合フォーラム2019in徳島,* P-15, 2019年2月.
1422. **川上 烈生, 宮脇 克行, 白井 昭博, 吉田 雅彦, 芳谷 勇樹, 髙見 直樹, 東 知里, 山路 諭 :** 可視光LEDによる光触媒ナノ複合材シートの鮮度保持効果, *LED総合フォーラム2019 in 徳島,* 77-78, 2019年2月.
1423. **永瀬 雅夫, 大野 恭秀 :** 単結晶グラフェン積層接合デバイス, *LED総合フォーラム2019in徳島, No.P-14,* 85-86, 2019年2月.
1424. **原口 雅宣, 北田 貴弘, 永瀬 雅夫, 安井 武史, 木内 陽介, 宮脇 克行, 髙橋 章, 岡久 稔也 :** LEDライフイノベーション総合プラットフォーム推進事業の取り組み, *LED総合フォーラム2019in徳島,* P-2, 2019年2月.
1425. **永瀬 雅夫, 他 :** 異種機能デバイス集積化技術の基礎と応用, --- ―MEMS, NEMS, センサ, CMOSLSIの融合― <普及版> ---, 株式会社 シーエムシー出版, 東京, 2019年4月.
1426. **川上 烈生, 白井 昭博 :** 第7章第3節第2項「LEDと光触媒」, 株式会社エヌ·ティー·エス, 東京, 2019年12月.
1427. **Xiaobo Li, Taiki Hoshi, Liuan Li, Taofei Pu, Tong Zhang, Tian Xie, Xianjie Li *and* Jin-Ping Ao :** GaN Schottky barrier diode with thermally stable nickel nitride electrode deposited by reactive sputtering, *Materials Science in Semiconductor Processing,* **Vol.93,** 1-5, 2019.
1428. **Liuan Li, Xiaobo Li, Taofei Pu, Yang Liu *and* Jin-Ping Ao :** Normally off AlGaN/GaN ion-sensitive field effect transistors realized by photoelectrochemical method for pH sensor application, *Superlattices and Microstructures,* **Vol.128,** 99-104, 2019.
1429. **Xiaobo Li, Taofei Pu, Taiki Hoshi, Tong Zhang, Xie Tian, Shigeki Fujiwara Joseph Luke, Hiroshi Kitahata, Liuan Li, Sachio Kobayashi, Motoo Ito, Xianjie Li *and* Jin-Ping Ao :** GaN Schottky barrier diodes with nickel nitride anodes sputtered at different nitrogen partial pressure, *Vacuum,* **Vol.162,** 72-77, 2019.
1430. **Yoshiaki Taniguchi, Tsubasa Miki, Yasuhide Ohno, Masao Nagase, Yukihiro Arakawa, Yasushi Imada, Keiji Minagawa *and* Mikito Yasuzawa :** Suppression of protein adsorption on a graphene surface by phosphorylcholine functionalization, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.58,** *No.5,* 055001, 2019.
1431. **Du Jiyao, Kimura Yukinobu, Tahara Masaaki, Matsui Kazushi, Teratani Hitoshi, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Vertically stacked graphene tunnel junction with structured water barrier, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.58,** *No.SD,* SDDE01-(4pp), 2019.
1432. **Shin-ichiro Yanagiya, Toshihiko Takahata, Yuuki Yoshitani, Retsuo Kawakami *and* Akihiro Furube :** Steady-state and time-resolved optical properties of multilayer film of titanium dioxide sandwiched by gold nanoparticles and gold thin film, *ChemNanoMat : Chemistry of Nanomaterials for Energy, Biology and More,* **Vol.5,** 1015-1020, 2019.
1433. **Taofei Pu, Xiaobo Li, Xiao Wang, Yuyu Bu, Liuan Li *and* Jin-Ping Ao :** GaN Schottky Barrier Diodes with TiN Electrode for Microwave Power Transmission, *Materials Science Forum,* **Vol.954,** 126-132, 2019.
1434. **Hengyu Xu, Caiping Wan *and* Jin-Ping Ao :** Improved Electrical Properties of 4H-SiC MOS Devices with High Temperature Thermal Oxidation, *Materials Science Forum,* **Vol.954,** 99-103, 2019.
1435. **Hengyu Xu, Caiping Wan *and* Jin-Ping Ao :** The Correlation between the Reduction of Interface State Density at theSiO2/SiC Interface and the NO Post-Oxide-Annealing Conditions, *Materials Science Forum,* **Vol.954,** 104-108, 2019.
1436. **Shihai Wang, Hengyu Xu, Caiping Wan *and* Jin-Ping Ao :** Effect of Grinding-Induced Stress on Interface State Density of SiC/SiO2, *Materials Science Forum,* **Vol.954,** 121-125, 2019.
1437. **Xu Hengyu, Wan Caiping *and* Jin-Ping Ao :** Reliability of 4H-SiC (0001) MOS Gate Oxide by NO Post-Oxide-Annealing, *Materials Science Forum,* **Vol.954,** 109-113, 2019.
1438. **Yoshiaki Taniguchi, Tsubasa Miki, Yasuhide Ohno, Masao Nagase, Yukihiro Arakawa *and* Mikito Yasuzawa :** Observation of the interaction between avidin and iminobiotin using a graphene FET on a SiC substrate, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.58,** *No.SD,* SDDD02, 2019.
1439. **Yuusuke Takashima, Keita Kusaba, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Highly Sensitive Refractive Index Sensor Using Dual Resonance in Subwavelength Grating/Waveguide With Normally Incident Optical Geometry, *IEEE Sensors Journal,* **Vol.19,** *No.15,* 6147-6153, 2019.
1440. **Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Dual-wavelengths filter operating at visible wavelength region using subwavelength grating on waveguide structure, *Optical Review,* **Vol.26,** *No.5,* 466-471, 2019.
1441. **Hengyu Xu, Caiping Wan, Bo Li, Huiping Zhu *and* Jin-Ping Ao :** Influence of curvature induced stress on first principle calculation and the reliability of 4H-SiC (0001) thermally grown SiO2 gate oxide, *Microelectronics and Reliability,* **Vol.100-101,** 113317-1, 2019.
1442. **Takaya Kujime, Yoshiaki Taniguchi, Daiu Akiyama, Yusuke Kawamura, Yasushi Kanai, Kazuhiko Matsumoto, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** High Stability of Epitaxial Graphene on a SiC Substrate, *Physica Status Solidi (B) Basic Solid State Physics : PSS,* **Vol.256,** 1900357, 2019.
1443. **Yuusuke Takashima, Kouhei Moriiwa, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Ni subwavelength grating/SiO2/Ag based optical magnetic field sensor with normal incident geometry, *Proceedings of SPIE,* **Vol.11089,** 11089V-1-11089V-6, 2019.
1444. **Tatsuya Okada, Takuro Tomita, Hiroyuki Katayama, Yuki Fuchikami, Tomoyuki Ueki, Hiromu Hisazawa *and* Yasuhiro Tanaka :** Local melting of Au/Ni thin films irradiated by femtosecond laser through GaN, *Applied Physics. A, Materials Science & Processing,* **Vol.125,** *No.10,* 690-1-690-6, 2019.
1445. **Xiaobo Li, Taofei Pu, Tong Zhang, Xianjie Li, Liuan Li *and* Jin-Ping Ao :** p-NiO/n-GaN heterostructure diodes for temperature sensor application, *IEEE Sensors Journal,* **Vol.20,** *No.1,* 62-66, 2020.
1446. **Caiping Wan, Hengyu Xu, Jinghua Xia *and* Jin-Ping Ao :** Ultrahigh-temperature oxidation of 4H-SiC (0001) and gate oxide reliability dependence on oxidation temperature, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.530,** 125250-1-125250-4, 2020.
1447. **Taofei Pu, Xiaobo Li, Taowei Peng, Tian Xie, Liuan Li *and* Jin-Ping Ao :** Influence of metal-insulator-semiconductor gate structure on normally-off P-GaN heterojunction field effect transistors, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.532,** 125395-1-125395-5, 2020.
1448. **Retsuo Kawakami, Yuki Yoshitani, Kimiaki Mitani, Masahito Niibe, Yoshitaka Nakano, Chisato Azuma *and* Takashi Mukai :** Effects of Air-Based Nonequilibrium Atmospheric Pressure Plasma Jet Treatment on Characteristics of Polypropylene Film Surfaces, *Applied Surface Science,* **Vol.509,** 144910:1-144910:10, 2020.
1449. **Xiaobo Li, Taofei Pu, Xianjie Li, Liuan Li *and* Jin-Ping Ao :** Correlation between anode area and sensitivity for the TiN/GaN Schottky barrier diode temperature sensor, *IEEE Transactions on Electron Devices,* **Vol.67,** *No.3,* 1171-1175, 2020.
1450. **Yoshiaki Sekine, Hibino Hiroki, Oguri Katsuya, Iwamoto Atsushi, Masao Nagase, Kageshima Hiroyuki *and* Akazaki Tatsushi :** Surface-enhanced Raman scattering from buffer layer under graphene on SiC in a wide energy range from visible to near-infrared, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.59,** *No.4,* 040902, 2020.
1451. **Ting-Ting Wang, Xiao Wang, Xiaobo Li, Jin-Cheng Zhang *and* Jin-Ping Ao :** Temperature-Dependent Characteristics of GaN Schottky Barrier Diodes with TiN and Ni Anodes, *Chinese Physics Letters,* **Vol.36,** *No.5,* 057101-1-057101-5, 2019.
1452. **Takaya Kujime, Yoshiaki Taniguchi, Daiu Akiyama, Yusuke Kawamura, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** High Stability of the epitaxial graphene film on SiC substrate, *Proceedings of Compound Semiconductor Week 2019,* MoP-1-10, May 2019.
1453. **Yasuhide Ohno, Takanori Mitsuno, Yoshiaki Taniguchi *and* Masao Nagase :** 1-aminopyrene-modified epitaxial graphene device for pH sensors, *Proceedings of Compound Semiconductor Week 2019,* TuC1-3, May 2019.
1454. **Takuro Tomita, Hiroki Kawakami *and* Yoshiki Naoi :** Femtosecond laser irradiation aided low-temperature thermal anneal of Ni electrode on SiC, *The 8th International Congress on Laser Advanced Materials Processing,* We2-L8, Hiroshima, May 2019.
1455. **Shigeki Fujiwara Joseph Luke, Nakao Shusuke, Yang Li, Jin-Ping Ao, Kazumi Takaishi *and* Hiroshi Kitahata :** Fabrication and clinical application of a wireless-power-transmission-type medical device, *Euroanaesthesia 2019,* Wien, Jun. 2019.
1456. **Masao Nagase :** Single-crystal graphene on SiC substrate for future electronic devices, --- [invited] ---, *Collaborative Conference on Materials Research (CCMR) 2019,* Goyang/Gyeonggi, Korea, Jun. 2019.
1457. **Yang Li, Shunsuke Nakao, Shigeki Fujiwara Joseph Luke, Kazuki Aoki, Hiroshi Kitahata *and* Jin-Ping Ao :** High resolution via-hole etching technique for silicon carbon substrate, *6th International Symposium on 2019 Single Crystal Diamond and Electronics,* Xi'an, Jun. 2019.
1458. **Nakao Shunsuke, Shigeki Fujiwara Joseph Luke, Yang Li, Aoki Kazuki, Hiroshi Kitahata *and* Jin-Ping Ao :** Microwave wireless power transfer system for small medical equipment, *6th International Symposium on 2019 Single Crystal Diamond and Electronics,* Xi'an, Jun. 2019.
1459. **Liu Zhangcheng, Zhao Dan, Min Tai, Jin-Ping Ao *and* Wang Hong-Xing :** Structure design for diamond UV photodetector-Three dimensional diamond UV detector and p-i-n photodiode, *2019 International Symposium on Single Crystal Diamond and Electronics,* Jun. 2019.
1460. **Taofei Pu, Xiao Wang, Qian Huang, Xiaobo Li, Yuyu Bu, Shigeki Fujiwara Joseph Luke, Hiroshi Kitahata *and* Jin-Ping Ao :** Normally-off AIGaN/GaN heterojunction field-effect transistors, *6th International Symposium on 2019 Single Crystal Diamond and Electronics,* Xi'an, Jun. 2019.
1461. **Retsuo Kawakami, Hirofumi Koide, Yuki Yoshitani, Shin-ichiro Yanagiya, Toshihiro Okamoto, Masanobu Haraguchi, Akihiro Furube, Masahito Niibe, Yoshitaka Nakano, Chisato Azuma *and* Takashi Mukai :** Photocatalytic Characteristics of Au/TiO2/Au Nanostructure Induced by Ultraviolet Irradiation, *Proceedings of 15th International Symposium of Sputtering & Plasma Processes,* 146-148, Kanazawa, Jun. 2019.
1462. **Xiaobo Li, Taofei Pu, Liuan Li, Xianjie Li *and* Jin-Ping Ao :** Correlation between anode area and sensibility for TiN/GaN Schottky diode temperature sensors, *The 2019 Asia-Pacific Conference on Silicon Carbide and Related Materials (APCSCRM2019),* Beijing China, Jul. 2019.
1463. **Yuki Naito, Souma Nishio *and* Katsushi Nishino :** Vacuum Evaporation of BaSi2 Thin Films on Textured Si (100) Substrates, *The 5th Asia-Pacific Conference on Semiconducting Silicides and Related Materials, 2019,* Miyazaki, Jul. 2019.
1464. **Yuusuke Takashima, Kohei Moriiwa, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Ni subwavelength grating/SiO2/Ag based optical magnetic field sensor with normal incident geometry, *SPIE Optics + Photonics 2019,* 11089-67, San Diego, Aug. 2019.
1465. **Jin-Ping Ao :** Synthesis of nickel nitride electrode for gallium nitride Schottky contact, *The 2019 Asia-Pacific Conference on Silicon Carbide and Related Materials (APCSCRM2019),* Beijing China, Sep. 2019.
1466. **Taofei Pu, Xiao Wang, Taowei Peng, Xiaobo Li, Yuyu Bu *and* Jin-Ping Ao :** Development of Normally-off AlGaN/GaN HFETs for Power Electronics, *16th China International Forum on Solid State Lighting & 2019 International Forum on Wide Bandgap Semiconductors (SSLCHINA2019 & IFWS 2019),* Shenzhen, China, Oct. 2019.
1467. **Jiyu Zhou, Tian Xie, Taofei Pu, Xiaobo Li *and* Jin-Ping Ao :** AlGaN/GaN heterostructure pH sensors with high Al composition in the barrier layer, *16th China International Forum on Solid State Lighting & 2019 International Forum on Wide Bandgap Semiconductors (SSLCHINA2019 & IFWS 2019),* Shenzhen, China, Oct. 2019.
1468. **Tatsuya Okada, Takuro Tomita, Yuki Fuchikami, Yusaku Mizuo, Hiromu Hisazawa *and* Yasuhiro Tanaka :** Formation of Ohmic Contact at Ni/SiC Interface with the Assistance of Femtosecond-Laser-Induced Modifications, *International Conference on Materials and Systems for Sustainability 2019,* A3-P-8-(1040), Nagoya, Nov. 2019.
1469. **Daiki Sengo, Taofei Pu *and* Jin-Ping Ao :** Normally-off AlGaN/GaN High Electron Mobility Transistors with AlN cap layer, *International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application,* Nanjing, China, Nov. 2019.
1470. **Taofei Pu, Xiao Wang, Taowei Peng, Xiaobo Li, Yuyu Bu *and* Jin-Ping Ao :** Normally-Off AlGaN/GaN Heterojunction Metal-Insulator-Semiconductor Field-Effect Transistors, *International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application,* Nanjing, China, Nov. 2019.
1471. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 導波層電子蓄積効果を利用した共鳴型カ ラーフィルター, *2019年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* Fp-8, 2019年7月.
1472. **水尾 優作, 渕上 裕暉, 富田 卓朗, 久澤 大夢, 岡田 達也 :** フェムト秒レーザ照射誘起改質を導入したSiC単結晶上Ni電極の特性評価, *2019年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会講演予稿集,* Fp-4, 2019年7月.
1473. **内田 健介, 今垣 諒彌, 植木 智之, 久澤 大夢, 富田 卓朗, 岡田 達也, 田中 康弘 :** ダイヤモンド単結晶表面におけるフェムト秒レーザ照射誘起改質とTiの反応, *日本金属学会中国四国支部第59回講演大会講演概要集,* B25, 2019年8月.
1474. **水尾 優作, 渕上 裕暉, 久澤 大夢, 富田 卓朗, 岡田 達也 :** SiC単結晶表面におけるフェムト秒レーザ照射誘起改質を応用したNi電極の作製, *日本金属学会中国四国支部第59回講演大会講演概要集,* B08, 2019年8月.
1475. **渕上 裕暉, 薮内 麻由, 宮本 美佑, 二村 大, 山口 誠, 岡田 達也, 富田 卓朗 :** 走査型電子顕微鏡を用いたフェムト秒レーザー加工過程のパルス分解観察, *第80回応用物理学会秋季学術講演会 講演概要集,* 18p-N304-8, 2019年9月.
1476. **谷口 嘉昭, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** ホール効果測定によるSiC上グラフェンのタンパク質吸着特性評価, *2019年第80回応用物理学会秋季学術講演会,* **Vol.18p-E308-14,** 2019年9月.
1477. **杉山 良輝, 都 継瑶, 久次米 孝哉, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** SiC上グラフェンの赤外線放射特性の観測, *2019年第80回応用物理学会秋季学術講演会,* **Vol.18a-E308-3,** 2019年9月.
1478. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** Niナノ粒子を用いた光学式磁場検出の高感度化, *第80回応用物理学会秋季学術講演会,* 19p-PA6-19, 2019年9月.
1479. **芳谷 勇樹, 川上 烈生, 新部 正人, 中野 由崇, 東 知里, 向井 孝志 :** 大気圧O2プラズマ支援アニーリング処理したP-25 TiO2ナノ粒子の光触媒活性, *令和元年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 38, 2019年9月.
1480. **川上 烈生, 芳谷 勇樹, 新部 正人, 中野 由崇, 東 知里, 向井 孝志 :** 低温大気圧空気プラズマジェット処理によるアルミニウムとニッケル表面の親水化, *令和元年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 39, 2019年9月.
1481. **小出 洋史, 川上 烈生, 芳谷 勇樹, 柳谷 伸一郎, 岡本 敏弘, 原口 雅宣, 古部 昭広, 新部 正人, 中野 由崇, 東 知里, 向井 孝志 :** Au/TiO2/Auナノ構造体の光触媒活性, *令和元年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 40, 2019年9月.
1482. **見谷 皇章, 川上 烈生, 芳谷 勇樹, 新部 正人, 東 知里, 中野 由崇, 向井 孝志 :** ポリプロピレン表面への大気圧非熱平衡プラズマジェット照射効果, *令和元年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 41, 2019年9月.
1483. **高見 直樹, 川上 烈生, 中橋 睦美, 新部 正人, 中野 由崇, 東 知里, 向井 孝志 :** 空気プラズマジェット照射による種子の発芽促進効果, *令和元年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 43, 2019年9月.
1484. **西尾 聡馬, 内藤 友紀, 西野 克志 :** 蒸着中の原料状態がBaSi2薄膜の品質に与える影響, *第80回応用物理学会秋季学術講演会,* 21a-PA3-6, 2019年9月.
1485. **芳谷 勇樹, 白井 昭博, 梶川 耕介, 安友 優子, 小出 洋史, 東 知里, 向井 孝志, 川上 烈生 :** 酸素プラズマ支援アニーリング処理した酸化チタンナノ粒子の殺菌効果, *日本防菌防黴学会 第46回年次大会,* 196, 2019年9月.
1486. **青木 一希, 藤原 茂樹, 中尾 俊介, 李 楊, 大塚 良, 江口 覚, 高石 和美, 敖 金平, 立原 敬一, 北畑 洋 :** オープンリング共振器を使用した医療機器への無線電力伝送について, *第47回日本歯科麻酔学会総会・学術集会,* 2019年10月.
1487. **ルクマンハムバリ ビンザイニ, 山口 誠, 山野 太久, 富田 卓朗, 岡田 達也 :** SiCにおけるフェムト秒レーザー誘起表面改質の可視・紫外ラマン散乱分光, *2019年度精密工学会東北支部学術講演会,* C05, 2019年11月.
1488. **櫻井 春希, 大野 椋介, 倉科 昌, 安澤 幹人, 永瀬 雅夫 :** 集束イオンビーム化学気相蒸着(FIB-CVD)法を用いたナノピラーの作製及び細胞挿入の試み, *2019年度日本化学会中国四国支部大会,* 2019年11月.
1489. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** Niナノ粒子を用いた光学式磁場センサー感度の粒子径・密度依存性, *日本光学会年次学術講演会Optics & Photonics Japan 2019,* 4aP2, 2019年12月.
1490. **真名野 皓介, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** インジウムにより制御したニッケル島状構造を用いた高感度光学式磁場センサー, *日本光学会年次学術講演会Optics & Photonics Japan 2019,* 4aP3, 2019年12月.
1491. **藤原 茂樹, 敖 金平, 北畑 洋 :** ワイヤレス給電式医療機器の製作および臨床応用, *ICTイノベーションフォーラム2020 予稿集,* 2020年1月.
1492. **原口 雅宣, 北田 貴弘, 永瀬 雅夫, 安井 武史, 木内 陽介, 宮脇 克行, 髙橋 章, 岡久 稔也 :** 2019年度におけるLEDライフイノベーション総合プラットフォーム推進事業の取り組み, *LED総合フォーラム2020in徳島,* 75-76, 2020年2月.
1493. **青野 零弥, 髙島 祐介, 直井 美貴, 安井 武史, 永松 謙太郎 :** 紫外光LEDの大気中における光減衰に関する研究, *第67回応用物理学会春季学術講演会予稿集,* 12p-B409-8, 2020年3月.
1494. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** GaNサブ波長格子を用いた400nm波長帯で動作する高感度屈折率センサー, *第67回応用物理学会春季学術講演会,* 13p-B409-9, 2020年3月.
1495. **大野 恭秀, 川越 悠斗, 谷口 嘉昭, 永瀬 雅夫 :** 溶液ゲートグラフェン FET における電気二重層の役割, *第67回応用物理学会春季学術講演会,* **Vol.13a-A401-5,** 2020年3月.
1496. **谷口 嘉昭, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** SiC 上グラフェン FET のタンパク質吸着特性とキャリア伝導, *第67回応用物理学会春季学術講演会,* **Vol.13a-A401-6,** 2020年3月.
1497. **中村 俊輔, 都 継瑶, 葛尾 理樹, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** エピタキシャルグラフェン上構造水層の電子輸送特性, *第67回応用物理学会春季学術講演会,* **Vol.13p-A401-6,** 2020年3月.
1498. **中野 由崇, 豊留 彬, 新部 正人, 川上 烈生, 川上 烈生 :** CF4プラズマ処理したp型GaNの電気的ダメージ評価, *第67回春季応用物理学会学術講演会, No.1,* 2020年3月.
1499. **村上 成汐, 杉山 良輝, 田原 雅章, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** 積層グラフェン p-n 接合の赤外線放射特性, *第67回応用物理学会春季学術講演会,* **Vol.14a-A404-1,** 2020年3月.
1500. **大下 悠, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 変調サブ波長周期電極を用いた集光機能を有する発光ダイオードの理論的検討, *第67回応用物理学会春季学術講演会,* 15a-PA4-10, 2020年3月.
1501. **真名野 皓介, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** In添加Niナノ粒子を用いた紫外波長フィルター, *第67回応用物理学会春季学術講演会,* 15a-PA4-16, 2020年3月.
1502. **永瀬 雅夫 :** ナノ炭素材料・グラフェン, --- 地上最強，史上最速!? ∼究極のナノ材料グラフェンの可能性と課題∼ ---, *夢ナビ編集部 LIVE,* 2019年7月.
1503. **青木 一希, 藤原 茂樹, 中尾 俊介, 江口 覚, 八木 香奈枝, 三上 可菜子, 立原 敬一, 李 楊, 大塚 良, 江口 覚, 高石 和美, 大浦 邦彦, 敖 金平, 北畑 洋 :** 医療機器への無線電力伝送に使用するオープンリング共振器の設計とシミュレーションについて, *第34 回中国・四国歯科麻酔研究会,* 2019年7月.
1504. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 微細ナノ構造を用いた可視∼紫外フォトニックデバイス, *第69回CVD研究会「第30回夏季セミナー」,* 2019年8月.
1505. **大下 悠, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 自動運転応用に向けた紫外LEDの高機能化に関する理論的検討および取り組み, *徳島大学ポストLEDフォトニクス公開シンポジウム2019,* P-21, 2019年10月.
1506. **津田 翔太, 直井 美貴, 髙島 祐介, 永松 謙太郎 :** 次世代殺菌浄水システム, *徳島大学ポストLEDフォトニクス公開シンポジウム2019,* P-18, 2019年10月.
1507. **青野 零弥, 髙島 祐介, 直井 美貴, 永松 謙太郎 :** 次世代癌治療用深紫外スポットLEDの開発, *徳島大学ポストLEDフォトニクス公開シンポジウム2019,* P-19, 2019年10月.
1508. **村上 堅也, 直井 美貴, 髙島 祐介, 永松 謙太郎 :** 深紫外LEDの発光層温度予測と寿命の関係, *徳島大学ポストLEDフォトニクス公開シンポジウム2019,* P-20, 2019年10月.
1509. **岡野 裕有, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 導波層電子蓄積効果を利用した共鳴型カラーフィルター, *レーザー学会中国・四国支部，関西支部連合若手学術交流研究会,* A-2, 2019年11月.
1510. **Masao Nagase :** Single-crystal graphene for functional devices, *令和元年度 共同プロジェクト研究発表会, No.P2,* Feb. 2020.
1511. **杉本 健太, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 高屈折率材料を用いたサブ波長回折格子電極による紫外LEDの偏光制御, *LED総合フォーラム2020in徳島,* P-10, 2020年2月.
1512. **大下 悠, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** Ge/Niサブ波長周期電極構造を用いた配光制御発光ダイオードの理論的検討, *LED総合フォーラム2020in徳島,* P-11, 2020年2月.
1513. **青野 零弥, 髙島 祐介, 直井 美貴, 永松 謙太郎 :** 深紫外LEDの大気中における光減衰に関する研究, *LED総合フォーラム2020in徳島,* P-16, 2020年2月.
1514. **永瀬 雅夫, 大野 恭秀 :** SiC上グラフェンを用いた黒体輻射エミッタ, *LED総合フォーラム2020in徳島, No.P-15,* 101-102, 2020年2月.
1515. **川上 烈生, 髙見 直樹, 芳谷 勇樹, 味元 勇樹, 東 知里, 宮脇 克行, 白井 昭博, 吉田 雅彦, 山路 諭 :** 可視光LED照射下でのプラズマ支援アニーリングした光触媒TiO2ナノ粒子の鮮度保持効果, *LED総合フォーラム2020 in 徳島,* 83-84, 2020年2月.
1516. **芳谷 勇樹, 川上 烈生, 梶川 耕介, 白井 昭博, 東 知里 :** 紫外線LED照射によるTiO2ナノ粒子の光触媒効果, *LED総合フォーラム2020 in 徳島,* 85-86, 2020年2月.
1517. **Retsuo Kawakami, Yuki Yoshitani, Akihiro Shirai, Shin-ichiro Yanagiya, Hirofumi Koide, Yuki Mimoto, Kosuke Kajikawa, Masahito Niibe, Yoshitaka Nakano, Chisato Azuma *and* Takashi Mukai :** Effects of Nonequilibrium Atmospheric-Pressure O2 Plasma-Assisted Annealing on Anatase TiO2 Nanoparticles, *Applied Surface Science,* **Vol.526,** 146684:1-146684:12, 2020.
1518. **Tatsuya Okada, Yuki Fuchikami, Kazuki Mimura, Tomoyuki Ueki, Hiromu Hisazawa *and* Takuro Tomita :** Formation of ohmic Ni electrodes on femtosecond laser-modified 4H-SiC surface, *Applied Physics. A, Materials Science & Processing,* **Vol.126,** *No.7,* 535-1-535-7, 2020.
1519. **Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** GaN-Based High-Contrast Grating for Refractive Index Sensor Operating BlueViolet Wavelength Region, *Sensors,* **Vol.20,** *No.16,* 4444-1-4444-12, 2020.
1520. **Yua Okano, Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Magnetically tunable visible reflectivity utilizing the electron accumulation in indium-tin-oxide waveguide layer with subwavelength grating, *Proceedings of SPIE,* **Vol.11467,** 114671U-1-114671U-7, 2020.
1521. **Li Yang, Pu Tao-Fei, Li Xiao-Bo, Zhong Yi-Run, Yang Lin-An, Shigeki Fujiwara Joseph Luke, Hiroshi Kitahata *and* Jin-Ping Ao :** GaN Schottky Barrier Diode-Based Wideband and Medium-Power Microwave Rectifier for Wireless Power Transmission, *IEEE Transactions on Electron Devices,* **Vol.67,** *No.10,* 4123-4129, 2020.
1522. **Yuusuke Takashima, Kohei Moriiwa, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Optical detection for magnetic field using Ni-subwavelength grating on SiO2/thin-film Ag/glass structure, *Scientific Reports,* **Vol.10,** 19298, 2020.
1523. **Kozo Sugimoto, Shigeki Matsuo *and* Yoshiki Naoi :** Inscribing diffraction grating inside silicon substrate using a subnanosecond laser in one photon absorption wavelength, *Scientific Reports,* **Vol.10,** 21451, 2020.
1524. **Li Liuan, Li Xiaobo, Pu Taofei, Cheng Shaoheng, Li Hongdong *and* Jin-Ping Ao :** Vertical GaN-Based Temperature Sensor by Using TiN Anode Schottky Barrier Diode, *IEEE Sensors Journal,* **Vol.21,** *No.2,* 1273-1278, 2021.
1525. **Tatsuya Okada, Hiromu Hisazawa, Akihiro Iwasaki, Katsuya Kawaguchi, Hiroki Morimoto, Kazuki Nakao, Tomoyuki Ueki *and* Takuro Tomita :** Creep fracture of aluminum and copper tricrystals having <110>-tilt Σ3, 3, 9 grain boundaries, *Materials Transactions,* **Vol.62,** *No.2,* 239-245, 2021.
1526. **Murakami Naruse, Sugiyama Yoshiki, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Blackbody-like infrared radiation in stacked graphene P-N junction diode, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.60,** *No.SC,* SCCD01-(4pp), 2021.
1527. **Zhou Jiyu, Li Xiaobo, He Liang, Pu Taofei, Li Liuan *and* Jin-Ping Ao :** Vertical GaN Schottky barrier diodes with area-selectively deposited p-NiO guard ring termination structure, *Superlattices and Microstructures,* **Vol.151,** 106820-1-106820-6, 2021.
1528. **He Yue, Wang Xiao, Zhou Jiyu, Wang Tingting, Ren Mengke, Chen Guoqiang, Pu Taofei, Li Xiaobo, Jia Mao, Bu Yuyu *and* Jin-Ping Ao :** Enhanced pH Sensitivity of AlGaN/GaN Ion-Sensitive Field-Effect Transistor by Recess Process and Ammonium Hydroxide Treatment, *IEEE Transactions on Electron Devices,* **Vol.68,** *No.3,* 1250-1255, 2021.
1529. **Xiaobo Li, Taofei Pu, Liuan Li *and* Jin-Ping Ao :** Enhanced sensitivity of GaN-based temperature sensor by using the series Schottky barrier diode structure, *IEEE Electron Device Letters,* **Vol.41,** *No.4,* 601-604, 2020.
1530. **Yua Okano, Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Magnetically tunable visible reflectivity utilizing the electron accumulation in indium-tin-oxide waveguide layer with subwavelength grating, *SPIE Optics + Photonics 2020 DIgital Forum,* 11467-64, DIgital Forum, Aug. 2020.
1531. **Zhong Yirun, Li Yang, Pu Taofei, Shigeki Fujiwara Joseph Luke, Hiroshi Kitahata *and* Jin-Ping Ao :** GaN Schottky Barrier Diodes for Microwave Rectification with Enhanced Cut-off Frequency, *The 2020 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2020),* Sep. 2020.
1532. **Murakami Naruse, Sugiyama Yoshiki, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** BLACKBODY-LIKE INFRARED RADIATION IN STACKED GRAPHENE PN JUNCTION DIODE, *33rd International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2020), No.2020-21-14,* Online, Nov. 2020.
1533. **Nakai Hiroki, Akiyama Daiu, Taniguchi Yoshiaki, Kishinobu Iori, Ikeda Takuya, Atsushi Tabata, Hideaki Nagamune, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Protein detection by electron donor using epitaxial graphene film on SiC substrate, *33rd International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2020), No.2020-21-12,* Online, Nov. 2020.
1534. **Li Yang, Pu Tao-Fei *and* Jin-Ping Ao :** GaN Schottky Barrier Diode Based Microwave Rectifier for Wireless Charging and Power Transmission, *17th China International Forum on Solid State Lighting & 2020 International Forum on Wide Bandgap Semiconductors (SSLCHINA2020 & IFWS 2020),* Nov. 2020.
1535. **Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Significant enhancement of magneto-optical effect at ultraviolet wavelength using Nisubwavelength grating on SiO2/Ni structure, *30th International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory (ISOM'20),* We-B-03, Online, Dec. 2020.
1536. **Yuusuke Takashima, Kentaro Nagamatsu, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** High refractive index contrast meta-structures for GaN-based and sensing applications operating at deep ultraviolet to visible wavelength, *13th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials,* 08pD07O, Online, Mar. 2021.
1537. **真名野 晧介, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** Niナノ粒子/サファイア基板系における紫外・可視光散乱のNi粒径依存性, *2020年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* Bp-3, 2020年8月.
1538. **杉本 健太, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** Ge/Niサブ波長周期電極を有する紫外LEDの偏光特性, *2020年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* Bp-6, 2020年8月.
1539. **水本 善雄, 髙島 祐介, 直井 美貴, 富田 卓朗 :** SiC上Ni電極剥離に着目したフェムト秒レーザ照射改質による電極形成, *2020年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* Bp-7, 2020年8月.
1540. **味元 勇樹, 川上 烈生, 新部 正人, 中野 由祟, 向井 孝志 :** アナターゼ/ルチル混晶型TiO2ナノ粒子への熱アシスト大気圧低温O2プラズマ処理効果, *2020年度 応用物理・物理系学会中国四国支部 合同学術講演会,* 9, 2020年8月.
1541. **泉 匠人, 川上 烈生, 粟飯原 睦美, 白井 昭博, 宮脇 克行, 向井 孝志 :** 植物養液への非平衡大気圧空気プラズマジェット照射効果, *2020年度 応用物理・物理系学会中国四国支部 合同学術講演会,* 10, 2020年8月.
1542. **坂東 賢哉, 植木 智之, 富田 卓朗, 久澤 大夢, 岡田 達也, 小林 幸雄, 伊藤 元雄 :** フェムト秒レーザ照射したダイヤモンド表面へのホウ素イオン注入, *2020年度 応用物理・物理系学会 中国四国支部 合同学術講演会 講演概要集,* Cp-2, 2020年8月.
1543. **岸信 伊織, 秋山 大宇, 中井 寛喜, 谷口 嘉昭, 大野 恭秀, 長宗 秀明, 永瀬 雅夫 :** 高い等電点を持つタンパク質のSiC上グラフェンへの吸着特性, *2020年度 応用物理・物理系学会 中国四国支部 合同学術講演会,* **Vol.Ga-2,** 2020年8月.
1544. **三村 一暉, 高橋 孝, 山口 誠, 小林 洋平, 富田 卓朗 :** 粗面化したSi におけるレーザ加工痕のパルス幅依存性, *2020年度 応用物理・物理系学会 中国四国支部 合同学術講演会 講演概要集,* Bp-10, 2020年8月.
1545. **山本 健, 高橋 孝, 内海 慶春, 柴田 明宣, 山口 誠, 小林 洋平, 富田 卓朗 :** ピコ秒レーザー照射による4H-SiC上DLCの改質, *2020年度 応用物理・物理系学会 中国四国支部 合同学術講演会 講演概要集,* Bp-8, 2020年8月.
1546. **森下 雄登, 李 小波, 敖 金平 :** NiOを用いた縦型GaN PNダイオード, *2020年度 応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* 2020年8月.
1547. **津田 将孝, 李 小波, 小橋 洸介, 蒲 涛飛, 敖 金平 :** NH3アニールによるNiN/GaNショットキー接触, *2020年度 応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* 2020年8月.
1548. **辻 航平, 西野 克志 :** 直接合成法によるβ-Ga2O3の結晶成長における供給ガス流量の検討, *2020年度 応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* Ea-4, 2020年8月.
1549. **永瀬 雅夫 :** SiC 基板上単結晶グラフェンの作製とそのデバイス応用, --- [招待講演] ---, *グラフェンコンソーシアム第22回研究講演会,* 2020年8月.
1550. **坂東 賢哉, 植木 智之, 富田 卓朗, 久澤 大夢, 岡田 達也, 小林 幸雄, 伊藤 元雄 :** ダイヤモンド単結晶表面へのフェムト秒レーザ照射誘起改質導入とホウ素イオン注入, *日本金属学会中国四国支部第60回講演大会講演概要集,* B05, 2020年8月.
1551. **水本 善雄, 髙島 祐介, 直井 美貴, 富田 卓朗 :** Ni/SiC界面へのフェムト秒レーザ照射による熱アニールを用いないオーミック電極形成, *第81回応用物理学会秋季学術講演会,* 9a-Z18-4, 2020年9月.
1552. **川上 烈生, 味元 勇樹, 小出 洋史, 柳谷 伸一郎, 新部 正人, 中野 由崇, 向井 孝志 :** 熱アシスト非平衡大気圧O2プラズマ処理したアナターゼ型TiO2ナノ粒子の物性, *日本物理学会2020年秋季大会,* 2020年9月.
1553. **南 朋貴, 越智 柊太, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** SiC上グラフェンの 水脱離によるシート抵抗変化, *第81回応用物理学会秋季学術講演会,* **Vol.9p-Z29-8,** 2020年9月.
1554. **神元 将太, 西野 克志 :** 直接合成法によるβ-Ga2O3 の結晶成長における供給温度の影響, *第81回応用物理学会秋季学術講演会,* 9p-Z20-7, 2020年9月.
1555. **山口 誠, 高林 圭祐, ルクマンハムバリ ビンザイニ, 富田 卓朗 :** SiC表面の短パルスレーザー照射よる表面改質層のラマン散乱分光法評価, *2020年度砥粒加工学会学術講演会,* B27, 2020年9月.
1556. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 高屈折率差周期ブリッジ構造による可視光フィルター, *第81回応用物理学会秋季学術講演会,* 11a-Z17-8, 2020年9月.
1557. **日口 聖規, 小出 洋史, 柳谷 伸一郎, 川上 烈生, 片山 哲郎, 古部 昭広, 太田 薫, 富永 圭介 :** 金ナノ構造-酸化チタン積層膜のTHz-TDS評価, *第81回応用物理学会秋季学術講演会,* 11a-Z24-7, 2020年9月.
1558. **森 俊之輔, 西尾 聡馬, 西野 克志 :** BaSi2薄膜の低速成長が膜品質に与える効果, *第81回応用物理学会秋季学術講演会,* 11a-Z01-2, 2020年9月.
1559. **西川 美佳, 藤原 茂樹, 青木 理紗, 江口 覚, 高石 和美, 大塚 拓, 吉田 雅彦, 李 楊, 敖 金平, 北畑 洋 :** ワイヤレス給電式医療機器の開発―2.45 GHz 帯域 Ver. 1―, *第48回日本歯科麻酔学会総会・学術集会,* 2020年10月.
1560. **髙島 祐介, 永松 謙太郎, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 構造高さを変調したTiO2メタ表面による集光紫外発光ダイオードの提案, *日本光学会年次学術講演会Optics & Photonics Japan 2020,* 17pC4, 2020年11月.
1561. **藤原 茂樹, 敖 金平, 北畑 洋 :** ワイヤレス給電式医療機器の製作および臨床応用, *ICT 2020,* 2021年1月.
1562. **木下 智裕, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** 液滴による電位差発生現象におけるバッファ層の影響, *第68回応用物理学会春季学術講演会,* **Vol.16p-Z31-12,** 2021年3月.
1563. **西尾 聡馬, 森 俊之輔, 西野 克志 :** 低速成長したBaSi2 蒸着膜へのin situ アニール効果, *第68回応用物理学会春季学術講演会,* 16a-Z23-8, 2021年3月.
1564. **伊藤 寛人, 岡本 敏弘, 山口 堅三, 直井 美貴, 髙島 祐介, 原口 雅宣 :** トンネル接合型テラヘルツ光源のための指向性アンテナの設計, *第68回応用物理学会春季学術講演会,* 17a-Z09-6, 2021年3月.
1565. **左海 夏輝, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** エピタキシャルグラフェン上の固液界面の液中観察, *第68回応用物理学会春季学術講演会,* **Vol.17a-Z31-7,** 2021年3月.
1566. **味元 勇樹, 川上 烈生, 柳谷 伸一郎, 新部 正人, 中野 由崇, 向井 孝志 :** 大気圧低温O2プラズマ支援熱処理したアナターゼ/ルチル混晶型TiO2ナノ粒子の紫外/可視光触媒活性, *第68回春季応用物理学会学術講演会,* 07-069, 2021年3月.
1567. **泉 匠人, 川上 烈生, 粟飯原 睦美, 白井 昭博, 宮脇 克行, 向井 孝志 :** 大気圧低温プラズマジェット照射による植物養液殺菌効果, *第68回春季応用物理学会学術講演会,* 07-070, 2021年3月.
1568. **三村 一暉, 高橋 孝, 山口 誠, 小林 洋平, 富田 卓朗 :** Siにおけるレーザー加工痕のパルス時間幅依存性, *第68回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集,* **Vol.68,** 18a-Z04-3, 2021年3月.
1569. **山本 健, 高橋 孝, 内海 慶春, 柴田 明宣, 山口 誠, 小林 洋平, 富田 卓朗 :** ピコ秒レーザー照射を用いたSiC上DLCにおけるレーザー誘起ナノ周期構造の形成, *第68回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集,* **Vol.68,** 18a-Z04-4, 2021年3月.
1570. **髙島 祐介, 永松 謙太郎, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** TiO2メタ周期構造を表面に有するAlGaN系深紫外発光ダイオードのコリメート特性, *第68回応用物理学会春季学術講演会,* 19a-Z08-7, 2021年3月.
1571. **川村 武寛, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 二波長で動作する高屈折率メタ構造による高感度屈折率検出, *第68回応用物理学会春季学術講演会,* 19p-Z08-1, 2021年3月.
1572. **中津 卓巳, 岡本 敏弘, 山口 堅三, 直井 美貴, 髙島 祐介, 原口 雅宣 :** Si導波路上に配置した金属ナノ構造の共鳴特性評価, *第68回応用物理学会春季学術講演会,* 19a-Z08-8, 2021年3月.
1573. **永松 謙太郎, 津田 翔太, 青野 零弥, 宮川 拓己, 揚田 侑哉, 平山 秀樹, 髙島 祐介, 直井 美貴 :** 高温有機金属気相成長装法におけるAlN成長の気相反応抑制, *第68回応用物理学会春季学術講演会,* 19p-Z27-14, 2021年3月.
1574. **津田 翔太, 青野 零弥, 揚田 侑哉, 宮川 拓己, 平山 秀樹, 髙島 祐介, 直井 美貴, 永松 謙太郎 :** AlNテンプレート上高温AlN結晶成長, *第68回応用物理学会春季学術講演会,* 19p-Z27-3, 2021年3月.
1575. **宮川 拓己, 津田 翔太, 青野 零弥, 揚田 侑哉, 平山 秀樹, 髙島 祐介, 直井 美貴, 永松 謙太郎 :** AlNの高流速成長における成長メカニズム, *第68回応用物理学会春季学術講演会,* 19p-Z27-13, 2021年3月.
1576. **高林 圭佑, カイディール カマロン, 山口 誠, 富田 卓朗, 高橋 孝, 小林 洋平 :** ピコ秒レーザー照射によるSi上DLC膜の構造変化, *第68回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集,* **Vol.68,** 19p-Z07-7, 2021年3月.
1577. **谷口 嘉昭, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** 液浸ラマン分光法を用いた SiC 上グラフェンのタンパク質吸着特性評価, *第68回応用物理学会春季学術講演会,* **Vol.19p-P01-6,** 2021年3月.
1578. **髙島 祐介, 直井 美貴 :** メタ周期構造による偏光UV-LED / メタ構造を利用したセンサーデバイス, *CEATEC 2020 Online,* 2020年10月.
1579. **川村 武寛, 髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** TiO2-メタ周期構造による高感度ガス検出用光デバイス, *第一回 電子情報通信学会支部CoEシンポジウム,* 11, 2021年1月.
1580. **杉本 健太, 髙島 祐介, 永松 謙太郎, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** サブ波長周期電極を有する紫外発光ダイオード偏光特性に対する電極材料の影響, *LED総合フォーラム2021in徳島,* P-10, 2021年2月.
1581. **揚田 侑哉, 髙島 祐介, 直井 美貴, 永松 謙太郎 :** AlN高温成長での面内膜厚分布の改善, *LED総合フォーラム2021in徳島,* P-17, 2021年2月.
1582. **川上 烈生, 味元 勇樹, 宮脇 克行, 白井 昭博, 吉田 雅彦 :** 熱支援プラズマ処理したアナターゼ/ルチル混晶型光触媒TiO2ナノ粒子の光分解と鮮度保持効果, *LED総合フォーラム2021 in 徳島,* 145-146, 2021年2月.
1583. **原口 雅宣, 北田 貴弘, 永瀬 雅夫, 安井 武史, 木内 陽介, 宮脇 克行, 髙橋 章, 岡久 稔也 :** 2020年度におけるLEDライフイノベーション総合プラットフォーム推進事業の取り組み, *LED総合フォーラム2021 in 徳島,* P-1, 2021年2月.
1584. **Masao Nagase :** Far infrared emission device using single crystal graphene, *令和二年度 共同プロジェクト研究発表会,* Feb. 2021.
1585. **Wang Ying, Pu Taofei, Li Xiaobo, Li Liuan *and* Jin-Ping Ao :** Application of p-type NiO deposited by magnetron reactive sputtering on GaN vertical diodes, *Materials Science in Semiconductor Processing,* **Vol.125,** 105628-1-105628-4, 2021.
1586. **Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Highly reflective visible color filter based on a double layer TiO2 subwavelength structure, *Optical Materials Express,* **Vol.11,** *No.8,* 2712-2721, 2021.
1587. **Hiroki Nakai, Daiu Akiyama, Yoshiaki Taniguchi, Iori Kishinobu, Hiromichi Wariishi, Yasuhide Ohno, Masao Nagase, Takuya Ikeda, Atsushi Tabata *and* Hideaki Nagamune :** Charge-independent protein adsorption characteristics of epitaxial graphene field-effect transistor on SiC substrate, *Journal of Applied Physics,* **Vol.130,** *No.7,* 074502-1-074502-8, 2021.
1588. **Yuusuke Takashima, Atsuki Sasada, Kentaro Nagamatsu, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Design of AlN-subwavelength grating for deep ultraviolet wavelength reflector operating at 244 nm of wavelength, *Proceedings of SPIE,* **Vol.11926,** 1192618-1-1192618-4, 2021.
1589. **Minami Tomoki, Ochi Shuta, Nakai Hiroki, Kinoshita Tomohiro, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Thermal desorption of structured water layer on epitaxial graphene, *AIP Advances,* **Vol.11,** 125012-(5pp), 2021.
1590. **Retsuo Kawakami, Yuki Mimoto, Shin-ichiro Yanagiya, Akihiro Shirai, Masahito Niibe, Yoshitaka Nakano *and* Takashi Mukai :** Photocatalytic Activity Enhancement of Anatase/Rutile-Mixed Phase TiO2 Nanoparticles Annealed with Low-Temperature O2 Plasma, *Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science,* **Vol.218,** 2100536-1-2100536-13, 2021.
1591. **Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Numerical finite difference time domain calculation for extreme enhancement of magneto optical effect at ultraviolet wavelength using Ni subwavelength grating on SiO2/Ni structure, *Optical Review,* **Vol.29,** *No.1,* 62-67, 2022.
1592. **Keisuke Takabayashi, Khamaron Bin Khaidir, Takuro Tomita, Takashi Takahashi, Yohei Kobayashi *and* Makoto Yamaguchi :** Raman Studies of Structural Change in Diamond-like Carbon Film on Si Induced by Ultrafast Laser Ablation, *Journal of Laser Micro/Nanoengineering,* **Vol.17,** *No.1,* 1-5, 2022.
1593. **Masao Nagase :** Vertically Stacked Junction Devices Fabricated Using Single-Crystal Graphene on SiC Substrate, *ECS Transactions,* **Vol.104,** *No.(4),* 27-31, 2021.
1594. **Yuusuke Takashima, Sasada Atsuki, Kentaro Nagamatsu, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Design of AlN-subwavelength grating for deep ultraviolet wavelength reflector operating at 244 nm of wavelength, *The 8th Optical Manipulation and Structured Materials Conference,* OMC-P-02, Online, Apr. 2021.
1595. **Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Theoretical investigation of tunable wavelength filter with TiO2-based bi-layer subwavelength grating, *12th International Conference on Optics-photonics Design & Fabrication,* 02PS2-10, Online, Jun. 2021.
1596. **Kazuki Mimura, Takashi Takahashi, Makoto Yamaguchi, Yohei Kobayashi *and* Takuro Tomita :** The pulse duration dependent ablation crater on Si, *The 22nd International Symposium on Laser Precision Microfabrication,* 55, Online, Jun. 2021.
1597. **Ken Yamamoto, Takashi Takahashi, Yoshiharu Utsumi, Akinori Shibata, Makoto Yamaguchi, Yohei Kobayashi *and* Takuro Tomita :** Spontaneous formation of the nano-periodic structures of DLC on SiC by picosecond laser irradiation, *The 22nd International Symposium on Laser Precision Microfabrication,* 56, Online, Jun. 2021.
1598. **Kenya Bando, Tomoyuki Ueki, Hiromu Hisazawa, Takuro Tomita, Tatsuya Okada *and* Makoto Yamaguchi :** Modifications induced by femtosecond laser irradiation on (001) surface of diamond crystal, *The 22nd International Symposium on Laser Precision Microfabrication,* 97, Online, Jun. 2021.
1599. **Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** High refractive index contrast meta-surfaces for sensing and emitting devices, *The 11th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics (META 2021),* 1A3, Online, Jul. 2021.
1600. **Masao Nagase :** Vertically Stacked Junction Devices Fabricated Using Single-Crystal Graphene on SiC Substrate, --- [invited] ---, *240th ECS meeting,* **Vol.G02-0910,** Online, Oct. 2021.
1601. **Kataoka Taichi, Fukunaga Fumiya, Murakami Naruse, Sugiyama Yoshiki, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Far-infrared emission from graphene on SiC by current injection, *34th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2021), No.P21-1,* Online, Oct. 2021.
1602. **Nakagawa Yoshinori, Okauchi Shigeki, Sano Masahiko, Takashi Mukai, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Deep ultraviolet light detection by AlGaN/Gr hetero junction photodiode array, *34th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2021), No.P21-10,* Online, Oct. 2021.
1603. **Masanobu Haraguchi, Shun Kamada, Toshihiro Okamoto, Kenzo Yamaguchi, Yuusuke Takashima *and* Yoshiki Naoi :** Plasmonic sensors for high density optical circuits, *International Meet & Expo on Laser, Optics and Photonics (OPTICSMEET 2021),* 1013, Online, Nov. 2021.
1604. **Izumi Takuto, Aihara Mutsumi, Retsuo Kawakami, Akihiro Shirai, Urakami Tomona, Katsuyuki Miyawaki *and* Takashi Mukai :** Bactericidal Effects of Nonequilibrium Atmospheric-Pressure Plasma Jet on Hydroponic Nutrient Solutions, *Proceedings of International Symposium of Dry Process 2021,* 129-130, Tokyo, Nov. 2021.
1605. **Retsuo Kawakami, Mimoto Yuki, Akihiro Shirai, Shin-ichiro Yanagiya, Niibe Masahito, Nakano Yoshitaka *and* Takashi Mukai :** Photobactericidal Activity of Anatase Titanium Dioxide Nanoparticles Annealed with the Assistance of Nonequilibrium Atmospheric-Pressure Oxygen Plasma, *Proceedings of International Symposium of Dry Process 2021,* 127-128, Tokyo, Nov. 2021.
1606. **Mimoto Yuki, Retsuo Kawakami, Shin-ichiro Yanagiya, Niibe Masahito, Nakano Yoshitaka *and* Takashi Mukai :** Nonequilibrium Atmospheric-Pressure O2 Plasma-Assisted Annealing Effect on Photocatalytic Activity of Anatase/Rutile-Mixed Phase TiO2 Nanoparticles, *Proceedings of International Symposium of Dry Process 2021,* 131-132, Tokyo, Nov. 2021.
1607. **Kentaro Nagamatsu, Shota Tsuda, Takumi Miyagawa, Reiya Aono, Hideki Hirayama, Yuusuke Takashima *and* Yoshiki Naoi :** The reduction of adduct formation during high-temperature growth in AlN by jet gas stream metalorganic vapor phase epitaxy, *Photonics West 2022,* 12001-6, San Francisco, Jan. 2022.
1608. **Shota Tsuda, Takumi Miyagawa, Reiya Aono, Atsushi Tomita, Hideki Hirayama, Yuusuke Takashima, Yoshiki Naoi *and* Kentaro Nagamatsu :** Threshold temperature in annihilation radius of dislocation for AlN, *Photonics West 2022,* 12001-66, San Francisco, Jan. 2022.
1609. **Shota Tsuda, Takumi Miyagawa, Reiya Aono, Atsushi Tomita, Hideki Hirayama, Yuusuke Takashima, Yoshiki Naoi *and* Kentaro Nagamatsu :** The improvement of crystal orientation in AlN with controlled inversion domain, *Photonics West 2022,* 12001-67, San Francisco, Jan. 2022.
1610. **小川 倖平, 久澤 大夢, 富田 卓朗, 岡田 達也 :** フェムト秒レーザ照射した4H-SiC表面におけるNi電極の電流-電圧特性, *2021年度応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* Fp-5, 2021年7月.
1611. **泉 匠人, 川上 烈生, 粟飯原 睦美, 松村 拓海, 白井 昭博, 宮脇 克行, 向井 孝志 :** 植物養液への大気圧低温空気プラズマジェット殺菌効果, *2021年度 応用物理・物理系学会中国四国支部 合同学術講演会,* 40, 2021年7月.
1612. **神谷 大樹, 西野 克志 :** テクスチャSi基板上に真空蒸着法で堆積したBaSi2膜の評価, *2021年度 応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* Fa-7, 2021年7月.
1613. **森 哲哉, 西野 克志 :** 温度変調した昇華法によるAlNの結晶成長, *2021年度 応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* Gp-6, 2021年7月.
1614. **安原 遼, 西野 克志 :** 昇華法によるN面AlN基板上への厚膜AlNの結晶成長, *2021年度 応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会,* Gp-7, 2021年7月.
1615. **藤原 颯真, 笠井 康平, 味元 勇樹, 菅野 智士, 南 康夫, 川上 烈生, 柳谷 伸一郎 :** 金/酸化チタンナノバレット構造の作製と光特性評価, *2021年度応用物理・物理系学会合同学術講演会,* Gp-5, 2021年7月.
1616. **富田 敦之, 津田 翔太, 青野 零弥, 宮川 拓己, 平山 秀樹, 髙島 祐介, 直井 美貴, 永松 謙太郎 :** 気相反応を抑制した高温MOVPEにおけるV/III比依存性, *応用物理学会中四国支部若手研究会,* 2021年8月.
1617. **津田 翔太, 宮川 拓己, 富田 敦之, 平山 秀樹, 髙島 祐介, 直井 美貴, 永松 謙太郎 :** 極性制御による高品質AlN成長手法の確立, *応用物理学会中四国支部若手研究会,* 2021年8月.
1618. **小川 倖平, 富田 卓朗, 久澤 大夢, 岡田 達也 :** フェムト秒レーザ誘起改質を導入した SiC 単結晶表面における Ni 電極形成, *日本金属学会中国四国支部第61回講演大会 講演概要集,* A16, 2021年8月.
1619. **秋山 大介, 川崎 祐, 岸本 豊, 真岸 孝一, 中村 浩一, 西野 克志, 何 長振, 伊藤 満 :** スピンギャップを持つ擬一次元系交代鎖BaCu2V2O8のNMR, *日本物理学会秋季大会,* 2021年9月.
1620. **川上 烈生 :** 新規光触媒材料の開発と食品鮮度保持への応用と展望, *日本防菌防黴学会 第48回年次大会,* 80, 2021年9月.
1621. **高尾 祐希, 川上 烈生, 白井 昭博, 味元 勇樹, 粟飯原 睦美, 向井 孝志 :** アナターゼ型光触媒TiO2ナノ粒子による非接触殺菌効果, *日本防菌防黴学会 第48回年次大会,* 136, 2021年9月.
1622. **味元 勇樹, 川上 烈生, 白井 昭博, 柳谷 伸一郎, 向井 孝志 :** 大気圧低温プラズマ支援熱焼結したアナターゼ/ルチル混晶型TiO2ナノ粒子の殺菌効果, *日本防菌防黴学会 第48回年次大会,* 137, 2021年9月.
1623. **髙島 祐介, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 光吸収を持つ導波路構造を利用した屈折率検出の高感度化, *第82回応用物理学会秋季学術講演会,* 11p-N205-11, 2021年9月.
1624. **三村 一暉, 坂東 賢哉, 山口 誠, 岡田 達也, 富田 卓朗 :** Cuをキャップ層として用いたAlのフェムト秒レーザー誘起構造変化, *第82回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集,* **Vol.82,** 11a-N321-8, 2021年9月.
1625. **片岡 大治, 杉山 良輝, 村上 成汐, 福永 郁也, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** SiC 上グラフェンへの電流注入による赤外線放射の観測, *第82回応用物理学会秋季学術講演会,* **Vol.11a-N306-6,** 2021年9月.
1626. **津田 翔太, 宮川 拓己, 富田 敦之, 平山 秀樹, 髙島 祐介, 直井 美貴, 永松 謙太郎 :** インバージョンドメインの抑制による高品質AlN成長手法の確立, *第82回応用物理学会秋季学術講演会,* 13p-N101-10, 2021年9月.
1627. **髙島 祐介, 笹田 侑, 永松 謙太郎, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** AlNサブ波長回折格子を用いた深紫外ミラーの広帯域化, *第82回応用物理学会秋季学術講演会,* 13a-N324-3, 2021年9月.
1628. **日野 友哉, 西野 克志 :** 直接合成法によるβ-Ga2O3ナノワイヤの作製, *第82回応用物理学会秋季学術講演会,* 23p-P12-11, 2021年9月.
1629. **富田 敦之, 津田 翔太, 宮川 拓己, 髙島 祐介, 直井 美貴, 平山 秀樹, 永松 謙太郎 :** 気相反応を抑制したMOVPEにおけるAlNのV/Ⅲ比依存性, *第50回結晶成長国内会議(JCCG-50),* 27p-A12, 2021年10月.
1630. **富田 敦之, 津田 翔太, 宮川 拓己, 髙島 祐介, 直井 美貴, 平山 秀樹, 永松 謙太郎 :** 気相反応を制御したMOVPEにおけるAlNのV/III比依存性, *第50回日本結晶成長学会,* 2021年10月.
1631. **野澤 明弘, ⾼林 圭祐, 三村 ⼀暉, 富田 卓朗, ⼭⼝ 誠 :** フェムト秒レーザー誘起のダイヤモンドの構造変化のラマン 分光法による評価, *2021年度 精密工学会東北支部学術講演会,* A02, 2021年11月.
1632. **⼤⽵ 康介, ⾼林 圭祐, 三村 ⼀暉, ⾼橋 考, 富田 卓朗, ⼩林 洋平, ⼭⼝ 誠 :** Si上DLC膜のレーザー痕のパルス幅・フルエンス依存性, *2021年度 精密工学会東北支部学術講演会,* B05, 2021年11月.
1633. **松尾 繁樹, 杉本 幸大造, 直井 美貴 :** 1光子吸収波長のサブナノ秒レーザーを用いたシリコン基板内部における回折格子の作製, *レーザー学会学術講演会第42回年次大会,* D03-12p-IV-01, 2022年1月.
1634. **富田 卓朗 :** (invited) ワイドバンドギャップ半導体をキャップ層として使用したフェムト秒レーザー照射による新規合金の作製, *レーザー学会学術講演会第42回年次大会,* **Vol.42,** D04-12p-IV-01, 2022年1月.
1635. **中河 義典, 佐野 雅彦, 岡内 茂樹, 向井 孝志, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** 層状物質応用イメージセンサ用受光素子の作製と特性評価, *第69回応用物理学会春季学術講演会,* **Vol.23p-E101-10,** 2022年3月.
1636. **髙島 祐介, 永松 謙太郎, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 高屈折率を有するTiO2極薄膜を用いた深紫外光吸収体, *第69回応用物理学会春季学術講演会,* 24a-E303-9, 2022年3月.
1637. **高林 圭佑, 三村 一暉, 高橋 孝, 富田 卓朗, 小林 洋平, 山口 誠 :** 加工閾値近傍でのピコ秒レー ザー誘起Si上DLC膜の構造評価, *第69回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集,* **Vol.69,** 24a-E106-4, 2022年3月.
1638. **古市 健人, 山本 健, 土屋 叡本, ⾼橋 考, 内海 慶春, 柴田 明宣, 山口 誠, 小林 洋平, 富田 卓朗 :** SiC上DLC膜におけるピコ秒レーザー誘起ナノ周期構造のパルス時間幅依存性, *第69回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集,* **Vol.69,** 24p-E106-1, 2022年3月.
1639. **河野 太洋, 峯 元希, 三村 一暉, 山口 誠, 岡田 達也, 富田 卓朗 :** フェムト秒レーザーアブレーションの走査電子顕微鏡によるその場観察, *第69回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集,* **Vol.69,** 24p-E106-2, 2022年3月.
1640. **宮川 拓己, 津田 翔太, 富田 敦之, 平山 秀樹, 髙島 祐介, 直井 美貴, 永松 謙太郎 :** 高温有機金属気相成長法におけるAlNの特異的なステップバンチング, *第69回応用物理学会春季学術講演会,* 25a-E203-2, 2022年3月.
1641. **富田 敦之, 津田 翔太, 宮川 拓己, 平山 秀樹, 髙島 祐介, 直井 美貴, 永松 謙太郎 :** 低オフ角サファイヤ基板を用いた高温AIN成長におけるV/Ⅲ比依存性, *第69回応用物理学会春季学術講演会,* 25a-E203-3, 2022年3月.
1642. **福永 郁也, 村上 成汐, 大井 基暉, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** グラフェン積層接合における電流スイッチング, *第69回応用物理学会春季学術講演会,* **Vol.25p-E102-15,** 2022年3月.
1643. **中野 泰輔, 中村 俊輔, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** エピタキシャルグラフェン上構造水層のトンネル電流解析, *第69回応用物理学会春季学術講演会,* **Vol.25p-E102-7,** 2022年3月.
1644. **新免 歩, 木下 智裕, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** SiC上グラフェンの液滴発電における異方性, *第69回応用物理学会春季学術講演会,* **Vol.25p-E102-18,** 2022年3月.
1645. **豊留 彬, 中野 由崇, 川上 烈生, 新部 正人 :** Ar+イオン衝撃により p 型 GaN に導入される電気的ダメージの UV 光照射効果, *第69回応用物理学会春季学術講演会,* 2022年3月.
1646. **津田 翔太, 宮川 拓己, 富田 敦之, 平山 秀樹, 髙島 祐介, 直井 美貴, 永松 謙太郎 :** 極性制御による高品質AlN成長手法の確立, *2021年度応用物理学会中国四国支部若手半導体研究会,* 1-12, 2021年8月.
1647. **富田 敦之, 津田 翔太, 青野 零弥, 宮川 拓己, 平山 秀樹, 髙島 祐介, 直井 美貴, 永松 謙太郎 :** 気相反応を抑制した高温MOVPEにおけるV/Ⅲ比依存性, *2021年度応用物理学会中国四国支部若手半導体研究会,* 1-11, 2021年8月.
1648. **髙島 祐介, 永松 謙太郎, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 高屈折率ナノ構造による深紫外∼可視域での発光およびセンシングデバイス, *第173回ラドテック研究会講演会,* 2, 2021年11月.
1649. **髙島 祐介 :** サブ波長構造の特異な光伝搬を利用したフラット型フォトニックデバイス, *第26回光科学若手研究会,* **Vol.5,** 2021年12月.
1650. **川上 烈生, 植田 迅, 味元 勇樹, 白井 昭博, 宮脇 克行, 吉田 雅彦 :** プラズマ支援熱焼結処理したアナターゼTiO2ナノ粒子の光殺菌と鮮度保持効果, *LED総合フォーラム2022 in 徳島,* 133-134, 2022年1月.
1651. **味元 勇樹, 白井 昭博, 柳谷 伸一郎, 川上 烈生 :** プラズマ支援アニーリングしたアナターゼ/ルチル混晶型酸化チタンナノ粒子の光分解と光殺菌効果, *LED総合フォーラム2022 in 徳島,* 135-136, 2022年1月.
1652. **高尾 祐希, 白井 昭博, 味元 勇樹, 粟飯原 睦美, 川上 烈生 :** LED照射下でのアナターゼTiO2ナノ粒子の非接触殺菌効果, *LED総合フォーラム2022 in 徳島,* 137-138, 2022年1月.
1653. **植田 迅, 榎本 康, 岡田 宏, 川上 烈生 :** UV-LED照射下での光触媒酸化チタンナノ粒子の脱臭効果, *LED総合フォーラム2022 in 徳島,* 139-140, 2022年1月.
1654. **原口 雅宣, 永瀬 雅夫, 安井 武史, 木内 陽介, 宮脇 克行, 髙橋 章, 岡久 稔也 :** 2021年度におけるLEDライフイノベーション総合プラットフォーム推進事業の取り組み, *LED総合フォーラム2022 in 徳島,* P-1, 2022年1月.
1655. **Masao Nagase :** Graphene far infrared emitter, *令和三年度 共同プロジェクト研究発表会,* Feb. 2022.
1656. **川上 烈生 :** 光触媒材料と光触媒効果, 徳島大学 人と地域共創センター, 東京, 2022年10月.
1657. **川上 烈生 :** 光触媒効果の実習とワークショップ, 徳島大学 人と地域共創センター, 東京, 2022年10月.
1658. **Taichi Kataoka, Fumiya Fukunaga, Naruse Murakami, Yoshiki Sugiyama, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Far-infrared emission from graphene on SiC by current injection, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.61,** *No.SD,* SD1019-(6pp), 2022.
1659. **Nakagawa Yoshinori, Okauchi Shigeki, Sano Masahiko, Takashi Mukai, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Graphene/AlGaN Schottky barrier photodiodes and its application for array devices, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.61,** *No.SD,* SD1013-(6pp), 2022.
1660. **Kentaro Nagamatsu, Shota Tsuda, Takumi Miyagawa, Reiya Aono, Hideki Hirayama, Yuusuke Takashima *and* Yoshiki Naoi :** Reduction of parasitic reaction in high temperature AlN growth by jet stream gas flow metal organic vapor phase epitaxy, *Scientific Reports,* **Vol.12,** 7662, 2022.
1661. **Keisuke Takabayashi, Kazuki Mimura, Takuro Tomita *and* Makoto Yamaguchi :** Characterization of Femtosecond Laser-induced Structural Changes in CVD Diamond by Raman Spectroscopy, *Journal of Laser Micro/Nanoengineering,* **Vol.17,** *No.2,* 103-106, 2022.
1662. **Keisuke Takabayashi, Takashi Takahashi, Eibon Tsuchiya, Kazuki Mimura, Yoshiyuki Yamamoto, Yohei Kobayashi, Takuro Tomita *and* Makoto Yamaguchi :** Morphology and structure of diamondlike carbon flm induced by picosecond laser ablation, *Applied Physics. A, Materials Science & Processing,* **Vol.128,** 850-1-850-6, 2022.
1663. **Tatsuya Okada, Kenya Bando, Fumiya Iwaasa, Tomoyuki Ueki, Hiromu Hisazawa *and* Takuro Tomita :** Boron ion implantation on femtosecond-laser-irradiated diamond surface, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.61,** *No.10,* 102002-1-102002-5, 2022.
1664. **Sohta Yamasaki, Hiroki Nakai, Keita Murayama, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Electron transfer characteristics of amino acid adsorption on epitaxial graphene FETs on SiC substrates, *AIP Advances,* **Vol.12,** *No.10,* 105310-1-105310-5, 2022.
1665. **Retsuo Kawakami, Mutsumi Aihara, Takuto Izumi, Akihiro Shirai *and* Mukai Takashi :** Bactericidal Effects of Low-Temperature Atmospheric-Pressure Air Plasma Jets with No Damage to Plant Nutrient Solutions, *Biochemical Engineering Journal,* **Vol.187,** 108661:1-108661:9, 2022.
1666. **Yuusuke Takashima, Kentaro Nagamatsu, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Ultra-thin deep ultraviolet perfect absorber using an Al/TiO2/AlN system, *Optics Express,* **Vol.30,** *No.24,* 44229-44239, 2022.
1667. **Retsuo Kawakami, Yuki Takao, Akihiro Shirai *and* Takashi Mukai :** Remote Bactericidal Effect of Anatase TiO2 Photocatalytic Nanoparticles Annealed with Low-Temperature O2 Plasma, *Biocontrol Science,* **Vol.27,** *No.4,* 217-222, 2022.
1668. **Kentaro Nagamatsu, Miyagawa Takumi, Tomita Atsushi, Hirayama Hideki, Yuusuke Takashima *and* Yoshiki Naoi :** High growth temperature for AlN by jet stream gas flow metalorganic vapor phase epitaxy., *Scientific Reports,* **Vol.13,** 2438, 2023.
1669. **Tomita Atsushi, Miyagawa Takumi, Hirayama Hideki, Yuusuke Takashima, Yoshiki Naoi *and* Kentaro Nagamatsu :** Investigation of V/III ratio dependencies for optimizing AlN growth during reduced parasitic reaction in metalorganic vapor phase epitaxy., *Scientific Reports,* **Vol.13,** 3308.1-7, 2023.
1670. **Motoki Ohi, Fumiya Fukunaga, Hayate Murakami, Hiroyuki Kageshima, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Resistive-switching behavior in graphene-stacked diode, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.62,** SG1031-(5pp), 2023.
1671. **片岡 大治, 久原 拓真, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** SiC 基板上短冊状グラフェンからの遠赤外線放射の観測, *第14回「集積化MEMSシンボジウム」,* 14P2-C-3-(6pp), 2022年.
1672. **福永 郁也, 大井 基暉, 村上 隼瑛, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** グラフェン積層接合への高電界印加による抵抗状態遷移, *第14回「集積化MEMSシンボジウム」,* 14P2-C-2-(5pp), 2022年.
1673. **Tomoki Kusaka, Akihiro Furube, Tetsuro Katayama, Hiroki Kishikawa, Yasuhide Ohno, Masao Nagase *and* Junichi Fujikata :** Demonstration of All-Optical Ultrafast Switching, Using High-Quality Graphene, *27th OptoElectronics and Communications Conference (OECC 2022),* WP-F-4, Toyama, Jul. 2022.
1674. **Masao Nagase :** Functional devices fabricated using single crystal graphene on SiC substate, --- [Invited] ---, *3rd Int. Conf. on Nanomaterials and Advanced Composites (NAC 2022),* **Vol.Keynote Talks IV,** Tokushima, Jul. 2022.
1675. **Yuusuke Takashima, Kentaro Nagamatsu, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Ultraviolet violet applications utilizing high refractive index subwavelength structure with ultra-thin thickness, *The 12th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics (META 2022),* 1A8, Online, Jul. 2022.
1676. **Masao Nagase :** Single-crystal graphene devices, --- [Invited] ---, *Int. Conf. on Physics and its Applications (Physics 2022),* **Vol.Session-II,** Online, Jul. 2022.
1677. **Tomoki Kusaka, Akihiro Furube, Tetsuro Katayama, Hiroki Kishikawa, Yasuhide Ohno, Masao Nagase *and* Junichi Fujikata :** Ultrafast All-Optical Switching with High-Quality Graphene and its Polarization Effect, *15th Pacific Rim Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO Pacific Rim, CLEO-PR 2022),* CTuA2D-04, Sapporo, Aug. 2022.
1678. **Kentaro Nagamatsu, Takumi Miyagawa, Atsushi Tomita, Hideki Hirayama, Yuusuke Takashima *and* Yoshiki Naoi :** The high-temperature growth in AlN with the unaffected parasitic reaction by Jet gas stream MOVPE, *International Workshop on Nitride semiconductor 2022,* Berlin, Oct. 2022.
1679. **Takumi Miyagawa, Atsushi Tomita, Shota Tsuda, Hideki Hirayama, Yuusuke Takashima, Yoshiki Naoi *and* Kentaro Nagamatsu :** Dependence of c-plane sapphire misorientation angle in high temperature AlN growth and specific step bunching at large angle, *International Workshop on Nitride semiconductor 2022,* Berlin, Oct. 2022.
1680. **Takumi Miyagawa, Atsushi Tomita, Hideki Hirayama, Yuusuke Takashima, Yoshiki Naoi *and* Kentaro Nagamatsu :** Lateral epitaxial overgrowth by mass transport in AlN with the temperature of 1700, *International Workshop on Nitride semiconductor 2022,* Berlin, Oct. 2022.
1681. **Atsushi Tomita, Shota Tsuda, Takumi Miyagawa, Hirayama Hideki, Yuusuke Takashima, Yoshiki Naoi *and* Kentaro Nagamatsu :** The dependence of the V/III ratio in high-temperature AlN growth with several misorientations off-angle sapphire substrate, *International Workshop on Nitride semiconductor 2022,* Berlin, Oct. 2022.
1682. **Kataoka Taichi, Kuhara Takuma, Fumiya Fukunaga, Ohi Motoki, Murakami Hayate, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Blackbody-like far-infrared emission from electrically biased graphene on SiC, *35th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2022), No.10P-1-11,* 徳島市, Nov. 2022.
1683. **Ohi Motoki, Fumiya Fukunaga, Murakami Hayate, Kageshima Hiroyuki, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Resistive switching behavior in graphene-stacked junction, *35th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2022), No.10P-1-12,* 徳島市, Nov. 2022.
1684. **Yamasaki Sohta, Yasuhide Ohno *and* Masao Nagase :** Amino acids adsorption characteristics of epitaxial graphene FETs on SiC substrates, *35th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2022), No.10P-1-9,* 徳島市, Nov. 2022.
1685. **Matsumoto Takumi, Retsuo Kawakami, Shin-ichiro Yanagiya, Niibe Masahito, Nakano Yoshitaka *and* Takashi Mukai :** Polyethylene Glycol Doping Effects on Photocatalytic Activity of Anatase/Rutile-Mixed Phase TiO2 Nanoparticles, *Proceedings of International Symposium of Dry Process 2022,* 101-102, Osaka, Nov. 2022.
1686. **Matsumura Takumi, Sogawa Ryutaro, Hashimura Nene, Ohashi Koichi, Rie Mukai *and* Retsuo Kawakami :** Effects of Quasi-Atmospheric-Pressure Low-Temperature Air Plasma Jet Irradiation on Increasing Minerals in Fresh Food, *Proceedings of International Symposium of Dry Process 2022,* 123-124, Osaka, Nov. 2022.
1687. **Nomoto Kazuki, Izumi Takuto, Mutsumi Aihara, Takagi Kousuke, Suzuki Misato, Matsumura Takumi, Akihiro Shirai, Takashi Mukai *and* Retsuo Kawakami :** Damage-Less Microbial Inactivation of Plant Nutrient Solutions Irradiated with Atmospheric-Pressure Low-Temperature Air Plasma Jets, *Proceedings of International Symposium of Dry Process 2022,* 127-128, Osaka, Nov. 2022.
1688. **Makino Yuta, Retsuo Kawakami, Shin-ichiro Yanagiya, Niibe Masahito, Nakano Yoshitaka *and* Takashi Mukai :** Atmospheric-Pressure Low-Temperature O2 Plasma-Assisted Annealing on Visible-Light-Induced Photocatalytic Activity of Pt-doped Rutile TiO2 Nanoparticles, *Proceedings of International Symposium of Dry Process 2022,* 125-126, Osaka, Nov. 2022.
1689. **Kusaka Tomoki, Akihiro Furube, Tetsuro Katayama, Hiroki Kishikawa, Yasuhide Ohno, Masao Nagase *and* Junichi Fujikata :** Demonstration of All-Optical Ultrafast Switching, Using High-Quality Graphene, *pLED international symposium 2023,* P-9, Mar. 2023.
1690. **岸田 崇秀, 植木 智之, 富田 卓朗, 岡田 達也 :** フェムト秒レーザ照射したSiC表面におけるNi電極形成, *2022年度 応用物理学会中国四国支部学術講演会 講演概要集,* Aa-1, 2022年7月.
1691. **岩浅 郁哉, 植木 智之, 富田 卓朗, 岡田 達也 :** フェムト秒レーザ照射したダイヤモンド結晶表面へのホウ素イオン注入, *2022年度 応用物理学会中国四国支部学術講演会 講演概要集,* Aa-2, 2022年7月.
1692. **大前 隆史, 大野 恭秀, 安澤 幹人, 永瀬 雅夫 :** 塩酸中におけるSiC上グラフェンFETのpH依存性, *2022年度応用物理学・物理系中国四国支部学術講演会,* Gp-1, 2022年7月.
1693. **古市 建人, 山口 誠, 岡田 達也, 富田 卓朗 :** SiC上のAu/Cu積層膜へのフェムト秒 レーザー照射, *2022年度 応用物理学会中国四国支部学術講演会 講演概要集,* Aa-4, 2022年7月.
1694. **河野 太洋, 山口 誠, 岡田 達也, 富田 卓朗 :** 銅/亜鉛界面へのフェムト秒レーザー照射による非熱力学的な合金生成手法, *2022年度 応用物理学会中国四国支部学術講演会 講演概要集,* Aa-5, 2022年7月.
1695. **岩浅 郁哉, 植木 智之, 久澤 大夢, 富田 卓朗, 岡田 達也 :** ダイヤモンド表面に形成したフェムト秒レーザ誘起改質によるホウ素イオ ン導入促進, *日本金属学会中国四国支部第65回講演大会講演概要集,* B14, 2022年8月.
1696. **岸田 崇秀, 植木 智之, 久澤 大夢, 富田 卓朗, 岡田 達也 :** フェムト秒レーザ照射したSiC表面におけるNiシリサイド形成, *日本金属学会中国四国支部第65回講演大会講演概要集,* B15, 2022年8月.
1697. **松本 拓海, 川上 烈生, 柳谷 伸一郎, 新部 正人, 中野 由祟, 向井 孝志 :** ポリエチレングリコールドーピングによるアナターゼ/ルチル混晶型酸化チタンナノ粒子の光触媒活性増強効果, *2022年第83回応用物理学会秋季学術講演会,* 05-024, 2022年9月.
1698. **野本 和希, 泉 匠人, 粟飯原 睦美, 高木 皓介, 鈴木 美里, 松村 拓海, 白井 昭博, 向井 孝志, 川上 烈生 :** 植物養液への大気圧低温空気プラズマジェットによるダメージレス微生物不活化効果, *2022年第83回応用物理学会秋季学術講演会,* 07-041, 2022年9月.
1699. **松村 拓海, 十川 竜太朗, 橋村 寧々, 大橋 孝一, 向井 理恵, 川上 烈生 :** 準大気圧低温空気プラズマジェット照射による食品機能性成分増量効果, *2022年第83回応用物理学会秋季学術講演会,* 07-042, 2022年9月.
1700. **Yuusuke Takashima, Masanobu Haraguchi *and* Yoshiki Naoi :** Enhancement of Polar Kerr Magneto-Optical Effect in wide wavelength region using TiO2/Fe/Ag multilayer system, *第83回応用物理学会秋季学術講演会 JSAP-Optica-SPP Joint Symposia 2022,* 20p-C304-12, Sep. 2022.
1701. **高田 晃平, 西野 克志 :** 直接合成法によるβ-Ga2O3薄膜成長における高品質化に向けた検討, *第83回応用物理学会秋季学術講演会,* 20p-B203-5, 2022年9月.
1702. **岩浅 郁哉, 植木 智之, 富田 卓朗, 岡田 達也 :** ダイヤモンド表面へのフェムト秒レーザ照射とホウ素イオン注入, *2022年第83回応用物理学会秋季学術講演会概要集,* 22a-C301-9, 2022年9月.
1703. **山内 俊, 柳谷 伸一郎, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫, 南 康夫 :** テラヘルツ時間領域分光法を用いた4H-SiC上の単層グラフェンの分光特性の評価, *2022年第83回応用物理学会秋季学術講演会,* 22p-P02-7, 2022年9月.
1704. **日下 智貴, 古部 昭広, 片山 哲郎, 岸川 博紀, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫, 藤方 潤一 :** SiC 上高品質グラフェンを用いた全光型超高速光スイッチ, *2022年第83回応用物理学会秋季学術講演会,* 22p-A402-17, 2022年9月.
1705. **亀井 優之, 山口 誠, 岡田 達也, 富田 卓朗 :** フェムト秒レーザー照射によるAlのSiCへの局所フルエンスに依存した拡散, *2022年第83回応用物理学会秋季学術講演会概要集,* 23p-C301-2, 2022年9月.
1706. **河野 太洋, 山口 誠, 岡田 達也, 富田 卓朗 :** 銅/亜鉛界面へのフェムト秒レーザー照射による新奇金属合金化手法, *2022年第83回応用物理学会秋季学術講演会概要集,* 23p-C301-3, 2022年9月.
1707. **牧野 祐大, 川上 烈生, 柳谷 伸一郎, 新部 正人, 中野 由祟, 向井 孝志 :** 白金ドープしたルチル型酸化チタンナノ粒子への大気圧低温酸素プラズマ支援アニーリング効果, *2022年第83回応用物理学会秋季学術講演会,* 07-101, 2022年9月.
1708. **西野 克志, 森 俊之輔, 山下 颯乃佳, 于 京芳 :** 真空蒸着法により作製した BaSi2膜におけるクラックの低減および厚膜化の試み, *第83回応用物理学会秋季学術講演会,* 23a-C101-4, 2022年9月.
1709. **下浦 琉, 西野 克志 :** ガラス基板上へのβ-Ga2O3ナノワイヤの作製, *令和4年度 電気・電子・情報関係学会四国支部連合大会,* 11-9, 2022年9月.
1710. **松岡 稜河, 西野 克志 :** 真空蒸着法による n 型 Si 基板上への BaSi2 薄膜成長, *令和4年度 電気・電子・情報関係学会四国支部連合大会,* 11-10, 2022年9月.
1711. **根津 武寛, 宮川 拓己, 髙島 祐介, 永松 謙太郎, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 2層サブ波長格子による紫外域用高感度屈折率検出素子の検討, *日本光学会年次学術講演会 Optics & Photonics Japan 2022,* **Vol.P14,** 2022年11月.
1712. **笹田 侑, 宮川 拓己, 髙島 祐介, 永松 謙太郎, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** エアギャップ型高屈折率差サブ波長格子を用いた深紫外高反射リフレクターの提案, *日本光学会年次学術講演会 Optics & Photonics Japan 2022,* **Vol.P15,** 2022年11月.
1713. **橋本 一輝, 池之上 篤志, 安澤 幹人, 倉科 昌, 永瀬 雅夫 :** FIB-CVD法を用いた安定なナノピラーの作製および細胞挿入の検討, *2022年度日本化学会中国四国支部大会,* 2022年11月.
1714. **福永 郁也, 大井 基暉, 村上 隼瑛, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** グラフェン積層接合への高電界印加による抵抗状態遷移, *第14回「集積化MEMSシンボジウム」, No.14P2-C-2,* 2022年11月.
1715. **片岡 大治, 久原 拓真, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** SiC 基板上短冊状グラフェンからの遠赤外線放射の観測, *第14回「集積化MEMSシンボジウム」, No.14P2-C-3,* 2022年11月.
1716. **森 優介, 松村 大夢, 村山 圭汰, 竹下 凌哉, HOANG ANH TUNG, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫, 田端 厚之, 長宗 秀明 :** His-tag 法を用いた SiC 上グラフェンへの抗体配向修飾技術, *第39回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム,* **Vol.16P2-P-52,** 2022年11月.
1717. **富田 敦之, 宮川 拓己, 平山 秀樹, 髙島 祐介, 直井 美貴, 永松 謙太郎 :** 気相反応抑制下におけるAlN高温成長の最適化のためのV/III比依存性, *第14回ナノ構造エピタキシャル成長講演会,* Fr-P19, 2022年11月.
1718. **加藤 優遼, 髙島 祐介, 永松 謙太郎, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 高屈折率差サブ波長周期構造を2つ組み合わせた2波長屈折率センサーの検討, *レーザー学会学術講演会第43回年次大会,* P01-20p-P-19, 2023年1月.
1719. **粟飯原 睦美, 泉 匠人, 白井 昭博, 向井 孝志, 川上 烈生 :** 非平衡大気圧プラズマジェットを用いた植物栽培における養液の衛生管理技術の開発, *第96回日本細菌学会総会,* 2023年3月.
1720. **橋村 寧々, 十川 竜太朗, 松廣 美優, 松村 拓海, 大橋 孝一, 川上 烈生, 向井 理恵 :** 準大気圧低温空気プラズマジェットを活用したタマネギ中ポリフェノールの増産, *日本農芸化学会2023年度大会,* 2023年3月.
1721. **和泉 建哉, 桑島 史欣, 谷 正彦, 守安 毅, 岡本 敏弘, 山口 堅三, 直井 美貴, 髙島 祐介, 原口 雅宣 :** ボウタイ型プラズモンアンテナの作製, *第70回応用物理学会春季学術講演会,* 15p-PB01-2, 2023年3月.
1722. **髙島 祐介, 永松 謙太郎, 原口 雅宣, 直井 美貴 :** 大きな光損失性材料を含む多層膜構造を用いた高感度屈折率検出の提案, *第70回応用物理学会春季学術講演会,* 17p-A305-14, 2023年3月.
1723. **久原 拓真, 片岡 大治, 大野 恭秀, 永瀬 雅夫 :** グラフェン遠赤外エミッタを用いた材料判別, *第70回応用物理学会春季学術講演会,* **Vol.17p-B309-14,** 2023年3月.
1724. **藤方 潤一, 日下 智貴, 関 和彦(産総研), 乗松 航(名古屋大), 伊藤 孝寛(名古屋大), 片山 哲郎, 永瀬 雅夫, 古部 昭広 :** SiC上グラフェンを用いた高速非線形光学応答, *2023年第70回応用物理学会春季学術講演会,* 17a-D215-5, 2023年3月.
1725. **富田 敦之, 宮川 拓己, 平山 秀樹, 髙島 祐介, 直井 美貴, 永松 謙太郎 :** 超高温MOVPEを用いたAlGaN成長, *第70回応用物理学会春季学術講演会,* 2023年3月.
1726. **古市 健人, 山口 誠, 岡田 達也, 富田 卓朗 :** SiC上のFe/Cr/Ni 積層膜へのフェムト秒レーザー照射, *第70回 応用物理学会春季学術講演会,* **Vol.70,** 18a-A405-6, 2023年3月.
1727. **河野 太洋, 土屋 叡本, 山口 誠, 岡田 達也, 小林 洋平, 富田 卓朗 :** 鉄/クロム/ニッケル薄膜へのピコ秒レーザー照射による新奇合金生成のパルス時間幅依存性, *第70回 応用物理学会春季学術講演会,* **Vol.70,** 18a-A405-7, 2023年3月.
1728. **藤田 将希, 宮川 拓己, 富田 敦之, 平山 秀樹, 髙島 祐介, 直井 美貴, 永松 謙太郎 :** MOVPE 超高温 成長中断 アニーリングによる A lN 転位低減手法, *応用物理学会中四国支部・若手半導体研究会,* 2022年8月.
1729. **藤井 滉樹, 宮川 拓己, 富田 敦之, 平山 秀樹, 髙島 祐介, 直井 美貴, 永松 謙太郎 :** X線回折を用いたステップバンチングの発生オフ角評価, *応用物理学会中四国支部・若手半導体研究会,* 2022年8月.
1730. **川上 烈生, 高木 皓介, 白井 昭博, 宮脇 克行, 立木 弥生, 吉田 雅彦, 福光 秀之 :** 可視光LED照射したグラファイト状窒化炭素の鮮度保持効果, *次世代光フォーラム2023 in 徳島,* 111-112, 2023年2月.
1731. **高木 皓介, 鈴木 美里, 松本 拓海, 粟飯原 睦美, 川上 烈生 :** 高圧アニーリングにより形成させたグラファイト状窒化炭素のLED光分解効果, *次世代光フォーラム2023 in 徳島,* 113-114, 2023年2月.
1732. **和泉 建哉, 岡本 敏弘, 山口 堅三, 直井 美貴, 髙島 祐介, 谷 正彦, 桑島 史欣, 守安 毅, 原口 雅宣 :** ナノ構造を搭載したボウタイ型アンテナの作製, *次世代光フォーラム2023 in 徳島,* P-10, 2023年2月.
1733. **Masao Nagase :** Single-crystal graphene functional device, *令和四年度 共同プロジェクト研究発表会,* Feb. 2023.